

جی نویز

Noise

ماهنامه تخصصی برق و الکترونیک ECA

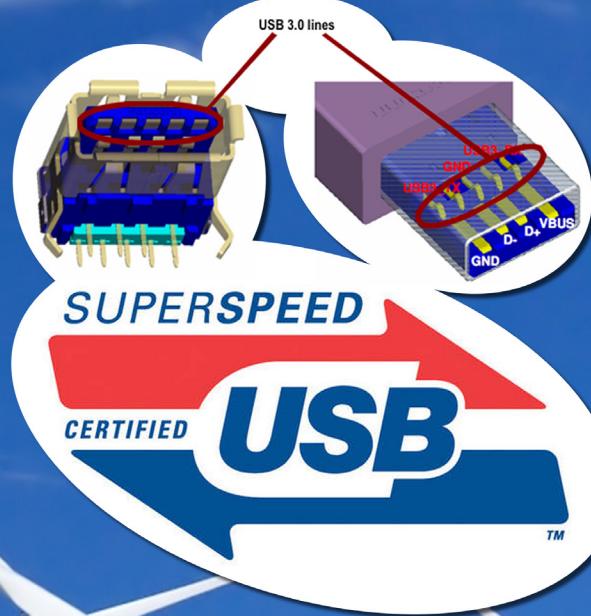
مهر ۹۴

شماره ۱

سال اول



ZigBee®



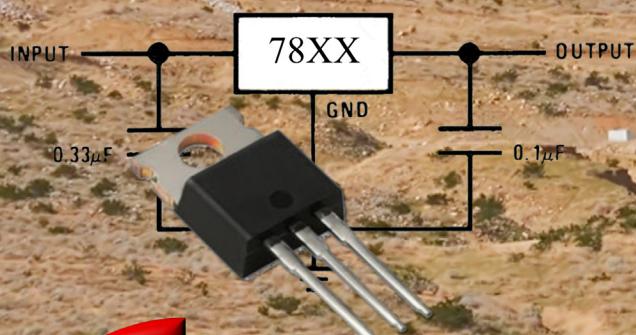
بررسی ساختار USB3.0

مقاله آموزشی کار با لامینت

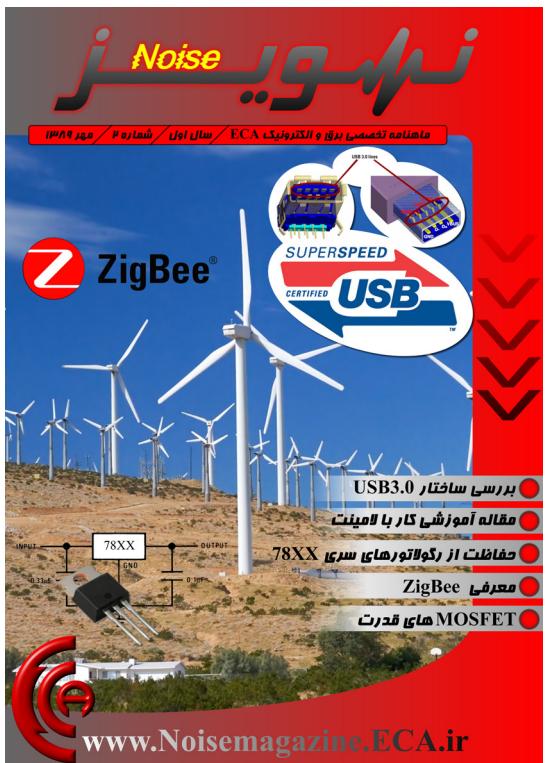
حافظت از رگولاتورهای سری 78XX

معرفی ZigBee

معرفی های قدرت MOSFET



www.Noisemagazine.ECA.ir



صفحه

فهرست مطالب :

۱	مدار جانشین کننده خازن های فوق العاده به جای باتری ها
۲	تکنولوژی باتری های شارژی توسعه یافته برای مصارف نظامی
۳	بررسی ساختار USB3.0
۴	طراحی فانکشن ژنراتور
۱۳	تراسه VNC1L
۱۶	مدار راه انداز موتورهای پله ای بدون نیاز به میکروکنترلر
۲۲	حافظت از رگولاتورهای سری 78XX
۲۵	شروعی ساده با Fat در محیط CodeVision
۳۰	ترسیم منحنی های سه بعدی در متلب
۳۷	پیاده سازی FPGA توسط نرم افزار Altium Designer
۳۹	معرفی آی سی 74HC4046
۴۷	طراحی فیلتر پائین گذر با استفاده از خطوط انتقال
۵۲	استاندارد مواد پایه مدارهای چاپی
۵۸	مقاله آموزشی کامل و گام به گام کار با لامینت
۶۳	نیروگاه بادی بینالود
۷۱	MOSFET های قدرت ۱
۷۷	Charles K. Kao
۸۴	Robust Control of a Mobile Inverted Pendulum Robot Using a RBF Neural Network Controller
۸۵	

noise

مجله تخصصی برق و الکترونیک نویز
سال اول - شماره ۲ - مهر ۱۳۸۹

صاحب امتیاز : وب سایت تخصصی برق و الکترونیک ECA
www.ECA.ir

سردیر : امیرعلی بلورچیان
مدیر اجرایی : فرشاد اکرمی
وب سایت اختصاصی مجله : www.Noisemagazine.ECA.ir

منشور مجله نویز

الف - معرفی

ماهنامه نویز، نشریه ای است علمی، خبری، آموزشی که با تکیه بر خلاقیت و نوآوری کارشناسان ایرانی و انجام کار گروهی آنان به مخاطبان خود کمک می کند تا نیازهای خود را در شکل مکتوب در این نشریه محقق شده بیابند.

ب - اهداف

۱- پیشبرد فرهنگ علم گرایی در کشور
۲- ایجاد روحیه تلاش و امید در نسل جوان
۳- توسعه کمی و کیفی روزافزون به سوی نشریه ای وزین، فراگیر و کم اشکال

۴- اطلاع رسانی به روز علوم مرتبط

ج- اصول و ارزش ها

۱- احترام به مخاطب

۲- راستی در گفتار و رفتار میان دست اندک کاران نشریه

۳- تلاش مستمر برای بهبود

۴- استفاده از پتانسیل موجود در قشر تحصیل کرده کشور

د- حوزه های فعالیت (موضوعات کلیدی)

۱- آموزش مبانی علوم برق و الکترونیک

۲- آشنایی با تکنولوژی های نوین دنیای فناوری

۳- طراحی مدارات آنالوگ و دیجیتال

۴- آموزش و معرفی نکات کاربردی پردازندۀ ها

۵- مدارات مجتمع

۶- آموزش کاربردی نرم افزارهای تخصصی

۷- سیستم ها و مدارات مخابراتی

۸- سیستم های قدرت

۹- معرفی مشاهیر برق

۱۰- موارد کاربردی و عملی علم الکترونیک

۱۱- بخش های متنوع مرتبط با موضوعات برق و الکترونیک

* استفاده از مقاله های مجله، با ذکر مأخذ و رعایت حقوق نویسنده بلامانع است.

* مجله نویز آماده دریافت آثار و مقالات ارسالی متخصصین و مهندسین است.

* لطفاً مقاله های خود را بصورت تایپ شده به همراه ضمیمه عکس های مورد استفاده ارسال نمایید.

* نشریه در ویرایش و اصلاح مطالب رسیده، آزاد است.

* چنانچه مطلب ارسالی ترجمه است، کپی اصل آن را ضمیمه نمایید.

صندوق پست الکترونیکی مجله : noisemagazine.eea@gmail.com



مدار جانشین کننده خازن های فوق العاده به جای باتری ها

بالاتر و موازی همدیگر در مدار استفاده کرد. وقتی که مقدار شارژ این خازن ها به 25% از حالت شارژ برسد و زمانی که ولتاژ آنها به $2.5V$ پایین تر از ولتاژ مرجع کاهش پیدا کند، انرژی تراشه به اتصالات خازن باز می گردد. این کلید پس از فعال شدن دو جفت متصل سری، موازی از خازن ها بوجود می آورد. ولتاژ هر جفت خازن موازی شده، برابر با ولتاژ مجموع همان خازن ها و یا $5V$ است. این مدار باعث بازگشت انرژی برای کار در دستگاه است. زمانی که شارژ خازن تخلیه شود مجدداً خازن، از راه دو جفت خازن سری در موازی شده به میزان کمتر از $1.25V$ شارژ می شود. بعد از آن تراشه کنترلی سیستم دوباره انرژی را مانند آن 4 خازن سری شده با هم که دارای ولتاژ $2.5V$ است در مدار انباسته می کند. در همان زمان افت ولتاژ دوباره به نقطه ناسازگار مدارات در دستگاه می رسد و 98% از شارژ اصلی استفاده می شود. هنگامی که خازن ها شارژ هستند عمل انباسته شدن معکوس می شود و به دو جفت خازن سری متصل شده و تنظیمات

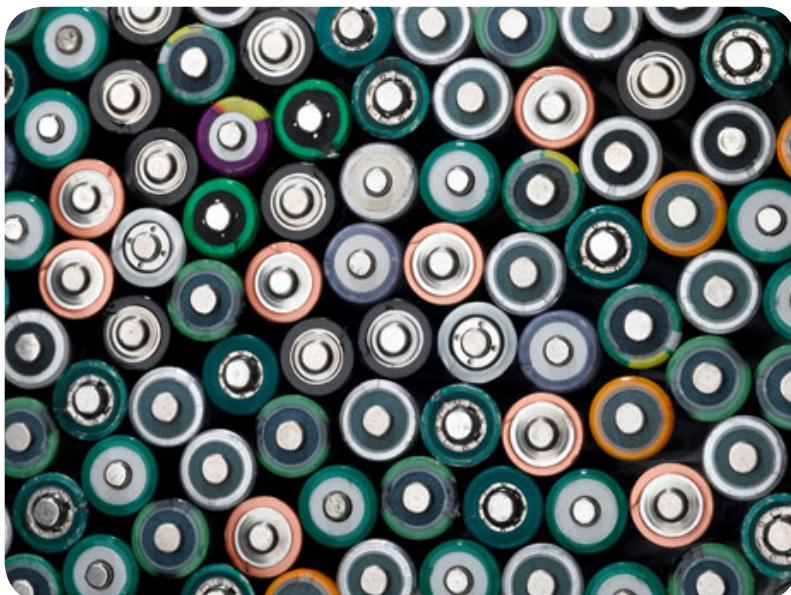
و پیکره بندی اصلی به صورت 4 خازن موازی انجام می شود. به گفته ویلیام سانچز، دانشجوی کارشناسی ارشد و سرپرست این پروژه، بالابردن راندمان مبدل های DC به DC یکی از چند موردی است که نیاز به پیشرفت آن احساس می شد و با این مدار امکان ارتقای آن ایجاد شد. در اولین آزمایش گزارش شده در این هفته تقریباً نیمی از انرژی از خازن به بار منتقل شده است. انتظار می رود اولین نسخه از تراشه انرژی سانچز در تابستان ارائه گردد که 65 تا 85 درصد کارآمد خواهد بود. او نیز بیان کرد 90 درصد از هدف ما برای ساخت این تراشه، دستگاه های تجاری بوده است.

<http://spectrum.ieee.org>

منبع :

Msn.elecomp@gmail.com

مترجم : میلاد صفایی نیا



مهندسين موسسه تكنولوجی MIT در حال طراحی و توسيعه مداری هستند که در آن به اندازه کافی از خازن های فوق العاده بکار رفته تا در ايمپلنت های (کاشت) پزشکی قابل استفاده باشند.

در نشيست مدارات VLSI در هاوابي، يك تيم مهندسي از موسسه تكنولوجی MIT گزارش اختراع يك تراشه ذخيره کننده انرژي که به گفته آنها يکی از آخرین موائع فني در طراحی مدار بوده را دادند. انتخاب خازن های فوق العاده به جای باتری ها به عنوان ذخيره کننده انرژي الکترونيکي برای کاربرد های خاص و ريزتراشه ها در الکترونيک است.

چندين مزيت خازن های فوق العاده نسبت به باتری ها عبارتند از چگالي انرژي بالا، شارژ سريع و قابلیت شارژ و دشارژ شدن نامحدود در يك چرخه ذخيره سازی انرژي. يکی از اشكالاتی که در خازن های فوق العاده وجود دارد اينست که در زمان شارژ شدن ولتاژ آنها کاهش پیدا می کند، در صورتی که اين ولتاژ در باتری، به هنگام شارژ کردن مجدد آن ثابت است. در زمانی که مقدراً شارژ خازن

های فوق العاده به 25% از حالت شارژ خود می رسد، ولتاژ آنها به نصف کاهش پیدا می کند (در صورتی که ولتاژ باتری های ساخته شده از سرب و اسید به میزان 5% در زمان شارژ کاهش پیدا می کند). از آنجاکه تراشه ها معمولاً در يك محدوده باريک ولتاژ فعال هستند و کاهش ولتاژ خازن های فوق العاده باعث غير فعال شدن آنها و یا تداخل در عملکرد مثل خواندن و نوشتن خطها در حافظه می شود.

$1/4$ از انرژي ذخيره شده خازن های فوق العاده در هر دستگاه مورد قبول هیچ کسی در زمينه استفاده کارآمد از انرژي نبود. بنابراین تيم مهندسي موسسه تكنولوجی MIT با راهی زيرکانه مانع از افت ولتاژ در مدار شده که اين باعث مصرف تمام انرژي در مدار می شود. اين مدار که به سرعت در حال پیشرفت است می تواند خازن های فوق العاده که دارای شارژ بيشتری هستند و ولتاژ آنها ثابت است را پیکره بندی کند. به عنوان مثال می توان برای تراشه های دارای ابعاد $1.3mm \times 1.4mm$ با ظرفیت $250mF-25V$ 4 عدد خازن $1.4mm$ تا $1.3mm$ از

تکنولوژی باتری های شارژی توسعه یافته برای مصارف نظامی



نقليه هوایي بدون سرنشين بازرسی می باشد.

ساخت باتری با وزن کم و طول عمر بالا که می تواند لباس های شارژی را به حقیقت برساند، می توانید برای مصارف نظامی و شخصی مورد استفاده قرار گیرد.

عموما سربازان می بایستی چند پوند باتری را با خود حمل کند اما اگر شما بتوانید لباس آنها را به یک بسته باتری تبدیل کنید آنها می توانند مقدار بسیاری از وزن را کم کنند . استفاده از این تکنولوژی برای سفر های کاری مکرر که در آن به همراه لوازم الکترونیکی باتری و شارژر های جدا گانه برای کامپیوتر های قابل حمل ، تلفن همراه و دستگاه های دیگر گنجانده شده است نیز مناسب است.

<http://spectrum.ieee.org>

منبع :

n.habibi6650@yahoo.com

مترجم : نوید حبیبی

دانشمندان به فناوری نوینی در تولید انرژی با استفاده از نوعی ویروس برای توسعه و بهبود موادی که دارای بیشترین کارایی در شارژ کردن باتری های لیتیومی می باشد، که می تواند در لباس برای تامین انرژی لوازم الکتریکی قابل حمل بافته شود، دست یافته اند. در دویست و چهل و هشتین جلسه بین المللی جامعه شیمی آمریکا (ACS) که در بوستون برگزار شد بحث برای ماد جدید جوشن مثبت و منفی باتری مطرح شد.

این منابع جدید انرژی در آینده به شکل پارچه مانند لباس فرم یا جلیقه بالیستیک می توانند بافته شوند و یا در سایز و شکل های مختلف ظروف ریخته یا اسپری شوند. دکتر مارک آلن دارای فوق (MIT) گفت: این باتری های قابل تطبیق، انرژی مورد نیاز تلفن های هوشمند، دستگاه های GPS و لوازم قابل حمل الکترونیکی دیگر را می توانند تامین کنند.

دکتر مارک آلن در مورد باتری های پارچه ای گفت: این باتری ها یک بار با لباس بافته می شوند و انرژی مورد نیاز تکنولوژی های جدید را می توانند تامین کنند. از جمله این دستگاه ها می توان به رادیو های دستی، دستگاه های GPS و دستگاه های دیجیتالی شخصی اشاره کرد.

این باتری ها همچنین در تمامی تلفن های همراه و تلفن های هوشمند استفاده می شوند. باتری ها انرژی الکتریکی را به وسیله تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی که به وسیله دو جوشن یکی مثبت و دیگری منفی (آند و کاتد) که توسط الکتروولیت از یکدیگر جدا می باشند تولید می کنند. در جلسه ACS دکتر مارک آلن در شرح این فناوری گفت: برای ساختن جوشن های جدید از ماده فلوراید آهن استفاده شده که می تواند به زودی باتری هایی با وزن کم و قابل انعطاف با کمترین تلفات انرژی، کارایی بهتر و شارژ شدن بهتر در مقایسه با منابع انرژی شارژ شونده امروزی تولید کرد.

دکتر مارک آلن : برای به نتیجه رسیدن در اصل شکست در یک سال گذشته با دانشمندان MIT آنجلا بلچر و همکاران آنها کار کردیم که اولین افرادی بودند که یک ویروس، مانند یک biotemplate را برای درست کردن کاتد و آند باتری های لیتیومی مهندسی کردند. این ویروس باکتری خوار M13 نام گذاری شده و شامل یک پوسته خارجی پروتئینی و یک هسته داخلی ژنتیکی می باشد. آنها تنها بر روی باکتری اثر دارند و ضرری برای مردم ندارند.

استفاده از باکتری خوار M13 به عنوان یک قالب شیمی سبز، یک روش دوستدار محیط زیست برای تولید باتری است. دکتر مارک آلن همچنین گفت: این فعالیت برای تمام مواد در دمای اتاق و در آب ممکن می باشد.

این مواد خطر کمتری از مواد استفاده شده در باتری های لیتیومی راچی دارند زیرا آنها با حرارت پایین تولید می شوند که خطر قابلیت اشتعال را کاهش می دهد.

گروه biomaterial بلچر در مراحل شروع آزمایش و مقایس گذاری مواد باتری فعل شده با ویروس هستند که شامل تامین انرژی وسایل

SUPERSPEED

CERTIFIED

USB

بررسی ساختار USB3.0

مرواری بر ساختار USB3.0 :

این مقاله ساختار گذرگاه سریال جهانی نوع ۳ و مفاهیم کلیدی مربوط به آن را بررسی می کند. USB3.0 شبیه به مدل های اولیه USB است که علت این تشابه وجود گذرگاه (bus) کابلی تقویت کننده تبادل داده ها بین کامپیوتر میزبان و تعداد زیادی از دستگاه جانبی است که در دسترسند. دستگاه های جانبی متصل شده به واسطه پروتکل فرمان یافته میزبان، پنهانی باند را تقسیم می کنند. همزمان با استفاده از کامپیوتر میزبان و سایر دستگاه های جانبی، این پورت به دستگاه های جانبی اجازه اتصال، پیکربندی، استفاده و جداسازی می دهد.

USB3.0 ساختار گذرگاه (bus) دوگانه را مورد استفاده قرار می دهد که سازگاری اندکی با USB2.0 دارد. این امر، عملکرد همزمان تبادل اطلاعات SuperSpeed و غیر SuperSpeed (سرعت های USB2.0) را میسر می سازد. این مقاله به دو مسئله مهم اشاره دارد. نخست مربوط به ساختار و مفاهیم مرتب با عواملی است که پورت SuperSpeed های دوگانه را محدود می کند. دوم به ساختار معین USB3.0 و مفاهیم آن اشاره می کند. از خواننده این مقاله انتظار می رود تا درک صحیحی از مفاهیم ساختاری USB2.0 داشته باشد. برای جزئیات بیشتر به کتاب، مشخصات گذرگاه سریال جهانی ۲ فصل دوم مراجعه کنید.

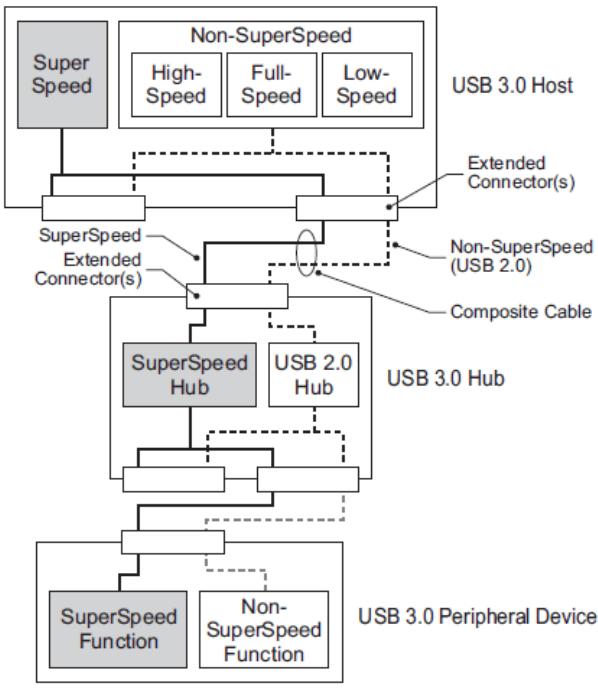
تشریح سیستم USB3.0

USB3.0 پورت فیزیکی است که به طور موازی با پورت فیزیکی USB2.0 ترکیب شده است (شکل ۱). این نوع اجزاء ساختار مشابهی با نوع ۲ آن دارد که عبارتند از:

- اتصال USB3.0

- دستگاه های USB3.0

- میزبان USB3.0



شکل ۱ : ساختار پورت دوگانه USB3.0

شوند. سازگاری forward / backwards مکانیکی و الکتریکی USB3.0 از طریق کابل کامپوزیت و مجموعه های بست وابسته که ساختار گذرگاه دوگانه را تشکیل می دهند، انجام می شود. دستگاه های USB3.0 با حضور واسطه های گذرگاه SuperSpeed و غیر SuperSpeed سازگاری کمتری دارند. میزبان های این USB همچنین شامل واسطه های گذرگاه SuperSpeed و غیر SuperSpeed است که اساساً گذرگاه هایی را که به صورت همزمان فعال هستند، موازی می کنند.

مدل اتصال USB3.0 امکان یافتن و پیکربندی دستگاه های USB در بیشترین سرعت سیگنالی تقویت کننده بوسیله دستگاه، تمامی هاب های بین میزبان و دستگاه ها و همچنین قابلیت میزبان موجود و پیکربندی آنرا می دهد.

هاب های USB3.0 نمونه ای خاص از دستگاه USB هستند که

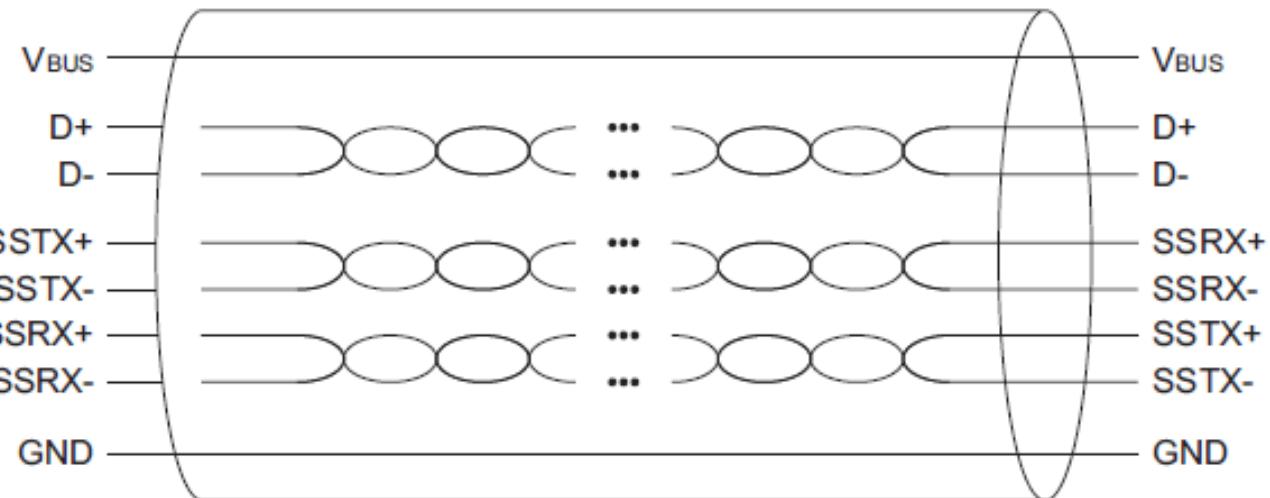
اتصال USB3.0 حالتی است که در آن دستگاه های USB نوع ۳ و نوع ۲ به یکدیگر متصل می شوند و با میزبان نوع ۳ تبادل اطلاعات می کنند. قسمت اتصالی آن شامل اجزای ساختاری اصلی از USB2.0 است، اگرچه بر تعداد بعضی از آنها افزوده شده تا با ساختار پورت دوگانه مطابقت داشته باشند.

توبولوژی ساختاری خط مبنا همانند USB2.0 است که شامل توبولوژی ستاره ای ردیفی همراه با یک میزبان در ردیف ۱ و هاب ها در ردیف های پایین تر است تا امکان اتصال پورت را با دستگاه ها فراهم کند.

مدل اتصال USB3.0 با سازگاری forward / backwards اتصال دستگاه های USB3.0 یا نوع ۲ به پورت نوع ۳ مطابقت می کند.

همچنین دستگاه های USB3.0 می توانند به پورت نوع ۲ متصل

بررسی ساختار USB3.0



شکل ۲ : کابل USB3.0

عملکرد الکتریکی (اتلاف جاندزای، اتلاف بازگشتی، crosstalk وغیره) برای USB3.0 با توجه به کابل های خام، بسته های هم جفت و مجموعه کابل های هم جفت، با قبول الزامات و استفاده از آزمایش صنعتی ویژگی ها که برای دو مورد آخر طراحی شده اند مشخص می شود. به همین نحو الزامات مکانیکی (نیروهای جاندزای/خارج سازی، مقاومت وغیره) و محیطی (دمای حیات، جریان گاز مخلوط وغیره) مشخص شده و از طریق آزمایش صنعتی شناسایی خصوصیات آنها به اثبات رسیده است.

توان USB3.0

این خصوصیات دوچوبه از توان را در نظر می گیرد

- توزيع توان در سراسر USB به موضوعاتی از قبیل اینکه چگونه دستگاه های USB توان را که توسط پورت های هم جهت تولید می شود و به آنها متصل شده اند مصرف می کنند، می پردازد. توزیع توان در USB3.0 همانند نوع ۲، به همراه منابع ذخیره افزایش یافته برای تجهیزات عمل کننده در SuperSpeed است.
- مدیریت نیرو به چگونگی عمل متقابل میزبان ها، دستگاه ها، هاب ها و سیستم نرم افزاری USB رسیدگی می کند تا اینکه عملکرد کارآمد نیرو برای پورت فراهم شود. مدیریت توان بخش پورت نوع ۲ تغییرناپذیر است.

پیکربندی سیستم USB3.0

Dستگاه های USB (با هر سرعتی) را که در هر زمانی به USB3.0 وصل و از آن جدا می شوند، پشتیبانی می کند. در نتیجه سیستم نرم افزار بایستی با تغییرات پویا در توپولوژی فیزیکی پورت مطابقت داشته باشد. عوامل ساختاری برای شناسایی اتصال و جداسازی دستگاه به نوع ۳ همانند عوامل نوع ۲ است. برای مدیریت خصوصیات پورت SuperSpeed در پیکربندی و مدیریت نیرو پیشرفت هایی صورت گرفته است. ساختار مستقل و دوگانه پورت، امکان فعل سازی هر پورت را به صورت مستقل و اتصال دستگاه های USB را به پورت با بالاترین سرعت ممکن برای دستگاه فراهم می سازد.

هدف این ایجاد نقاط اتصالی بیشتر برای پورت، بیش از آنکه توسط میزبان فراهم شده، می باشد. در این ویژگی، دستگاه های غیر هابی به عنوان دستگاه های جانبی قلمداد می شوند تا از دستگاه های هابی متمایز شوند. به علاوه، در USB2.0، واژه «تابع» گاهی اوقات بطور تبادل پذیر با دستگاه ها استفاده می شد. در این ویژگی، تابع مفهوم منطقی مطابق با دستگاه هاست. (شکل ۳)

واسط فیزیکی USB3.0

واسط فیزیکی USB3.0 متشکل از خصوصیات الکتریکی، مکانیکی و فیزیکی برای گذرگاه ها می باشد.

مکانیک USB3.0

تمامی دستگاه های USB از اتصال خلاف جریان (upstream) بهره مند هستند. میزبان ها و هاب ها (که در ادامه تعریف شده اند) از یک یا چند اتصال موافق جریان (downstream) برخوردارند. اتصال های موافق جریان یا خلاف آن بصورت مکانیکی تبادل پذیر نیستند، حذف اتصالات دستگاه لوب بک غیر مجاز در هاب ها از این نوع هستند.

کابل های USB3.0 دارای ۸ رسانای اصلی هستند. ۳ مورد از آنها جفت های سیگنالی به هم تابیده برای مسیرهای داده USB و جفت توان است. شکل ۲ ترتیبات سیگنالی اصلی کابل USB3.0 را نشان می دهد.

علاوه بر جفت سیگنالی تابیده شده مسیر داده USB نوع ۲، دو جفت سیگنالی به هم تابیده برای بوجود آوردن مسیر داده می SuperSpeed استفاده می شود که یکی از آنها برای ارسال مسیر و دیگری برای دریافت مسیر کاربرد دارد.

کانکتورهای USB3.0 (هم جهت و خلاف آن) با فیش های بست نوع ۲ سازگاری کمتری دارند. انتظار نمی رود که کابل ها و فیش های نوع ۳ با کانکتورهای خلاف جریان نوع ۲ سازگاری داشته باشند. برای کمک به کاربران USB3.0، رنگ آمیزی استانداردی برای قسمت های پلاستیکی فیش ها و پریز های آن در نظر گرفته شده است.

Characteristic	SuperSpeed USB	USB 2.0
Power management	Multi-level link power management supporting idle, sleep, and suspend states. Link-, Device-, and Function-level power management.	Port-level suspend with two levels of entry/exit latency Device-level power management
Bus power	Same as for USB 2.0 with a 50% increase for unconfigured power and an 80% increase for configured power	Support for low/high bus-powered devices with lower power limits for un-configured and suspended devices
Port State	Port hardware detects connect events and brings the port into operational state ready for SuperSpeed data communication.	Port hardware detects connect events. System software uses port commands to transition the port into an enabled state (i.e., can do USB data communication flows).
Data transfer types	USB 2.0 types with SuperSpeed constraints. Bulk has streams capability (refer to Section 3.2.8)	Four data transfer types: control, bulk, Interrupt, and Isochronous
Data Rate	SuperSpeed (5.0 Gbps)	low-speed (1.5 Mbps), full-speed (12 Mbps), and high-speed (480 Mbps)
Data Interface	Dual-simplex, four-wire differential signaling separate from USB 2.0 signaling Simultaneous bi-directional data flows	Half-duplex two-wire differential signaling Unidirectional data flow with negotiated directional bus transitions
Cable signal count	Six: Four for SuperSpeed data path Two for non-SuperSpeed data path	Two: Two for low-speed/full-speed/high-speed data path
Bus transaction protocol	Host directed, asynchronous traffic flow Packet traffic is explicitly routed	Host directed, polled traffic flow Packet traffic is broadcast to all devices.

لایه های ارتباطی از توبولوژی میزبان گرفته تا سطوح ۰ تا ۵ هاب
ها و دستگاه ها نشان می دهد.

لایه فیزیکی

لایه فیزیکی تعیین کننده بخش PHY پورت و اتصال فیزیکی بین جریان هم جهت پورت متقابل (در میزبان یا هاب) و خلاف جریان SuperSpeed پورت طرف دیگر در دستگاه هاست. اتصال فیزیکی شامل ۲ جفت داده تقاضلی است که یکی مسیر ارسال و دیگری مسیر دریافت است (شکل ۲). میزان سیگنال دهی داده هی اسمی ۵Gbps است. جوانب الکتریکی هر مسیری به عنوان فرستنده، مجرما و گیرنده مشخص می شود. این مجموعه نمایانگر لینک یک سوی تقاضلی است. هر لینک تقاضلی به حافظه های بخش فرستنده ی آن متصل شده است. مجرأ شامل خصوصیات الکتریکی کابل ها و کاکتتورها است.

در سطح الکتریکی، هر لینک تقاضلی با فرآهم آوری امکان پایان یابی گیرنده هی خود، اولین مقدار خود را تعیین می کند. ارسال کننده مسئول تعیین زمان پایان یابی گیرنده به عنوان نشانه ای بر اتصال پورت و آگاهی از لایه فیزیکی است. بنابراین، وضعیت اتصالی می تواند به عوامل عملکرد لینکی و مدیریت آن تقسیم بندی شود.

لایه فیزیکی ۸ بیت داده را از لایه فیزیکی دریافت می کند و داده ها را در هم می سازد تا گسترش تداخل الکترومغناطیسی را کاهش دهد. سپس لایه ۸ بیتی در هم ساخته شده را به ارقام ۱۰ بیتی کد گذاری می کند تا در طول اتصال فیزیکی، مخابره صورت گیرد. داده های برآیند شده به میزانی فرستاده می شوند که شامل طیف گسترشی برای کاهش دادن بیشتر انتشار تداخل الکترومغناطیسی شوند. سیر بیت توسط دریافت کننده از لینک تقاضلی بازیابی، به ارقام ۱۰ بیتی

خلاصه ساختار USB3.0

USB3.0 یک پورت با ساختار دوگانه است که با نوع ۲ آن و پورت SuperSpeed ترکیب شده است. در جدول ۱ خلاصه هی تفاوت مهم ساختاری بین USB2.0 و USB SuperSpeed را مشاهده می کنید.

SuperSpeed ساختار

گذرگاه SuperSpeed دارای ساختار ارتباطی لایه ای است که شامل اجزای زیر است:

- اتصال SuperSpeed: اتصال SuperSpeed حالتی است که در آن دستگاه ها به میزبان متصل می شوند و از طریق گذرگاه SuperSpeed با آن تبادل اطلاعات می کنند. این امر شامل توبولوژی دستگاه های متصل شده به پورت، لایه های برقرار کننده ارتباط، ارتباط بین آنها و چگونگی عمل متقابله برای انجام تبادل اطلاعات بین میزبان و دستگاه هاست.

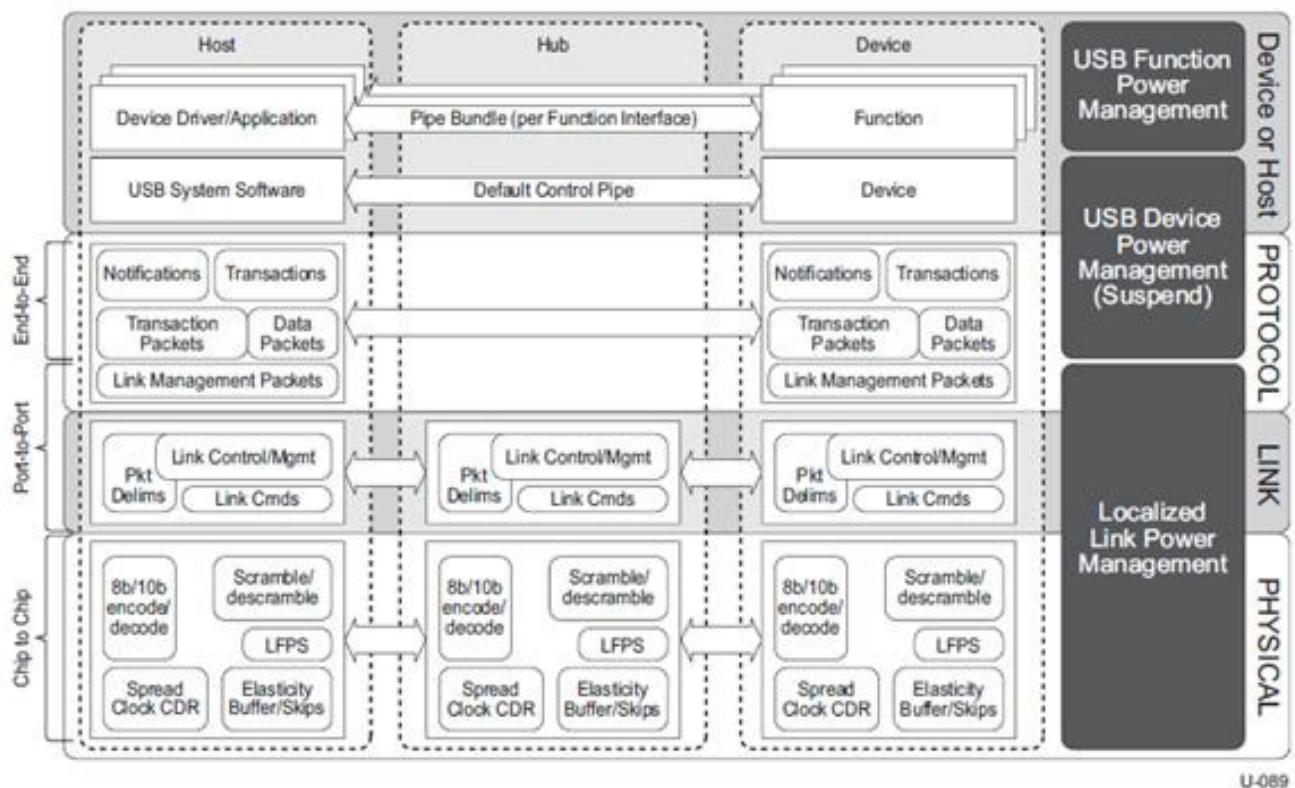
- دستگاه ها: دستگاه های SuperSpeed منبع یا دریافت کننده تبادل اطلاعات هستند. این دستگاه ها عملیات مورد نیاز دستگاه را انجام می دهند، لایه های ارتباطی SuperSpeed برای انجام تبادل اطلاعات بین گرداننده میزبان و تابع منطقی در دستگاه را ایفا می کنند.

- میزبان: میزبان SuperSpeed منبع یا دریافت کننده اطلاعات است و همچنین عملیات مورد نیاز میزبان و لایه های ارتباطی SuperSpeed برای انجام تبادل اطلاعات را در سراسر پورت ایفا می کند؛ از برنامه فعالیت داده هی SuperSpeed و مدیریت گذرگاه SuperSpeed و تمامی دستگاه های متصل شده به آن برخوردار است. شکل ۳ نمودار مرتع اتصال SuperSpeed را که به عنوان

بررسی ساختار USB3.0

- مدیریت حالت PHY خود (یعنی پایان اتصال فیزیکی آن)، شامل مدیریت توان و رخدادها (اتصال، جابجایی و شارژ)

گردآوری، کد گذاری، جداسازی می شود، داده های ۸ بیتی تولید شده و سپس برای پردازش بیشتر به لایه های لینک فرستاده می شود.



شکل ۳ : لایه های ارتباط پورت SuperSpeed و اجزای مدیریت توان

- ارسال و دریافت مسیرهای بایت به همراه سیگنال های اضافی که مسیر بایت را همانند توالی کنترل یا داده تعیین می کنند. لایه فیزیکی شامل لینک های فیزیکی دریافت و ارسال متمایز است، بنابراین پورت می تواند به طور همزمان اطلاعات داده و کنترل را ارسال و دریافت نماید.

لایه های پروتکل
لایه های پروتکل ارتباط پیوسته های حاکم بین میزبان و دستگاه را معین می کند (رجوع شود به شکل ۳).
پروتکل SuperSpeed برای تامین تبادل اطلاعات داده های کاربردی بین یک میزبان و نقطه هایی دستگاه مجهز می باشد. این ارتباط مخابراتی لوله (Pipe) نام دارد. این لوله یک پروتکل هدایت شونده از سوی میزبان می باشد و بدین معنی است که میزبان هنگامی که داده های کاربردی بین میزبان و دستگاه انتقال یافته است، تعیین می گردد. SuperSpeed یک پروتکل انتخاب شده نیست بلکه به عنوان یک دستگاه قادر است به صورت نا هماهنگ (آنسنکرون) از طرف یک نقطه های پایانی خاص از میزبان درخواست سرویس نماید. تمامی ارتباطات لایه های پروتکل از بسطه های قابل دستیابی می باشند. بسطه های مجموعه توالی هایی از بایت های داده به همراه مجموعه توالی های کنترل خاصی هستند که به عنوان حاصل (مرز بین دستور و آرگومان) هدایت شوند از سوی لایه های لینک قلمداد می شود. بسطه های پروتکل ارسالی از میزبان از طرف هاب های میانی به صورت مستقیم به یک دستگاه جانبی فرستاده شده اند. این بسطه ها

لایه های لینک SuperSpeed یک اتصال منطقی و فیزیکی بین دو پورت است. پورت های متصل شده، جفت های پیوندی نامیده می شوند. هر پورتی دارای یک بخش فیزیکی و یک بخش منطقی است. لایه های لینک بخش منطقی پورت و ارتباطات بین جفت های پیوندی را معین می کند.

بخش منطقی هر پورت شامل :

- دستگاه های تعیین وضعیت برای مدیریت ارتباط فیزیکی نهایی آن، که شامل فرمت لایه فیزیکی و مدیریت واقعه است. برای مثال: اتصال، جداسازی و مدیریت توان.
 - دستگاه های تعیین وضعیت و حافظه میانی برای مدیریت تبادل اطلاعات با لایه های لینک. در این فرایند از پروتکل هایی برای کنترل جریان، انتقال معتبر بسته های پیام (از پورتی به پورت دیگر) و مدیریت لینک توان استفاده می شود.
 - حافظه های میانجی برای عوامل اطلاعاتی داده و لایه های لینک چهارچوب درستی از ترتیب بایت ها در طول ارسال در بسته ها فراهم می شوند. برای مثال تعبیه های حاصل های بسته های پیام دریافت شده شامل حاصل های بسته های بسته های بسته های دریافت شده (جهت ارسال مطمئن) را آشکار می سازد.
 - بسته های دریافت شده شامل حاصل های بسته های بسته های بسته های پیام دریافت شده (جهت ارسال مطمئن) را آشکار می سازد.
 - واسطه مناسب برای لایه های پروتکل به منظور عبور از تبادل اطلاعات بسته های لایه های پروتکل فراهم می شود.
- لایه های فیزیکی برای پورت منطقی واسطه را فراهم می آورد که به واسطه های آن می تواند:

و پیام می باشد . به علاوه کلمه ی کنترل لینک (در هر بسته ی پیام) CRC خود را دارد. یک CRC ناموفق در پیام یا کلمه ی کنترل لینک به عنوان یک خطای جدی قلمداد می شود که منجر به آزمایش مجدد سطح لینک برای بازگشت به وضعیت طبیعی پس از خطا می شود.

لایه های لینک و فیزیکی جهت میسر ساختن انتقال مطمئن بسته ی پیام با یکدیگر کار می کنند. لایه ی فیزیکی میزان خطایی را فراهم می آورد که (به طور متوسط) از یک بیت در هر 10^{12} بیت فراتر نمی رود. لایه ی لینک بررسی خط را برای گرفتن خطا و انتقال بسته ی پیام را برای کاهش بیشتر میزان خطای بسته ی پیام مورد استفاده قرار می دهد.

رفع خطا

ممکن است خطاها در سخت افزار یا نرم افزار رفع شوند. رفع خطای موجود در سخت افزار شامل گزارش و آزمایش مجدد بسته های پیام ناکارامد می باشد. یک کنترل کننده ی میزان خطایی USB انتقالی را مورد آزمایش قرار می دهد که تا ۳ بار پیش از آگاه کردن نرم افزار کلاینت از خرابی با وقوع خطای مواجه می شود . نرم افزار کلاینت می تواند به روشن خاص کاربردی به حالت عادی بازگردد.

مدیریت توان SuperSpeed ، مدیریت توان SuperSpeed را در نواحی مجزای موجود در ساختار پورت، لینک، دستگاه و تابع (رجوع شود به شکل ۳) میسر می سازد. این نواحی مدیریت توان به هم وابسته نیستند اما وابستگی هایی نیز دارند، این وابستگی ها اغلب به انتقال حالت توان قابل استفاده ی مبتنی بر وابستگی به حالت

های توان لینک ها، دستگاه ها و توابع مربوط می شود. مدیریت توان لینک در هر لینک (یعنی محلی) به صورت سلسه مراتب و غیر همزمان روی می دهد. سیاست مدیریت توان لینک ممکن است برگرفته از تایمراهی عدم فعالیت پورت خلاف جهت جریان باشد که توسط نرم افزار میزان خطایی قبل برنامه نویسی هستند. حالت های توان لینک به صورت بالاگرا توسط هاب ها گسترش می یابند (مثلا هنگامی که تمامی پورت های خلاف جریان در حالت کم مصرف هستند، یک هاب برای انتقال پورت خلاف جریان خود به حالت کم مصرف مورد نیاز است). تصمیمات مربوط به تغییر حالت های توان لینک به صورت محلی اتخاذ می شوند. میزان مستقیما حالت های نیروی کم منفرد را پیگیری نمی کند. از آنجایی که صرفا آن لینک هایی که بین میزان و دستگاه هستند در تبادل داده می وجودد درگیر می باشند، لینک هایی که برای ارتباطات داده مورد استفاده قرار نمی گیرند را می توان در حالت توان کم جای داد.

از مسیرهای پورت که بخشی از مسیر مستقیم بین میزان و دستگاه جانبی مقصد به شمار نمی روند، عبور نمی کند. انتظار می رود که یک دستگاه جانبی به واسطه هر بسته لایه ی پروتکلی که دریافت می کند، به عنوان هدف محسوب شود. بسته های پروتکل ارسالی از دستگاه به سادگی از طریق هاب ها به سمت میزان در جهت موافق جریان می یابند. بسته های پیام جزء اصلی لایه ی پروتکل می باشند. این بسته ها، بسته هایی در اندازه ی ثابت و با رمزگذاری میدانی الگویی و زیرالگویی برای اهداف خاصی هستند. یک یادداشت (رکورد) کوچک در داخل بسته ی پیام به منظور مدیریت جریان بسته از پورتی به پورت دیگر توسط لایه ی لینک (از پورتی به پورت دیگر) مورد استفاده قرار گرفته است . بسته های پیام به طور قابل اعتماد از طریق لایه ی لینک (از پورتی به پورت دیگر) دریافت شده اند. میدانهای باقیمانده را اپروتکل پیوسته مورد استفاده قرار می دهد.

توانمندی

USB SuperSpeed ویژگی های گوناگونی دارد که در توانمندی آن

سهیم است :

- انسجام سیگنال با استفاده از راه اندازهای دیفرانسیل، گیرنده ها و استحفاظ

- حفاظت CRC برای بسته های پیام و داده

- بسته های پیام سطح لینک برای اطمینان بخشی از تحويل قابل اعتماد آنها مجدد آزمایش قرار می گیرند.

- پروتکل پیوسته ی بسته های داده را مجدد مورد آزمایش قرار می دهد تا از تحويل قابل اعتماد آنها اطمینان یابند.

- تشخیص ساختار متصل، مجزا و سطح سیستمی منابع

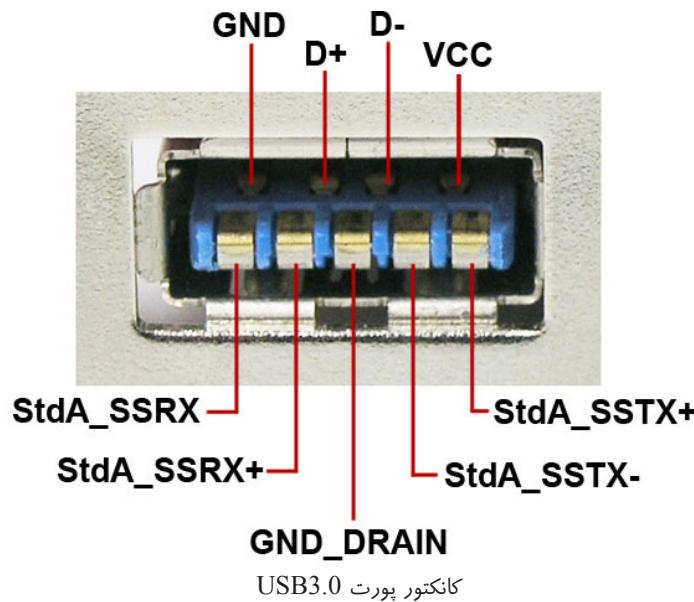
- ساختارهای لوله ی کنترلی و داده برای تضمین استقلال از ارتباطات ناسازگار بین توابع

خطایابی

انتظار می رود که میزان خطای بیت لایه ی فیزیکی SuperSpeed USB کمتر از یک بیت در 10^{12} بیت باشد. برای ایجاد حفاظت در مقابل وقوع خطاهای بیت اتفاقی، قاب بندی بسته های لینک جهت تحمل خطاهای تک بیت به میزان کافی زیاد می باشد. هر بسته دربرگیرنده ی یک CRC برای میسر ساختن خطایابی خطاهای چند بیتی است.

هنگامی که انسجام داده مورد نیاز است، فرایند بازگشت به وضعیت طبیعی پس از خطای ممکن است در سخت افزار یا نرم افزار برانگیخته شود.

پروتکل شامل CRC های مجزا برای بارهای مفید بسته ی داده



بررسی ساختار USB3.0

تمامی توابع مجزای درون دستگاه در حالت معلق هستند ، به صورت خود کار به حالت معلق انتقال نخواهد یافت.

دستگاه ها

تمامی دستگاه های SuperSpeed ساختار مبنای خود را با USB2.0 سهیم هستند. این دستگاه ها ایجاب می کنند که اطلاعات را برای ساختارهای همانند و کلی انتقال دهنند. همچنین لازم است که این دستگاه ها رفتاری مطابق با حالت های دستگاه SuperSpeed توصیف شده نشان دهند.

تمامی دستگاه ها زمانیکه توسط میزبان برشمرده می شوند به عنوان آدرس USB قلمداد می شوند. هر دستگاه از یک یا چند لوله پشتیبانی می نماید که از طریق آنها ممکن است میزبان با دستگاه ارتباط برقرار نماید. تمامی دستگاه ها باید از یک لوله ی اختصاصی در نقطه ی پایانی صفر که لوله ی کنترل پیش فرض دستگاه بدان متصل است، پشتیبانی نمایند. تمامی دستگاه ها از یک مکانیسم دستیابی مشترک به منظور دستیابی به اطلاعات از طریق این لوله کنترل حمایت می کنند.

SuperSpeed بخشی از اطلاعاتی را که در لوله ی کنترل پیش فرض USB2.0 پشتیبانی شده اند، گرفته است.

خصوصیات USB3.0 دو مجموعه از دستگاه های USB را که می توانند به میزبان SuperSpeed اتصال یابند را تبیین می کند که به طور خلاصه در زیر ذکر شده اند.

دستگاه های جانبی

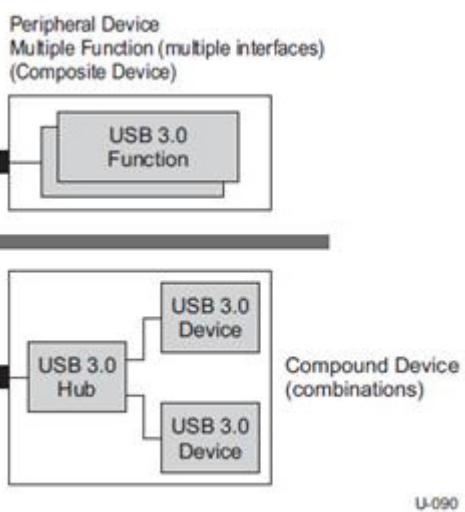
دستگاه های جانبی USB3.0 باید امکان پشتیبانی را برای هر دو گروه سرعت یعنی سرعت مافوق(SuperSpeed) و حداقل یک سرعت غیر مافوق فراهم آورند. حداقل نیاز سرعت غیر مافوق، نیاز به دستگاهی است که در میزبان USB نوع ۲ آشکار شده و به نرم افزار سیستم اجازه دهد که کاربر را جهت اتصال دستگاه به گذرگاه مستعد

میزبان مستقیماً حالت های توان مربوط به لینک های مجزا را کنترل نکردد یا مورد توجه قرار نمی دهد. این امر دلالت براین دارد که یک یا چند لینک موجود در مسیر بین میزبان و دستگاه زمانی که میزبان ارتباطی را با پورت آغاز می کند، می توانند در حالت توان تقلیل یافته قرار گیرند . مکانیسم های پروتکل داخل باندی وجود دارند که این لینک ها را وادار به انتقال به حالت توان عملکردی کرده و میزبان را از وقوع انتقال مطلع می سازد. میزبان با استفاده از این مکانیسم ها (می تواند محاسبه کند) بدترین زمان انتقال را به منظور راه گشایی برای هر دستگاه خاص در حالت فعلی یا آماده را می شناسد. مشابه این دستگاه آغاز کننده ی ارتباط بر روی پورت با لینک هم جهت خود در حالت توان تقلیل یافته ، ابتدا لینک خود را به یک حالت عملکردی انتقال خواهد داد که این عمل منجر به انتقال تمامی لینک های موجود بین این دستگاه و میزبان به حالت عملکردی خواهد شد.

نکات کلیدی مدیریت توان لینک عبارتند از:

- دستگاه ها و اخطار غیر همزمان آماده به میزبان
- بسته ها ارسال شده و لینک هایی را که در ارتباطات داده برای انتقال و یا ماندن در حالت نیروی کم درگیر نیستند، دریافت می کنند.
- بسته هایی که با پورت های موجود در حالت های نیروی کم برخورد می کنند سبب انتقال آن پورت ها به خارج از حالت نیروی کم به همراه نشانه هایی از وقوع انتقال می شود.
- دستگاه یا میزبان چندگانه حالت های لینک را با نیروی کم و با تأخیر افزایش یافته ی خروج پیش می برند.

همانند پورت 2 USB، دستگاه ها به وضوح می توانند به واسطه ی مکانیسم پورت معلق مشابه به طور موقت کنار گذاشته شوند. این امر لینک را در حالت پایین ترین توان لینک قرار داده و محدودیتی را بر نیاز دستگاه به دریافت نیرو و اعمال می کند. SuperSpeed پشتیبانی از مدیریت نیروی تابع را علاوه بر مدیریت توان دستگاه میسر می سازد. برای دستگاه های چند تابعی (کامپوزیت) هر تابع را



U-090

شکل ۴ : نمونه هایی از تopolوژی های دستگاه فیزیکی USB SuperSpeed پشتیبانی شده

SuperSpeed هدایت کند. به کارگیری دستگاه می تواند کارامدی SuperSpeed را به هنگام فعالیت در حالت غیر فراهم آورد. عملکرد همزمان حالت های SuperSpeed فراهم آورده است.

می توان به طور مستقل در یک حالت توان پایین تر قرار داد. توجه داشته باشید که دستگاه زمانی می تواند به حالت معلق انتقال یابد که توسط میزبان به واسطه ی فرمان پورت هدایت شود. زمانیکه

- جمع کردن بسته های داخلی در پورت هم جهت
- ارسال بسته های استامپ زمان به تمامی پورت های خلاف جریان و نه در حالت کم توان
- آشکارسازی زمانی که بسته ها با پورتی که در حالت کم توان است مواجه می شوند. هاب، پورت هدفمند را به خارج از حالت کم توان انتقال می دهد و میزبان و دستگاه (داخل باند) را مطلع می سازد که بسته با پورتی که در حالت کم مصرف است مواجه شد.

میزبان ها

میزبان 3.0 از طریق کنترل کننده ی میزبان با دستگاه های USB ارتباط دارد. به منظور پشتیبانی از ساختار پورت دوگانه ی USB3.0، کنترل کننده ی میزبان باید هم شامل اجزای SuperSpeed و هم شامل اجزای USB2.0 باشد که می تواند به طور همزمان تبادلات کنترل، وضعیت و اطلاعات بین میزبان و دستگاه های فرای هر پورت را مدیریت کند.

میزبان شامل تعدادی پورت خلاف جریان اصلی مخصوص به کارگیری برای SuperSpeed و USB2.0 می باشد:

- اتصال و جابجایی دستگاه های USB را نمایان می کند.

رونده کنترل بین میزبان و دستگاه های USB را مدیریت می کند.

جریان داده بین میزبان و دستگاه های USB را مدیریت می کند.

آمار و ارقام مربوط به وضعیت و فعالیت را جمع آوری می نماید.

نیروی لازم را برای دستگاه های USB متصل فراهم می آورد.

نرم افزار سیستم USB نیازهای ساختاری خود را از USB2.0 گرفته است که مشتمل بر موارد زیر است :

- مشکل و ذکر جزئیات دستگاه

زمانبندی انتقال های دوره ای و غیر همزمان داده

مدیریت نیروی تابع و دستگاه

اطلاعات مدیریت دستگاه و پورت

مدل های جریان داده

مدل های USB SuperSpeed مدل های جریان داده را از USB2.0 گرفته است که عبارتند از:

تبادل کنترل و داده بین میزبان و دستگاه از طریق مجموعه ای از

لوله های یک جهتی با دو جهتی انجام می گیرد.

انتقالات داده بین نرم افزار میزبان و نقطه ی پایانی خاص برروی دستگاه روی می دهد. نقطه ی پایانی با یک تابع خاص برروی دستگاه در ارتباط می باشد. این ارتباطات بین نرم افزار میزبان و نقطه ی پایانی مربوط به تابع خاص، لوله نام دارد. یک دستگاه ممکن است دارای بیش از یک لوله فعال باشد. ۲ نوع لوله وجود دارد: مسیر و پیام. داده ی مسیر ساختار USB تعریف شده ندارد در حالی که پیام این ساختار را دارد. لوله ها دارای ارتباطات پنهانی باند داده، خدمات انتقال و ویژگی های نقطه ی پایانی نظریه جهت و اندازه ی حافظه ی میانی می باشد.

اغلب لوله ها هنگامی که دستگاه توسط نرم افزار سیستم ایجاد می شود، بوجود می آیند لذا، لوله ی تک پیام، لوله ی کنترل پیش فرض، همواره زمانی که یک دستگاه نیرومند شده و در حالت پیش فرض

عملکرد همزمان حالت های SuperSpeed و غیر SuperSpeed برای دستگاه های جانبی مجاز نمی باشد.

دستگاه های USB3.0 موجود در بسته های فیزیکی مجза (یعنی یک دستگاه جانبی مجزا) می توانند مشتمل بر تعدادی توپولوژی تابعی شامل تابع مجزا، تابع چندگانه بر روی یک دستگاه مجزا (دستگاه کامپوزیت) و دستگاه های جانبی به طور ثابت متصل به پشت هاب مجتمع (دستگاه ترکیبی) باشند. (رجوع شود به شکل ۴).

هاب ها

هاب ها همواره جزء کلیدی ساختار USB plug & play بوده اند. میزبان ها تعدادی پورت های مخالف جریان مخصوص بکارگیری را فراهم می آورند که دستگاه ها می توانند به آنها متصل شوند. هاب ها پورت های خلاف جریان اضافی را تامین می نمایند که در نتیجه برای کاربران مکانیسم ساده افزایش اتصال را به منظور اتصال دستگاه های اضافی به USB فراهم می کنند.

در راستای پشتیبانی ساختار پورت دوگانه از USB3.0، هاب USB3.0 ترکیبی منطقی از ۲ هاب است : هاب ۰ و هاب ۱ SuperSpeed (رجوع شود به هاب موجود در شکل ۳-۱). نیرو و پایه ی متصل به پورت هم جهت از طریق کابل از طریق هر دو دستگاه موجود در داخل هاب USB3.0 تسهیم شده اند. دستگاه هاب USB نوع ۲ به خطوط داده ی USB2.0 متصل شده و هاب SuperSpeed به خطوط داده ی USB2.0 متصل شده است. هاب USB3.0 هم جهت را به صورت دو دستگاه متصل می کند ، یک هاب SuperSpeed بر روی پورت و یک هاب USB2.0 بر روی پورت USB2.0.

هاب SuperSpeed بخش های SuperSpeed پورت های خلاف جریان را مدیریت کرده و هاب USB2.0 بخش های USB2.0 پورت های خلاف جریان را مدیریت می کند.

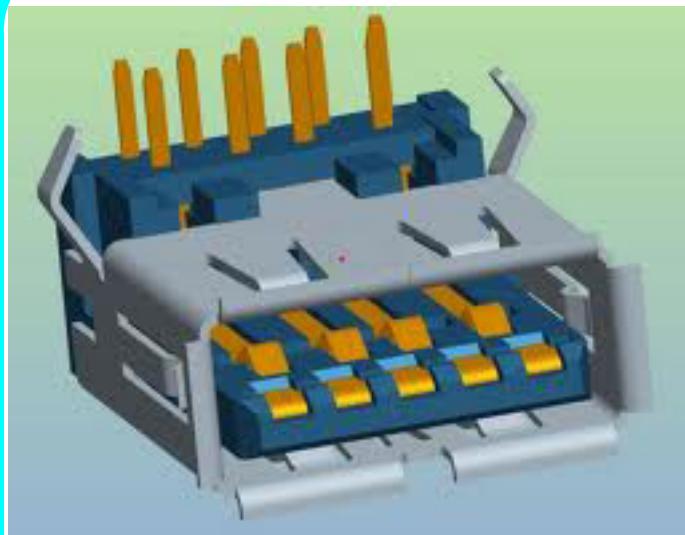
برای اطلاعات بیشتر در مورد هاب USB2.0 به ویژگی های گذرگاه سریال جهانی، چاپ دوم مراجعه کنید. هاب ها، اتصال دستگاه، واقعی جابجایی و شارژ از راه دور را بر روی پورت های خلاف جریان شناسایی کرده و امکان توزیع نیرو را در دستگاه های خلاف جریان فراهم می آورند.

یک هاب SuperSpeed مشتمل بر دو مولفه ی منطقی است : کنترل کننده هاب SuperSpeed و تکرار کننده-فرستنده SuperSpeed از سوی پروتکل موجود بین پورت هم جهت SuperSpeed و پورت های خلاف جریان اطلاق می شود و همچنین دارای یک پشتیبانی سخت افزاری برای علامت دهی راه اندازی مجدد و از کار انداختن موقتی و اجرای مجدد می باشد. کنترل کننده ی SuperSpeed به فرمان های استاندارد و کنترل وضعیت مخصوص به هاب پاسخ می دهد که این فرمان ها توسط میزبان به منظور شکل دهی به هاب و نظارت و کنترل پورت های آن مورد استفاده قرار می گیرند.

هاب های SuperSpeed فعالانه به روش های مختلف در پروتکل (پیوسته) شرکت می کنند که این روشها عبارتند از :

- انتقال بسته ها به خارج و به سمت پورتهای خلاف جریان مشخص

بررسی ساختار USB3.0



کانکتور پورت USB3.0

باشد بوجود می آید تا دسیابی به اطلاعات ساختار دستگاه، وضعیت و کنترل میسر گردد.

• لوله از یکی از ۴ نوع انتقال بیان شده در USB2.0 پشتیبانی می کند (حجم بزرگ، کنترل، توقف و همزمانی). عوامل پایه ای ساختار این نوع انتقال از USB2.0 به بعد تغییر نیافته اند.

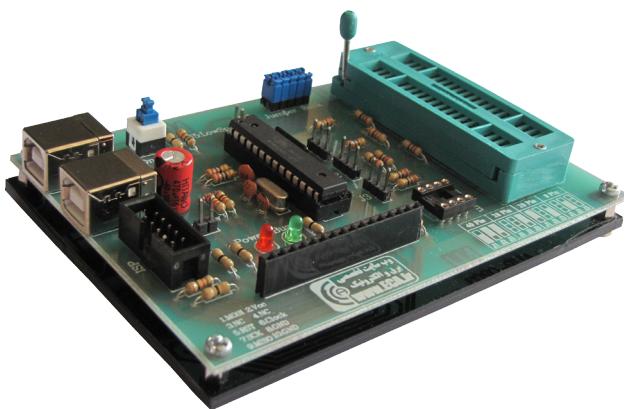
• نوع انتقال در حجم بزرگ دارای یک پسوند برای SuperSpeed به نام مسیرها می باشد. مسیرها، پشتیبانی داخل باند، سطح پروتکلی را برای تسهیم مسیرهای داده ی منطقی وابسته ی چندگانه از طریق لوله ی استاندارد در حجم بزرگ فراهم می آورند.

www.usb.org

برگه های اطلاعاتی USB3.0

مترجم : فریبا سماواتیان

Multi AVR Programmer



- » هماهنگی با پورت های USB2.0 و USB1.1
- » دارای ۲ پورت USB جهت برطرف نمودن کمبود جریان احتمالی
- » بدون نیاز به تغذیه خارجی
- » مجهز به کانکتور ISP خروجی
- » دارای سرعت بالا و قابل تنظیم (5kBytes/sec)
- » مولد پالس ساعت برای بازیابی میکرووهایی که فیوز بیت آنها به اشتباہ تغییر داده شده است

- » سازگاری با سیستم عامل های Linux / Mac OS X / Windows
- » پشتیبانی از تمامی میکرووهای خانواده AVR
- » پشتیبانی از میکروکنترلرهای سری AT89Sxx
- » پشتیبانی از حافظه های سریال 24Cxx
- » توانایی تست LCDهای کاراکتری
- » کارت گارانتی ۱۲ ماهه

AVR USB Programmer



- » هماهنگی با پورت های USB2.0 و USB1.1
- » بدون نیاز به تغذیه خارجی
- » مجهز به ۲ کانکتور ISP خروجی
- » دارای سرعت بالا و قابل تنظیم (5kBytes/sec)
- » مولد پالس ساعت برای بازیابی میکرووهایی که فیوز بیت آنها به اشتباہ تغییر داده شده است
- » سازگاری با سیستم عامل های Linux / Mac OS X / Windows
- » پشتیبانی از تمامی میکرووهای خانواده AVR
- » کارت گارانتی ۱۲ ماهه

ECA WiKi

تاریخچه ویکی

«ویکی ویکی» که باز تکرار کلمه «ویکی» است، در زبان محلی اهالی هاوایی معنی «سریع»، «تر و فرز» می‌دهد. در زبان انگلیسی اگر «ویکی» را سر نام کلمه‌ای بگذاریم معنای «آنچه می‌دانم این است» به آن کلمه افزوده می‌گردد. نظیر کلمه ویکی پدیا (بزرگترین دانشنامه آزاد آنلاین جهان) که از دو کلمه مستقل ویکی + پدیا (از ریشه کلمه *encyclopedia* ایجاد شده است و مفهوم مشارکت جمعی کاربران در تکمیل دانشنامه را در دل خود دارد. ویکی ECA نیز با همین هدف و جهت افزایش علوم پایه در زمینه برق و الکترونیک ایجاد گشته و امیدواریم تا چند سال آینده به یک مرجع علمی در زمینه برق و الکترونیک تبدیل گردد.

در حوزه فناوری اطلاعات اصطلاح ویکی برای شناسایی نوع ویژه ای از فرامتن‌ها و یا نرم‌افزارهای مشارکت‌گرای تولید‌کننده آن‌ها به کار برده می‌شود.

ویکی چیست؟

ویکی مجموعه صفحات وی‌است که محتوای آن‌ها بصورت مشارکتی تولید شده و فرایند توسعه آن نیز در مدل مشارکتی توسط مکانیزمی خاص مدیریت می‌شود. مشارکت‌کننده‌ها می‌توانند بصورت عام و یا کسانی باشند که دسترسی آن‌ها به نرم‌افزار سرویس‌دهنده ویکی مشخص شده است. در واقع ویکی‌ها به کاربران این اجازه را می‌دهند که بدون داشتن برنامه‌نویسی اقدام به ایجاد صفحات وب درباره موضوعات مختلف بکنند. ویکی‌ها با واسطه کاربری نسبتاً ساده‌ای امکان تولید فرامتن و استفاده از زبان‌های نشانه‌گذاری را فراهم می‌آورند و اغلب برای ایجاد پایگاه‌های وب گروهی و ارتقای پایگاه‌های اجتماعی و تحقق مدیریت دانش به کاربرده می‌شوند. در ویکی کاربران این اجازه را دارند که محتوای صفحات سایت را ویرایش کنند، صفحات جدید ایجاد کنند و حتی صفحات موجود را حذف کنند. با استفاده از این ویژگی، کاربران می‌توانند به سرعت و بدون نیاز به دانش فنی خاص، درباره موضوعات مختلف صفحاتی را ایجاد کنند و با کمک کاربران دیگر آن‌ها را به مرور زمان کامل کنند.

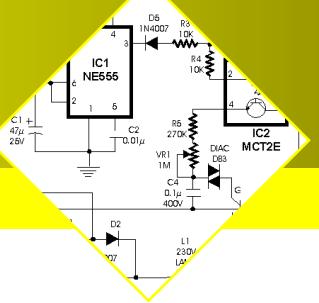
در یک سیستم ویکی، از تمام تغییرات ایجاد شده توسط کاربران، یک نسخه پشتیبان نگاه داشته می‌شود تا در صورت بروز اشتباه و یا هرگونه خرابکاری در محتوای یک ویکی، بتوان به راحتی یک نسخه سالم را جایگزین آن کرد.

مزایای ویکی
ایجاد ویکی در سازمان‌ها مزایای بسیاری را به همراه دارد، از جمله آن ثبت شدن دانش محدود افراد در موضوعات مختلف و پیوند خوردن این دانش‌های محدود با یکدیگر و تولید دانشی وسیع و جامع در سرتاسر سازمان می‌شود. ویکی باعث می‌شود تا افراد در رقابتی شدید برای تکمیل اطلاعات و اظهار اطلاعات خود در هر زمینه ای اعم از حوزه‌های تخصصی سازمان و سایر موارد، قرار گیرند و در نتیجه سازمان از پایگاه داده‌ای مملو از اطلاعات، دانش و تجربیات برخوردار می‌گردد که هر روز نیز بر غنای آن افزوده می‌گردد.
www.WiKi.ECA.ir



www.WiKi.ECA.ir

www.ECA.ir



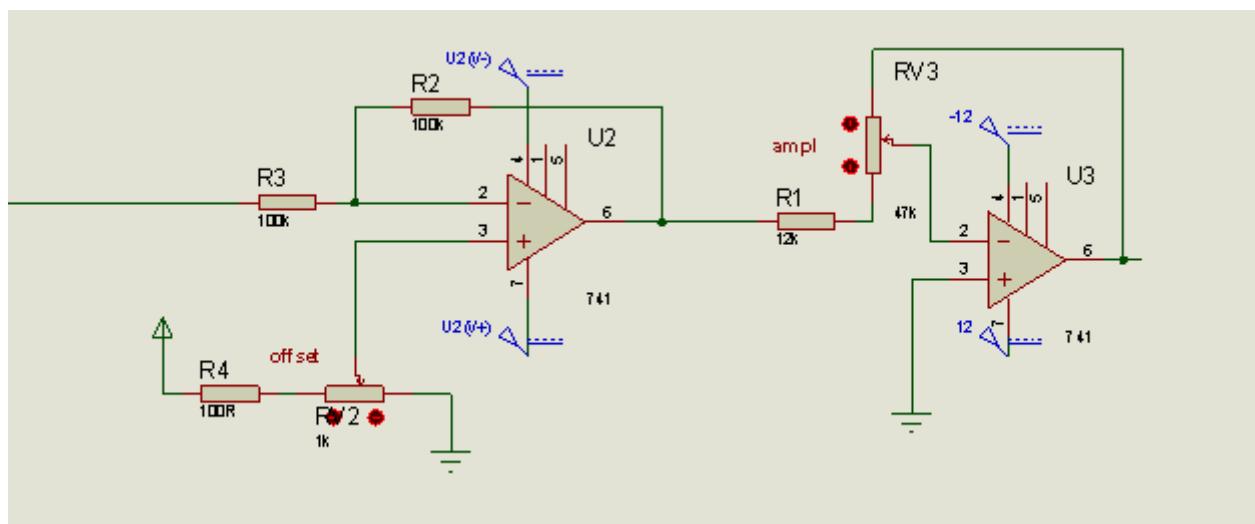
طراحی فانکشن ژنراتور

فانکشن ژنراتور دستگاهی است که قابلیت تولید شکل موج های مختلف را با فرکانس و دامنه مختلف دارد.

در اینجا برآمیم که با چند نمونه طراحی فانکشن ها آشنا شویم.

می دانیم برای ساخت موج سینوسی از مدارات اسیلاتور ترانزیستوری یا آپ امپی استفاده می شود و برای ساخت موج مربعی از مدارات آ-استabil اسیلاتور ترانزیستوری یا آپ امپی و یا منطقی استفاده می شود. برای تولید شکل موج مثلثی هم از شارژ و دشارژ خازن با جریانی ثابت استفاده می کنند. البته می توان از آی سی های فانکشن نیز برای شکل موج های مختلف بهره جست. همچنین به وسیله آی سی های تایمر مانند 555 و یا مدارات میکروپروسسوری نیز می توان شکل موج های متفاوتی را ایجاد کرد. در اکثر این مدارات دامنه شکل موج ثابت است بنابر این با مداراتی مانند مدار زیر می توان دامنه همچنین افست شکل موج ها را تغییر داد. گاهای دیده شده در بعضی موارد که تراشه ها در سطح ولتاژ وسیعی از تغذیه کار می کنند با تغییر ولتاژ تغذیه دامنه را تغییر می دهند.

استفاده می کنند. البته می توان از آی سی های فانکشن نیز برای شکل موج های مختلف بهره جست. همچنین به وسیله آی سی های تایمر مانند 555 و یا مدارات میکروپروسسوری نیز می توان شکل موج های متفاوتی را ایجاد کرد. در اکثر این مدارات دامنه شکل موج ثابت است بنابر این با مداراتی مانند مدار زیر می توان دامنه همچنین افست شکل موج ها را تغییر داد. گاهای دیده شده در بعضی موارد که تراشه ها در سطح ولتاژ وسیعی از تغذیه کار می کنند با تغییر ولتاژ تغذیه دامنه را تغییر می دهند.



<No data from link>

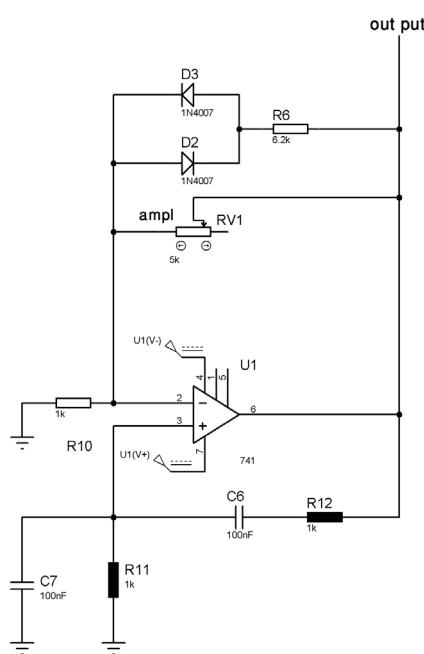
در ادامه نیز یک نمونه از مدارات ساده فانکشن را با هم بررسی می نماییم.

بخش اول : ساخت شکل موج سینوسی

برای این بخش یک مدار اسیلاتور آپ امپی وین در نظر گرفته ایم.

در اینجا با تغییر پتانسیومتر ampl دامنه و با تغییر هم زمان مقاومت های R_{11} و R_{12} می توان فرکانس را تغییر داد.

برای تغییر هم زمان مقاومت ها می توان از ولوم دوبل استفاده کرد.

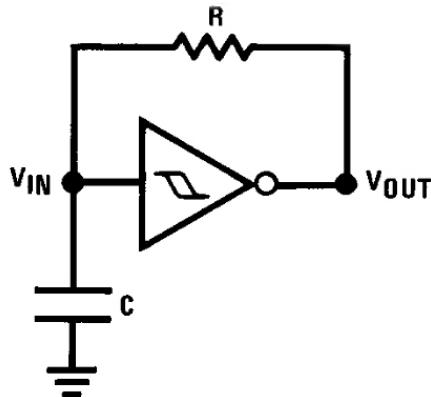


طراحی فانکشن ژنراتور

بخش دوم : ساخت شکل موج مربعی

برای این بخش از گیت CMOS 40106 استفاده کرده ایم. هسته اصلی مدار به صورت زیر است.

Low Power Oscillator

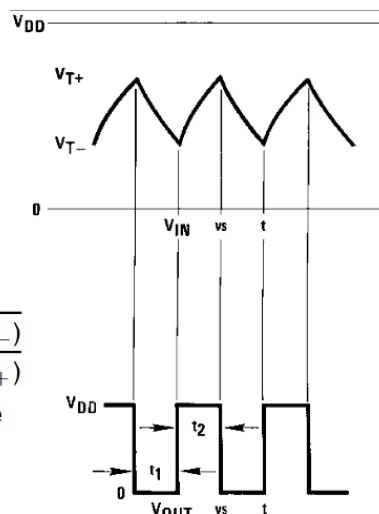


$$t_1 \approx RC \ell n \frac{V_{T+}}{V_{T-}}$$

$$t_2 \approx RC \ell n \frac{V_{DD} - V_{T-}}{V_{DD} - V_{T+}}$$

$$f \approx \frac{1}{RC \ell n \frac{V_{T+}(V_{DD} - V_{T-})}{V_{T-}(V_{DD} - V_{T+})}}$$

Note: The equations assume
 $t_1 + t_2 \gg t_{PHL} + t_{PLH}$

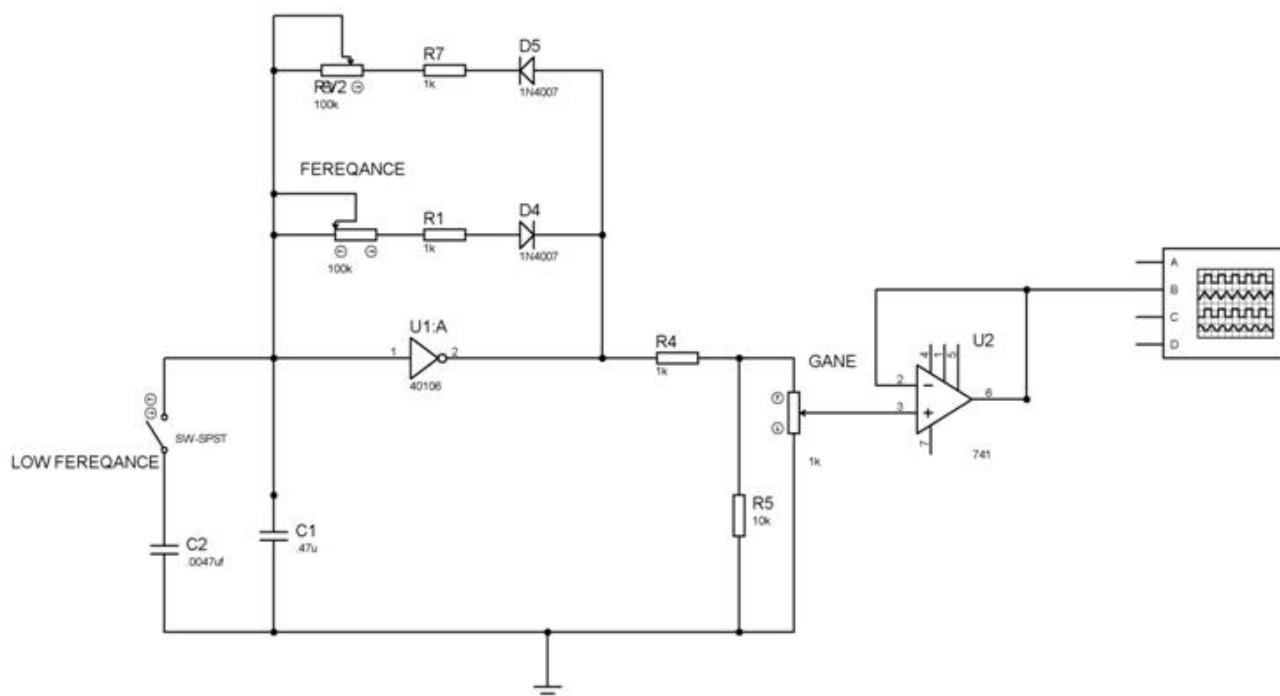


<No data from link>

در این مدار با تغییر مقاومت R و یا خازن C میتوان فرکانس مدار را تغییر داد اما چون خازن های متغیر محدوده تغییرات کوچکی دارند با تغییر مقاومت R فرکانس را تغییر می دهیم. برای اینکه شکل موج ما از بین نزود نیز یک مقاومت ثابت را با R سری می کنیم که هر چه مقدار ان کمتر باشد فرکانس کاری فانکشن به خاطر کم شدن ثابت زمانی بیشتر می گردد. طرز کار مدار به این صورت است که :

اگر فرض کنیم مدار حالت پایدار داشته باشد پس خازن باز است یعنی $V_{in} = V_{out}$ که این غیر ممکن است. پس حتما خازن در حال شارژ و دشارژ است. اگر $V_o = \text{high}$ باشد در حال افزایش به سمت VCC است اما به محض رسیدن V_{in} به $V_{in} = \text{high}$ خروجی صفر می گردد و V_{in} شروع به کاهش می نماید. در این مرحله نیز با رسیدن V_{in} به $V_{in} = \text{low}$ خروجی دوباره high می شود و این روند ادامه پیدا می کند.

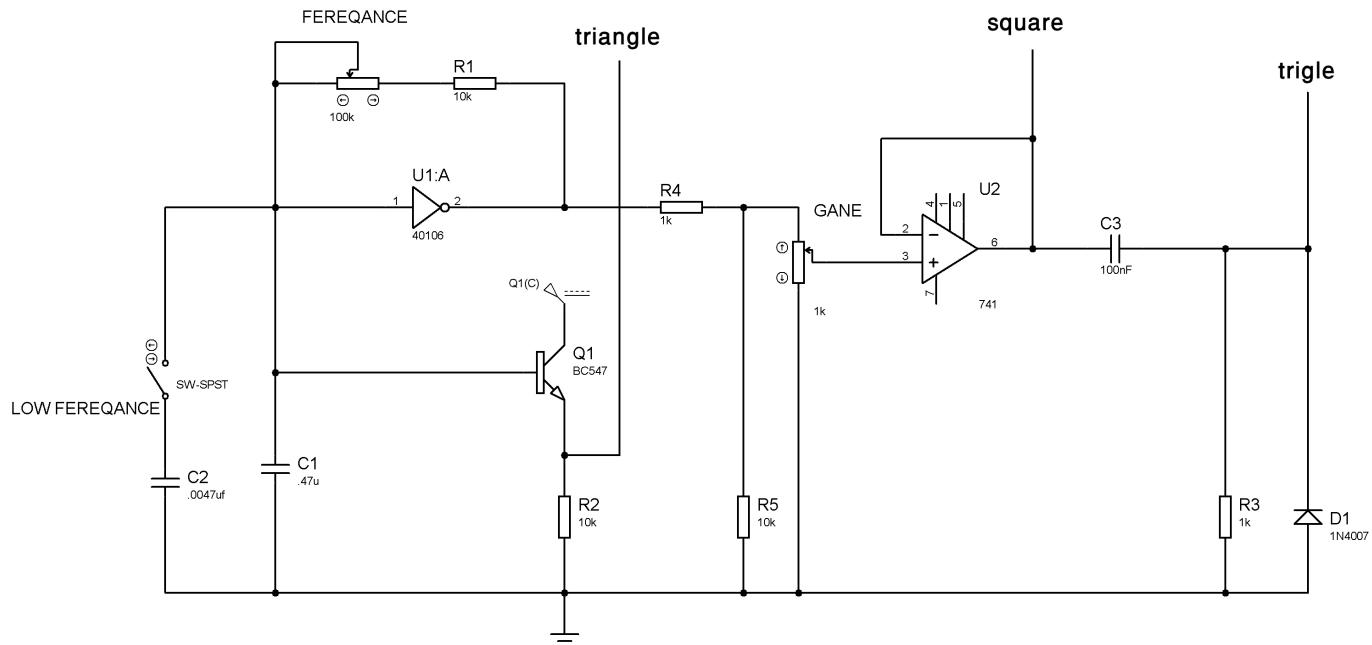
اگر بخواهیم duty cycle مدار هم تغییر دهیم کافیست مدار را به صورت زیر بیندیم. با این کار به وسیله دیود می توان مقدار utp و ltp مدار را به صورت مجزا تغییر داد.



<No data from link>

بخش سوم : ساخت شکل موج مثلثی

در شکل بالا چون گیت جریان ورودی ناچیزی دارد خازن تقریباً به صورت خطی شارژ و دشارژ می‌گردد. در این حالت ما شکل موج مثلثی را داریم اما اگر خروجی را به آن متصل کنیم به خاطر مقاومت بار شکل موج بهم می‌خورد برای این منظور بهتر است با یک بافر ولتاژ سر خازن را به خروجی دهیم. ساده‌ترین حالت استفاده از مدار کلکتور مشترک است فقط باید توجه کنید ورودی مدار باعث قطع و یا اشباع ترانزیستور نگردد.



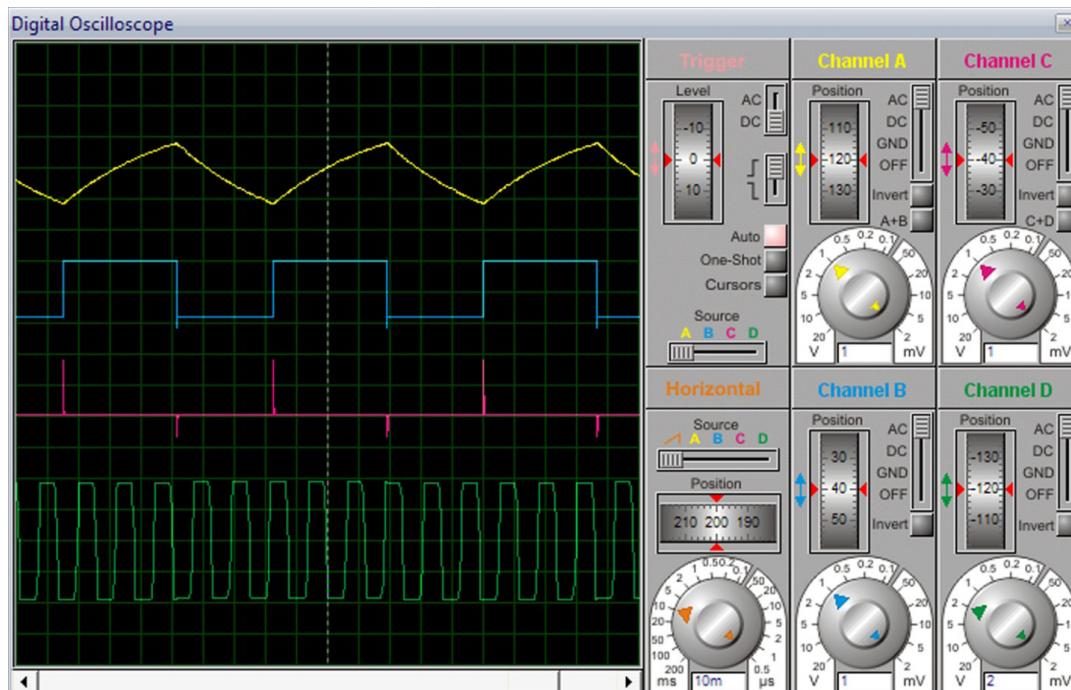
<No data from link>

در مدار بالا خازن C_3 و مقاومت R_3 تولید یک مدار مشتق گیر را کرده اند کا پالس های سوزنی شکل درست می کند و دیود D_1 لبه های منفی آنرا حذف می کند.

دامنه پالس مربعی به وسیله تقسیم ولتاژ کنترل می شود و بعد از گذشتن از یک بافر به خروجی می رود.

اگر بخواهیم شکل موج مثلثی دقیق تر گردد به جای مقاومت ها باید از منبع جریان دو طرفه استفاده کرد.

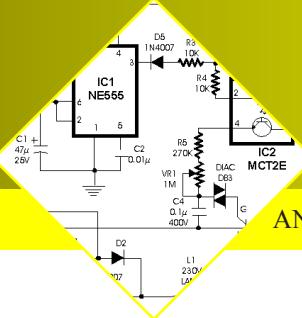
برای انتخاب اینکه کدام شکل موج به خروجی برود می توانید از سلکتور های دستی معمولی و یا به وسیله تراشه 74HC4016 به طور دیجیتال خروجی مورد نظر خود را انتخاب کنید.



شکل موج نهایی دستگاه در شبیه سازی

Design

ANALOG AND DIGITAL CIRCUITS



تراشه VNC1L



تراشه VNC1L

- Configurable options to interface to external Command Monitor via either UART,FIFO or SPI slave interface.
- Entire USB protocol handled on the chip.
- Integrated pull-up and pull-down resistors.
- Integrated FTDI proprietary, 8/32-bit embedded MCU processor core – Vinculum MCU (VMCU) - usig “enhanced CISC” technology.
- Integrated, reconfigurable, 64k bytes of embedded Flash (E-FLASH) memory to store firmware. 4k bytes data RAM.Field upgradeable firmware over UART or USB.
- Integrated Numeric Co-Processor (NCP) enhances 32 bit arithmetic speeds.
- Twin DMA controllers (one per USB interface) provide hardware acceleration of data transfer from USB to external IO bus.
- Operational configuration via a choice of free,downloadable firmware – no external software control required.
- Four fully configurable data and control I/O buses providing up to 28 pins of general purpose I/O.
- Integrated firmware allows read from and write to FAT format USB Flash keys.
- Supports bus powered, self powered and high-power bus powered USB configurations.
- Programmable via UART interface.
- +3.3V single supply operation with 5V safe inputs.
- Low power operation (25mA operational, 2mA in

مطلب ارائه شده در رابطه با ارتباط مستقیم وسایل مثل USB flash، موبایل، دوربین های USB و ... به میکروکنترلر می باشد. این مقاله در مورد استفاده از تراشه VNC1L-1A می باشد که در این راستا استفاده می گردد. مقالات ارایه شده قبلی مثلا استفاده از ft233 و ft245 در رابطه با این مطلب هستند که بتوانیم اطلاعات ارسالی که بصورت سریال از میکرو خارج می شوند را تبدیل به اطلاعات مورد قبول USB کرده و به کامپیوتر بفرستیم و یا بالعکس. کاربرد این مطلب جایی است که به عنوان مثال تجهیزات ما که می توانند کامپیوتر باشد دارای پورت سریال یا COM نباشد که می دانیم پورت USB در حال جایگزین شدن با پورت سریال می باشد.

ولی با استفاده از تراشه VNC1L-1A که یک USB Host یا میزبان USB می باشد می توانیم وسایل USB را بدون نیاز به کامپیوتر واسط (به عنوان یک USB Host) به میکروکنترلر خود وصل نماییم و ارتباط مستقیمی با وسایل برقرار نماییم.



نمونه ای از ارتباط USB توسط تراشه VNC1L

مشخصات چیپ A : VNC1L-1A

The VNC1L is a single chip embedded dual USB host controller with the following advanced features:

- Two independent USB 2.0 Low-speed/Fullspeed USB host ports.
- Individual ports can be configured as host or

شرح مختصری از ویژگی ها ذکر شده در بالا بدین صورت می باشد:

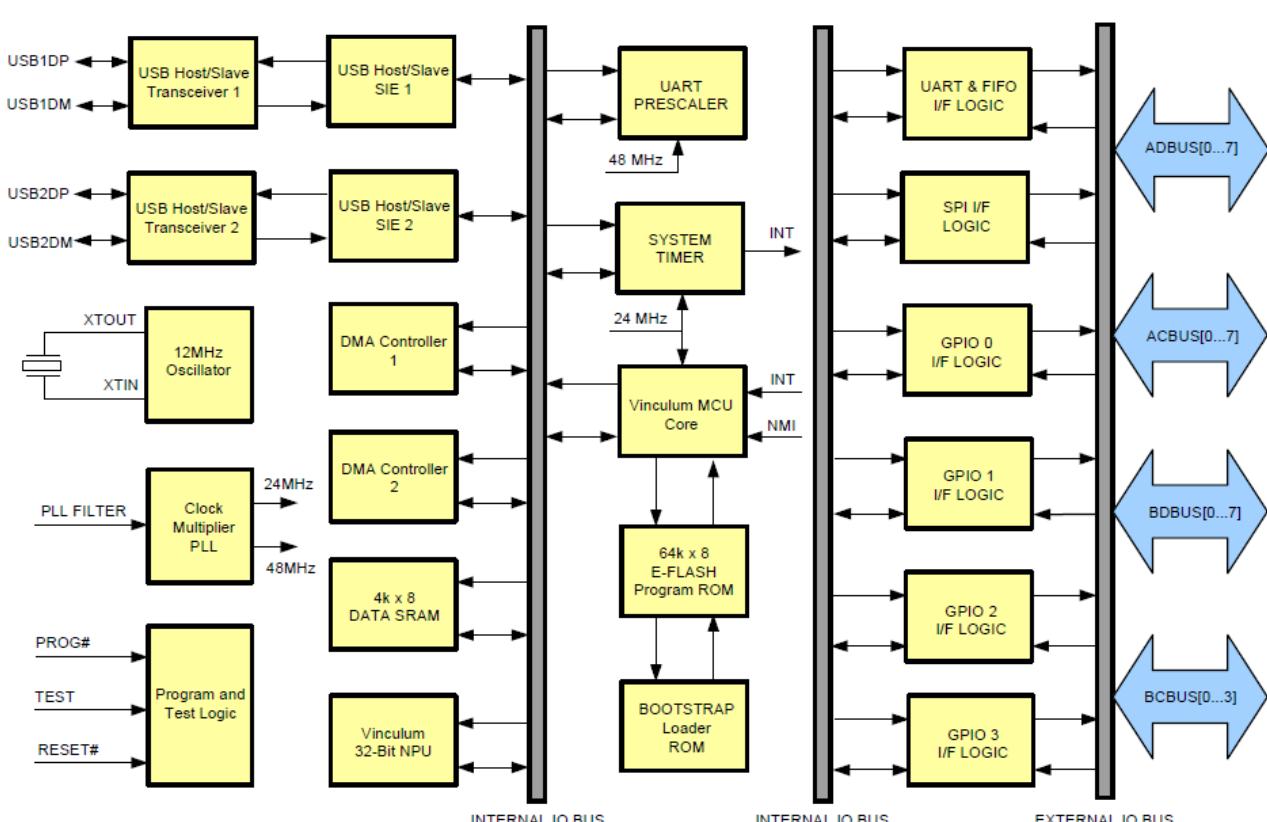
- کنترلر USB HOST
- تبادل اطلاعات با USB FLASH و دیگر تجهیزات دارای پورت USB
- تبادل داده با و کنترل بوسیله MCU/FPGA/PLD
- دارای firmware جهت کاربردهای گوناگون
- دارای قابلیت کنترل دو پورت USB مجزا
- قابلیت اتصال به میکرو کنترلرهای ۸ و ۳۲ بیتی
- دارای ۲ مرکز DMA جهت ثبات کاری هرچه بیشتر مازول
- فرکانس کاری بین ۱۲ تا ۴۸ مگاهرتز
- قابلیت ریست خودکار در هنگام روشن شدن به همراه پایه reset
- دارای ۶۴ کیلوبایت حافظه برنامه flash rom و ۴ کیلو بایت sram داخلی
- دارای کتابخانه استاندارد برای ساخت افزار usb که توسط شرکت FTDI پشتیبانی می شود
- قابلیت بروز رسانی برنامه سخت افزاری usb از طریق UART Flash disk
- بروز رسانی راحت برنامه سخت افزاری USB
- پشتیبانی از ۲ پورت USB 2.0 با قابلیت سرعت پایین ، سرعت بالا، میزبانی Slave ports به کمک پول اپ و پول دون کردن مقاومت ها
- دارای ۴ حالت تنظیم برای تبادل باس اطلاعات ورودی و خروجی
- قابلیت بروز رسانی برنامه سخت افزار، حالت اطلاعات ورودی و خروجی و دستورات برای نمایش اطلاعات از طریق سریال uart
- قابلیت اتصال از طریق پروتکل SPI برای اطلاعات ورودی و خروجی و command monitor interface

standby).

- -40° to +85° extended operating temperature range.
- Available in compact Pb-free 48 Pin LQFP package (RoHS compliant).

نمونه کاربرد تراشه:

- Add USB host capability to embedded products.
- Interface USB Flash drive to MCU/PLD/FPGA.
- USB Flash drive to USB Flash drive file transfer interface.
- Digital camera to USB Flash drive or other USB slave device interface.
- PDA to USB Flash driver or other USB slave device interface.
- MP3 Player to USB Flash drive or other USB slave device interface.
- USB MP3 Player to USB MP3 Player.
- Mobile phone to USB Flash drive or other USB slave device interface.
- GPS to mobile phone interface.
- Instrumentation USB Flash drive or other USB slave device interfacing.
- Data-logger USB Flash drive or other USB slave device interface.
- Set Top Box – USB device interface.
- GPS tracker with USB Flash disk storage.



ساختار داخلی تراشه VNC1L-1A

وظیفه این بخش تبدیل اطلاعات USB از سری به موازی و بالعکس می باشد و بررسی خطاهای بوجود آمده هم چنین CRC generation / checking, USB frame generation : 12MHz Oscillator

این بخش شامل اسیلاتوری می باشد که فرکانس ۱۲ مگاهرتز را بر اساس کریستال ۱۲ مگاهرتز متصل به برد خواهد ساخت هم چنین که فرکانس مورد نیاز جهت بخش Clock Multiplier PLL را تمامین می کند.

Clock Multiplier PLL •

این بخش فرکانس اولیه خود را از اسیلاتور گرفته و با توجه به فرکانس ورودی ۱۲ مگاهرتز فرکانس های ۲۴ و ۴۸ مگاهرتز را برای بخش های USB SIE و بخش MCU CORE و سیستم تایмер مدار و فرکانس سریال را تولید می کند.

Program and Test Logic •

این بخش وظیفه پروگرم کردن حافظه E-Flash داخلی را دارد، وقتی که پایه #PROG را به زمین وصل کنید و مدار را ریست کنید بعد از روشن شدن مدار حافظه E-Flash به کمک بوت استارت rom جهت پروگرم کردن از طریق uart آماده می شود.

DMA Controller 1 and 2 •

وجود ۲ کانال dma باعث میشود که حتی در موقعی که بیشترین بار پردازشی بر روی cpu باشد باز هم بخش های مختلف مدار از جمله UART و SPI و پایه های ورودی و خروجی و ارتباط بین sram داخلی و میکرو متصل به مدار بدون مشکل ، پایدار بماند و وظیفه خود را انجام بدنهند.

Data SRAM •

این بخش که شامل حافظه ۴ کیلو بایتی ۸ بیتی میباشد وظیفه آماده

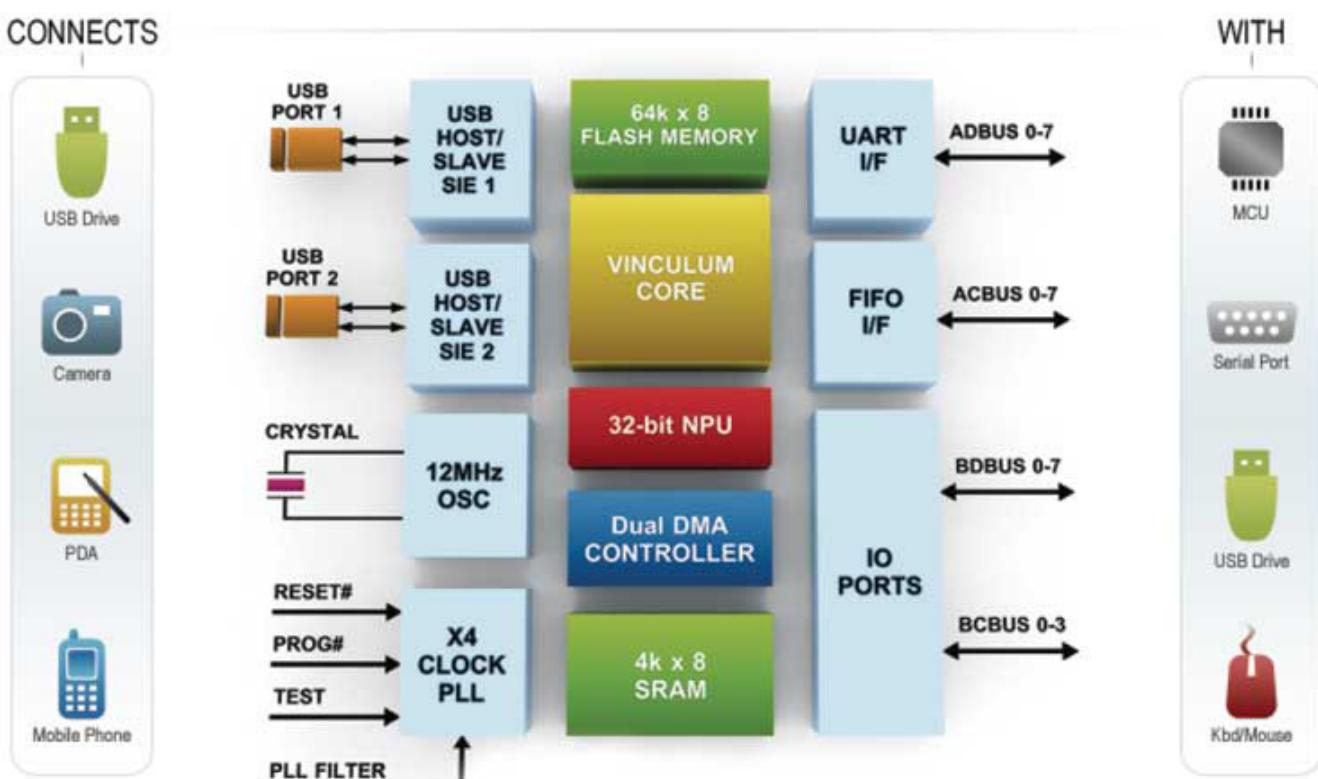
- قابلیت افزایش تا ۲۸ پایه برای تبادل اطلاعات command monitor
- قابلیت اتصال به MCU / PLD / FPGA از طریق پروتکل های UART, FIFO, SPI
- قابلیت اتصال از طریق پروتکل موس و کیبورد و اتصال موس و کیبورد
- قابلیت تنظیم برای چند پردازشگر
- پشتیوانی در ارسال اطلاعات به صورت تکه به تکه و معلق شده bus powered, self powered, highpower
- پشتیوانی از bus دستگاه های متصل bus
- قابلیت کار در ولتاژ ۳,۰ و ۳,۶ ولت به همراه حفاظت در برابر ولتاژ ۵ ولت ورودی
- سازگاری کامل با USB 2.0 و پشتیوانی از سرعت بالا تا ۱۲Mbps و سرعت پایین ۱,۵Mbps
- رنج دما بین ۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد

دراین بخش به توضیح بخش های مختلف آی سی طبق بلوک دیاگرام بالا خواهیم پرداخت:

:USB Host / Slave Transceivers 1 and 2•

این بخش مربوط به ارسال و دریافت اطلاعات از طریق میباشد که به صورت SLAVE و USB HOST عمل خواهد کرد هم چنین که از USB 1.1 و USB 2.0 و USB 3.0 را پشتیوانی می کند و با استفاده از مقاومت ها و نحوه قرار گیری به صورت پول آپ و پول دون میتوان آنرا در دو وضعیت میزان HOST USB و SLAVE قرار داد.

:(USB Host / Slave Serial Interface Engine (SIE •



بلوک دیاگرام عملکرد و کاربردهای تراشه VNC1L

VNC1L تراشه



نمونه مازول ارتباط با پورت USB

را پروگرم کنید

سازی و ارائه اطلاعات به پورت خروجی را دارد هم چنین که این بخش توسط dma نیز کنترل می شود.
• NPU (Numeric CoProcessor)

بیشترین میکرو های متصل به این آی سی ۸ بیتی هستند اما در موقعی نیز ممکن است که میکرو ۳۲ بیتی نیز به این آی سی وصل شود و وظیفه این بخش تنظیم سرعت و نوع اطلاعات ارسالی به میکرو کنترلر می باشد.

• UART Prescaler

وظیفه اصلی این بخش آماده سازی کلک مورد نیاز برای uart می باشد که براحتی می توان توسط این بخش فرکانس لازم را برای نرخ تبادل اطلاعات بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ms را تامین کرد.

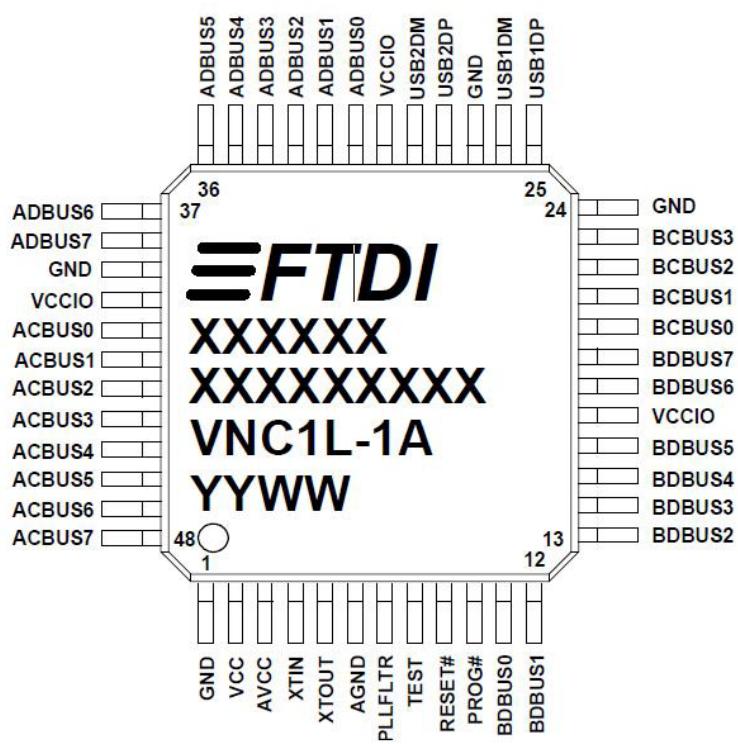
• SYSTEM TIMER

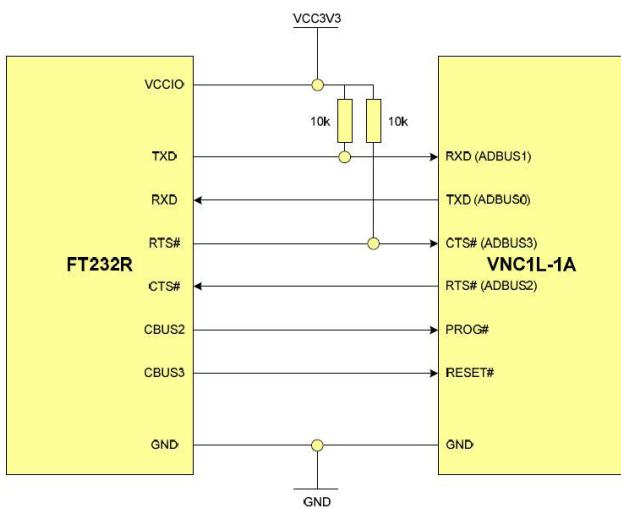
این بخش وظیفه ساخت اینترپت های لازم در ارتباط با بخش اصلی و میکرو را بر عهده دارد و زمان ۱ms را میسازد

• VINCULUM MCU CORE

در اصل از این بخش به عنوان قلب این IC یاد می شود، بخش VMCU است که براساس تکنولوژی FTDI و به صورت ۸ بیتی ساخته شده است، در این قسمت دیتا ها و آدرس ها از هم جدا می شوند و از ۶۴ کیلوبایت کد های پروگرم و ۶۴ کیلو بایت دیتا و ۲۵۶ بایت فضای رجیستر های ورودی و خروجی نیز برخوردار می باشد.

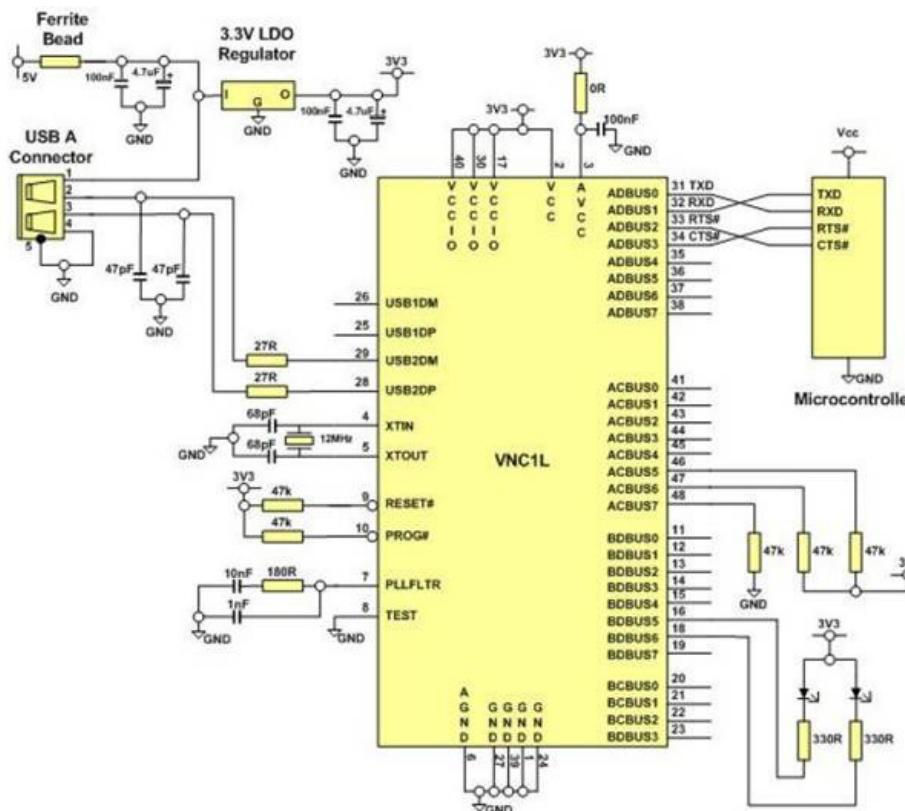
• E-FLASH Program ROM





برنامه ریزی VNC1L از طریق ارتباط سریال

نصب درایور تجهیز در شماره یک مجله نویز آموزش داده شده است.



مدار نمونه برای ارتباط با میکروکنترلر برای یک ارتباط سریال

منبع :
برگه اطلاعاتی تراشه VNC1L
وب سایت یزد کیت

نویسنده : صادق ساعی اصفهانی
mohammadsa_2@yahoo.com

همچنین می توان تا دو دستگاه مجزا را همزمان به آن متصل نمود:
پایه های ارتباطی:

pull down و pull up USB2DP و USB1DP: بوسیله مقاومت می توان slave و یا Host بودن را برای دیتا مشخص نمود.

USB2DM و USB1DM: انتخاب slave و یا Host بدون مقاومت pull down و pull up .
پایه های متفرقه:

XTOUT و XTIN: ورودی کریستال ۱۲MHz. یک کریستال ۱۲mhz به پایه های ۴ و ۵ متصل می گردد به همراه یک خازن مناسب به زمین. همچنین می توان یک پالس ساعت ۱۲Mhz خارجی به این پین اعمال نمود.

PLLFLTR: ورودی مدار فیلتر PLL خارجی.
TEST: بردن دستگاه به مد تست IC. برای عملکرد عادی بایستی به زمین متصل گردد.

#RESET: می توان با یک وسیله خارجی اقدام به Reset دستگاه نمود. این پین می تواند با پین #PROG تلفیق شده و از یک نرم افزار برای ارتباط UART استفاده نمود.

پایه های دیتا و کنترل:
BDBUS0-7: ارتباط دو سویه ایمن دیتا و کنترل ۵ ولت، بیت BD 0-7

BCBUS0-3: ارتباط دو سویه ایمن دیتا و کنترل ۵ ولت، بیت BC 0-3

ACBUS0-7: ارتباط دو سویه ایمن دیتا و کنترل ۵ ولت، بیت AD 0-7

ACBUS0-4: ارتباط دو سویه ایمن دیتا و کنترل ۵ ولت، بیت AC0-7

ACBUS5-6: ارتباط دو سویه ایمن دیتا و کنترل ۵ ولت، پین انتخاب مد ارتباطی، بیت AC5-6

ACBUS7: ارتباط دو سویه ایمن دیتا و کنترل ۵ ولت، بیت AC7

برای استفاده از کریستال ۱۲MHZ یک مقاومت ۴۷k را بصورت pull down باید قرار داده شود.

مشابها برای سوئیچ کردن به حالت خاموشی ضرب کننده کلک داخلي بایستی یک مقاومت

۴۷k pull up قرار داده شود. این حالت برای استفاده از پالس ساعت ۴۸MHZ روی پین XTIN استفاده می گردد.

تستر قطعات الکترونیک



یکی از مشکلات موجود بر سر راه طراحان الکترونیک که همیشه باعث اتلاف وقت بسیار زیادی می شود ، خرابی و معیوب شدن قطعات الکترونیکی بوده که هیچ گاه از ظاهر قابل تشخیص نیست و فقط با تست قطعه معیوب می توان از خرابی آن آگاه شد . این دستگاه یک تست کننده چند کاره مخصوص آزمایشگاه ها و جزئی لاینک از تجهیزات طراحان حرفه ای می باشد که دارای امکاناتی جهت تست انواع IC های پر کاربرد خانواده های TTL و CMOS و Op-Amp ، تست LCD های کاراکتری و تست تمامی ترانزیستورهای PNP (BJT) و NPN می باشد و می تواند در کمترین زمان ممکن قطعات را تست و سالم بودن یا خراب بودن قطعه را مشخص نماید .

محفویات محصول :

- » دستگاه تستر
- » منبع تغذیه مورد نیاز دستگاه
- » CD شامل آموزش استفاده از دستگاه به همراه دیتاشیت IC های قابل تست
- » دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه
- » برگه ضمانتنامه ۱۲ ماهه دستگاه

قطعات قابل تست دستگاه :

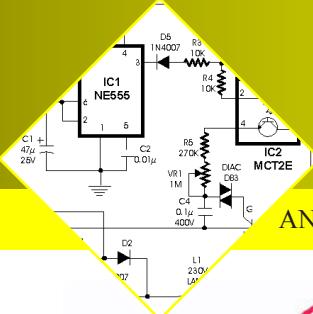
- » TTL های پر کاربرد
- » CMOS های پر کاربرد
- » Op-Amp های پر کاربرد
- » LCD های کاراکتری (۲۰*۲۰ ، ۱۶*۴)
- » تمامی ترانزیستورهای NPN-PNP

لیست قطعات قابل تست :

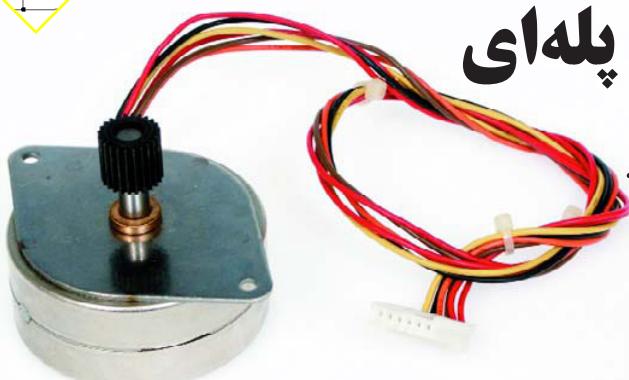
TTL ICs : 7400 , 7401 , 7402 , 7404 , 7405 , 7408 , 7409 , 7410 , 7400 , 7412 , 7415 , 7420 , 7421 , 7422 , 7426 , 7427 , 7428 , 7430 , 7432 , 7437 , 7438 , 7440 , 7442 , 7447 , 7448 , 7474 , 7476 , 7483 , 7485 , 7486 , 7495 , 74138 , 74147 , 74148 , 74151 , 74153 , 74173 , 74194 , 74748

CMOS ICs : 4001 , 4002 , 4008 , 4009 , 4010 , 4011 , 4012 , 4013 , 4014 , 4021 , 4023 , 4025 , 4027 , 4042

Op-Amp ICs : 358 , 324 , 3130 , 3140 , 741



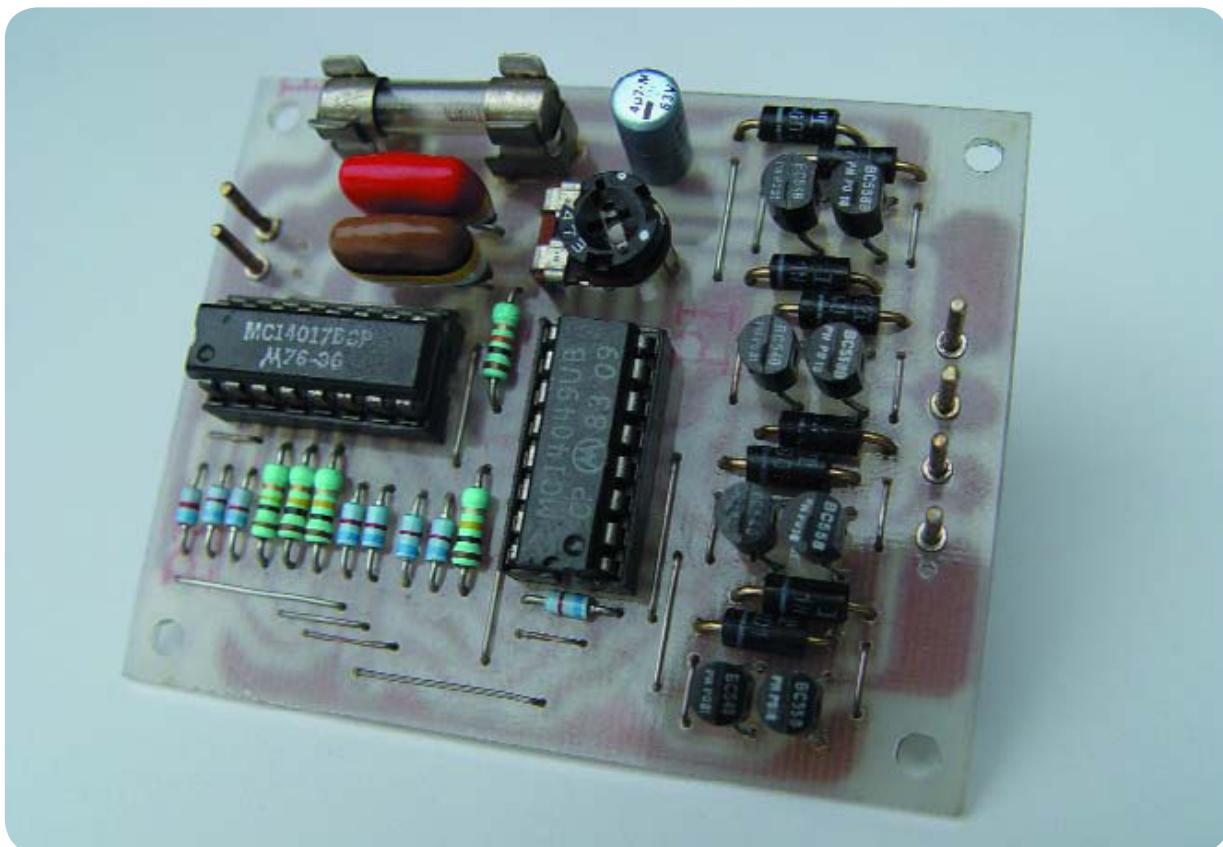
مدار راه انداز موتورهای پلهای بدون نیاز به میکرو کنترلر



هدف ایجاد پله‌های کوچک است. شما باید ویژگی هایی را برای منبع توان سیم پیج و تعداد درجات هر پله مد نظر قرار دهید. هنگامیکه زاویه‌ی پله از $1/8$ درجه بیشتر شود یعنی کمتر از 200 پله در هر دور، در این صورت پله‌های مجزا را همواره می‌توان تشخیص داد و نمی‌توان یک حرکت چرخشی آهسته و یکنواخت را با این مدار عملی کرد. بهترین نتیجه، با یک موتور پله‌ای با زاویه‌ی پله $0/9$ درجه یعنی 400 پله در هر دور بدست خواهد آمد. در عمل، پله‌های بیشتر در هر دور غیر معمول است.

این مدار صرفاً بدین منظور طراحی شده است که امکان چرخش موتور پله‌ای کوچک را در یک جهت و با سرعت خیلی کم و بدون نیاز به میکروکنترلرها میسر سازد. کاربرد اصلی این مدار در حوزه‌ی ساخت مدل است.

مداری مانند آنچه که در اینجا توضیح داده شده است، به هنگام نیاز به توان اندک و سرعت کم می‌تواند بسیار مفید واقع شود. اما جعبه دندۀ دارای تاثیرات نا مطلوب است. برخی از کاربردهای مورد بررسی، آتن رادار بر روی کشتی مدل می‌باشد که در هر دقیقه حدوداً ۳۰ بار می‌چرخد و یا به عنوان بخشی از قطار مدل است که حدوداً ۲۰ دور در دقیقه نمی‌چرخد. مدار راه اندازی که در اینجا توضیح داده شده، سرعتی را حدوداً از 5 rpm تا 100 rpm فراهم می‌کند و بنابراین برای کاربردهایی از این نوع ایده‌آل است.



نمایی از مدار ساخته شده

طرح کلی

همچنانکه در طرح کلی نشان داده شده در شکل ۱ می‌توان مشاهده کرد، مدارهای راه انداز کامل مشکل از اندکی بیش از دو IC و ترانزیستور می‌باشند. در این شکل هیچگونه بخش پیجدهای وجود

اندازه پله (step)

در عمل، موتورهای پله‌ای عموماً برای کاربردهای مربوط به چرخش در نظر گرفته نشده‌اند و برای موقعیت یابی به کار برد هم شوند. در حقیقت، یک موتور پله‌ای به معنای واقعی چرخشی نمی‌باشد، بلکه

مدار راه انداز موتورهای پلهای بدون نیاز به میکروکنترلر

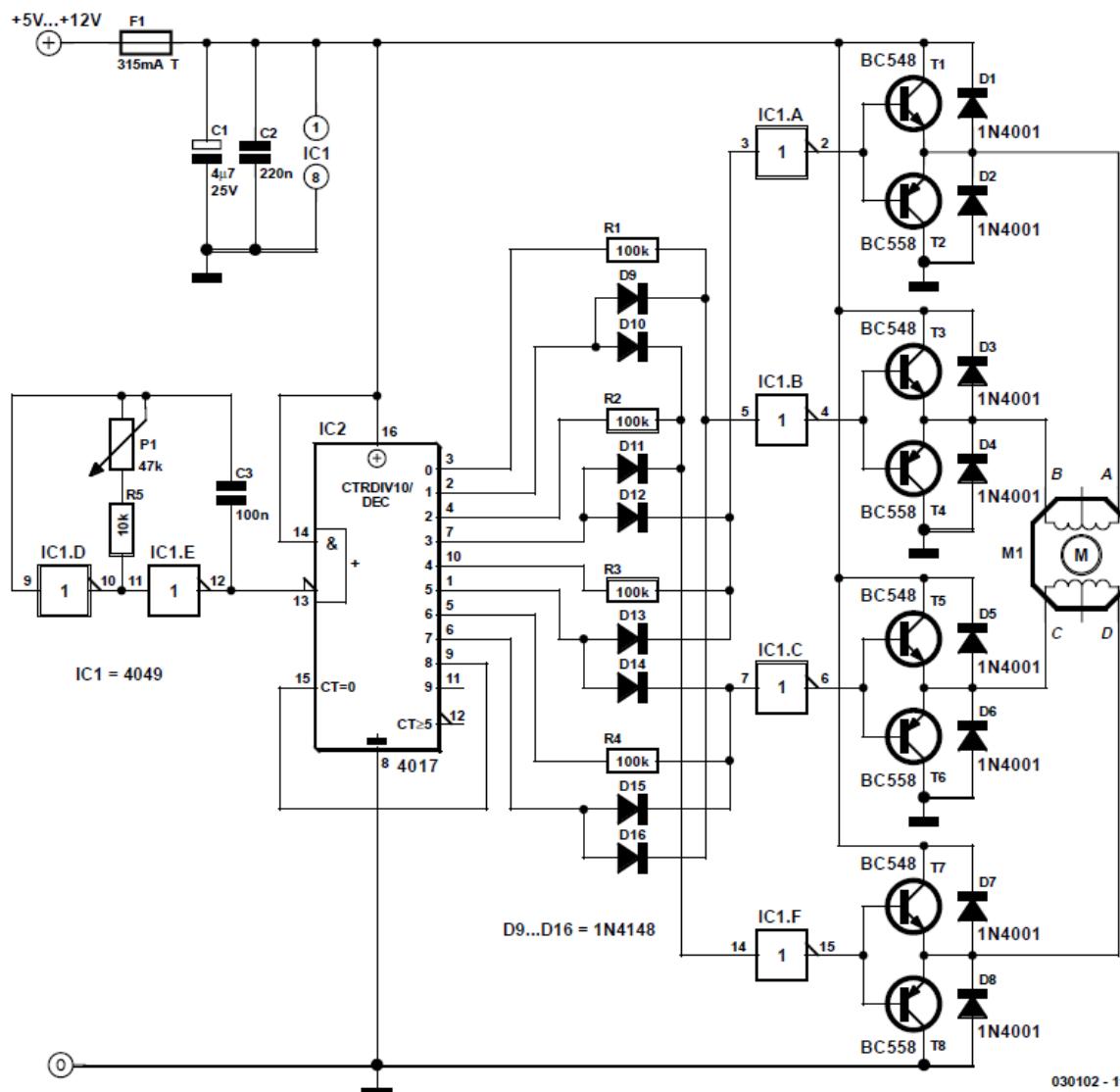
و نیز نتایج ولتاژهای سیم پیچ UAB و UCD را لیست کرده است. راه انداز شامل T1 تا D1 ، T8 تا D8 و IC1d تا IC1a در پایانه‌های C، B، A و D می‌باشد. پایانه‌های سیم پیچ یا به منبع یا به زمین متصل هستند که بستگی به سطح منطق در خروجی اینورتر دارد. بدیهی است که ولتاژ درون سیم پیچ زمانیکه هر دو پایانه به ریل منبع توان یکسان متصل هستند، برابر صفر است.

ملاحظات

بسیاری از موتورهای پلهای سیم پیچ‌هایی با یک سر مشترک مرکزی دارند. این اتصال باید باز گذاشته شود چرا که در این مدار راه‌انداز دارند.

نadar و همگی بدون استثنا اجزای استانداردی هستند. سرعت چرخش موتور پلهای توسط موقعیت P1 تعیین می‌گردد که P1 فرکانس تولید پالس کلاک را که شامل IC1d، IC1e، P1، R5 و C3 می‌باشد، تنظیم می‌کند. مقدار C3 ممکن است به منظور تطبیق تغییر یابد، اما در بیش از ۱۰۰ دور در دقیقه، اکثر موتورهای پلهای کار نخواهند کرد. اینجا سرعت مینیممی تعریف نشده است.

پالس کلاک به ورودی کلاک (پایه ۱۳) IC2 فرستاده شده است. این IC یک شمارنده ده دهی نوع ۴۰۱۷ است و به گونه‌ای شکل یافته است که در هر پالس کلاک، خروجی‌های Q0 (پین ۳) تا Q7



030102 - 11

مدار درایور که از قطعات بسیار کمی تشکیل شده است.

قطبی مورد بحث، مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. موارد فاقد مشترک مرکزی را می‌توان بین طریق تشخیص داد که این موارد فقط ۴ سیم اتصال دارند. مدل‌های دارای مشترک مرکزی ۵ یا ۶ سیم دارند. توجه داشته باشید که موتورهایی با ۵ سیم برای این نوع کاربرد مناسب نیستند زیرا مشترک‌های مرکزی از درون اتصال یافته‌اند.

مداری که در اینجا توضیح داده شده، برای کوچکترین موتور پلهای

(پین ۶) به صورت پیاپی به سطح بالای منطقی می‌روند. هنگامیکه Q7 افزایش یابد، شمارنده مجدداً خود راه اندازی کرده و چرخه تکرار می‌شود. جدول درستی نشان داده شده در شکل ۲ این فرایند را نشان می‌دهد.

R1 تا D16 و R4 تا D9 ماتریسی را تشکیل می‌دهند که ۸ حالت A، B، C و D تبدیل می‌کنند. جدول درستی، پتانسیل ولتاژ پایانه‌های سیم پیچ

مدار راه انداز موتورهای پله‌ای بدون نیاز به میکروکنترلر

شده و از مکمل آن یعنی BD678 برای جایگزینی در ، T4 ، T2 و T8 استفاده شود. این ترانزیستورها دارای تعداد زیادی دیود بهمنی مجتمع می باشند، بنابراین ممکن است دیودهای D1 تا D8 حذف شوند.

Elektor Mgazine

منبع :

مترجم : فریبا سماواتیان

و کمترین ولتاژ منبع موجود در نظر گرفته شده است. هرچه موتور بزرگتر بوده و ولتاژ منبع بیشتر باشد، ترانزیستورهای راهانداز T1 تا T8 باید بیشتر کار کنند. فیوز F1 عبور جریان از ترانزیستورها و دیودها را محدود می کند. چنانچه این الزام وجود داشته باشد که راه انداز جزیان بیشتری تولید نماید، آنگاه مطلوب است که BD677 جایگزین T7 با ترانزیستور دارلینگتون D1 ، T5، T3 و T1

CLK IC2 S13	Q0 IC2 S3	Q1 IC2 S2	Q2 IC2 S4	Q3 IC2 S7	Q4 IC2 S10	Q5 IC2 S1	Q6 IC2 S5	Q7 IC2 S6	A	B	C	D	U_{AB}	U_{CD}
→ 0	1	0	0	0	0	0	0	0	+V	GND	+V	+V	↑	
→ 1	0	1	0	0	0	0	0	0	+V	GND	+V	GND	↑	↓
→ 2	0	0	1	0	0	0	0	0	+V	+V	+V	GND		↓
→ 3	0	0	0	1	0	0	0	0	GND	+V	+V	GND	↓	↓
→ 4	0	0	0	0	1	0	0	0	GND	+V	+V	+V	↓	↓
→ 5	0	0	0	0	0	1	0	0	GND	+V	GND	+V	↓	↑
→ 6	0	0	0	0	0	0	1	0	+V	+V	GND	+V		↑
→ 7	0	0	0	0	0	0	0	1	+V	GND	GND	+V	↑	↑



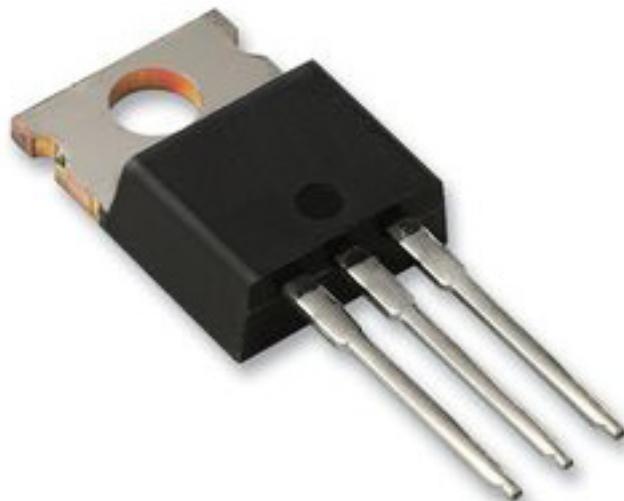
030102 - 12

جدول درستی نشاندهنده عملکرد موتورهای پله‌ای

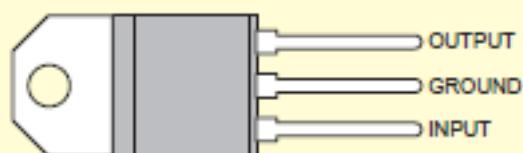
CADENCE SPB/OrCAD 16.3 HF1

نرم افزار OrCAD یکی از قدیمی ترین و حرفه‌ای ترین نرم افزارهای آنالیز و شبیه ساز الکترونیکی است. این نرم افزار امکان آنالیز مدارهای الکترونیکی را با استفاده از تحلیلگر پی اسپایس در اختیار کاربران قرار می دهد. دقت تحلیل این نرم افزار به حدیست که در مجتمع علمی نیز از آن استفاده می شود. این نسخه آخرین نسخه از این نرم افزار بوده که تعداد زیادی امکانات مفید و قابلیتهای جدید به آن اضافه شده است. این محصول در قالب یک DVD ارائه شده است.



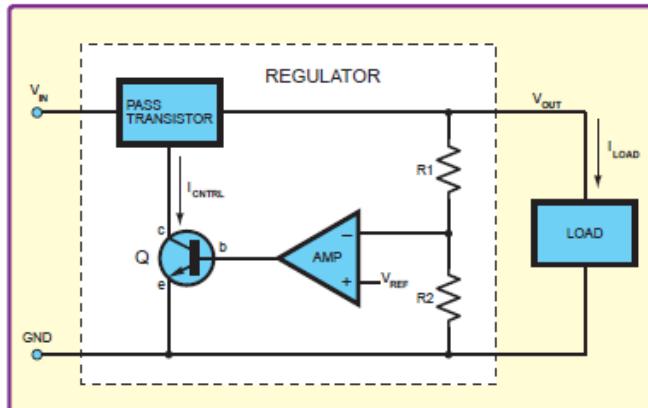


هستند و برخلاف قطعات بسیار پیشرفته با افت پایین (LDO) از الزامات ظرفیت الکتریکی بحرانی برخوردار نیستند. با این حال در مقایسه با دستگاه های LDO، آنها نیازمند تفاضل زیاد ولتاژ ورودی و خروجی هستند، به همین دلیل کارآبی کمتری دارند.



شکل ۲ : پایه های LM78xx برای بسته متعارف TO-220

تصویر ساده ای از قسمت داخلی مدار رگولاتور خطی ساده در شکل ۳ نشان داده شده است. رگولاتور جریان تولید شده برای بار خروجی را به گونه تنظیم می کند که ولتاژ خروجی (V_{out}) ثابت بماند. هر رگولاتور شامل مقسم ولتاژی است که با ولتاژ ثابت خروجی مقایسه می شود. اگر ولتاژ خروجی کاهش یابد، تقویت کننده خروجی نیز افزایش می یابد زیرا مقسم ولتاژ به ورودی وارونگر متصل است.



شکل ۳ : طرح کلی مدار نمونه برای رگولاتور خطی

جراحی مدار

حافظت از رگولاتورهای سری 78XX

همه ما می دانیم که با رعایت موارد زیر رگولاتورهای سری 78XX علاوه طول عمر بسیار بالایی خواهند داشت :

- ۱- حفاظت حرارتی
- ۲- محدود کردن جریان
- ۳- حفاظت از اتصال کوتاه

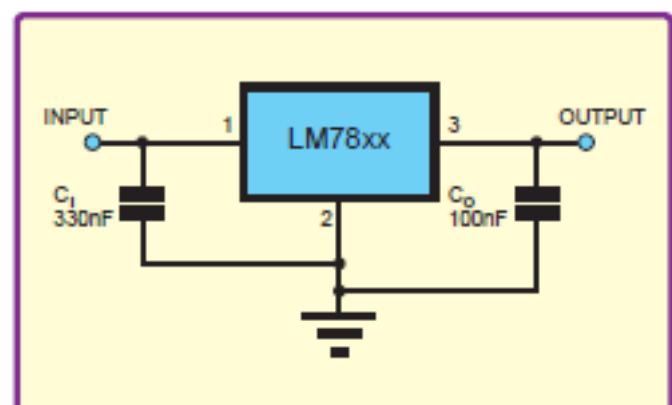
در این شماره از مجله موضوع حفاظت از بار اضافی رگولاتورها و بعضی از مفاهیم مذکور را بررسی خواهیم کرد.

رگولاتورهای سری 78XX

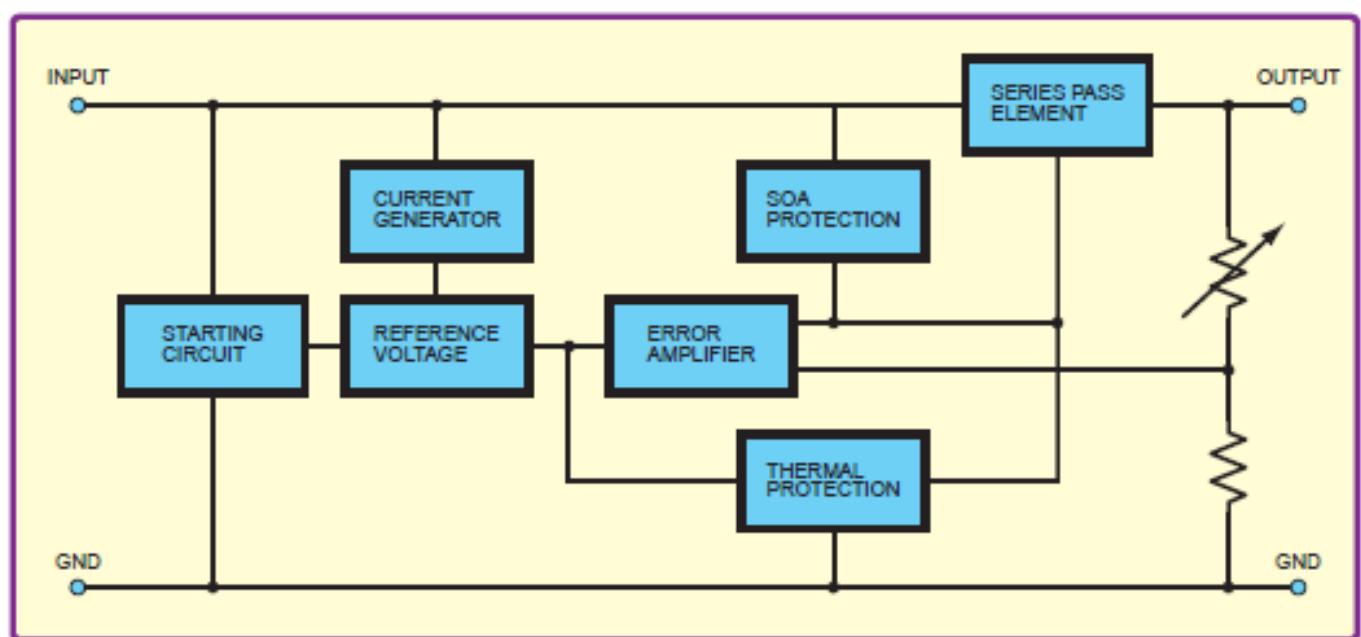
سال های متمادی است که رگولاتورهای سری 78XX مورد استفاده قرار می گیرند. اینها قطعات عمومی هستند که از طریق تعدادی از تولید کنندگان نیمه هادی که هنوز هم آنها را تولید می کنند، قابل تهیه هستند. اما تولید کنندگان نیمه هادی National Semiconductor توافق تولید نوع LM78xx را اعلام و نوع LM340 را جایگزین آن کرده است. با این حال آنها هنوز هم در برگ اطلاعاتی نوع LM340 به توضیح قطعات LM78xx پرداخته اند.

وجود حرف XX در نام قطعات نشانگر ولتاژ خروجی رگوله شده است. این سری در مقادیر ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۲، ۱۵، ۲۴ و ۱۸، ۲۰ و ۲۴ ولتی موجود هستند. نمونه ای از مدار این قطعه را در شکل ۱ مشاهده و پایه های بسته مربوط به آن در شکل ۲ نشان داده شده است. توجه داشته باشید رگولاتورهای سری 78XX در انواع بسته ها موجود است. بنابراین قبل از استفاده بایستی همیشه نمودار بسته ای را که در برگ اطلاعاتی سازنده آن ذکر شده بررسی کنید.

در شکل ۱ اگر رگولاتور در فاصله زیادی نسبت به خازن های صافی منبع قدرت قرار گیرد یا ظرفیت الکتریکی بار خروجی زیاد باشد، خازن C1 مورد نیاز است. خازن تانتاییوم، پولیستری یا انواع دیگر با امپدانس کم در فرکانس بالا مورد استفاده قرار می گیرد. این خازن بایستی پایه های کوتاهی داشته باشد و تا جاییکه امکان دارد نزدیک رگولاتور قرار گیرد. خازن C0 مورد نیاز نیست اما پایداری و پاسخ گذرا را افزایش می دهد. رگولاتورهای سری 78XX معمولا مقاوم



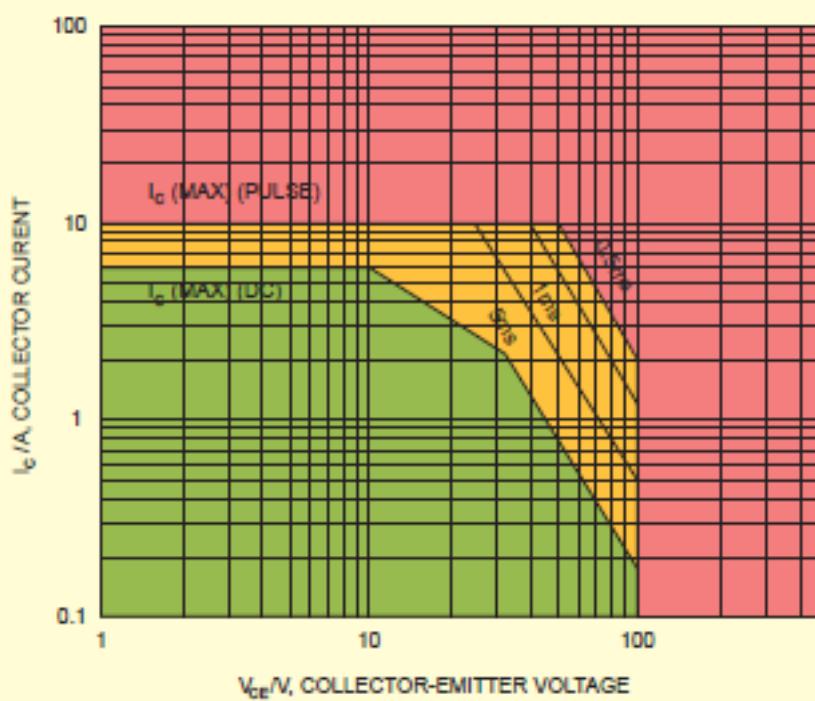
شکل ۱ : ترسیم مدار استاندارد برای رگولاتور سری 78XX



شکل ۴: ترسیم طرح کلی بسته برای رگولاتور سری LM78XX طبق دیتاشیت شرکت Fairchildsemi

که از جریان تولید شده می‌کاهد، تعادل ایجاد می‌کند تا مصرف انرژی را کاهش دهد.
بخش عملکرد امن یا به طور کاملتر بخش عملکرد امن مستقیم FBSOA که در ترانزیستورهای قدرت منحنی ایجاد می‌کند، برای نشاند دادن بیشترین ولتاژ مطمئنه و ترکیبات جریان برای عملیات متوالی و ضربه‌ای است. مثال شکل ۵ بر اساس منحنی‌های SOA در ترانزیستور قدرت Tip41C NPN می‌باشد.

ولتاژ خروجی افزایشی بر جریان کنترلی برای عبور به ترانزیستور و عبور آن به بار خروجی می‌افزاید، که این امر موجب افزایش ولتاژ خروجی می‌شود و کاهش اولیه را جبران می‌کند. این حلقه بازخوردی منفی باعث برابری ولتاژ مقسم ولتاژ خروجی می‌شود، در نتیجه با تغییرات بار خروجی ولتاژ خروجی را ثابت نگه می‌دارد. در شکل ۳ هیچ حفاظتی از بار زیاد مدارات نشان داده نشده است.



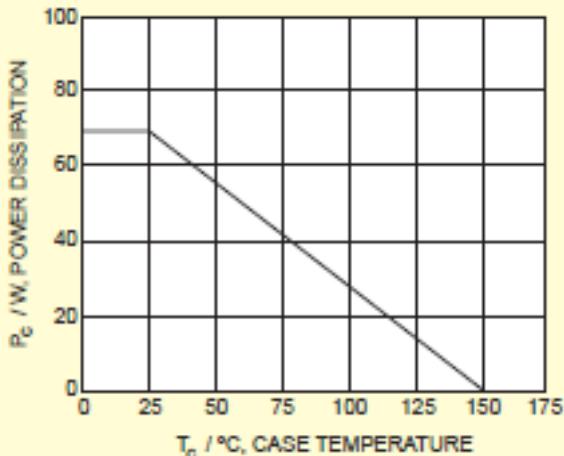
شکل ۵: نمونه‌ای از منحنی دو قطبی بخش عملکرد امن SOA در ترانزیستور قدرت TIP41C

در شکل ۵ سایه سبز رنگ نشانگر عملیات متوالی مطمئنه در دمای معین است. ناحیه قرمز رنگ بخش خطرناک است، زیرا خرابی یا نابودی دستگاه رخ می‌دهد. قسمت کهربایی تنها برای مدت کوتاهی بی خطر است. برای مثال همانطور که روی منحنی مشخص شده،

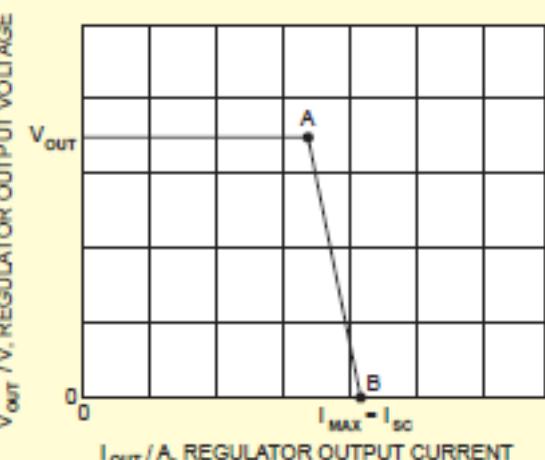
بررسد، محافظت حرارتی فعالیت خود را آغاز می‌کند و جریان بار خارجی را کاهش می‌دهد. کاهش جریان بار خارجی گرمایی تلف شده رگولاتور را کاهش می‌دهد. بنابر این مدار به نقطه‌ای می‌رسد که بین اتصالی که باعث گرمایی بیشتر می‌شود و مدار محافظتی

78XX حفاظت از رگولاتورهای سری

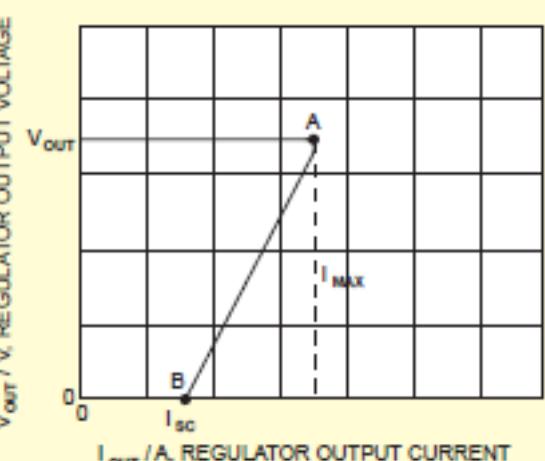
A در نمودار). اگرچه ولتاژ ورودی کاملی در سراسر رگولاتور است، اما جریان اتصال کوتاه کاهش یافته، موجب اتلاف کمتر در شرایط اضافه باری می‌شود.



شکل ۶ : نمونه‌ای از منحنی نزولی توان در ترانزیستور قدرت دوقطبی



شکل ۷ : ولتاژ خروجی رگولاتور بر حسب جریان بار خارجی با جریان محدود شده پایه



شکل ۸: ولتاژ خروجی رگولاتور بر حسب جریان بار خارجی با جریان محدود شده خروجی

بیشترین جریان ممتد کلکتور در $V_{CE}=5V$ برابر ۶A است. در این قطعه جریان کلکتور A ۱۰A در مدت زمان پایین تر از ۵ هزارم ثانیه می‌توانند جریان داشته باشند.

در ترانزیستور خطی، SOA جریان اصلی ترانزیستور از عنصری می‌گذرد (شکل ۳ و ۴) که اصلی ترین عامل نگرانی است. مدارات محافظه سعی می‌کنند تا ترانزیستور را در بخش عامل امن نگه دارند.

اتلاف توان

منحنی SOA به تنها برای تعیین عملیات مطمئنه دستگاه به طراحی کمک نمی‌کند. هر منحنی در دمای عملیاتی معین که اغلب ۲۵ درجه است، تعیین می‌شود. در دماهای بالاتر توان کنترل کننده ترانزیستورهای قدرت کاهش می‌یاد. این گفته با استفاده از منحنی نزولی در برگ اطلاعاتی توضیح داده شده است. دمای عملیاتی هر دستگاه با استفاده از اتلاف توان و ویژگی‌های حرارتی هر یک از ساختارهای هیتسینک یا سایر خنک کننده‌هایی که برای برونو سازی گرما از دستگاه کار گذاشته شده اند تخمین زده می‌شود.

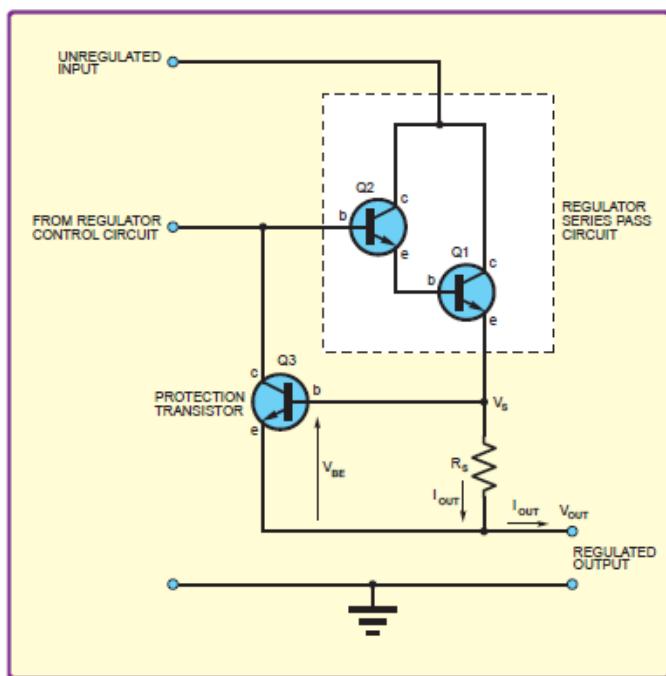
اتلاف توان در بدترین شرایط صورت می‌گیرد. همانند شرایط اتصال کوتاه خارجی که در مقایسه با عملیات معمولی به میزان زیادی اتفاق می‌افتد. این بدان معنی است که برخلاف محدودیت جریان مدارات رگولاتور، قطعه بسیار گرم می‌شود که یک راه حل ساختن هیتسینک با اندازه بسیار بزرگ است، اما اغلب بسیار عملی یا اقتصادی نیست. راه حل دیگر استفاده از محدود کننده جریان خروجی است که در شرایط اضافه باری از ولتاژ خروجی می‌کاهد تا جریان اتصال کوتاه خروجی را نسبت به بخشی از جریان بار خروجی نامی کاهش دهد.

محدود کننده جریان

اکنون به موضوع محدود کننده جریان در دو حالت پایه و foldback می‌پردازیم. به جای اشاره به اجزایی که کار برده شده در هر ترانزیستور به خصوصی، راجع به قاعده اصلی بحث خواهیم کرد. نمودار شکل ۷ ولتاژ خروجی بر حسب جریان خروجی را در رگولاتوری با محدودیت جریان پایه نشان می‌دهد. اگر پیوسته مقاومت بار خروجی کاهش یابد، به دلیل فعالیت رگولاتور، با افزایش جریان ولتاژ ثابت می‌ماند. وقتی جریان محدود شود (نقطه A نمودار) کاهش زیادی که در مقاومت بار خارجی رخ می‌دهد، موجب تقلیل ولتاژ خروجی می‌شود. اغلب حتی زمانی که مقاومت بار خارجی تا صفر کاهش می‌یابد جریان ثابت می‌ماند. (اتصال کوتاه خروجی رگولاتور) این رویداد با نقطه B در نمودار نشان داده شده که جریان خروجی بیشینه و اتصال کوتاه جریان با یکدیگر برابر هستند.

هنگامی که $V_{out} = 0$ است، افت ولتاژ در سرتاسر رگولاتور برابر با ولتاژ ورودی V_{in} است. بنابر این اتلاف توان در نقطه B بسیار بیشتر از نقطه A است، نقطه ای که جریان در آن یکسان است، اما افت ولتاژ با $V_{out} - V_{in}$ محاسبه می‌شود. در نتیجه توان اتصال کوتاه بسیار بیشتر از توان عملیات معمولی است.

اگر از حالت foldback استفاده شود، جریان خروجی در شرایط اضافه باری کاهش می‌یابد (شکل ۸). و اتصال کوتاه جریان (نقطه B نمودار) بسیار پایین تر از جریان عملیات بیشینه می‌شود (نقطه



شکل ۱۰ : ترسیم مدار محدود کننده جریان خروجی

با مجموع V_{BE} و افت V_{out} ترانزیستور محافظ برابر است. همچنین این مقدار با ولتاژ خروجی مقسم ولتاژی که از طریق مقاومت های R_1 و R_2 که در مقاومت الکتریکی حسی ولتاژ تولید می کنند، یکسان است. بنابر این می توان نوشت :

$$V_{out} + V_{BE} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_s$$

اکنون V برابر است با مجموع V_{out} و ولتاژی که با جریان داشتن جریان خروجی در مقاومت الکتریکی حسی افت پیدا می کند که آن است. با جایگزین کردن این مجموعه در فرمول $V_s = V_{out} + I_{out} R_s$ فوق الذکر خواهیم داشت:

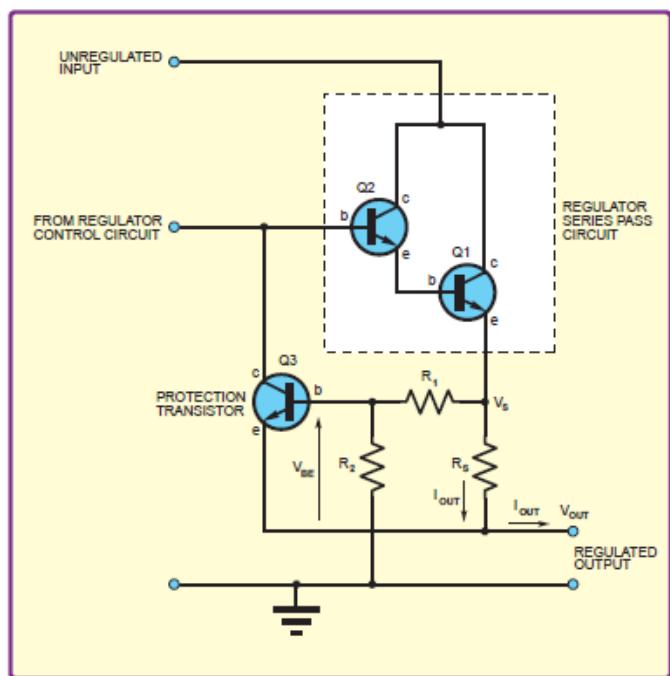
$$V_{out} + V_{BE} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) (V_{out} + I_{out} R_s)$$

برای نوشت I_{out} به صورت تابع، می توان معادله بالا را چنین نوشت: ابتدا آنها را در $(R_1 + R_2)$ ضرب می کنیم :

$$\begin{aligned} (R_1 + R_2) V_{out} + (R_1 + R_2) V_{BE} \\ = R_2 V_{out} + R_2 R_s I_{out} \end{aligned}$$

سپس $R_2 V_{out}$ حذف می شود.

$$R_1 V_{out} + (R_1 + R_2) V_{BE} = R_2 R_s I_{out}$$



شکل ۹ : ترسیم مدار محافظ جریان محدود کننده پایه

مدارات محدود کننده جریان

شکل ۹ مدار محدود کننده جریان پایه در رگولاتور خطی را نشان می دهد. این نمودار مجموعه مدار عبوری را به تصویر کشیده است (که شامل ترانزیستور Q_1 است) اما شامل کنترل باقیمانده و تنظیم مدارات که در شکل ۳ نشان داده شده نیست. مدارات محافظ شامل مقاومت الکتریکی حسی (مقدار کم)، R و ترانزیستور Q_3 است.

جریان خروجی رگولاتور در سراسر مقاومت الکتریکی حسی جاری و باعث افت ولتاژ می شود که برای بیس-امیتر Q_3 به کار گذاشته شده است. اگر جریان خروجی I_{out} ، به اندازه کافی زیاد باشد، ولتاژ افتی R برای جریان انداختن Q_3 کافی خواهد بود و جریان بیس را از Q_2 می گیرد، بنابر این موجب کاهش جریان خروجی می شود. هرگونه امری برای افزایش بیشتر I_{out} موجب فعالیت بیشتر Q_3 خواهد شد و I_{out} را کاهش می دهد.

زمانی که Q_3 در جریان است، جریان خروجی تقریباً ثابت خواهد ماند. هر کاهش دو مقاومت بار خارجی تحت چنین شرایطی، به جای حفظ ولتاژ خروجی در مقدار تنظیم شده آن، باعث کاهش آن می شود. وضعیت این مدار در نمودار شکل ۷ به خوبی نشان داده شده است.

مقادیر جریان محدود شده $I_{out,max}$ و اتصال کوتاه خروجی $I_{out,sc}$ از طریق فرمول کاربردی اهم، برای R_s محاسبه می شوند :

$$I_{out,sc} = I_{out,max} = \frac{V_{BE}}{R_s}$$

محدود کننده جریان خروجی

از مدار شکل ۱۰ می توان توضیح قواعد اساسی محدود کننده جریان خروجی استفاده کرد. با اضافه کردن مقسم ولتاژ که مقاومت الکتریکی حسی R_s را به ترانزیستور محافظ Q_3 وصل می کند. این مدار به محدود کننده جریان پایه شبیه می شود.

در مدار نشان داده شده در شکل ۱۰، ولتاژ بیس ترانزیستور محافظ

78XX حفاظت از رگولاتورهای سری

هر گاه V_{out} برابر صفر باشد، می‌توان جریان اتصال کوتاه را محاسبه کرد (نقطه B در شکل ۸) :

$$I_{OUT,SC} = \frac{1}{R_s} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) V_{BE}$$

نسبت $I_{out,SC}$ به $I_{out,max}$ مقدار خروجی را تعیین می‌کند. مقدار $I_{out,max}$ در حدود یک سوم مقدار $I_{out,max}$ است. بنابر این باید گفت محدود کننده جریان دقیقاً به جریان اتصال کوتاه و خروجی که در واقع جریان اتصال کوتاه را کنترل می‌کند بستگی دارد، اما در تمامی رگولاتورها لزوماً از جریان خروجی استفاده نمی‌شود. مطابق معمول برای آگاهی از جزئیات و چگونگی کارکرد دستگاه، بایستی برگه‌های اطلاعاتی را مطالعه کنید. مدارهای محدود کننده جریان به طور کلی با توضیحات داده شده برابر می‌کنند و همچنین برای محافظت از مراحل خروجی تقویت کننده انرژی کاربرد دارند.

هر دو طرف معادله با یکدیگر عوض می‌شوند و سپس آن‌ها را در R_2 تقسیم می‌کنیم:

$$R_s I_{OUT} = \left(\frac{R_1}{R_2} \right) V_{OUT} + \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) V_{BE}$$

در محله بعد بر R_2 تقسیم می‌کنیم:

$$I_{OUT} = \frac{1}{R_s} \left[\frac{R_1}{R_2} V_{OUT} + \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) V_{BE} \right]$$

در این معادله V_{BE} ولتاژی است که در آن ترانزیستور محافظ Q_3 فعالیت خود را آغاز می‌کند. مقدار متناظر I_{out} برابر است با تفاضل جریان خروجی بیشینه و جریان مدار محافظی که کنترل جریان را آغاز می‌کند. در چنین شرایطی V_{out} برابر ولتاژ خروجی تنظیم شده است، نقطه A در شکل ۸، V_{REG} را نشان می‌دهد.

بنابر این برای بدست آوردن جریان خروجی بیشینه :

$$I_{OUT,MAX}$$

$$= \frac{1}{R_s} \left[\frac{R_1}{R_2} V_{REG} + \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) V_{BE} \right]$$

Everyday Practical Electronics Magazine منبع :

متترجم : گیتی ایران تاج

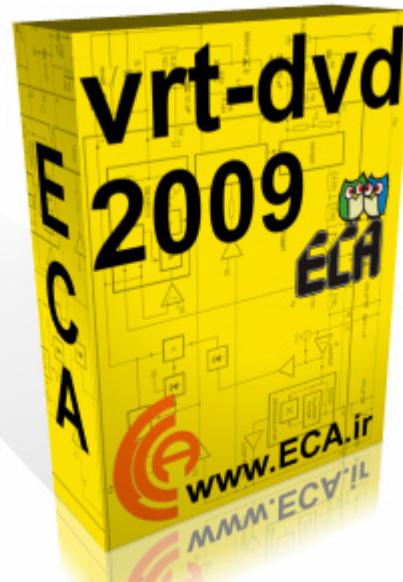
virt-dvd 2009

دیتابیسی کامل و عظیم شامل
electronic components like integrated circuits
transistors, diodes, FETs, thyristors, UJTs.

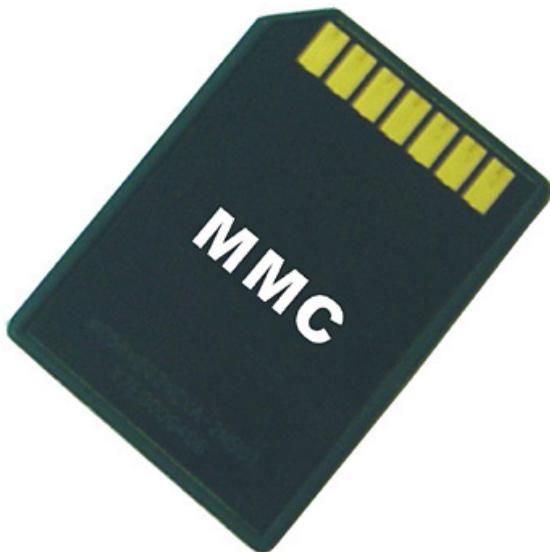
مشخصات این نسخه :

- * over 90.000 diodes
- * over 55.000 FETs
- * over 130.000 transistors
- * over 18.000 thyristors
- * over 105.000 integrated circuits

نسخه ۲۰۰۹ این مجموعه بر روی DVD ارائه گشته است.



شروعی ساده با CodeVision در محیط Fat



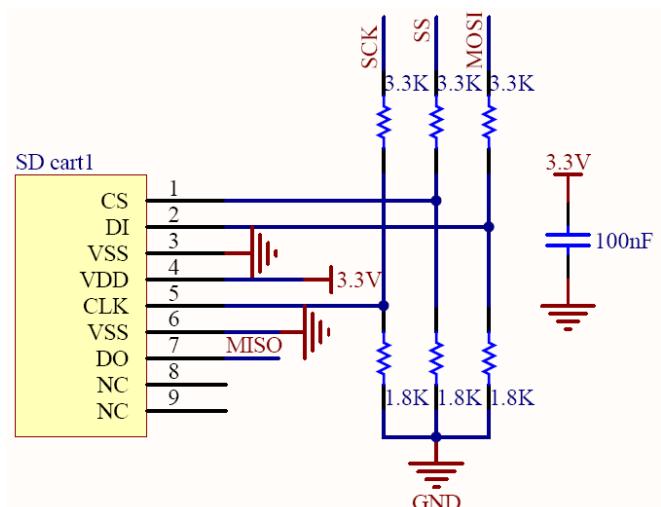
کتابخانه‌ی استفاده شده در محیط کدویزن جهت دسترسی به FAT از پیشرفته‌ترین و کاملترین کتابخانه‌های موجود می‌باشد که با کمی تغییر از سایت elm-chan.org استفاده شده است که به شما امکان استفاده از FAT12, FAT16, FAT32 را می‌دهد.

توابع مربوط به این کتابخانه، در کتابخانه‌ی «FFh» قرار دارد که می‌توانید با استفاده از دستور include این کتابخانه را به برنامه خود اضافه کنید.

جهت استفاده از MMC/SD ابتدا باید مدار سخت افزاری زیر را آماده کنید.

شمایک مدار:

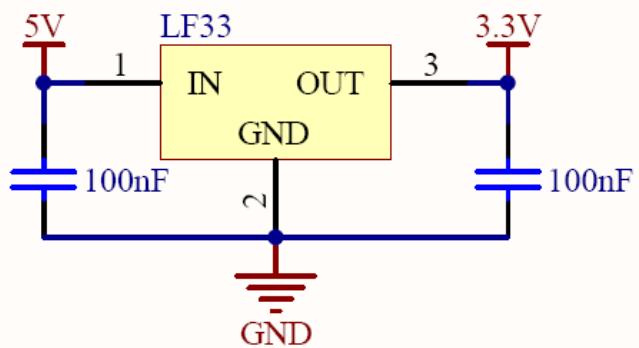
جهت استفاده از کتابخانه‌ی FAT می‌توانید از حداقل مدار زیر استفاده نمایید.



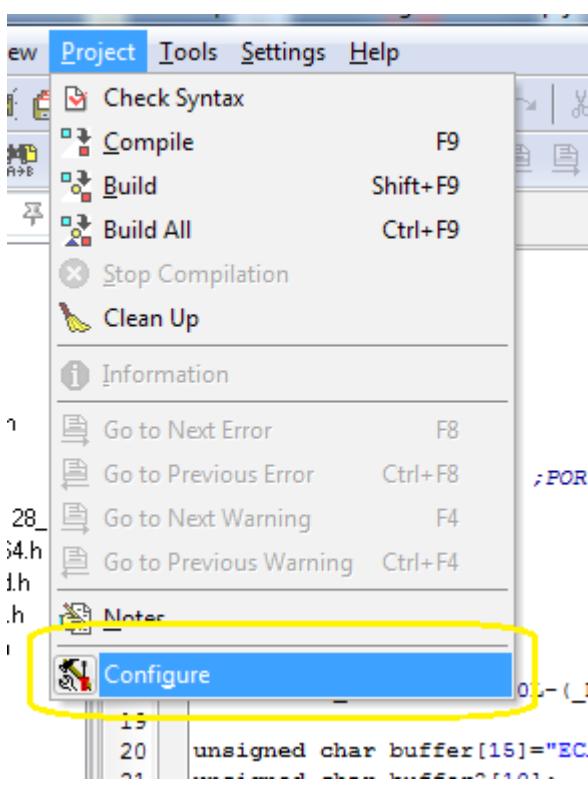
نمایش سیم بندی مربوط به MMC

توجه داشته باشید که تغذیه‌ی MMC/SD، ۳.۳ ولت می‌باشد و در صورت استفاده از ولتاژ بیشتر مطمئناً MMC/SD صدمه خواهد دید.

جهت ایجاد این ولتاژ می‌توانید از رگولاتور LF33 استفاده کنید.



مدار راه اندازی LF33



گزینه‌ی Configure از منوی Project

شروعی ساده با Fat در محیط CodeVision

- چند نکته قبل از استفاده از کتابخانه FAT:
 - جهت استفاده از کتابخانه FAT و استفاده از ارتباط با MMC باید تابع disk_timerproc واقع در کتابخانه sdcard.h با استفاده از وقفه تایمیر هر ۱۰ ms فراخوانی گردد.
 - کتابخانه FAT فقط از نام فایل های سازگار با DOS 8.3 پشتیبانی می کند و نام های طولانی تر در این ورژن پشتیبانی نمی شود.
 - در نام فایل ها و پوشه ها و فایل ها نباید از کارکتر های Unicode استفاده شود.
 - قبل از استفاده از کتابخانه MMC/SD را توسط کامپیوتر به فرمت FAT تبدیل کنید.

شمارشگرها (Struct) و ساختارها (enum)

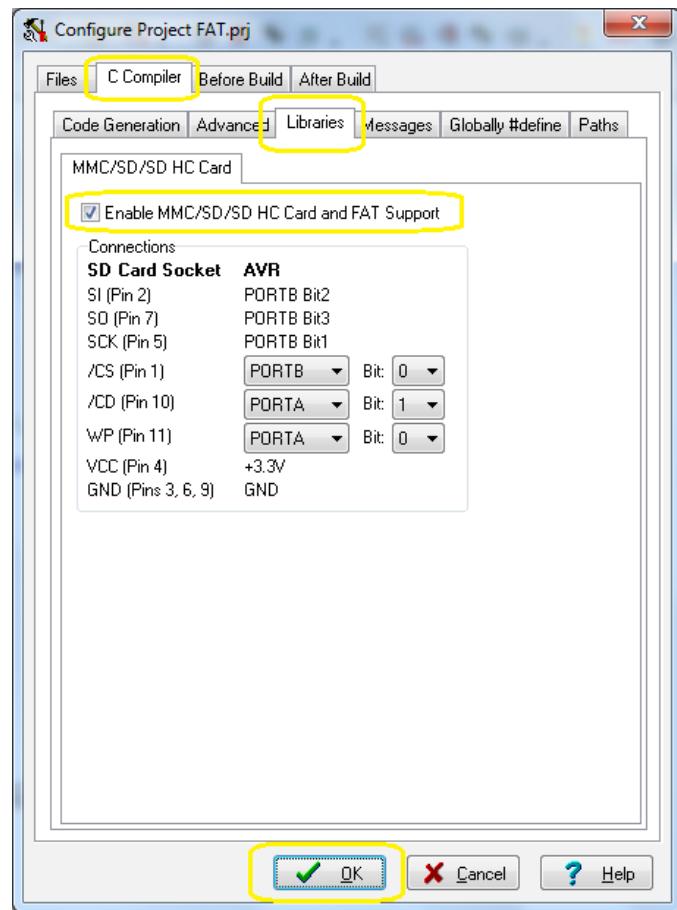
: FRESULT شمارشگر

این شمارشگر جهت برگرداندن نتیجه توابع به کار می رود.

typedef enum

```
{
    FR_OK = 0,          /* 0 */
    FR_DISK_ERR,        /* 1 */
    FR_INT_ERR,         /* 2 */
    FR_NOT_READY,       /* 3 */
    FR_NO_FILE,         /* 4 */
    FR_NO_PATH,         /* 5 */
    FR_INVALID_NAME,    /* 6 */
    FR_DENIED,          /* 7 */
    FR_EXIST,           /* 8 */
    FR_INVALID_OBJECT, /* 9 */
    FR_WRITE_PROTECTED,/* 10 */
    FR_INVALID_DRIVE,  /* 11 */
    FR_NOT_ENABLED,     /* 12 */
    FR_NO_FILESYSTEM,   /* 13 */
    FR_MKFS_ABORTED,   /* 14 */
    FR_TIMEOUT          /* 15 */
} FRESULT;
```

در صفحه C compiler وارد سبرگ Libraries شوید و گزینه Enable MMC/SD... را فعال کنید : Connections قسمت Enable MMC/SD... MMC/SD خواهد شد که مشخص کننده اتصالات پایه های MMC/SD به میکرو می باشد.



در صورت استفاده نکردن از پایه های WP و CD می توانید آنها را به طور مستقیم به زمین وصل کنید.
بعد از اعمال تنظیمات پنجره را با گزینه OK تائید کنید و خارج شوید.

جدول شماره (۱)

اتصال	توضیح	نام
MOSI	ورودی دیتا به MMC	SI
MISO	خروجی دیتا از MMC	SO
SCK	کلکی MMC	SCK
دلوخواه	انتخاب MMC	CS
دلوخواه	وجود کارت	CD
دلوخواه	محافظت از نوشتن	WP

ترجمه تخصصی
متون برق و الکترونیک

Translate.ECA

ترجمه کلیه متون تخصصی ، علمی ، دانشگاهی ، فنی و ...

www.Translate.ECA.ir

ساختار : FATFS

این ساختار مشخصات درایو جاری را در خود ذخیره می کند.

```
typedef struct _FATFS_
{
    unsigned char fs_type;          /* FAT sub type */
    unsigned char drive;            /* Physical drive number */
    unsigned char csize;            /* Number of sectors per cluster */
    unsigned char n_fats;           /* Number of FAT copies */
    unsigned char wflag;            /* win[ ] dirty flag (1:must be written back) */
    unsigned short id;              /* File system mount ID */
    unsigned short n_rootdir;        /* Number of root directory entries (0 on FAT32) */
    unsigned char fsi_flag;          /* fsinfo dirty flag (1:must be written back) */
    unsigned long last_clust;        /* Last allocated cluster */
    unsigned long free_clust;        /* Number of free clusters */
    unsigned long fsi_sector;         /* fsinfo sector */
    unsigned long cdir;              /* Current directory (0:root) */
    unsigned long sects_fat;          /* Sectors per fat */
    unsigned long max_clust;          /* Maximum cluster# + 1. Number of clusters is max_clust - 2 */
    unsigned long fatbase;            /* FAT start sector */
    unsigned long dirbase;            /* Root directory start sector (Cluster# on FAT32) */
    unsigned long database;           /* Data start sector */
    unsigned long winsect;             /* Current sector appearing in the win[ ] */
    unsigned char win[512];            /* Disk access window for Directory/FAT */
}
```

مقادیر بالا بعد از اجرای تابع `f_mount` در متغیری از نوع ساختار FATFS قرار می گیرد.

```
typedef struct _FILINFO_
{
    unsigned long fsize;             /* File size */
    unsigned short fdate;             /* Last modified date */
    unsigned short ftime;             /* Last modified time */
    unsigned char fattrib;            /* Attribute */
    char fname[13];                  /* Short file name (DOS 8.3 format) */
} FILINFO;
```

: ftime

این عضو از ساختار نشان دهنده زمان ساخت فایل می باشد به این گونه که:

بیت ۰ تا ۴ نشان دهنده ثانیه تقسیم بر ۲ (۰ تا ۳۰)

بیت ۵ تا ۱۰ نشان دهنده دقیقه (۰ تا ۵۹)

بیت ۱۱ تا ۱۵ نشان دهنده ساعت (۰ تا ۲۳)

: FILINFO

این ساختار اطلاعات یک فایل را بعد از اجرای تابع `f_stat` و `f_readdir` در خود ذخیره می کند.

: fdate

این عضو از ساختار مشخص کننده تاریخ ساخت فایل می باشد به این گونه که:

بیت ۱ تا ۴ : نشان دهنده روز (۱...۳۱)

بیت ۵ تا ۸ : نشان دهنده ماه (۱۲...۱)

بیت ۹ تا ۱۵ : نشان دهنده سال (از ۱۹۸۰ ، ۱۹۸۱... ۲۰۱۷)

شروعی ساده با Fat در محیط CodeVision

- Volume : فایل AM_VOL
- AM_DIR : فایل دایرکتوری
- AM_ARC : فایل آرشیو
- AM_MASK : فایل دارای تمام ویژگی های بالا
- DIR : ساختار

این ساختار مشخصات مربوط به دایرکتوری جاری را در خود ذخیره می‌کند و با فرآخوانی توابع `f_readdir` و `f_opendir` آپدیت می‌شود. توابع کار با FAT در کدویزن:

:fattrib

مقدار این عضو از چند حالت زیر خارج نمی باشد. (جهت سهولت در برنامه نویسی مقادیر این عضو قبلا در کتابخانه به صورت Define شده می باشد)

AM_RDO • فقط خواندنی

• AM_HID : مخفی

• فایل مربوط به سیستم AM_SYS.

typedef struct _DIR_

```
{  
FATFS*    fs;          /* Pointer to the owner file system object */  
unsigned short id;        /* Owner file system mount ID */  
unsigned short index;     /* Current read/write index number */  
unsigned long sclusl;     /* Table start cluster (0:Static table) */  
unsigned long clust;      /* Current cluster */  
unsigned long sect;       /* Current sector */  
unsigned char* dir;       /* Pointer to the current SFN entry in the win[] */  
unsigned char* fn;        /* Pointer to the SFN (in/out) {file[8],ext[3],status[1]} */  
} DIR;
```

این تابع یک شیء (object) جهت کار با فایل در ساختاری از نوع FIL می‌سازد.

fp•: یک اشاره گر از نوع ساختار FIL جهت ذخیره کردن مشخصات
شیء فایل ساخته شده
path•: آدرس فایل هدف

آدرس فایل باید از قانون زیر پیروی کند :
[logical_drive_number:] [/] [directory_name/] file_name
برای مثال آدرس :

آدرس فایلی به اسم ECA.txt واقع در درایو ۰ می باشد.
توجه داشته باشید پس از فراخوانی این تابع ، شما باید از fp در توابع
دیگر جهت انجام عملیات روی فایلها استفاده نمائید و به طور خود کار
مقدار path در توابع دیگر بی معنایست.
Mode : مشخص کننده چگونگی دسترسی به فایل را مشخص کرده
، و فقط مقادیر زیر را می گیرد (جهت ساخت کار قبل Define شده
است) :

- FA_READ : فقط دیتا از فایل خوانده می شود.
- FA_WRITE : دیتا فقط روی فایل نوشته می شود.

• **FA_OPEN_EXISTING** : فایل را باز می کند، در صورت

- موجود نبودن فایل، تابع با شکست مواجه می شود.
FA_CREATE_ALWAYS: فایل را باز می کند، در صورت

موجود نبودن فایل ابتدا فایل را ایجاد کرده و سپس فایل را باز می‌کنیم.

- FA_CREATE_NEW : ایجاد فایل جدید، در صورت اینکه

تابع f_mount :
FRESULT f_mount(unsigned char vol, FATFS *fs)
اختصاص یک درایو از حافظه جهت کار بر روی آن.
این تابع در ابتدای شروع کار با کتابخانه و قبل از هر گونه تابعی می
باشد اجرا شود.
ورودی ها :

- FS: یک اشاره گر از نوع ساختار FATFS می باشد که بعد از مقدار دهی اولیه ، مشخصات درایو باز شده بر روی آن قرار می گیرد.
- خروجی ها:
- FR_OK : عملیات با موفقیت انجام شد.
- FR_INVALID_DRIVE : شماره درایو نامعتبر است.

```
Main()
{
    FRESULT res;
    FATFS drive;
    if ((res=f_mount(0,&drive))==FR_OK)
        printf("Logical drive 0: mounted OK\r\n");
    while(1);
}
```

FRESULT f_open(FIL* fp, const char* path,
unsigned char mode)

- FR_DISK_ERR : به دلیل عدم ارتباط تابع شکست خورده است.
- FR_INT_ERR : به دلیل خطأ در ساختار FAT تابع شکست خورده (ارتباط سخت افزاری چک شود).
- FR_INVALID_OBJECT : فایل باز نشده (از تابع f_open استفاده کنید).

f_write :
FRESULT f_write(FIL* fp, const void* buff, unsigned int btw, unsigned int* bw)
نوشتن اطلاعات در فایلی که قبلاً توسط تابع f_open باز شده است.

- fp : یک اشاره گر از نوع ساختار FIL می‌باشد که مشخص کننده فایلی است که قرار است در آن نوشته شود.
- buff : آرایه‌ای است که حاوی اطلاعاتی است که قرار است در فایل نوشته شود.

• btw : تعداد بایتی که قرار است در فایل نوشته شود.
• bw : تعداد بایتی که در فایل نوشته شده است.

خروجی ها :

- FR_OK : عملیات با موفقیت انجام شد.
- FR_DENIED : دسترسی به فایل به دلیل اینکه فایل در حالت فقط خواندنی (Read only) باز شده امکان پذیر نمی‌باشد.
- FR_NOT_READY : آماده نبودن حافظه.
- FR_DISK_ERR : به دلیل عدم ارتباط تابع شکست خورده است.

• FR_INT_ERR : به دلیل خطأ در ساختار FAT تابع شکست خورده (ارتباط سخت افزاری چک شود).

- FR_INVALID_OBJECT : فایل باز نشده (از تابع f_open استفاده کنید).

f_close :

FRESULT f_close(FIL* fp)
این تابع شیء ایجاد شده توسط تابع f_open را می‌بندد.

ورودی ها :

fp : شیء ساخته شده از فایلی که تصمیم بر بستن آن دارد.

خروجی ها :

FR_OK : عملیات با موفقیت انجام شد.

FR_NOT_READY : آماده نبودن حافظه

FR_DISK_ERR : به دلیل عدم ارتباط تابع شکست خورده است.

FR_INT_ERR : به دلیل خطأ در ساختار FAT تابع شکست خورده (ارتباط سخت افزاری چک شود).

- FR_INVALID_OBJECT : فایل باز نشده (از تابع f_open استفاده کنید).

مثال :

برنامه‌ی زیر اطلاعات موجود در آرایه‌ی buffer را بر روی فایل ECA.txt ذخیره کرده، سپس در دو مرحله (اول ۱۰ بایتی سپس ۵ بایتی) اطلاعات را خوانده و داخل آرایه‌های buffer2,buffer3 کپی می‌کند.

- FA_CREATE_ALWAYS : ایجاد فایل جدید، در صوراً اینکه فایل از قبل وجود داشته باشد، فایل قبل را باز کرده و محتويات آنرا پاک می‌کند (overwritten).

خروجی تابع :

- FR_OK : عملیات با موفقیت انجام شد
- FR_NO_FILE : چنین فایلی پیدا نشد
- FR_NO_PATH : چنین آدرسی پیدا نشد
- FR_INVALID_NAME : نام فایل معتبر نیست
- FR_INVALID_DRIVE : نام درایو معتبر نیست
- FR_EXIST : فایل از قبل وجود دارد
- FR_DENIED : دسترسی به فایل به یکی از دلایل زیر موجود نمی‌باشد:

- تلاش برای خواندن فایل فقط نوشتاری (Write only)
- فایل به وسیله‌ی مشخصات به صورت Read only تعیین شده
- ناتوان در ساخت فایل به دلیل پر بودن حافظه
- FR_NOT_READY : آماده نبودن حافظه

- FR_WRITE_PROTECTED : نوشتن یا ایجاد فایل به دلیل محافظت فایل مقدور نبوده
- FR_DISK_ERR : به دلیل عدم ارتباط تابع شکست خورده است

- FR_INT_ERR : به دلیل خطأ در ساختار FAT تابع شکست خورده (ارتباط سخت افزاری چک شود)
- FR_NOT_ENABLED : مکان حافظه انتخاب نشده، f_mount از تابع استفاده نماید.

- FR_NO_FILESYSTEM : هیچ پارتیشن قابل پشتیبانی بر روی درایو پیدا نشد!
- **f_read :**

FRESULT f_read(FIL* fp, void* buff, unsigned int btr, unsigned int* br)

خواندن اطلاعات از فایل که قبلاً توسط تابع f_open باز شده است

- fp : یک اشاره گر از نوع ساختار FIL که مشخص کننده مشخصات فایلی است که قرار است اطلاعات از آن خوانده شود.
- توجه داشته باشید که قبل از استفاده از این ساختار در این تابع باید از آن در تابع f_open استفاده کنید تا مشخصات فایل در آن ذخیره گردد.

- buff : یک آرایه جهت ذخیره اطلاعات خوانده شده از فایل
- btr : تعداد اطلاعاتی که قرار است خوانده شود.

- br : اشاره گری که مشخص می‌کند چند بایت از فایل خوانده شده است، کاربرد این متغیر در تشخیص به آخر رسیدن فایل می‌باشد.

- **خروجی :** FR_OK : عملیات با موفقیت انجام شد.
- FR_DENIED : دسترسی به فایل به دلیل اینکه فایل در حالت فقط نوشتنی (Write only) باز شده امکان پذیر نمی‌باشد
- FR_NOT_READY : آماده نبودن حافظه

شروعی ساده با Fat در محیط CodeVision

```
#include <mega64.h<
#include <ff.h<
#include <stdio.h<
#include <delay.h<
#asm
.equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
#endasm
#include <lcd.h<
#define T1_OVF_FREQ 100
#define T1_PRESC 1024L
#define T1_INIT (0x10000L-(_MCU_CLOCK_FREQUENCY_/(T1_PRESC*T1_OVF_FREQ)))
unsigned char buffer[15]={"ECA the BEST.."};
unsigned char buffer2[10];
unsigned char buffer3[5];
FRESULT res;
unsigned int nbytes;
FATFS fat;
FIL file;
char path[]="0:/ECA.txt";
interrupt [TIM1_OVF] void timer_comp_isr(void)
{
TCNT1H=T1_INIT>>8;
TCNT1L=T1_INIT&0xFF;
disk_timerproc();
}
void main(void)
{
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=(1<<CS12)|(1<<CS10);
TCNT1H=T1_INIT>>8;
TCNT1L=T1_INIT&0xFF;
TIMSK=1<<TOIE1;
#asm("sei")
lcd_init(16);
lcd_clear();
///////////
if ((res=f_mount(0,&fat))==FR_OK)
lcd_putsf("FAT mounted = OK");
delay_ms(1000);
///////////
lcd_clear();
if ((res=f_open(&file,path,FA_CREATE_ALWAYS))==FR_OK)
lcd_putsf("File opened");
delay_ms(1000);
///////////
lcd_clear();
if ((res=f_write(&file,buffer,15,&nbytes))==FR_OK)
lcd_putsf("Writing Data");
delay_ms(1000);
///////////
lcd_clear();
if ((res=f_close(&file))==FR_OK)
```

```

lcd_putsf("File closed");
delay_ms(1000);
///////////
lcd_clear();
if ((res=f_open(&file,path,FA_READ))==FR_OK)
lcd_putsf("File opened" );
delay_ms(1000);
///////////
lcd_clear();
if ((res=f_read(&file,buffer2,10,&nbytes))==FR_OK)
lcd_putsf("Reading Data");
delay_ms(1000);
///////////
lcd_clear();
if ((res=f_read(&file,buffer3,5,&nbytes))==FR_OK)
lcd_putsf("Reading Data");
delay_ms(1000);
///////////
lcd_clear();
if ((res=f_close(&file))==FR_OK)
lcd_putsf("File closed" );
while(1);
}

```

Hamed.Mohri@gmail.com

نویسنده : مهدی مهری

مجموعه پروژه های میکروکنترلرهای AVR-PIC-8051

هدف از ارائه این محصول تسریع در یادگیری و صرفه جویی در وقت دانشجویان برای انجام پروژه های گوناگون با سری های مختلف میکرو های AVR و PIC و ۸۰۵۱ است. در این مجموعه بیش از ۵۰۰ پروژه به صورت دسته بندی شده گردآوری شده که بررسی آنها میتواند در تسریع امر یادگیری و تقویت بنیه عملی و فنی دانشجویان کمک شایانی نماید. این مجموعه در قالب یک DVD ارائه شده است.

این محصول در قالب یک DVD ارائه شده است.



Windows Embedded CE 6.0 +R2&R3

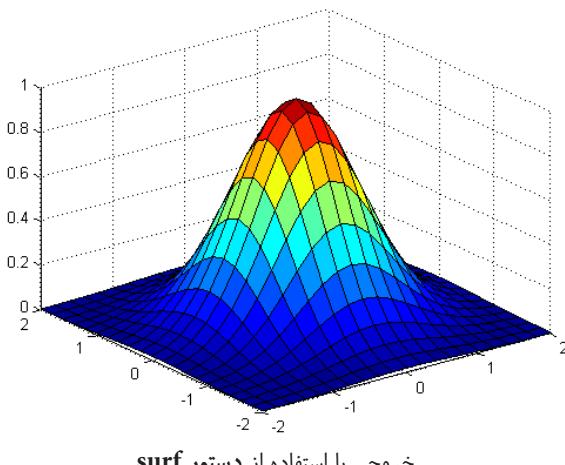
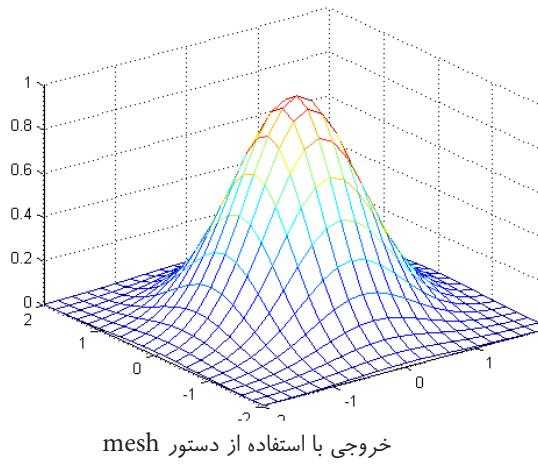
ویندوز CE ، که رابط گرافیکی آن مشابه رابط گرافیکی ویندوز ۹x و NT است ، نسخه کوچکی از برخی از برنامه های کاربردی مایکروسافت را در خود جای داده است . این سیستم عامل قابلیت نسب بروی نسل های ۹ به بعد تراشه های ARM را دارا می باشد . این نسخه شامل پک کامل نرم افزار های مورد نیاز جهت نصب این سیستم عامل به همراه مجموعه ای از مقالات ، نکات آموزشی و فیلم جهت کار با این سیستم عامل بوده که لیست کامل محتویات پک در زیر قرار داده شده است

Windows CE 6.0
Windows CE 6.0 R2
Windows CE 6.0 R3
Visual Studio 2005 Pro
Mini2440 CE6 Suite 1001
UPDATE MINI2440
Training set





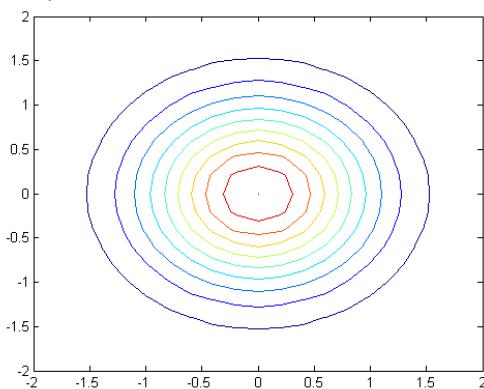
ترسیم منحنی های سه بعدی در متلب



دستور :contour

این دستور سطح کانتوری مربوط به داده های سه بعدی را ترسیم می کند. هر چند نمودار به دست آمده پس از اجرای این تابع، یک نمودار دو بعدی است، اما برای ترسیم آن، می بایستی داده های سه بعدی ایجاد شده باشد. همچنین می توانید از دستورهای meshc و surf برای ترکیب این نوع از نمودار با نمودارهای mesh و meshc استفاده نمایید. برای فراخوانی تابع contour این عبارت را وارد می کنیم:

```
>> contour(X,Y,Z);
```



قصد داریم در این مطلب، نحوه ترسیم منحنی های سه بعدی را آموزش دهیم. ترسیم منحنی و اشکال مختلف، بخش لاینفک بسیاری از کارهای علمی هستند. در بسیاری از موارد، می توان با یک شکل مناسب، به اندازه چندین پاراگراف و حتی چندین صفحه، مفهوم را به مخاطب منتقل نمود. نرم افزار متلب، در کنار قابلیتهای فراوانی که دارد، یکی از قوی ترین هسته های گرافیکی را برای ترسیم و مدیریت انواع منحنی ها و شکل ها دارا می باشد. توانایی استفاده از این امکانات نرم افزار متلب، یکی از ارکان کاربری آن می باشد. در این مطلب، در در آینده در مطالبی مشابه، نحوه کار با توابع ترسیم و گرافیکی متلب را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در اینجا قصد داریم، نمودار مربوط به تابع زیر را در متلب ترسیم نماییم:

$$z = \exp[-(x^2 + y^2)]$$

فرض کنید که بازه تغییرات متغیرهای x و y، هر دو بین -2 و 2 باشد. به این منظور تعریف می کنیم:

```
>> x=-2:0.2:2;
>> y=-2:0.2:2;
```

برای ترسیم منحنی های سه بعدی، می بایست تمام نقاط موجود در بردار x با تمام نقاط موجود در بردار y ترکیب شوند و مقدار تابع در نقطه به دست آمده، محاسبه شود. برای این منظور، از تابع meshgrid به صورت زیر استفاده می کنیم:

```
>> [X,Y]=meshgrid(x,y);
```

حال مختصات بعد سوم را به صورت زیر محاسبه می کنیم:

```
>> Z=exp(-(X.^2+Y.^2));
```

داده های مورد نیاز برای ترسیم انواع منحنی های سه بعدی، آمده شده اند. می توانیم با فراخوانی دستورهای مربوطه، منحنی های مختلفی را ترسیم نماییم. نمونه ای از دستورهای قابل اجرا بر روی داده های به دست آمده، به همراه نمودارهای مربوط به هر دستور، در ادامه آمده اند:

دستور :mesh

این دستور برای ترسیم نمودارهای شبکه ای (اسکلتی) سه بعدی به کار می رود. برای اجرای این دستور این عبارت را وارد می کنیم:

```
>> mesh(X,Y,Z);
```

دستور :surf

این دستور برای ترسیم نمودارهای سه بعدی سطحی (اسکلت به همراه سطح رنگی) به کار می رود. برای اجرای این دستور این عبارت را وارد می کنیم:

```
>> surf(X,Y,Z);
```



فروشگاه تخصصی برق و الکترونیک ECA

<> خرید و پشتیبانی آنلاین

<> ارسال به تمامی نقاط ایران در کمترین زمان ممکن

<> ضمانت عملکرد تمامی محصولات

مجموعه ای از کتب مرجع و پر کاربرد دانشگاهی و تخصصی
در تمامی گرایش های برق



جدیدترین و حرفه ای ترین نرم افزارهای تخصصی برق و
الکترونیک جهت استفاده دانشجویان و متخصصین



مقالات معتبرترین نهاد های علمی داخلی و خارجی و همچنین
جدیدترین مقالات کنفرانس های کشوری و بین المللی



جامعترین اطلاعات مورد نیاز متخصصین ، آموزش های
کاربردی نرم افزارها و فیلم های آموزشی



تجهیزات و دستگاه های تخصصی مرتبط با الکترونیک و رایانه



معتبرترین مجلات برق ، الکترونیک و علوم مرتبط در قالب
مجموعه های چند ساله



مجموعه قطعات و لوازم تخصصی و پر کاربرد الکترونیک و
رباتیک



بردهای سخت افزاری کاربردی و آموزشی طراحی شده
توسط تیم وب سایت ECA



www.eShop.ECA.ir

لیست نمایندگی های فروش :

نام شهر	شرکت / فروشگاه	مسئول / رابط	آدرس	شماره تماس
اصفهان	دفتر پخش اصفهان	مهدي مهرى	----	۰۹۱۳۸۰۶۷۵۲۹
تبريز	دفتر مرکزی ECA	فرشاد اکرمی	پايين تر از چهارراه شريعتی به سمت باغ گلستان، مجتمع تجاری گلستان، ط ۴، واحد ۱۶	۴۱۱۵۵۳۳۷۳۲
تهران	دفتر پخش تهران	اميرحسين وزيري	خ كريم خان زند - ضلع جنوب غربي - بين استاد نجات الهي و شهيد قرني - جنب ساختمان بيمه البرز - پلاک ۲۰۰ - طبقه اول - واحد ۱	۰۹۳۷۷۴۷۷۷۵۶
Shiraz	ارتباط بهينه جنوب	فرشته جعفری	خیابان فلسطین (باغشاه) - چهارراه هدایت - جنب ساختمان سبز - ساختمان مرکز مشاوره راه سبز زندگی - طبقه اول	۰۹۳۶۰۳۵۹۳۶۱
مشهد	ماورا صنعت باراثاوا	محمد مقبلی	بلوار احمدآباد، خ ابوذر غفاری، بين ابوذر ۳۱، ۳۳و۳۱، پلاک ۳۲۷، طبقه ۲	۵۱۱۸۴۲۴۶۷۳

نرم افزارهای برق Software

DESIGN , ANALYSIS AND SIMULATION



پیاده سازی FPGA توسط نرم افزار Altium Designer

محیط طراحی

برای پیاده سازی طرح با CPLD-FPGA محیط های مختلف وجود دارد مانند :

- * محیط ISE که محیط استاندارد شرکت XILINX می باشد.
- * محیط Altium که بسیار قدرتمند و جذاب می باشد.
- * Activ HDL
- * ... وغیره ...

نمونه کد های نوشته شده بر اساس محیط توانمند Altium می باشد. قطعاً از برنامه نویسی و طراحی با این نرم افزار لذت خواهید برداشت. آینده راهنمای برنامه نویسی با ISE نیز گفته خواهد شد.

ایجاد یک پروژه

در این قسمت نحوه ساخت یک پروژه کاری مبتنی بر CPLD-FPGA در محیط نرم افزار Altium را فرا می گیریم. پس از نصب برنامه آن را اجرا کنید. اگر برنامه را درست نصب کرده باشید صفحه Home Page برنامه را می بینید.

شما می توانید به سه صورت طرح ها را خود را با CPLD یا FPGA پیاده سازی کنید:

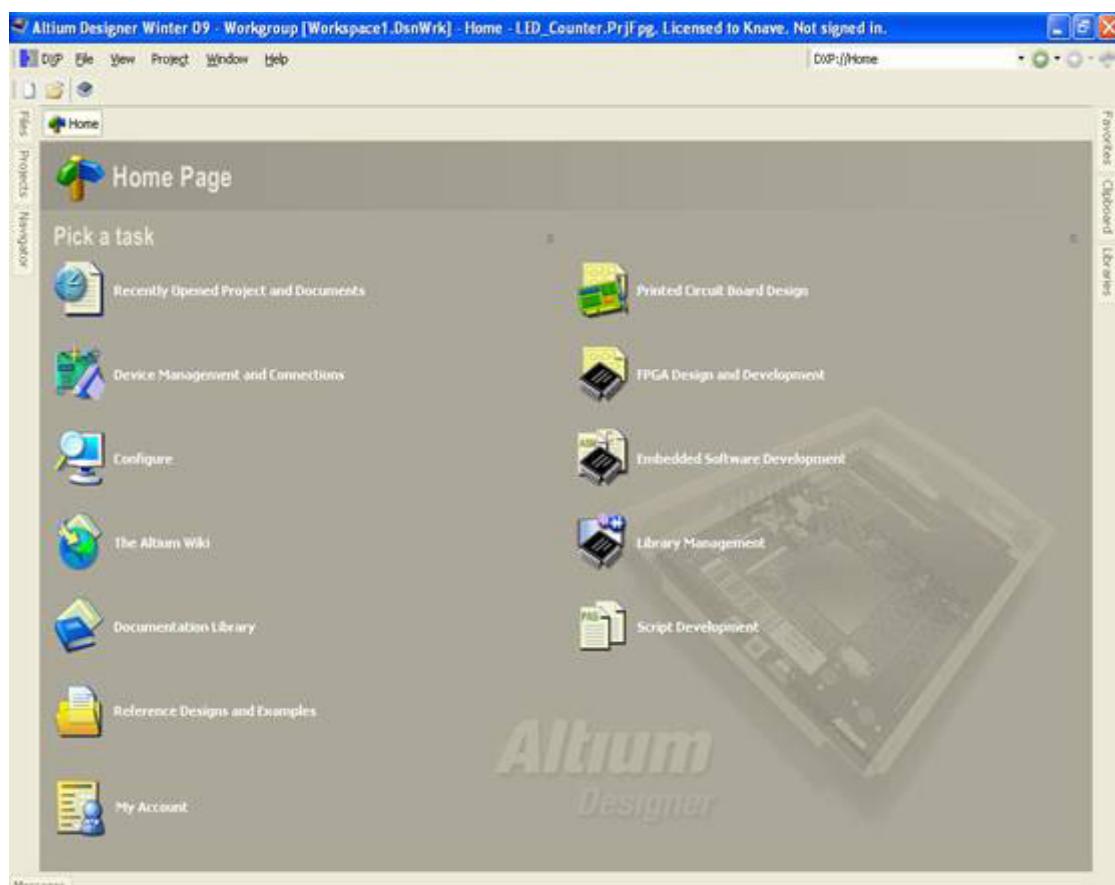
- طراحی HDL
- کد نویسی
- ترکیبی

در طراحی HDL شما می توانید همانند محیط شماتیک نرم افزار ALTIUM قطعات را از کتابخانه انتخاب و در صفحه قرار دهید و سپس اقدام به سیم کشی طرح نمایید.

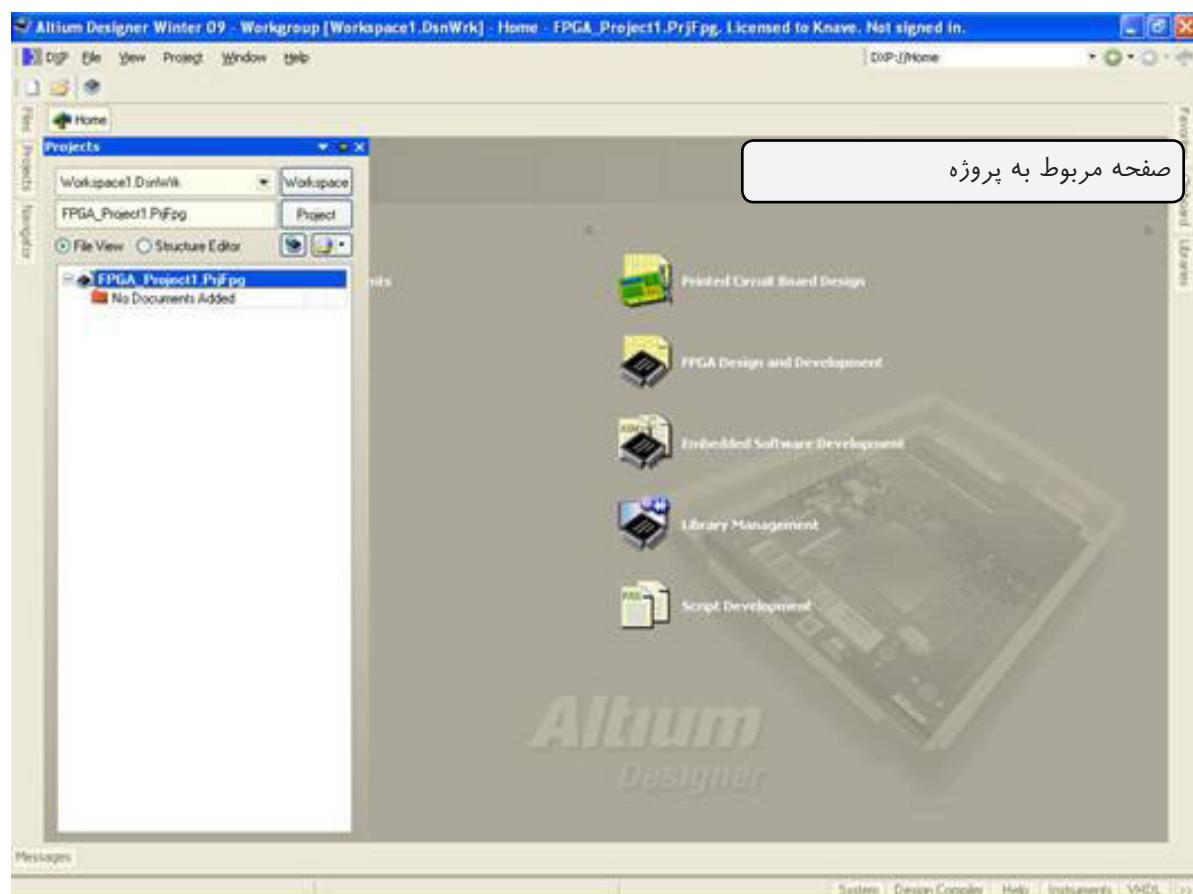
در روش کد نویسی شما با بهره گیری از زبان های برنامه نویسی قدرتمندی همانند VHDL، VERILOG طرح خود را پیاده سازی کنید.

در روش ترکیبی نیز می توانید از هردو روش بطور همزمان استفاده کنید. این روش بهترین و توانمند ترین روش می باشد.

در این راهنمای از روش ترکیبی بهره می گیریم.



پیاده سازی FPGA توسط نرم افزار Altium Designer



پیاده سازی FPGA توسط نرم افزار Altium Designer



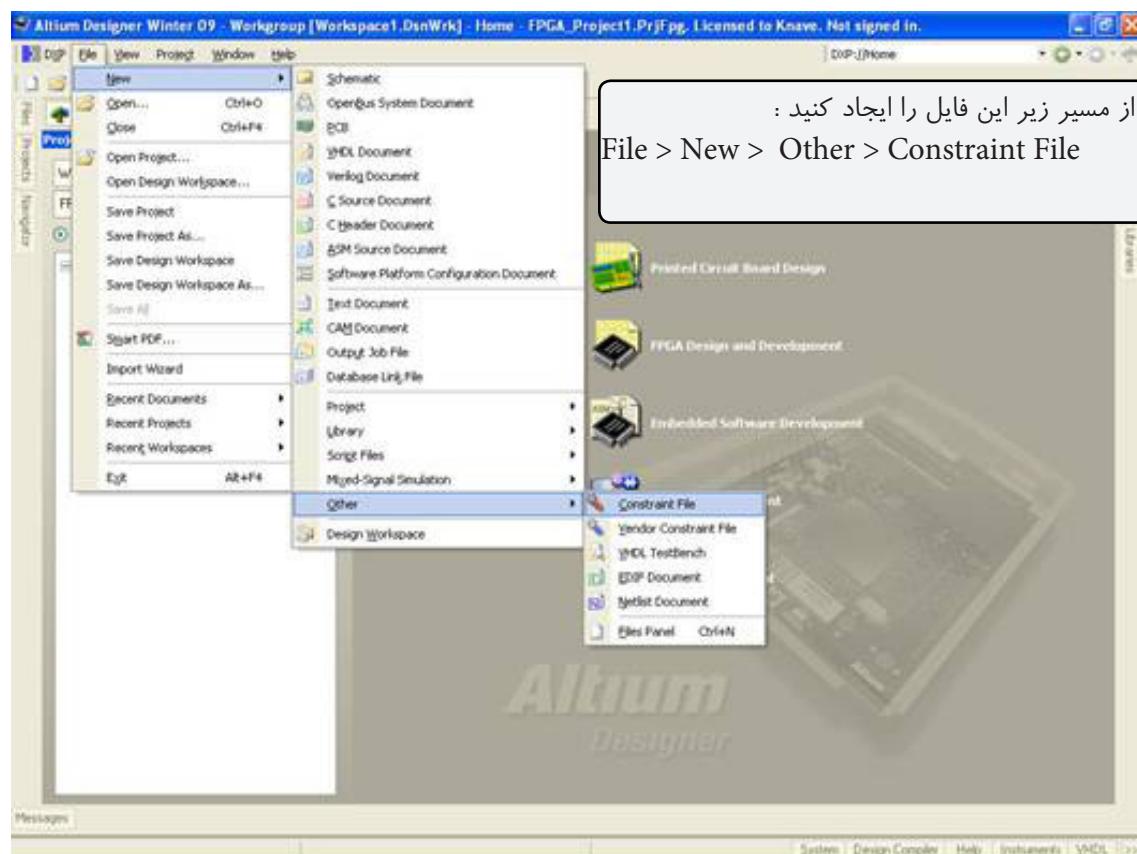
در این فایل با استفاده از قطعات موجود در کتابخانه اقدام به پیاده سازی طرح می کنیم.

Verilog
از این فایل برای کد نویسی به زبان Verilog استفاده می کنیم.



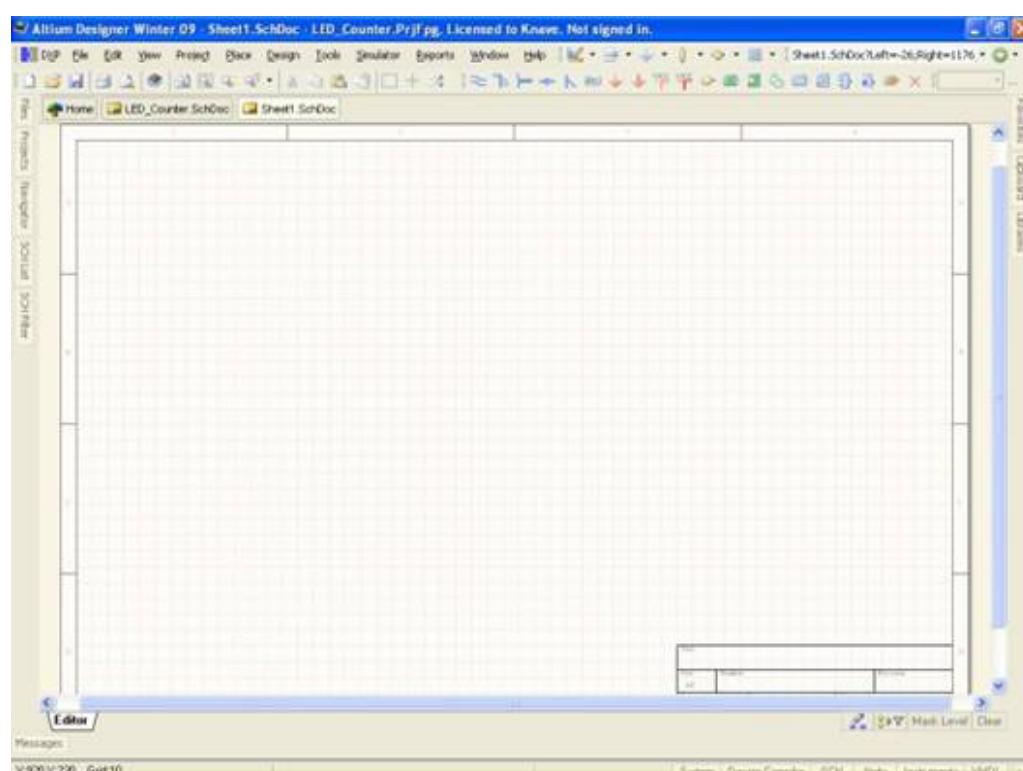
پیاده سازی FPGA توسط نرم افزار Altium Designer

: ایجاد فایل Constraint File



از مسیر زیر این فایل را ایجاد کنید :
File > New > Other > Constraint File

از این فایل جهت معرفی نوع و شماره چیپ و ورودی ها و خروجی ها به پروژه استفاده می کنیم.
ذخیره پروژه :
بس از این مرحله تمامی فایل ها را با نام مناسب و در محل مناسب ذخیره کنید .
من فایل شماتیک را با نام LED_Counter و فایل Verilog divider27 را با نام Constraint را با نام



شروع طراحی :

هدف طرح :

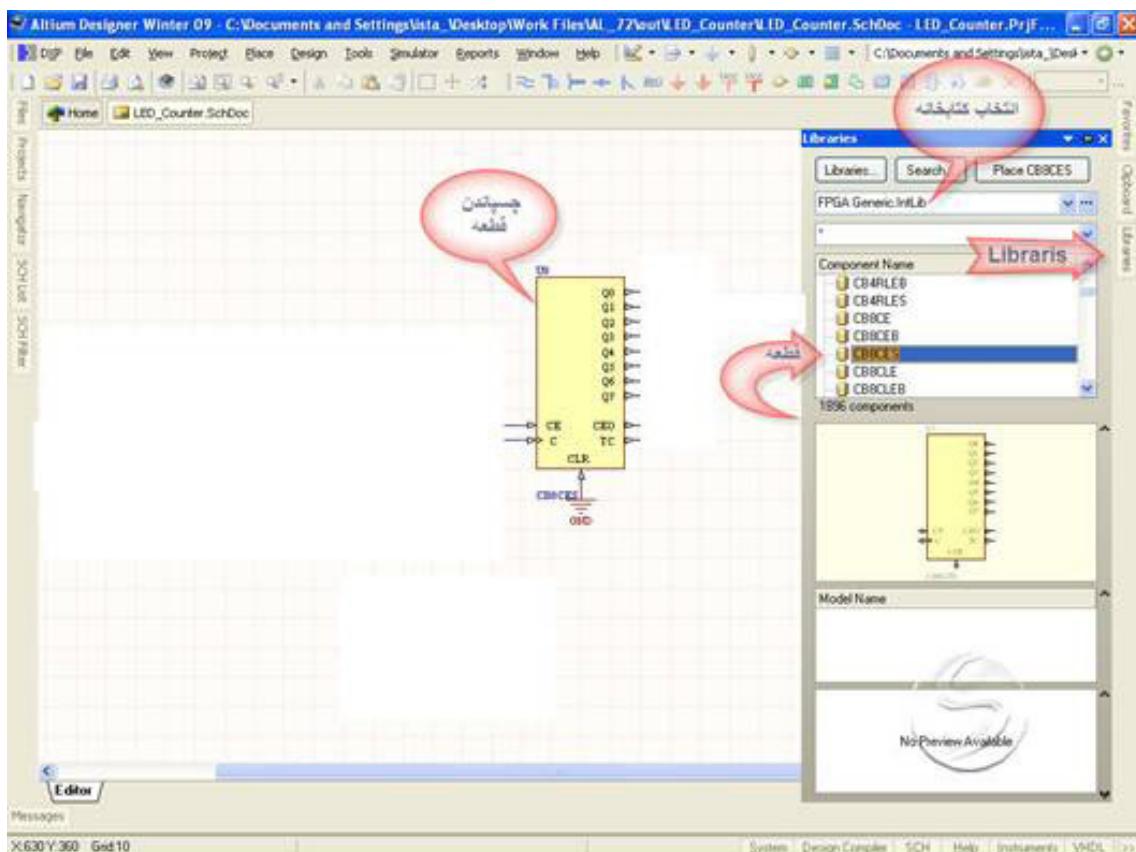
هدف در این پروژه طراحی یک شمارنده هشت بیتی می باشد.
خروجی این شمارنده بر روی LED نمایش داده می شود.
فایل شماتیک را که قبل ذخیره کردید را باز کنید.

پیاده سازی FPGA توسط نرم افزار Altium Designer

برای پایه CE از CB8CES نیز یک پورت از نوع ورودی با نام SW0 ایجاد و با WIRE آنرا وصل کنید.
مقدمه فرکانسی :

در برد اصلی برای تامین فرکانس مورد نیاز مدار از نوسان ساز ۱۲MHz استفاده شده است. در این پروژه ما به فرکانسی در حدود چند هرتز نیاز داریم. پس باید فرکانس ورودی را تا حد چند هرتز کاهش داد. به این منظور از یک مقدمه فرکانسی استفاده می‌کنیم.

- در سمت چپ پانل تولبار Libraries را انتخاب کنید.
- از لیست باز شو کتابخانه FPGA Generic.intLib را انتخاب کنید.
- لیست قطعات موجود نمایان می‌شود. از این لیست قطعه CB8CES را انتخاب کنید و به شماتیک منتقل کنید.
- به تمامی پایه‌های Q0 تا Q7 و (WIRE) CE, C, CLR و ایر (Q7) وصل کنید.
- به پایه‌های Q0 تا Q7 به هر کدام یک NetLabel وصل کنید و به آنها نام‌های LEDS0 تا LEDS7 بدهید.



کد نویسی با Verilog

برای آشنایی شما با نحوه استفاده از کدنویسی با زبان Verilog در پروژه این بخش را با Verilog می‌نویسیم.
فایل Verilog را که قبلاً ایجاد کردید را باز کنید.
کدهای زیر را که به زبان Verilog نوشته شده است را وارد و ذخیره کنید.

```
module divider27(clkin,clkout);
    input clkin;
    output clkout;

    reg [26:0] cnt;
    always @(posedge clkin) cnt <= cnt + 1 ;

    assign clkout = cnt[23] ;

endmodule
```

- پایه‌های CE, C نیاز به NetLabel ندارند.

تعریف خروجی‌ها در شماتیک برای اینکه یک پایه به عنوان ورودی و خروجی در نظر گرفته شود باید آن را به ابزار PORT وصل کرد.
برای این کار :

- ابزار PORT را در تولبار بالا کلیک کنید.
- در مقابل هر کدام از پایه‌های خروجی CB8CES یک PORT می‌قرار دهید. PORT های که ایجاد کردید با استفاده از ابزار WIRE به پایه‌های خروجی CB8CES وصل کنید.
بر روی PORT ها دبل کلیک کنید.
- در صفحه ظاهر شده در قسمت NAME عبارت LED7 تا LED0 را به عنوان نام به ترتیب برای هر PORT انتخاب کنید.
- در قسمت I/O TYPE عبارت OUTPUT را برای هر یک از PORT ها انتخاب کنید. توجه کنید چون این پایه‌ها خروجی هستند عبارت OUTPUT را انتخاب کردیم. اگر پایه ورودی بود آن را از نوع INPUT انتخاب می‌کردیم.

پیاده سازی FPGA نرم افزار Altium Designer

اتصال مژول کد به مدار

برای استفاده از این مژول باید آن را سیم کشی کرد. این مژول یک ورودی فرکانس دارد و یک خروجی فرکانس.

فرکانس ورودی از سمت نوسان ساز تامین می شود و خروجی مژول به ورودی شمارنده وصل می گردد.

برای این منظور :

- یک PORT از نوع ورودی با نام CLK_BRD ایجاد و آن را به ورودی CLKIN از مژول وصل کنید.

- خروجی CLKOUT از مژول را به ورودی C از CB8CES وصل کنید.

- مژول به مدار وصل و قابل استفاده است.

استفاده از کد در شماتیک

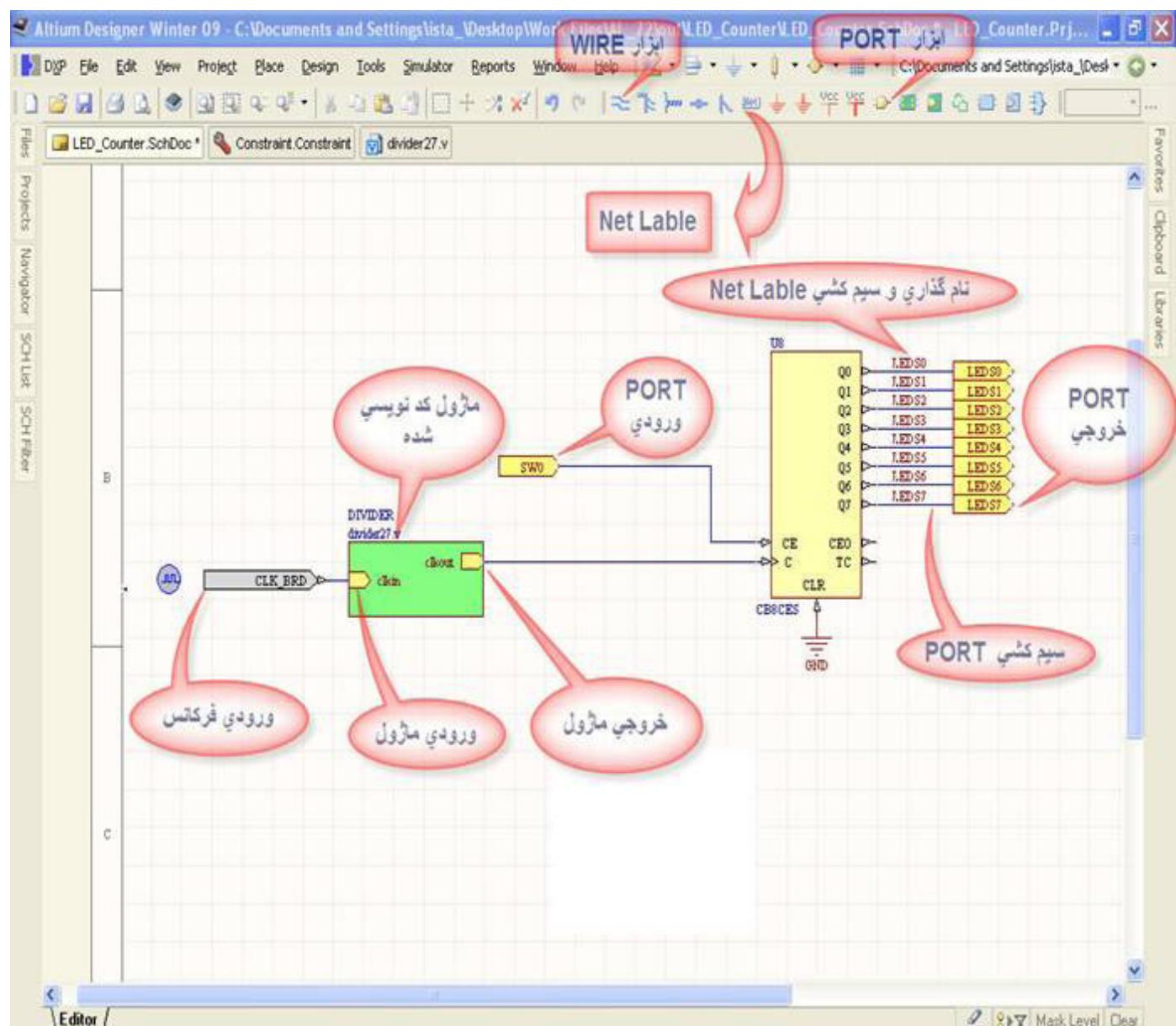
برای استفاده از کد نوشته شده باید آن را بصورت مژول به شماتیک اضافه و سپس سیم کشی کرد.

برای این منظور :

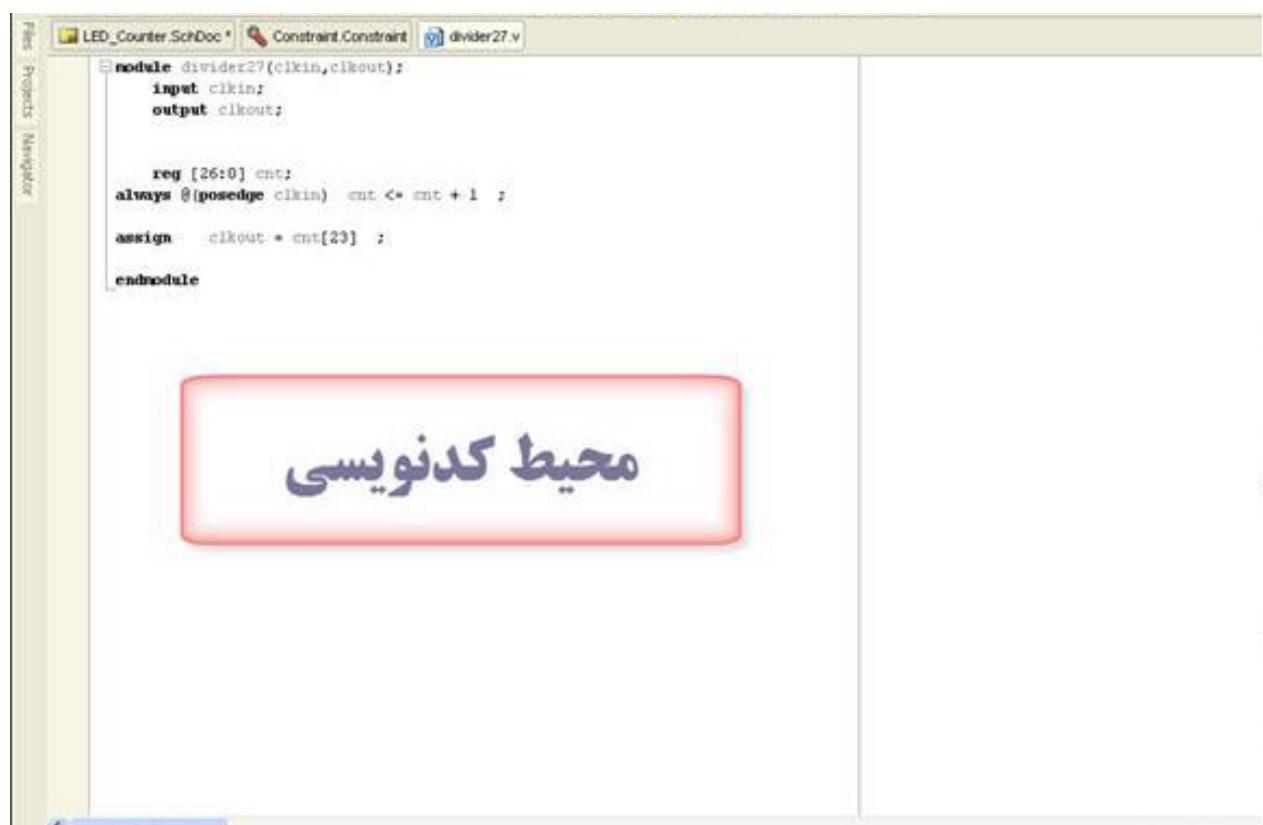
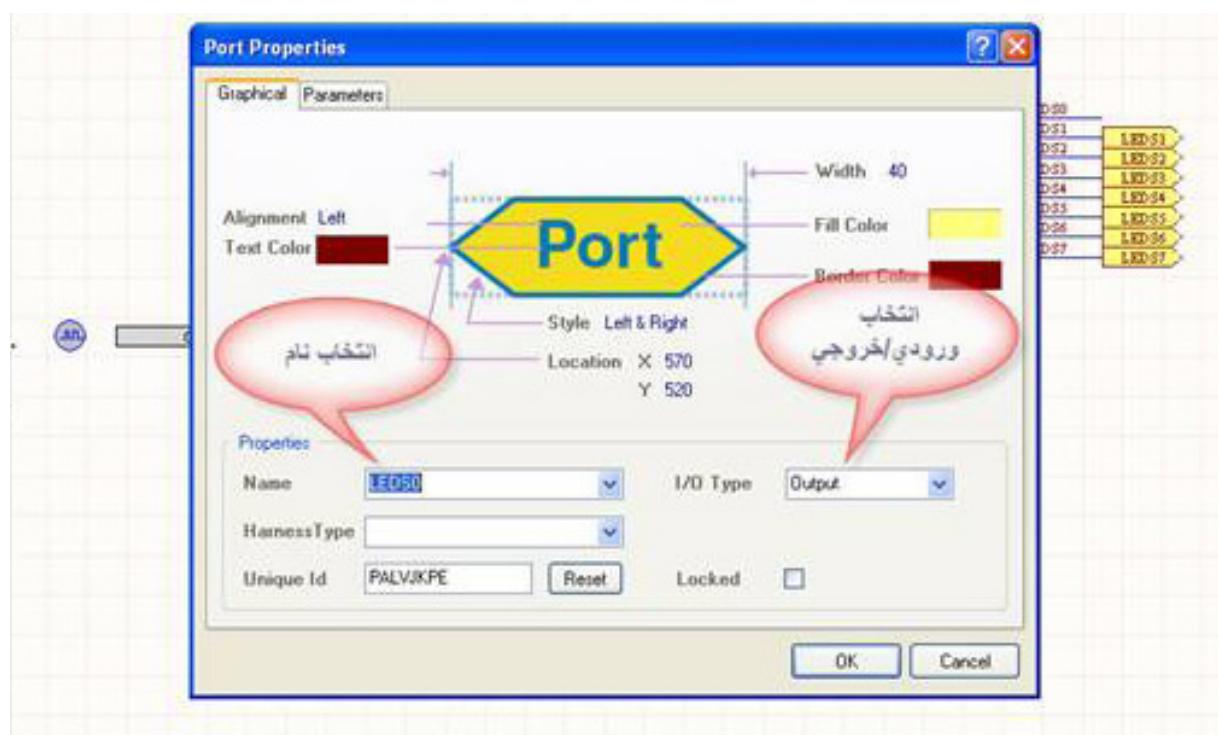
- در محیط شماتیک منوی Design را باز و گزینه Symbol From Sheet Or HDL را انتخاب کنید.

- در صفحه باز شده نام فایل Verilog را که ذخیره کردید (divider27.v) را انتخاب و OK کنید.

- یک Symbol ایجاد می شود آن را در محل مناسب در شماتیک قرار دهید.



پیاده سازی FPGA توسط نرم افزار Altium Designer



- مشاهده کنید.
- بر روی عبارت **Compile** کلیک کنید تا عملیات کامپایل برنامه شروع شود. اگر در طرح ایرادی نباشد پس از چند ثانیه به رنگ سبز خواهد شد.
- بر روی عبارت **Synthesize** کلیک کنید تا عملیات سنتز شروع شود. اگر در طرح ایرادی نباشد پس از چند ثانیه به رنگ سبز خواهد شد.
- بر روی عبارت **Build** کلیک کنید تا عملیات ساخت فایل قابل برنامه ریزی ساخته شود. اگر در طرح ایرادی نباشد پس از چند ثانیه به رنگ سبز خواهد شد.
- حال بر روی عبارت **Program CPLD** کلیک کنید. در این مرحله ابتدا CPLD پاک (ERASE) و سپس پروگرام می شود.
- تمام شد. CPLD پروگرام شد.
- ابتدا تغذیه را جدا کنید. سپس برد اصلی (IX144) را به مازول (ICONT) وصل کنید. لطفاً به جهت کابل اتصال دقت کنید و مجدد تغذیه را وصل کنید. شاهد عملکرد مدار خواهید شد.
- نکته : به دلیل جریان کشی مدار توصیه می شود هنگام انجام فرایند پروگرام مازول های جانبی را از برد اصلی جدا کنید.
- نکته : حتی هنگام اجرای برنامه در مازول از هیت سینگ برای رگلاتور استفاده کنید.
- نکته : من در این مقاله از برد های آماده استفاده نمودم. برد اصلی که می باشد دارای یک CPLD شماره XC95144 می باشد.



برد اصلی IX144



ماژول ICNT

طراحی مدار به پایان رسید. در این بخش باید سخت افزار را به پروژ معرفی کرد. بطور مثال شماره IC CPLD استفاده شده چیست؟ یا LED0 که در طرح به عنوان خروجی معرفی شده است به کدام پایه CPLD وصل می شود؟ و یا ورودی فرکانس که در طرح استفاده شده است به کدام پایه CPLD وصل شده است؟

تمامی این موارد باید در فایل Constraint تعریف شود. برای این منظور:

• فایل Constraint را باز کنید.

• جهت معرفی چیپ در انتهای فایل عبارت زیر را وارد کنید :

```
Record=Constraint | TargetKind=Part | TargetId=XC95144XL
```

در این عبارت CPLD از نوع XC95144XL معرفی شده است.

• تخصیص پایه ها : جهت تخصیص پایه به خروجی LED0 و اتصال به پایه CPLD عبارت زیر را وارد کنید :

```
Record=Constraint | TargetKind=Port | TargetId=LEDS0 |
```

```
FPGA_PINNUM=P80
```

در این عبارت LED0 به پایه ۸۰ از CPLD وصل و معرفی شده است.

برای بقیه خروجی ها و ورودی ها نیز مانند همین پایه عمل می کنیم. همانطور که متوجه شدید فرکانس ورودی به پایه ۱۰ و SW0 نیز به پایه ۸۳ وصل شده است.

```
Record=Constraint | TargetKind=Port | TargetId=LEDS1 |
```

```
FPGA_PINNUM=P82
```

```
Record=Constraint | TargetKind=Port | TargetId=LEDS2 |
```

```
FPGA_PINNUM=P84
```

```
Record=Constraint | TargetKind=Port | TargetId=LEDS3 |
```

```
FPGA_PINNUM=P2
```

```
Record=Constraint | TargetKind=Port | TargetId=LEDS4 |
```

```
FPGA_PINNUM=P4
```

```
Record=Constraint | TargetKind=Port | TargetId=LEDS5 |
```

```
FPGA_PINNUM=P6
```

```
Record=Constraint | TargetKind=Port | TargetId=LEDS6 |
```

```
FPGA_PINNUM=P13
```

```
Record=Constraint | TargetKind=Port | TargetId=LEDS7 |
```

```
FPGA_PINNUM=P11
```

```
Record=Constraint | TargetKind=Port | TargetId=CLK_BRD |
```

```
FPGA_PINNUM=P10
```

```
Record=Constraint | TargetKind=Port | TargetId=SW0 |
```

```
FPGA_PINNUM=P83
```

• تخصیص پایه ها نیز پایان یافت فایل را ذخیره کنید.

• نکته : شماره پایه های باید با سخت افزار نهایی همخوانی داشته باشد.

پروگرام کردن

بعد از این همه تلاش نوبت به پروگرام کردن طرح در CPLD می باشد. برای این منظور :

• برد اصلی (IX144) را با استفاده از کابل مخصوص به مازول (IPRO) وصل کنید. این مازول جهت پروگرام کردن از طریق JTAG استفاده می شود.

• مازول (IPRO) را به پورت LPT وصل کنید.

• تغذیه مدار را وصل کنید.

• از منوی View گزینه Devices View را انتخاب کنید. در صورتی که همه کارها درست انجام داده اید باید تصویر زیر را



می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد؛ این مساله می‌تواند باعث شود که در همان مرحله تولید یک چیپ بی‌سیم درون لامپ قرار دهیم! دوم اینکه در این شرایط دستگاه‌ها می‌توانند شکل شبکه به خود بگیرند و تازه در اینجاست که قدرت واقعی Zigbee نمایان می‌شود. در همان مثال چراغ‌ها، فرض کنیم در یک شرکت هستیم و می‌خواهیم یک کلید تمام چراغ‌های داخل یک طبقه را خاموش کند، اما این کلید تنها زمانی اجازه دارد تمام چراغ‌ها را خاموش کند که هیچ کس در اداره نباشد. انجام این کار ساده است؛ با استفاده از یک PIR Detector. زیبایی Zigbee این است که دستگاه‌های ساخت شرکت‌های مختلف، تا زمانی که با استانداردها هم خوانی داشته باشند، می‌توانند با هم کار کنند.



تاریخچه

ایده یک ارتباط بی‌سیم ارزان از یک سوال بر می‌خیزد: «چه می‌شد اگر رادیوهای و یا میکروپروسسورها مجانی بودند؟» این سوال Robert Poor را تحریک نمود تا پژوهه تحقیقات مش بی‌سیم را در آزمایشگاه لوازم و رسانه‌های MIT در سال ۱۹۹۷ شروع کند. اکنون از نتایج این تحقیقات، شرکت‌های تجاری بوجود آمده اند، و هم اکنون محصولاتی را نیز در اختیار داریم؛ چیپ‌های رادیوئی و پشت‌های پروتکل نرم افزاری. این تکنولوژی باید:

• ارزان باشد
• برای قابل نصب باشد (حتی در صورت امکان کاربر به تنها یک آن را نصب کند)

قابل اتکا باشد (با یک بار نصب به راحتی کار کند)
تنها با برآورده شدن این شرایط است که این تکنولوژی می‌تواند در همه جا حضور داشته باشد.

قابلیت نصب خودکار و ملاحظات قابل اتکا بودن این مساله را نشان می‌دهد که توبولوژی ایده آل جهت این سیستم یک شبکه مش با ارتباطات peer-to-peer می‌باشد. شکل ۲ یک نوع پیکربندی محتمل مش را نشان می‌دهد.

چه چیزی باعث تمایز Zigbee می‌شود

در یک کلام؛ استانداردها! سیستم Zigbee در دو سطح استاندارد سازی می‌شود؛ چیپ‌های رادیوئی مورد استفاده باید از قوانین مشخصی پیروی کنند؛ و لایه‌های پروتکل که در واقع عملیات‌های شبکه را بوجود می‌آیند هم بر اساس پیوستگی‌های Zigbee تعریف و کنترل می‌شوند.

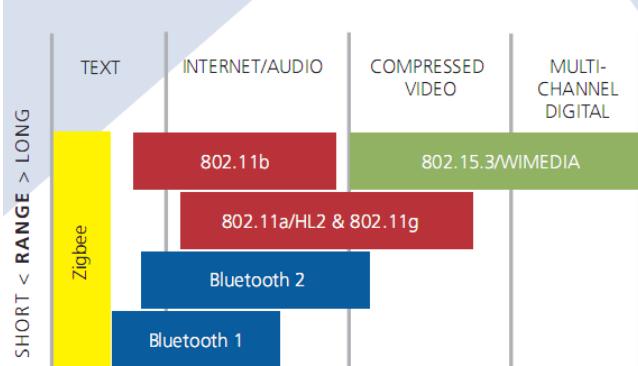
پروتکل Zigbee سه نوع گره بی‌سیم را معرفی می‌کند؛ تطبیق کننده شبکه ناحیه شخصی (PAN)، قطعات کاملاً عملیاتی و قطعات نیمه عملیاتی. گره‌های کاملاً عملیاتی می‌توانند هر نوع مورد نیاز شبکه را شکل دهی کنند (مش، ستاره، هیبرید) در حالی که گره‌های

معرفی ZigBee

بیشتر خوانندگان با تکنولوژی‌های صدا و دیتای دیجیتال مثل Bluetooth و GSM، Wi-Fi آشنایی دارند. این تکنولوژی‌ها در کل برای برقراری ارتباط و یا انتقال اطلاعات گسترش داده شده اند. حتی Bluetooth هم که به عنوان یک راه همگانی جهت ارتباط PC با دستگاه هایی مثل پرینتر معرفی شد، بیشتر برای ارتباطات صوتی یک لوازم جانی رایج در موبایل‌های مدرن مورد استفاده قرار گرفت. این تکنولوژی‌ها تماماً دارای یک نقطه اشتراک می‌باشند؛ مقدار نسبتاً زیادی اطلاعات با سرعت نسبتاً زیاد ارسال می‌شود. شکل ۱ تکنولوژی‌های مختلف بی‌سیم را نشان می‌دهد.

اما اگر ما نیاز به ارسال مقدار بسیار کمی اطلاعات داشته باشیم چطور؟ به عنوان یک مثال روزمره، مثلاً اگر بخواهیم کلید برق روی دیوار را به جای اینکه با سیم به لامپ‌ها متصل کنیم، بخواهیم به صورت بی‌سیم متصل کنیم؟ البته انجام این کار هم اکنون ممکن است، مثلاً همه ما درب گاراژ باز کن‌های بی‌سیم و یا دزدگیر‌های بی‌سیم ماشین را دیده ایم. اینها همه مثال‌هایی از کنترل‌های بی‌سیم نقطه به نقطه می‌باشند. اما این روش‌ها شخصی می‌باشند و از هیچ استانداردی پیروی نمی‌کنند؛ ضمن اینکه این تکنولوژی‌ها مقدار

ILLUSTRATION 1: WIRELESS TECHNOLOGIES



LOW < ACTUAL THROUGHPUT > HIGH

شکل ۱: تکنولوژی‌های بی‌سیم

قابل توجهی از طیف از پیش تعیین شده بی‌سیم – باند ISM- را هم مصرف می‌نمایند.

Zigbee یک روش استاندارد کم مصرف و کم هزینه جهت ساخت یک شبکه کامپیوتری ارائه می‌کند. در ابتدا لازم است بیان کنیم که یک سیستم استاندارد چه مزیت‌هایی دارد؟ اول از همه تولید انبوه، چیپ‌های رادیویی را می‌توان در حجم بالا تولید نمود (چه تعداد کلید برق در دنیا وجود دارد؟) و این خود

کنند. مشابه با راه هایی که بسته های اطلاعاتی درون یک شبکه مشترک می کنند.

اما در واقع چیزی که برای نگارنده در طی یکی از تورهای اتحادیه Zigbee (که اخیراً توسط Bob Heile. ریاست اتحادیه) برگزار شده آشکار شده، این است که این نام گذاری تقریباً بی مسما است. در واقع آنها نیاز به پیدا نمودن یک URL استفاده نشده داشتند (کاری که این روزها آسان نیست) و کلمات کوچک و خوش خوان تصادفی zig و bee انتخاب شده است.

پتانسیل

این شبکه به گفته Bob Metcalfe (خالق اترنت) «بزرگتر از اینترنت» می باشد. البته برحسب تعداد قطعات تولیدی این مساله قطعاً درست می باشد؛ زیرا میلیارد ها قطعه تولید خواهد شد. حتی در حال حاضر با اینکه Zigbee تقریباً ناشناخته می باشد هم، صدها هزار چیپ ساخته و به مناطق مختلف فرستاده می شوند، که این در سال آینده به میلیون ها قطعه افزایش می یابد.

در مورد اینکه آیا این سیستم می تواند تاثیر شگرفی که اینترنت داشت را تکرار کند یا نه (همان طور که در مورد «ایده های بسیار خوبی» که تاکنون در مورد آنها به خوبی فکر نشده است) هنوز نمی توان به طور قطع سخن گفت.

خلاصه

Zigbee دارای آنچنان پتانسیلی می باشد که هیچ شرکتی نتواند براحتی آن را نادیده بگیرد. این تکنولوژی می تواند نوعی «اکوسیستم بی سیم» را شکل دهد و این شرکت ها به عنوان بخشی از آن باید از آن مطلع باشند. Zigbee می تواند در بسیاری موارد نقطه انتهایی شبکه های M2M باشد. شرکت های توسعه محصولاتی مثل Soft Edge Technology Ltd در تسهیل و توسعه این تکنولوژی نقش مهمی را ایفا می کنند. گرچه «برنامه های نابود کننده» هم چون سیستم روشنایی ساختمان ها در حال حاضر دامنه حضور بازیگران مهمی می باشد (فیلیپس در حال راه اندازی سیستمی در این رابطه می باشد)، با این حال، طبیعت موجود در همه جای Zigbee به این معنا است که هنوز مسیر های متعددی از کاربردهای این سیستم وجود دارد که برای اکتشاف باقی میماند.

منبع :

News+Views from MX Alliance and beyond
Issue 3, December 2004

hamedazad@gmail.com

مترجم : حامد پورآزاد

نیمه عملیاتی تنها می تواند به گره های کاملاً عملیاتی متصل شوند. تطبیق دهنده های PAN به عنوان روتور برای بسته های موجود در شبکه عمل می کنند؛ بنابراین هر دستگاه کاملاً عملیاتی می تواند یک تطبیق دهنده PAN باشد. در حالی که گره های نیمه عملیاتی دارای مزیت مصرف کم هستند و می توانند در مثال ما به عنوان کلید های برق به کار برده شوند. اتحادیه Zigbee مشکلات مربوط به عدم تطابق را از Bluetooth فرا گرفته، و فرم های کاربردی را تعریف نموده، که مشخص می کنند انواع مختلف قطعات چگونه باید با هم کار کنند.

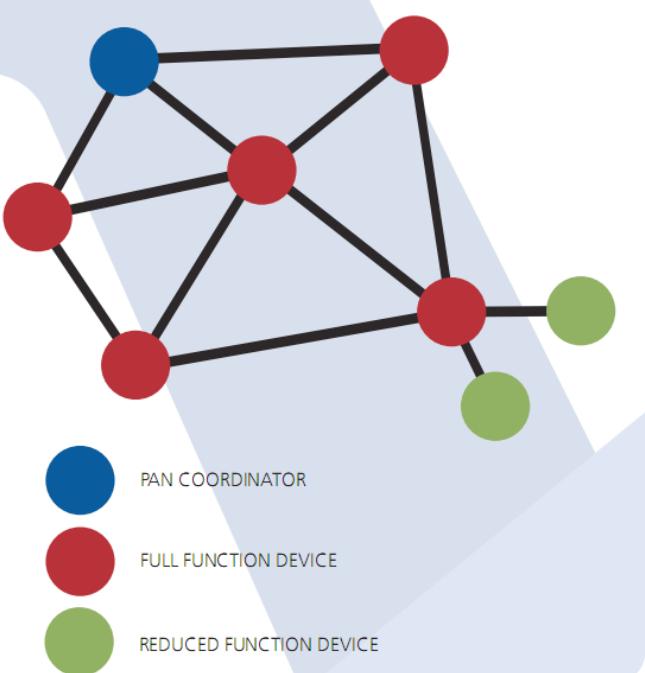
کاربردها

گستردگی کاربردهای بالقوه Zigbee واقعاً زیاد است. Zigbee می تواند تکنولوژی باشد که امکان محل داد و ستد ماشین-با-ماشین (M2M) را فراهم می کند تا وعده های آن را برآورده سازد.

پیش بینی می شود که M2M در سال های آتی 100% داشته باشد. موارد زیر نمونه هایی از آن است:

- مدیریت انرژی (روشنایی، گرمایشی، سیستم های تهویه مطبوع)
- سیستم های امنیتی (ساختارهای ابزار دقیقی کشش سنجی مثل پل ها)
- ارتش (شبکه های سنسوری مش، شناسایی تهدید شیمیایی)
- کشاورزی (شبکه های شناسایی برفک، کنترل آبیاری)
- مدیریت سرمایه (گزارش گیری دما، مدیریت کاتینرها)

ILLUSTRATION 2: MESH NETWORK



شکل ۲ : شبکه مش

علت نام گذاری

بدون شک همه سوال می کنند: چرا این سیستم را Zigbee می نامند؟ این اسم مسلمًا یک اسم جذاب و خاطره انگیز است. اما این اسم به چه معناست؟

پیشنهاد شده که نام این سیستم تداعی کننده مسیرهای تصادفی باشد که زنبور ها (bees) در حین گرده افشاری محصولات طی می



معرفی آی سی 74HC4046



ترشه 4046

ها دارای یک پایه فعال ساز می باشد که با فعال سازی آن بخش های دیگری از جمله بافر خروجی نیز فعال می شود و به عبارت دیگر آی سی روشن می شود. با فعال سازی بخش VCO، در خروجی یک شکل موج مربعی قرار می گیرد که در صورتی که سیگنال ورودی صفر باشد، دارای یک فرکانس ثابت است که به آن فرکانس آزادرو می گویند.

علاوه بر این، این خانواده ها دارای محدودیت فرکانس آزادرو نیز می باشند و از این میان، 74HC4046 با حداکثر فرکانس آزادروی ۱۹MHz بیشترین توانایی را دارد. بیشتر PLL ها حداکثر فرکانس آزادروی که می توانند داشته باشند در حد ۱MHz می باشد. علاوه بر این، این IC مزیت های ویژه ای هم نسبت به بقیه IC ها دارد که باعث شده است در کاربردهای مخابراتی و ارسال با فرکانس RF در حد چند مگاهرتز، بیشتر از این نوع IC ها استفاده شود. البته این IC در ایران بشدت کم یاب می باشد که این مساله مهم ترین اشکال این IC می باشد. در مقایسه انواع مختلف آی سی ها، تعدادی از موارد برتری 74HC4046 نسبت به بقیه IC های خانواده 4046 در زیر اشاره شده است :

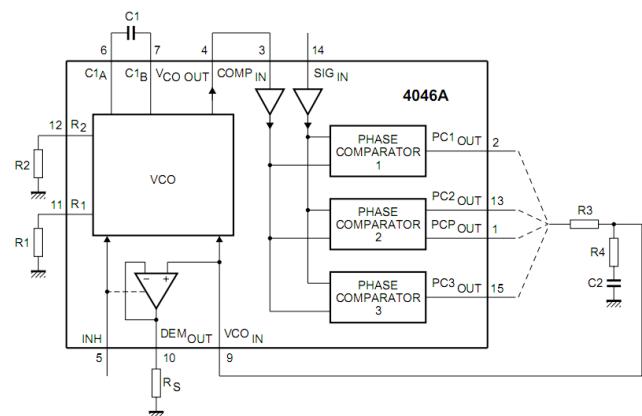
(۱) محدوده ولتاژ تغذیه بسیار پائین

بیشتر IC های 4046 محدوده ولتاژ تغذیه بسیار وسیعی دارند و این به این معنی است که برای کار مناسب، نیاز به حداقل ولتاژی در حد ۱۰ ولت دارند. این در حالی است که در اکثر مدارهای امروزی تغذیه ها از نوع دیجیتال (۵ ولت) بوده و در صورتی که بخواهیم از این آی سی ها استفاده کنیم، نیاز به دو تغذیه داریم. اما 74HC4046 محدوده تغذیه کمتری دارد (ولتاژ ورودی حداکثر آن ۶ ولت است). ضمن اینکه ولتاژ مناسب برای کار آن ۵ ولت است که این برای استفاده در مدارات دیجیتال بسیار مناسب است. ضمناً جریان ورودی پایه های تغذیه آن هم ۵۰mA می باشد که

آی سی های خانواده 4046 جزو آی سی های PLL هستند. این آی سی ها دارای انواع و اقسام مختلفی می باشند که از لحاظ توان مصروفی و امکانات تراشه تفاوت هایی دارند و در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت:

IC های خانواده 4046 که شامل چندین نوع مختلف تمام IC های (hef4046, CD4046) 74HC4046 هستند. در مورد کاربردهای PLL در مقالات آینده توضیحاتی خواهیم داد. ضمناً در این IC ها این امکان وجود دارد که بتوان از بخش VCO آن بصورت مجزا (و بدون بستن حلقه) استفاده نمود.

VCO در این IC دارای یک فرکانس آزادرو می باشد که مقدار آن بر اساس مقادیر خازن C1 و مقاومت های R1 و R2 تعیین می شود.



شکل ۱: بلک دیاگرام 74HC4046

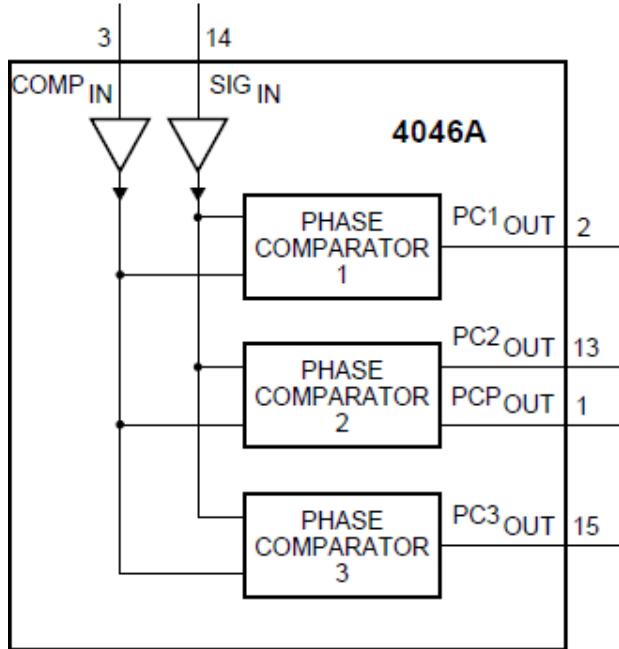
انواع مختلف IC های 4046 در مورد این فرکانس آزادرو با یکدیگر اختلافات فراوانی دارند. برخی از انواع برای تعیین مقدار فرکانس آزادرو دارای یک نمودار لگاریتمی بسیار دقیق می باشند (hef4046 و 74HC4046) و برخی دیگر از جمله CD4046، دارای نمودار خاصی نیستند و مقادیر خازن آنها باید بصورت تجربی تعیین شود و از آنجاییکه تغییرات فرکانس بر اساس مقادیر خازن یک رابطه غیر خطی (لگاریتمی) است، تعیین فرکانس آزادرو در این IC ها کاری بس دشوار است و عموماً از آنها برای کار در حالاتی

استفاده می شود که مقدار فرکانس آزادرو مهم نیست. تمام آی سی های 4046 دارای حداقل ۲ مقایسه کننده فاز می باشند. البته بعضی از مدل ها (مثل 74HC4046) دارای ۳ مقایسه کننده فاز می باشند. ضمناً پایه های ورودی سیگنال و ورودی مقایسه کننده (پایه های ۳ و ۴ در شکل ۱) نیز بافر شده اند و جریان ورودی آنها ماکزیمم ۳mA می باشد. البته در بیشتر کاربردها این جریان در حد ۳mA می باشد.

خروجی تمام آی سی های PLL بصورت یک موج مربعی با Duty Cycle = 50% می باشد. این پایه می تواند جریانی تا حد ۲۰mA را برای خروجی تامین کند. ضمناً بخش VCO این آی سی

ضمانت پایه ۵ هم به عنوان فعالساز VCO و خروجی آشکارساز (پایه ۱۰) به کار می رود. با اتصال این پایه به صفر منطقی، VCO و خروجی آشکارساز روشن می شوند و با اتصال به سطح یک منطقی، VCO (و به عبارتی کل PLL) خاموش می شود.

(۲) آشکارساز فاز (Phase Detector) در 74HC4046، برخلاف بقیه IC های خانواده 4046، سه عدد آشکارساز فاز وجود دارد (شکل ۲):
Phase Comparator 1



شکل ۲: بلوک های PD

این PD، یک شبکه از نوع exclusive-OR بوده و حداکثر گستره قفل آن ۱۸۰ درجه می باشد. برای داشتن حداکثر گستره قفل، سیگنال ورودی و فرکانس خروجی VCO باید از نوع موج مربعی با $Duty\ Cycle = 50\%$ باشد.

تابع انتقال و بهره این مقایسه کننده به صورت روبرو می باشد:
که V_{DEMOUT} ولتاژ خروجی از پایه ۱۰ می باشد.

$$V_{DEMOUT} = \frac{V_{CC}}{\pi} (\varphi_{SIGIN} - \varphi_{COPMIN})$$

$$K_P = \frac{V_{CC}}{\pi} (V/r)$$

:Phase Comparator 2

این PD، نسبت به لبه بالارونده سیگنال ورودی حساس است. با استفاده از این PD، حساسیت نسبت به Duty Cycle از سیگنال ورودی و خروجی VCO از بین می رود. PD2 از دو D Flip Flop کیت کنترل و بافر سه حالت در خروجی می باشد. این مقایسه کننده براحتی می تواند از -360° تا $+360^\circ$ اختلاف فاز را ردیابی کند و به عبارت دیگر در صورت استفاده از این مقایسه کننده، از قفل خارج شدن PLL امری بسیار سخت می باشد.

با یک ضرب ساده می بینیم که توان مصرفی این آی سی خیلی کم (250mW) می باشد.

(۲) دارای فرکانس VCO خطی با تغییر سطح ولتاژ ورودی به پایه ورودی VCO می توان فرکانس خروجی VCO را تغییر داد، که در این IC این تغییر فرکانس خطی است و می توان به راحتی از آن برای محاسبه رابطه بین تغییر ولتاژ با تغییر فرکانس VCO استفاده نمود.

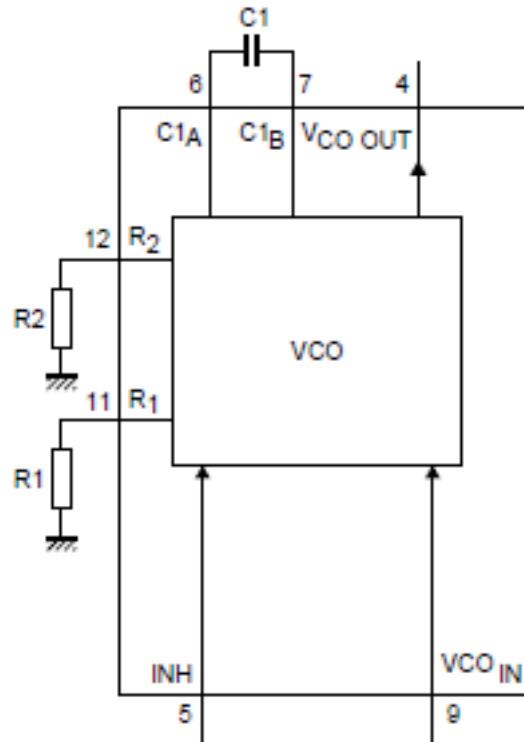
(۳) فرکانس آزادرو پایدار و ثابت با الارونده RS flip flop حساس به لبه

تمامی مدل های دیگر خانواده 4046 به جز ۷4HC4046 دارای ۲ عدد PD هستند که معمولاً XOR و JK flip flop با داشتن ۳ عدد PD می تواند به خوبی هر نوع تغییرات شدید فرکانس و فاز را پیگیری کند و اصطلاحاً حلقه به راحتی از قفل خارج نمی شود.

74HC4046 قسمت های مختلف

VCO(۱)

VCO، اسیلاتوری است که فرکانس نوسان آن با ولتاژی که به پایه ورودی آن داده می شود، تغییر می کند. شکل ۲ نمودار بلوکی این بخش از 74HC4046 را نشان می دهد.



شکل ۲: بلوک VCO

در این آی سی، این امکان فراهم شده است تا بتوان از VCO به تنهایی استفاده نمود. بنابراین می توان با اعمال یک ولتاژ به پایه ورودی VCO (پایه شماره ۹)، مقدار فرکانس خروجی را تغییر داد. حال اگر این پایه را به یک ولتاژ متغیر متصل کنیم، می توان فرکانس خروجی را با تغییر این ولتاژ تغییر داد.

74HC4046 معرفی آی سی

Cycle ندارد. ضمناً حداکثر گستره قفل آن 360° درجه می باشد.
تابع انتقال و بهره این مقایسه کننده به صورت زیر می باشد:

$$V_{DEMOUT} = \frac{V_{CC}}{\gamma\pi} (\varphi_{SIGIN} - \varphi_{COPMIN})$$

$$K_P = \frac{V_{CC}}{\gamma\pi} (V/r)$$

تابع انتقال و بهره این مقایسه کننده به صورت زیر می باشد:

$$V_{DEMOUT} = \frac{V_{CC}}{\gamma\pi} (\varphi_{SIGIN} - \varphi_{COPMIN})$$

$$K_P = \frac{V_{CC}}{\gamma\pi} (V/r)$$

:Phase Comparator 3

hamedazad@gmail.com

نویسنده : حامد پورآزاد

این PD یک آشکارساز فاز حساس به لبه مثبت با استفاده از یک RS Duty می باشد. در این حالت هم حساسیتی نسبت به Flip Flop

Advanced Design System (ADS) 2009

Advanced Design System (ADS) 2009 نام نرم افزاری است که شرکت آن کار خود را از سال ۱۹۸۳ شروع کرده و اکنون همتایی برای رقابت با این نرم افزار وجود ندارد! این نرم افزار دارای تکنولوژی پیشرفته ای می باشد که این نسخه دارای آخرین تکنولوژی روز دنیا در این عرصه است. در این نسخه شما شاهد بهینه سازی چشمگیری خواهید بود، امکانات این نسخه از نرم افزار باعث می شود شما در عین سادگی به بهترین نحو به مدیریت پروژه های خود پردازید. در این نسخه شاهد افزایش چشمگیر سرعت و بهبود شبیه سازی مدارات الکترونیکی و همچنین مغناطیسی خواهید بود.

Advanced Design System (ADS) 2009 با تکنولوژی و امکانات پیشرفته خود باعث صرفه جویی در وقت شما شده و باعث می شود که هر روز بهره وری کار شما افزایش یافته و بتوانید طرح های خود را در کمترین زمان ممکن و به بهترین نحو انجام دهید.

یعنی نرم افزار توان طراحی و شبیه سازی cellular and portable phones، pagers، wireless networks، radar و همچنین satel-lite communications systems را دارا می باشد. این نرم افزار در قالب یک DVD ارائه گشته است



مزایای عمدۀ این نرم افزار عبارتند از :

- مجموعه کامل و بی نقصی از سیستم های سریع و دقیق با امکان کاربرد آسان ، شبیه سازی EM و مدار ، موفقیت طرح First – pass را در یک جریان کامل سطحی امکان پذیر می سازد.
- راهنمای مخصوص کاربری نتیجه سالها مهارت را در یک واسط با امکان کاربرد آسان گنجانده است.
- شرکت های صنعتی عموما نرم افزار ADS را چندین ماه پیش از سایر نرم افزار ها پشتیبانی میکنند.

Agilent EMPro v2009.02

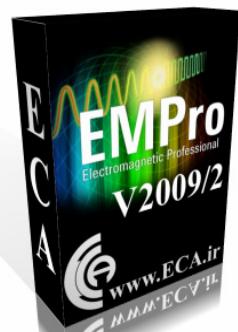
EMPRO پلتفرم طراحی نرم افزار Agilent EE شرکت برای آنالیز اثرات سه بعدی میدانهای الکترومغناطیسی RF و امواج microwave برای تراشه های on-chip, off-high-speed, آنتن، chip و طراحی PCB این نوع مدارات می باشد.

مزایای عمدۀ EMPro :

یکپارچگی روند طراحی : ایجاد مولفه های سه بعدی که میتوانند با layout و الگوی دو بعدی مدار داخل ADS که در شبیه سازی چندگانه ای مدار EM مورد استفاده قرار میگیرد ، با یکدیگر شبیه سازی شوند .

تکنولوژی طراحی گسترده : آنالیز ، نصب و راه اندازی مورد استفاده در تکنولوژی های شبیه سازی سه

بعدی EM هم در حوزه ای زمان و هم در حوزه فرکانس : FEM ، FDTD واسط موثر کاربر : ایجاد سریع ساختارهای سه بعدی اختیاری از طریق GUI ساده و مدرن که در زمان صرفه جویی کرده و ویژگی های نوشتاری پیشرفته ای را در اختیار کاربر قرار کی دهد.





طراحی فیلتر پائین گذر با استفاده از خطوط انتقال (Designing of Low Pass Filter with Transmission Lines (Microstrip))

مدار معادل خط انتقال یه خازن با ظرفیت C برابر است با یک خط انتقال (استاب) مدار باز شده با طول $l = \lambda/8$ و امپدانس $1/C$ می باشد که سوپیتانس این خازن به صورت زیر تعریف می شود : (در فرکانس ω_c)

برای آنکه فرکانس قطع ω_c یکسانی برای فیلتری که توسط تبدیل ریچارد به دست آمده داشته باشیم باید رابطه i زیر را داشته باشیم : $\Omega = 1 = \tan\beta l$

در نتیجه طول خطوط انتقال (استاب ها) به صورت $l = \lambda/8$ (به دست می آید که λ طول موج خط در فرکانس ω_c می باشد. در فرکانس $\omega_c = \omega$ خطوط دارای طول $l = \lambda/4$ بوده و یک قطب تعییف به وجود خواهد آمد . در فرکانس های دور از ω_c ، امپدانس استاب ها دیگر با امپدانس عناصر فشرده تطبیق نگردد و پاسخ فیلتر از پاسخ الگوی مورد نظر متفاوت خواهد بود . به دلیل متناوب بودن استاب ها ، لذا هر $4\omega_c$ تکرار می شود .

پس سلف ها و خازن های یک طراحی فیلتر با المان های فشرده را می توان با استاب های اتصال کوتاه و مدار باز تعویض نمود . آنجاکه طول تمام استاب ها یکی است در نتیجه این خطوط را خطوط سوریت مشترک Ω می نامند.

مدل های تبدیل خطوط انتقال با استفاده از اتحاد های کورودا : چهار اتحاد کورودا از بخش های خط انتقال اضافی استفاده نموده و کاربرد عملی تری از فیلتر مایکروویو را با انجام یکی از اعمال زیر به دست می دهد:

۱ - به طور فیزیکی استاب های خط انتقال را جدا می سازد .
۲ - استاب های سری را به استاب های مواری و بالعکس تبدیلی می نمایند .

۳ - امپدانس های مشخصه ω_c غیر عملی و غیر قابل ساخت را به مقادیر عملی و قابل ساخت تغییر می دهند .

بخش های اضافی را المان های واحد نامیده و طول آن ها در ω_c برابر $\lambda/8$ است، در نتیجه المان های واد با استاب های به کار رفته برای سلف ها و خازن های الگوی طراحی شده به صورت سوریت مشترک می باشند . در چهار اتحاد زیر هر بلوك بیانگر یک المان واحد یا خط انتقال با امپدانس مشخصه بیان شده و در داخل آن و طول $\lambda/8$ در ω_c می باشد. سلف ها و خازن ها به ترتیب نشان دهنده می استاب های اتصال کوتاه و مدار باز هستند .

که مقدار n از رابطه i زیر بدست می آید :

$$n^2 = 1 + Z_2/Z_1$$

Common surate ۴

مقدمه :

طراحی فیلتر با عناصر فشرده^۱ برای فرکانس های پائین کاربرد دارد و در فرکانس های ماکروویو (در حد گیگا هرتز) دارای دو مشکل اساسی است. نخست اینکه عناصر فشرده نظیر سلف ها و خازن ها عموما فقط برای محدوده i خاصی از مقادیر در دسترس بوده و در فرکانس های RF و مایکروویو با دشواری به کار می روند و نویز پذیری برای این المان ها در فرکانس های ماکروویو بالا می رود لذا می بایست با عناصر گسترده یا خطوط انتقال تقریب زده شوند. ثانیا اینکه در فرکانس های مایکروویو فاصله i میان عناصر تطبیقی قابل صرفنظر نمی باشد. برای تبدیل المان های فشرده به بخش های خط انتقال از تبدیل ریچارد^۲ استفاده می نماییم، در حالیکه اتحاد های کوردا^۳ برای جداسازی المان های فیلتر توسط بخش های خط انتقال مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجاکه این بخش های اضافی خط انتقال هیچ گونه تاثیری در پاسخ فیلتر ندارند لذا این نوع از طراحی را ساخت فیلتر با عناصر اضافی می نامند.

تبدیل ریچارد :

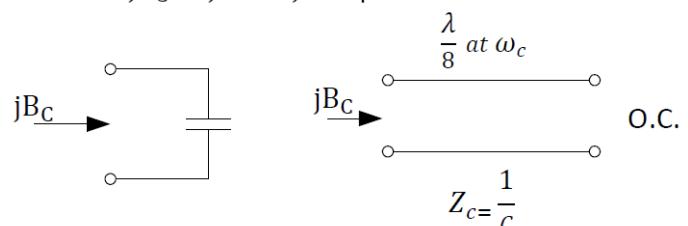
صفحه i ω_c را به صفحه i Ω تبدیل نموده و با پریود μ/ω_c تکرار می گردد .

که هدف اصلی تبدیل ریچارد ساخت شبکه LC با استفاده از خطوط

$$\Omega = \tan\beta\ell = \tan\left(\frac{\omega\ell}{v_p}\right)$$

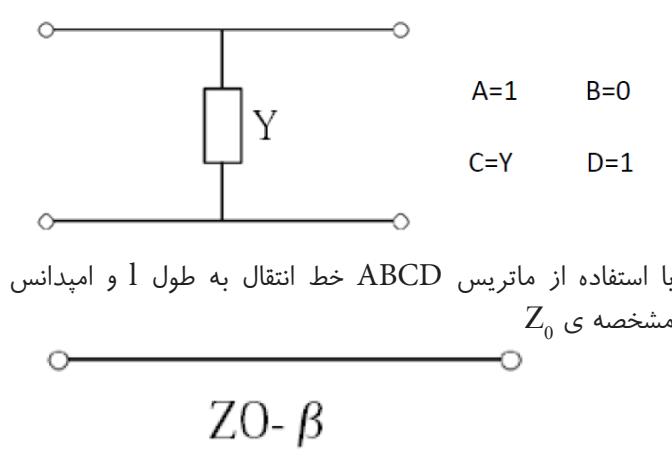
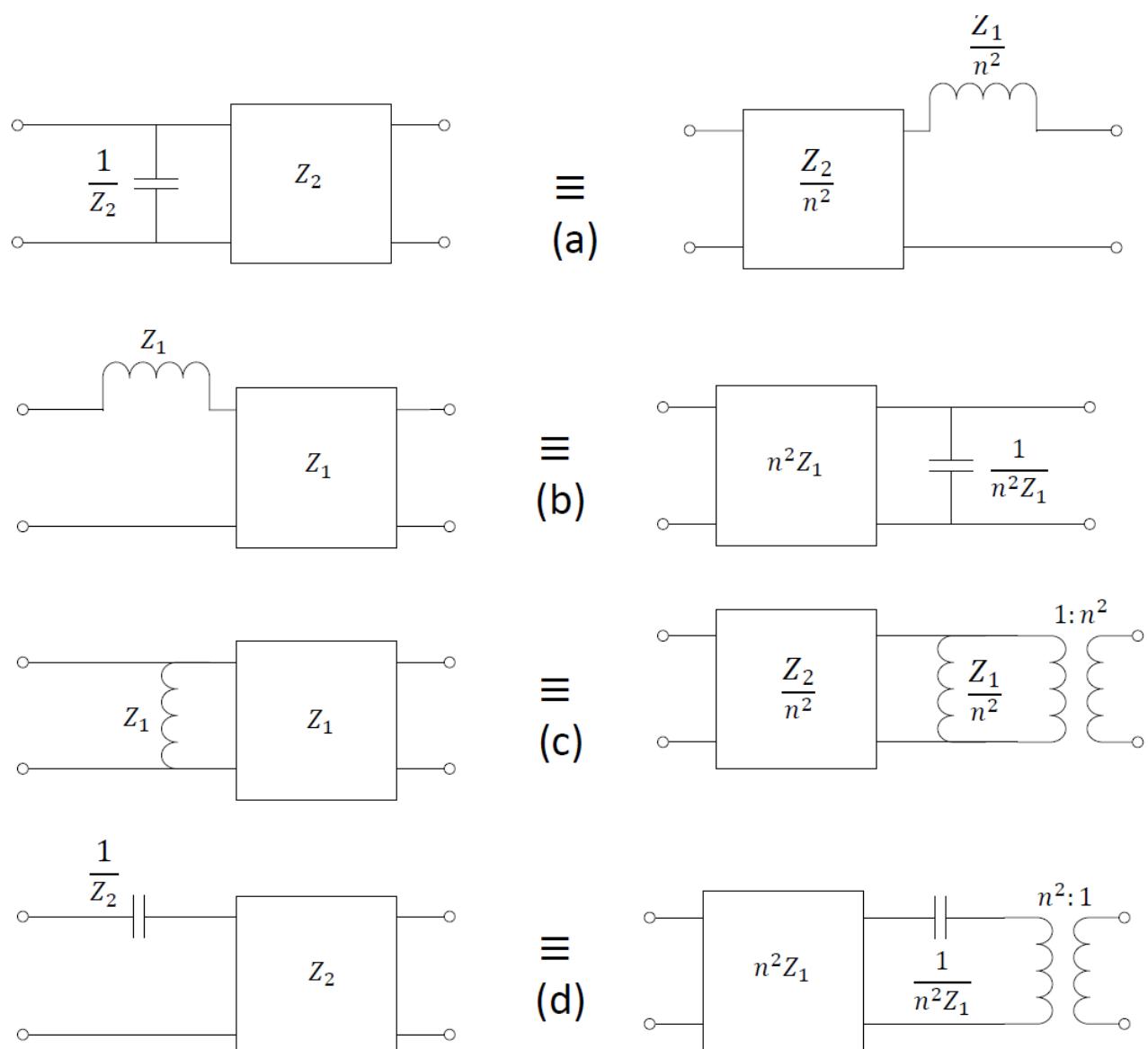
انتقال مدار باز و اتصال کوتاه می باشد . که می توان گفت : مدار معادل خط انتقال یه سلف با اندوکتانس L برابر است با یک خط انتقال (استاب) اتصال کوتاه شده با طول $l = \lambda/8$ و امپدانس L می باشد که راکتانس این سلف به صورت زیر تعریف می شود : (در فرکانس ω_c)

$$jB_C = j\Omega C = jC\tan\beta\ell$$



Lumped Element ۱
Richards ۲
Kuroda ۳

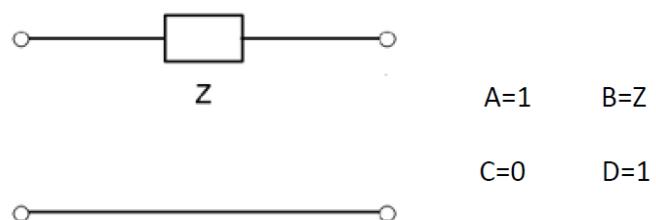
طراحی فیلتر پائین گذر با استفاده از خطوط انتقال



$$A = \cos\beta\ell \quad B = jZ_0 \sin\beta\ell \\ C = jY_0 \sin\beta\ell \quad D = \cos\beta\ell$$

ما در این گزارش قبل از اینکه به اثبات اتحاد اول کورودا بپردازیم
ابتدا ماتریس ABCD مربوط به امپدانس سری و ادمیتانس موازی
یک المان و یک خط انتقال به طول ℓ و امپدانس مشخصه Z را
به صورت زیر تعریف می کنیم :

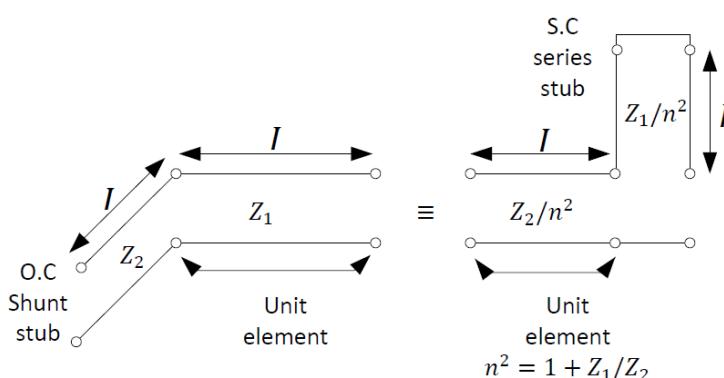
ماتریس ABCD مربوط به امپدانس سری :



طراحی فیلتر پائین گذر با استفاده از خطوط انتقال

نتایج بدست امده برای مدارهای سمت چپ و راست a در صورتیکه برابر هستند.

مدارهای معادل نمایش دهنده‌ی اتحاد a کورودا به صوت شکل ۲-۱ زیر می‌باشد:



حال با توجه به تعاریف بالا، به طراحی یک فیلتر پائین گذر برای ساخت با استفاده از خطوط مایکرواستریپ می‌پردازیم که می‌بایست مشخصات زیر را دارا باشد:

مشخصات فیلتر:

فرکانس قطع: GHz $\frac{1}{4}$

درجه: ۳

امپدانس: ۵۰ اهم

مشخصه‌ی ریپل مساوی: dB $\frac{1}{3}$

ابتدا می‌بایست با استفاده از جدول المان‌های فیلتر پائین گذر نرمالیزه شده که در زیر اورده شده، مقادیر المان‌ها را در می‌آوریم: جدول مقادیر المان‌ها برای ریپل ۰.۵dB و درجه N از ۱۰ تا ۱ و :

$$g_0=1 \text{ و } \omega_c=1$$

ماتریس ABCD طرف چپ شکل a) به صورت زیر بدست می‌آید:

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\beta\ell & jZ_1\sin\beta\ell \\ j\frac{1}{Z_1}\sin\beta\ell & \cos\beta\ell \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{1+\Omega^2}} \begin{bmatrix} 1 & j\Omega Z_1 \\ j\Omega & \frac{1}{Z_1} \end{bmatrix}$$

که در آن $\Omega=\tan\beta\ell$ می‌باشد. و از طرفی می‌دانیم که استاب مدار موازی در مدار اول سمت چپ دارای امپدانس $-jZ_2\sin\beta\ell=-jZ_2/\Omega$ است. بنابراین ماتریس ABCD کل مدار سمت چپ به صورت زیر بدست آمده است:

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j\Omega & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & j\Omega Z_1 \\ j\Omega & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{1+\Omega^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+\Omega^2}} \begin{bmatrix} 1 & j\Omega Z_1 \\ j\Omega(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}) & 1 - \Omega^2 \frac{Z_1}{Z_2} \end{bmatrix}$$

استاب‌های سری اتصال کوتاه شده در مدار شکل سمت راست به صورت

$$j(Z_1/n^2)\tan\beta\ell = j(\Omega Z_1/n^2)$$

است. بنابراین ماتریس ABCD کل مدار در سمت راست به صورت زیر است:

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_R = \begin{bmatrix} 1 & j\frac{\Omega Z_2}{n^2} \\ j\Omega n^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & j\Omega Z_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{1+\Omega^2}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1+\Omega^2}} \begin{bmatrix} 1 & j\Omega(n^2(Z_1+Z_2)) \\ j\Omega n^2 & 1 - \Omega^2 \frac{Z_1}{Z_2} \end{bmatrix}$$

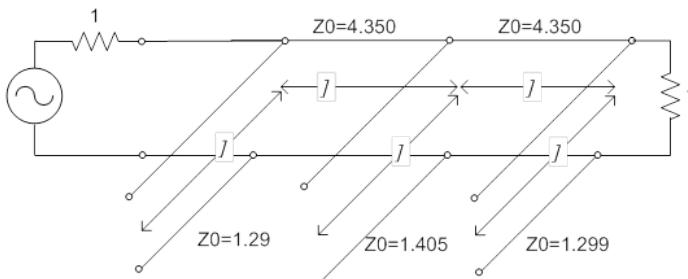
$$n^2 = 1 + \frac{Z_2}{Z_1}$$

3.0 dB Ripple

N	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5	g_6	g_7	g_8	g_9	g_{10}	g_{11}
1	1.9953	1.0000									
2	3.1013	0.5339	5.8095								
3	3.3487	0.7117	3.3487	1.0000							
4	3.4389	0.7483	4.3471	0.5920	5.8095						
5	3.4817	0.7618	4.5381	0.7618	3.4817	1.0000					
6	3.5045	0.7685	4.6061	0.7929	4.4641	0.6033	5.8095				
7	3.5182	0.7723	4.6386	0.8039	4.6386	0.7723	3.5182	1.0000			
8	3.5277	0.7745	4.6575	0.8089	4.6990	0.8018	4.4990	0.6073	5.8095		
9	3.5340	0.7760	4.6692	0.8118	4.7272	0.8118	4.6692	0.7760	3.5340	1.0000	
10	3.5384	0.7771	4.6768	0.8136	4.7425	0.8164	4.7260	0.8051	4.5142	0.6091	5.8095

طراحی فیلتر پائین گذر با استفاده از خطوط انتقال

با بکار بردن اتحاد دوم کورودا :

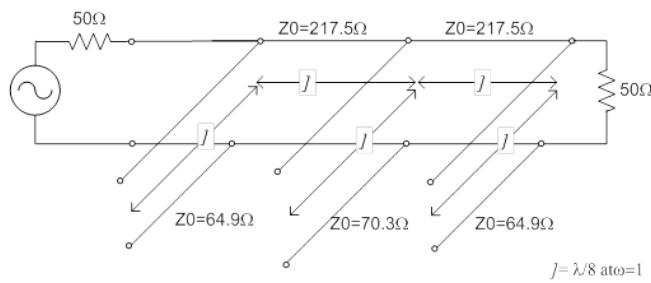


و مقدار n از رابطه‌ی بدست می‌آید :

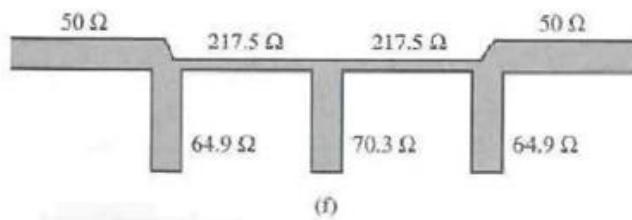
$$n^2 = 1 + \frac{Z_2}{Z_1} = 1 + \frac{1}{3.3487} = 1.299$$

حال با ضرب کردن عدد ۵۰ در امپدانس تمام المانهای مایکرواستریپی

از حالت نرمالیزه خارج می‌شویم :



حال فیلتر پائین گذر با استفاده از خطوط مایکرواستریپ به شکل زیر در می‌آید :



شبیه سازی فیلتر پائین گذر بالا با استفاده از نرم افزار های AWR و HFSS :

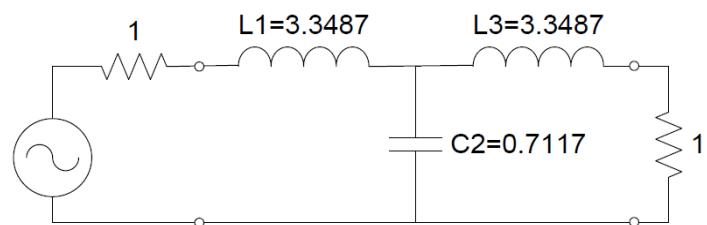
ابتدا با استفاده از TXline نرم افزار (Microwave Office) امپدانس هر یک از خطوط مایکرواستریپ را به همراه ضخامت دی الکتریک ۱.۶ میلی متر و ضریب دی الکتریک ۴.۴ در نظر گرفته شده و عرض و طول خطوط مایکرواستریپ هر امپدانس خط را محاسبه می کنیم طراحی را بدین صورت ادامه می دهیم :

پس المان فشرده فیلتر پائین گذر به صورت زیر بدست می‌آید :

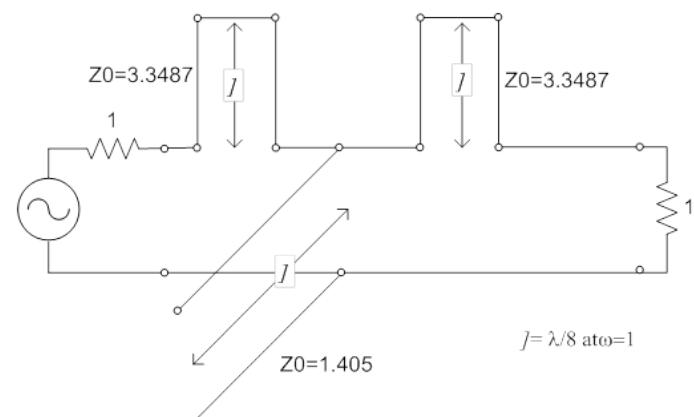
$$g_1 = 3.3487 = L_1$$

$$g_2 = 0.7117 = C_2$$

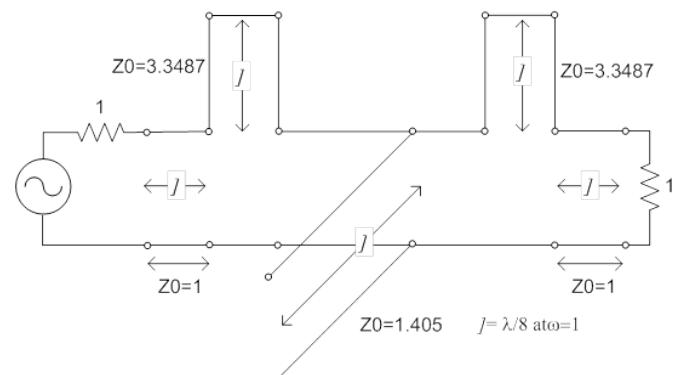
مدار با المان های فشرده به صورت زیر بدست می‌آید :



حال با استفاده از تبدیل ریچارد سلف ها و خازن ها به استاب های اتصال کوتاه و اتصال مدار باز تبدیل می کنیم : (امپدانس مشخصه‌ی یک استاب سری (سلف) برابر با L است و امپدانس مشخصه‌ی یک استاب موازی (خازن) برابر با 1/C می باشد.)

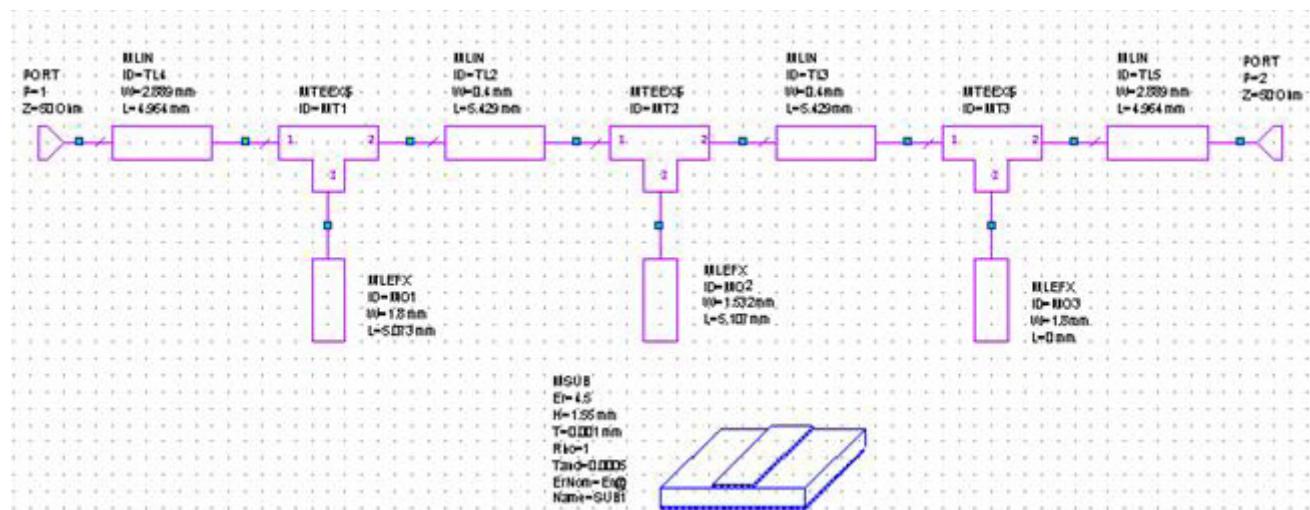


برای ساخت خط سوریت مشترک می بایست المان های اضافی را واحد را در دو انتهای فیلتر اضافی کنیم (این المان های اضافی تاثیری بر مشخصه‌ی کلی نمی گذارد چون به منبع و بار متصل شده است). سعی می کنیم از کمیت های نرمالیزه استفاده کنیم.



پیاده سازی استاب های سری شکل C بالا با خطوط مایکرواستریپ بیسیار مشکل است پس با استفاده از اتحاد های کورودا این استاب های سری را به استاب های موازی تبدیل می کنیم .

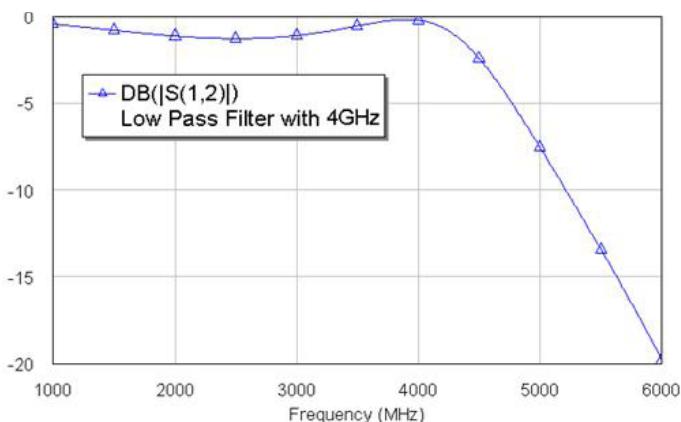
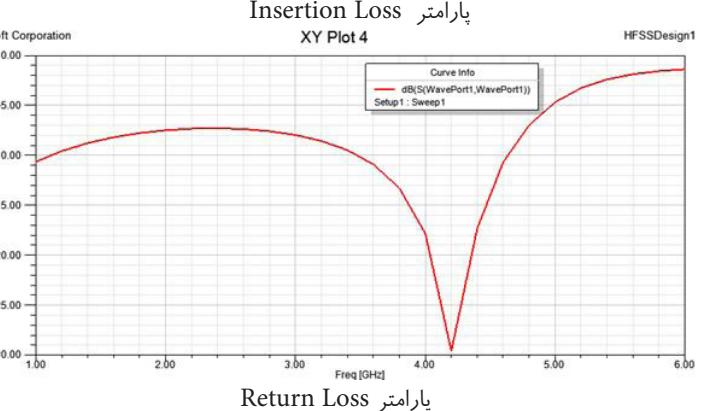
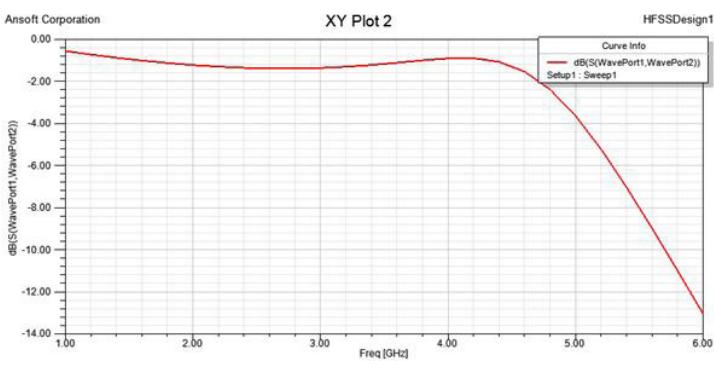
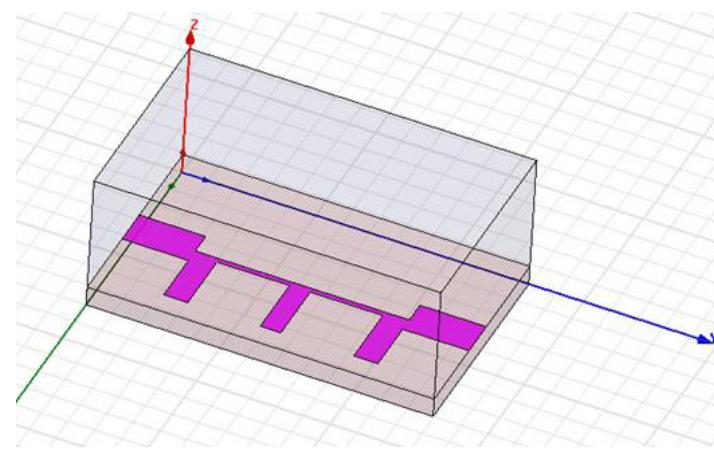
طراحی فیلتر پائین گذر با استفاده از خطوط انتقال



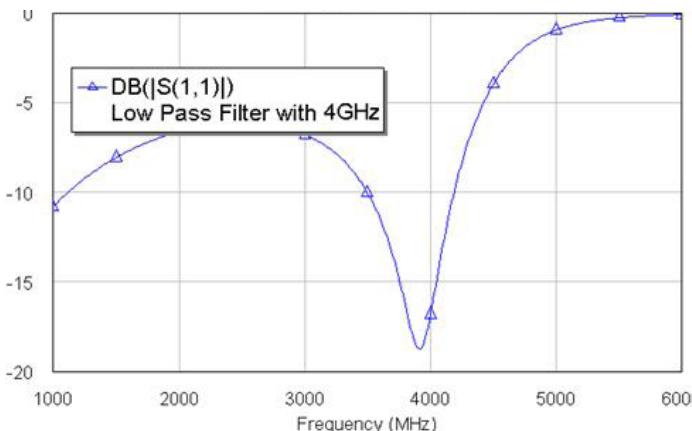
نما کلی فیلتر به صورت زیر می باشد :

حال دو پارامتر Return Loss و Insertion Loss را به صورت زیر داریم :

و پارامتر Return Loss به صورت زیر می باشد :



حال فیلتر را با استفاده از نرم افزار HFSS شبیه سازی می کنیم :



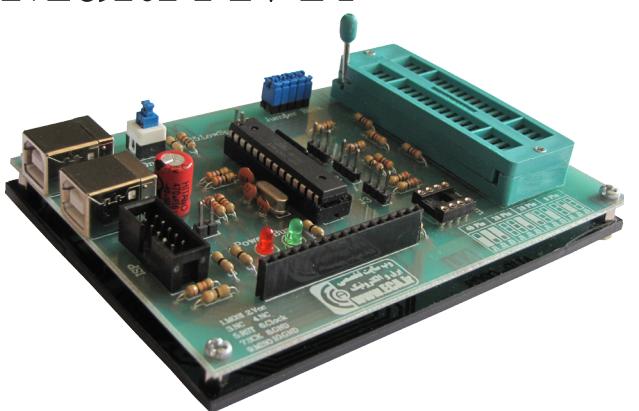
mosizaza@gmail.com

نویسنده : محسن رهمنا

معرفی محصولات وب سایت تخصصی برق و الکترونیک ECA

Multi AVR

Programmer



AVR USB

Programmer



» هماهنگی با پورت های USB1.1 و USB2.0

» دارای ۲ پورت USB جهت برطرف نمودن کمبود جریان احتمالی

» بدون نیاز به تغذیه خارجی

» مجهز به کانکتور ISP خروجی

» دارای سرعت بالا و قابل تنظیم (5kBytes/sec)

» مولد پالس ساعت برای بازیابی میکرووهایی که فیوز بیت آنها به

اشتباه تغییر داده شده است

Linux / Mac OS X / Windows

» سازگاری با سیستم عامل های AVR

» پشتیبانی از تمامی میکرووهای خانواده سری AT89Sxx

» پشتیبانی از حافظه های سریال 24CXX

» توانایی تست LCD های کاراکتری

» کارت گارانتی ۱۲ ماهه

» هماهنگی با پورت های USB1.1 و USB2.0

» بدون نیاز به تغذیه خارجی

» مجهز به ۲ کانکتور ISP خروجی

» دارای سرعت بالا و قابل تنظیم (5kBytes/sec)

» مولد پالس ساعت برای بازیابی میکرووهایی که فیوز بیت آنها به

اشتباه تغییر داده شده است

Linux / Mac OS X / Windows

» پشتیبانی از تمامی میکرووهای خانواده AVR

» کارت گارانتی ۱۲ ماهه

ARM Wiggler

Programmer



» توانایی پروگرام کردن انواع ARM های سری CORTEX-M3, XSCALE و ARM7, ARM9

» توانایی کار در سیستم عامل های Win98 , ME , 2000 , NT , XP , Vista

» کار با پورت پارالل (LPT)

» سازگاری کامل با کامپایلر CDRMDN KEIL ARM MDK

» سازگاری کامل با کامپایلر CDRMDN IAR ARM

» توانایی debugging کامل در محیط Keil IAR و

» کارت گارانتی ۱۲ ماهه

STK300 AVR

Programmer



» سبک و کوچک بودن

» بدون نیاز به تغذیه خارجی

» مولد پالس ساعت برای بازیابی میکرووهایی که فیوز بیت آنها به

اشتباه تغییر داده شده است

» پشتیبانی از تمامی میکرووهای خانواده AVR

» انجام تمامی عملیات مورد نیاز (خواندن ، نوشتن ، پاک کردن ،

تنظیم فیوز بیتها و ...)

» قابلیت دسترسی به EEPROM داخلی میکرو

» سازگاری با سیستم عامل های Linux / Mac OS X / Windows

» سازگاری با تمامی کامپایلرها

» کار با پورت پرینتر

» کارت گارانتی ۱۲ ماهه

استاندارد مواد پایه مدارهای چاپی

قسمت اول: مشخصات ورق فنولی با کاغذ سلولزی و روکش مس با کیفیت الکتریکی بالا

۱-۲ - پایه عایقی
رزین فنولی پیوند یافته با لایه‌های کاغذ سلولزی

۲ - ۲ - ورقه نازک فلزی
مس مطابق با استاندارد ملی ۳۶۵۵-۲ تحت عنوان : « مشخصات ورقه نازک مسی برای ساخت مواد پایه با روکش مس» می‌باشد.

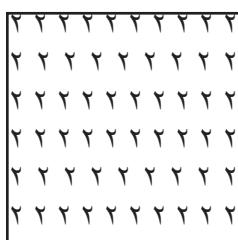
ورقهای نازک فلزی از « نوع A » (مس حاصل از آبکاری الکترولیتی) با چکش خواری استاندارد، ترجیح داده می‌شود.

۳ - نشانه گذاری داخلی
هر ورق باید علامت شناسایی سازنده را بشرح زیر داشته باشد :
الف) به رنگ سیاه یا رنگی دیگر که با رنگ قرمز اشتباه نشود (رنگ قرمز نباید بکار برده شود چون این رنگ معرف ماده‌ای با اشتغال‌پذیری معین می‌باشد).

ب) این علامت شناسایی در فواصل منظمی تکرار شود بطوريکه هیچ قسمتی از صفحه بیش از ۷۵ میلیمتر از دورترین نقطه نزدیکترین نشانه فاصله نداشته باشد.

ج) علائم شناسائی باید طوری چاپ شود که جهت حرکت دستگاه تزریق رزین را نشان دهد. چنانچه حروف یا ارقام بکار رود، این حروف یا ارقام باید بطور خوانا در جهت حرکت ماشین باشد.
(جدول شماره ۱)

مثال :



استاندارد مواد پایه مدارهای چاپی قسمت اول : مشخصات ورق فنولی با کاغذ سلولزی و روکش مس با کیفیت الکتریکی بالا که بوسیله کمیسیون فنی مربوط تهیه و تدوین شده و در هفتاد و هفتمین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک مورخ ۱۶/۱۱/۷۵ مورد تایید قرار گرفته است، اینک با استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاحی قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می‌گردد.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم استانداردهای ایران در موقع لزوم مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها بررسد، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.

بنابر این برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده نمود.

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور و بین این استاندارد و استاندارد کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود. لذا با بررسی امکانات و مهارت های موجود و اجرای آزمایش های لازم این استاندارد با استفاده از منابع زیر تهیه گردیده است:

IEC 249-2-1 (1985)

+ Amendment NO.2 (1993)

Base materials for printed circuits

Part 2: Specifications

Specification NO.1 Phenolic cellulose paper copper – clad laminated sheet, high electrical quality

مواد پایه مدارهای چاپی مشخصات ورق فنولی با کاغذ سلولزی و روکش مس با کیفیت الکتریکی بالا

۱ - هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه مقرراتی برای خواص ورق فنولی با کاغذ سلولزی و روکش مس با کیفیت الکتریکی بالا با ضخامت‌هایی بین ۰/۵ تا ۴/۶ میلیمتر می‌باشد.

۲ - مواد و ساختمان

ورق از پایه‌ای عایق که ورقه‌ای نازک فلزی به یک یا دو طرف آن چسبیده شده، تشکیل شده است.

استاندارد مواد پایه مدارهای چاپی

۴- خواص الکتریکی

(جدول شماره ۱)

مقررات	روش آزمون (بند فرعی استاندارد ملی ۳۶۵۳)	خواص
مطابق استاندارد ملی ۳۶۵۵-۲	۱-۳	مقاومت ورقه نازک فلزی
حداقل ۱۰۰۰ مگاهم	۲-۳	مقاومت سطحی بعد از گرمای مرطوب هنگامیکه در محفظه رطوبت قرار دارد (اختیاری)
حداقل ۱۰۰۰۰ مگاهم	۲-۳	مقاومت سطحی بعد از گرمای مرطوب و بگشت به شرایط عادی (بازیابی)
حداقل ۱۰۰ مگاهم متر	۳-۳	مقاومت ویژه حجمی بعد از گرمای مرطوب و هنگامیکه در محفظه رطوبت قرار دارد (اختیاری)
حداقل ۱۰۰۰ مگاهم متر	۳-۳	مقاومت ویژه حجمی بعد از گرمای مرطوب و برگشت به شرایط عادی
هیچگونه اثری از خوردگی در شکاف دیده نشد.	۴-۳	خوردگی سطحی
قطب مثبت : بدتر از A+B . قطب منفی : بدتر از ۱/۶ نباشد	۵-۳	خوردگی در لبه
مقدار متوسط نباید از ۵/۵ بیشتر باشد.	۷-۳	گذردگی نسبی ^۱ بعد از گرمای مرطوب و برگشت به شرایط عادی
مقدار متوسط نباید از ۵۰٪ بیشتر شود.	۷-۳	ضریب تلفات دی الکتریکی بعد از گرمای مرطوب و برگشت به شرایط عادی
حداقل ۱۰۰ مگاهم	۱-۹-۳	مقاومت سطحی در ۱۰۰°C
حداقل ۱۰۰۰ مگاهم متر	۱-۹-۲	مقاومت ویژه حجمی در ۱۰۰°C

1- Relative permittivity

می‌رود. خراش‌های مجاز بر روی سطحی از ورقه نازک مشی با ضخامت ۱۸ میکرومتر (152 g/m^2) هنوز تحت بررسی است.

مساحت کل سوراخهای سوزنی در ناحیه‌ای به مساحت ۵٪ متر مربع نباید از ۱۲٪ میلیمتر مربع بیشتر شود.

نقایص هر ورق نباید بیشتر از انواعی باشد که در جدول شماره (۲) مجاز شمرده شده است.

یادآوری ۱ - برای ورقه‌ای با مساحت یک متر مربع یا بیشتر، مقادیر ستون چهارم برای هر سطحی با مساحت ۱ متر مربع بکار می‌رود، با وجود این برای همین ورقه‌ها در هر ناحیه‌ای با ابعاد $300 \times 300 \text{ mm}$ مقادیر ستون پنجم اعمال می‌شود، در مورد هر ورقه‌هایی با مساحت کمتر از یک متر مربع، ستون پنجم در مورد هر ناحیه‌ای با ابعاد $(300 \times 300 \text{ mm})$ بکار می‌رود.

یادآوری ۲ - در مورد پانلهای بریده شده، تعداد و حداکثر اندازه نقایص باید با توافق خریدار و عرضه کننده باشد.

۵- ضخامت

ضخامت ورق شامل ضخامت ورقه نازک فلزی نباید از مقادیر ضخامت نامی مندرج در جدول شماره (۳) بیشتر باشد.

یادآوری ۱ - برای ورقه‌ای با مساحت یک متر مربع یا بیشتر، مقادیر ستون چهارم برای هر سطحی با مساحت ۱ متر مربع بکار می‌رود، با وجود این برای همین ورقه‌ها در هر ناحیه‌ای با ابعاد $300 \times 300 \text{ mm}$ مقادیر ستون پنجم اعمال می‌شود، در مورد

۵- خواص غیر الکتریکی ورق با روکش مس

۱-۵ - شکل ظاهری روکش مس

۱-۱-۵ - سطح نهائی عادی

سطح روکش مس باید اساساً فاقد تاول، چروک، سوراخهای سوزنی، خراشهای عمیق، حفره و رزین باشد. هر گونه تغییر رنگ یا آلودگی باید به آسانی با محلول اسید کلریدریک (هیدروکلریک اسید) با چگالی 0.2 g/m^3 یا با حلal آلی مناسبی قابل برداشتن باشد.

۱-۵ - سطح نهائی با کیفیت بالا (اختیاری) اگر نیاز به سطحی با کیفیت بالا برای آبکاری با فلز گرانبهای یا فلز بری ظرفی (مدارها) باشد و توسط خریدار سفارش داده شود، مقدرات زیر علاوه بر مقررات بند فرعی ۱-۱-۵، هنگامیکه مطابق بند فرعی ۹-۴ استاندارد ملی ۳۶۵۳ بارزسی می‌شود، باید اعمال شود.

سطح روکش مس باید طوری باشد که نقایص را پنهان نکند.

سطح روکش مس باید فاقد خراشهایی با عمق بیشتر از 0.100 mm میلیمتر یا یک پنجم ضخامت نامی ورقه مسی، هر کدام که کمتر است، باشد.

کل طول خراشهایی با عمق بیشتر از 0.050 mm میلیمتر حداقل تا 100 mm باید از یک متر در هر متر مربع کل مساحت ورقه تحت آزمون بیشتر شود.

این مقررات در مورد سطح ورقه‌های نازک فلزی (روکش مس) با ضخامت ۳۵ و 70 میکرومتر (30.5 g/m^2 و 61.0 g/m^2) بکار

استاندارد مواد پایه مدارهای چاپی

(جدول شماره ۲)

تعداد نقاط مجاز		اندازه (طول ، مگر اینکه بنحو دیگری مشخص شود)		نوع
در هر ناحیه با ابعاد ۳۰۰ mm × ۳۰۰ mm	در هر ورقی با مساحت ۱m ² تقریبی	بیشتر بناشد از mm	بیشتر از mm	
هر تعدادی ۴۰ صفر	هر تعدادی ۳۰ صفر	۰/۱ ۰/۲۵ -----	----- ۰/۱ ۰/۲۵ ۰/۱ با پهنای ۳٪.	مواد زائد
هر تعدادی ۳ * ۱ *	هر تعدادی ۱۳** ۳** صفر	۰/۲۵ ۱/۲۵ ۱/۰ با پهنای ۳٪. -----	----- ۰/۲۵ ۱/۲۵ ۰/۱ با ارتفاع ۴٪.	فرورفتگی
هر تعدادی ۲ صفر	هر تعدادی ۱۰ صفر	۰/۱ ۰/۰ با ارتفاع ۴٪. -----	----- ۰/۱ ۰/۰ با ارتفاع ۴٪.	برآمدگی
صفر	صفر	به هر اندازه ای		چروک تاول زدگی

* تعداد کل فرورفتگی ها برای این اندازه ها ۳ است

** تعداد کل فرورفتگی ها برای این اندازه ها ۱۳ است

۲ - مقررات پیچش و خمش فقط در مورد ورقهای ساخته شده و قطعه های بریده شده (پانل ها) که طول و عرض آنها کمتر از ۴۶۰ میلیمتر بناشد معتبر است.

ورقهای با مساحت کمتر از یک متر مربع، ستون پنجم در مورد هر ناحیه ای با ابعاد (mm ۳۰۰ × mm ۳۰۰) بکار می رود.

یاد آوری ۲ - در مورد پانلهای بریده شده، تعداد و حداکثر اندازه نقاطیض باید با تواافق خریدار و عرضه کننده باشد.

۴-۵- خواص مربوط به چسبیدگی ورقه نازک مسی

۳- ۵- حداکثر خمش و پیچش
یاد آوری :

۱ - حدود خمش و پیچش ورقهای لایه بندی شده روکش دار که ضخامت نامی ورقه نازک فلزی آنها از ۷۰ میکرومتر بیشتر است باید مورد تواافق خریدار و عرضه کننده قرار گیرد.

(جدول شماره ۴)

مقررات	روشن آزمون (بند فرعی استاندارد ملی (۳۶۵۳	خواص
نایاب از مقدار بدست آمده لز فرمول $D=d(L/1000)^{2}m^{\prime \prime}$ بیشتر شود ، که در آن L طول لبه صاف بر حسب میلیمتر است. d باید مطابق جدول شماره ۵ باشد	۱-۴	خمش
نایاب از مقدار بدست آمده از فرمول $D=d(L/1000)^{2}m^{\prime \prime}$ بیشتر شود ، که در آن L طول گوشه ای از صفحه که در تماس با سطح افقی نیست و گوشه مقابله آن بر حسب میلیمتر می باشد . d باید مطابق جدول شماره ۵ باشد	۳-۴	پیچش

(جدول شماره ۳)

انحراف ±	ضخامت نامی
mm	mm
۰/۷۰	۰/۵
۰/۰۹	۰/۷
۰/۱۱	۰/۸
۰/۱۲	۱/۰
۰/۱۴	۱/۲
۰/۱۴	۱/۵
۰/۱۵	۱/۶
۰/۱۸	۲/۰
۰/۱۸	۲/۴
۰/۲۰	۳/۲
۰/۳۰	۶/۴

استاندارد مواد پایه مدارهای چاپی

(جدول شماره ۵)

d ضخامت ورقه نازک مسی روی دو طرف	d ضخامت ورقه نازک مسی روی یک طرف			ضخامت نامی (mm)
	پیچش	خمس		
بیشتر از ۷۰ میکرومتر * نباشد	بیشتر از ۷۰ میکرومتر* نباشد	بیش از ۳۵ میکرومتر تا ۷۰ میکرومتر*	بیشتر از ۳۵ میکرومتر* نباشد	
۲۵	۲۵	۱۰۵	۵۵	از ۱/۲ تا ۱/۸
۲۰	۲۰	۷۵	۳۸	بیش از ۱/۶ تا ۱/۲
۱۵	۱۵	۵۵	۳۲	بیش از ۱/۶ تا ۳/۲
۱۲	۱۲	۴۰	۲۷	بیش از ۳/۲ تا ۶/۴

* مقادیر نامی عبارتند از ۳۵ میکرومتر و ۷۰ میکرومتر^۳

(جدول شماره ۶)

مقررات	روش آزمون (بند فرعی استاندارد ملی ۳۶۵۳)	خواص
کمتر از N ۵۰ نباشد	۵-۴	نیروی کندن
کمتر از ۱/۰ N/mm نباشد	۲-۲-۶-۴ ، ۱-۲-۶-۴ ۳-۲-۶-۴ ۳-۶-۴ ۴-۶-۴	نیروی ورآوری بعد از شوک حرارتی ۱۰ ثانیه ای بروش ۱ یا ۲ یا بعد از شوک حرارتی ۵ ثانیه ای بروش ۳ نیروی ورآوری بعد از گرمای خشک در ۱۰۰ درجه سلسیوس نیروی ورآوری بعد از قرارگیری در معرض بخار حلال حلال بصورتیکه بین خریدار و عرضه کننده توافق شده است
کمتر از ۰/۶ N/mm نباشد	۵-۶-۴	نیروی ورآوری بعد از آبکاری بعد از آبکاری مشابه سازی شده
هیچگونه تاول زدگی یا گسیختگی لایه ای نباید بوجود آید	۲-۲-۷-۴ ، ۱-۲-۷-۴ ۳-۲-۷-۴	تاول پس از شوک حرارتی ۱۰ ثانیه ای

اندازه ورقها به همان صورتی که عرضه کننده تحويل داده نباید

بیشتر از ۱۰ + میلیمتر با اندازه نامی اختلاف داشته باشد

روشهای آزمون خواص ماده پایه از نظر پانچ و ماشینکاری و مقررات مربوط به آنها مواردی هستند که می‌تواند مورد توافق خریدار و عرضه کننده قرار گیرد.

۵ - ۸ - رواداریهای اندازه پانلهای بریده شده

در مورد پانلهایی که مطابق مشخصه خریدار بریده شده‌اند، رواداری های زیر در مورد طول و عرض آنها اعمال شود.

۵ - پانچ و ماشینکاری

روشهای آزمون خواص ماده پایه از نظر پانچ و ماشینکاری و مقررات مربوط به آنها مواردی هستند که می‌تواند مورد توافق خریدار و عرضه کننده قرار گیرد.

۶ - لحیم‌پذیری

این بند فرعی حذف می‌شود.

۷ - پایداری ابعادی

(جدول شماره ۸)

رو اداری (mm)	اندازه پانل (mm)
ذقيق	معمولی
۰/۵	۳۰۰ تا
۰/۸	بیش از ۳۰۰ تا ۶۰۰
۱/۶	بیش از ۶۰۰

یادآوری - رو اداریهای مشخص شده کلیه انحرافات ناشی از بریدن پانلها را در بر میگیرد

(جدول شماره ۷)

مقررات	روش آزمون (بند فرعی استاندارد ملی ۳۶۵۳)	خواص
حداکثر ۰/۲ میلی متر در هر متر	۱۱-۴ $T=(150\pm 2)\cdot C$	پایداری ابعاد

۵ - رواداریهای اندازه

۵ - رواداریهای اندازه ورقها

۹ - راست گوشه‌ای بودن پانلهای بریده شده

(جدول شماره ۱۰)

مقررات	روش آزمون (بند فرعی استاندارد ملی ۳۶۵۳)	خواص
کمتر از ۸۰۰۰ N/cm ² نباشد	۱-۵	استحکام در برابر انعطاف (در مورد رقمهای که ضخامت نامی آنها کمتر از ۱۰ میلیمتر نیست ، معتبر می باشد) موادی با قابلیت پانچ خوب در دمای اتاق ، می تواند استحکام در برابر انعطافگیری داشته باشد : حد ۶۰۰۰ N/cm ² مناسب است

هر ورق با روکش فلزی (مس) و (یا) بسته‌بندی باید یک نشانه‌گذاری (بر چسب یا وسیله مناسب دیگری) داشته باشد که برحتی قابل برداشتن باشد این نشانه‌گذاری شامل شناسه نوع ماده مطابق این استاندارد ، نام سازنده ضخامت نامی ماده ، ضخامت نامی روکش مس و شماره مرجع بهر ۵ می‌باشد. هنگام حمل و نقل و جابجایی معمولی، نشانه‌گذاری باید خوانا بماند. نشانه‌گذاری بر روی بسته‌بندی باید تعداد ورقها را نیز نشان دهد.

با توافق بین خریدار و عرضه کننده شماره سفارش می‌تواند بجای شناسه نوع ماده و شماره مرجع بهر استفاده شود و به جای تعداد ورقها می‌توان وزن را جایگزین کرد.

۸ - آزمون‌های قبولی

اگر آزمون با نظارت خریدار ماده انجام می‌شود ، آزمونهای زیر توصیه می‌شود .

طرجهای نمونه‌برداری و سطح قبولی موضوعاتی هستند که بین خریدار و عرضه کننده مورد توافق قرار می‌گیرد .

۱- مقادیر فوق بترتیب معادل (۱ oz/ft² و ۲ oz/ft²) می‌باشند .

۲- مقدار فوق معادل (۰/۵ oz/ft²) است .

۳- مقادیر فوق بترتیب معادل (۱ oz/ft² و ۲ oz/ft²) می‌باشد .

Interleaving packing material -۴

Batch reference number -۵

(جدول شماره ۱۲)

خواص	بند فرعی استاندارد ملی ۳۶۵۳
مقاومت سطحی و مقاومت ویژه حجمی بعد از گرمای مرطوب و بازگشت به شرایط عادی	۲-۳ ۳-۳
گزندگی و ضریب تلفات بعد از گرمای مرطوب و بازگشت شرایط عادی	۷-۳
خمش پیچش	۱-۴ ۳-۴
نیروی ور آوری بعد از شوک حرارتی سطح نهایی ضخامت	۲-۶-۴ ۹-۴ ۱۴-۴

* با تشکر از شرکت محترم کارا الکترونیک

(جدول شماره ۹)

مقررات	روش آزمون (بند فرعی استاندارد ملی ۳۶۵۳)	خواص
۲۰	۳	۱۵-۴ راست گوشه‌ای بودن پانلهای بریده شده

۶ - خواص غیر الکتریکی ماده پایه بعد از برداشتن کامل ورقه مس

۶-۱- شکل ظاهری ماده پایه ماده پایه باید اساساً فاقد حفره ، سوراخ ، خراش ، خلل و فرج و مواد زائد خارجی (از حمله ذرات رزینی پخته شده) بوده و باید رنگی یکنواخت داشته باشد . مقدار کمی تغییر رنگ در سطح ماده پایه مجاز است .

۶-۲- استحکام در برابر انعطاف

۶-۳- اشتعال پذیری

این بند فرعی کاربردی ندارد .

۶-۴- جذب آب

۶-۵- گسیختگی حرارتی بافت

این بند فرعی کاربردی ندارد .

۷ - بسته‌بندی و علامت‌گذاری

ورقهای باید بنحو مناسبی بسته‌بندی شوند تا از بروز هر گونه آسیب ،

(جدول شماره ۱۱)

مقررات	روش آزمون (بند فرعی استاندارد ملی ۳۶۵۳)	خواص
mg حداکثر	ضخامت mm نامی	
۳۰	۰/۵	
۳۰	۰/۷	
۳۰	۰/۸	
۳۳	۱/۰	
۳۵	۱/۲	
۴۰	۱/۵	
۴۰	۱/۶	
۴۵	۲/۰	
۵۰	۲/۴	
۶۵	۳/۲	
۸۰	۶/۴	
		۴-۵ جذب آب
		در مورد ضخامت‌هایی که در جدول ذکر نشده ، مقررات نزدیکترین ضخامت بعد از آن باید اعمال شود

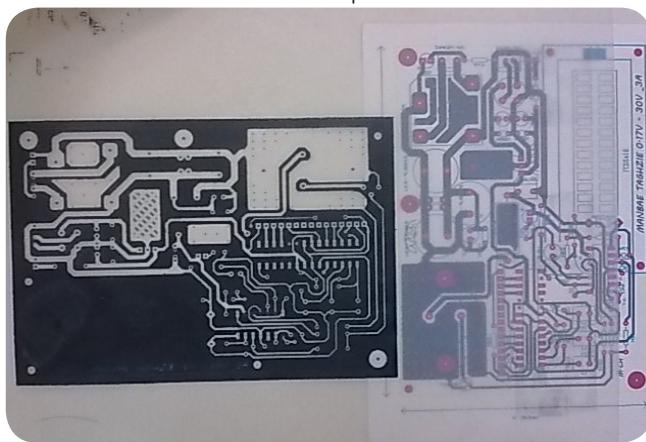
خمش و آلودگی در ورقها جلوگیری شود ، مثلاً با قرار دادن مواد بسته‌بندی ۴ در بین آنها .



مقاله آموزشی کامل و گام به گام با لامینت

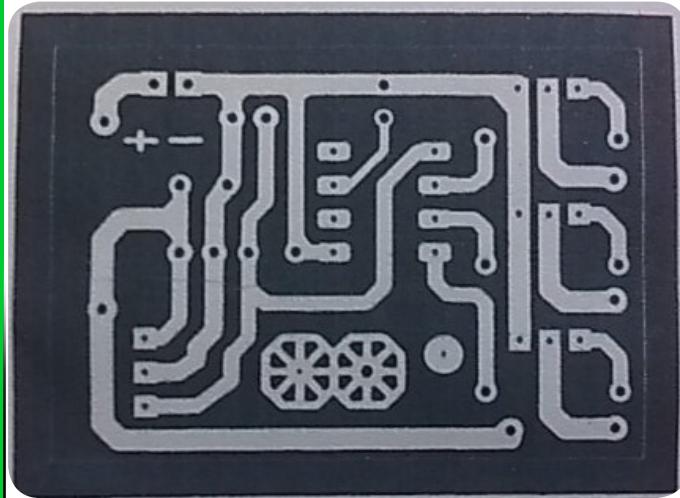
۲- پرینت بر روی کاغذ کالک (نیمه شفاف) که در اولویت دوم است و کیفیت کار مطلوبی دارد.

کاغذ کالک را می توانید از فروشگاه لوازم تحریر خریداری کنید و بسیار ارزان است. اما توجه داشته باشید که هیچگاه این کاغذ را قبل از پرینت به صورت مستقیم لمس نکنید زیرا پس از پرینت رد انگشتتان در آن قسمت پدیدار خواهد شد که این اثر مخرب را در سمت چپ شکل فوق قابل مشاهده است. برای بالا رفتن کیفیت کار بهتر است ۳ الی ۳ برگ پرینت شده از طرح بر روی کاغذ کالک را بر روی هم قرار دهید و توجه داشته باشید که کاملا خطوط طرح بر روی هم قرار گرفته باشند بعد با چسب نواری لایه ها را به هم بچسبانید. ولی زمان نوردهی هم با این کار افزایش پیدا خواهد کرد



پرینت بر روی کاغذ کالک

۳- پرینت بر روی کاغذ معمولی که در درجه سوم است و کیفیت کار خوبی دارد.



پرینت بر روی کاغذ

در این مقاله به موارد زیر پرداخته خواهد شد:

۱-آموزش کار با لامینت و لوازم مورد نیاز

۲- اشاره کوتاه به نحوه زدن چاپ سبز به روش ابتکاری

۳- روشی ساده برای قلع اندود کردن پشت فیبر

۴- روش ابتکاری برای نصب اسپیسر بدون پیچ یا مهره

۵- دستگاهی با لامپ فلور سنت برای نور دهی به لامینت

مواد ضروری لازم برای کار با لامینت:

۱- لامینت، که می توانید از فروشگاه یا سایت های مربوطه خریداری کنید.

۲- ماده ظهور، بی کربنات سدیم (جوش شیرین) و واپتکس

۳- سود سوزآور، پولکی شکل است و می توانید از فروشگاه لوازم آزمایشگاهی تهیه کنید.

۴- اسید پر کلرودوفر، می توانید از فروشگاه لوازم آزمایشگاهی تهیه کنید.

۵- مته ۱m، کاتر، فیبر مسی، سمباده پوست آب (کاغذی)، مساوک، ظرف پلاستیکی

۶- یک قطعه شیشه به اندازه کاغذ A4

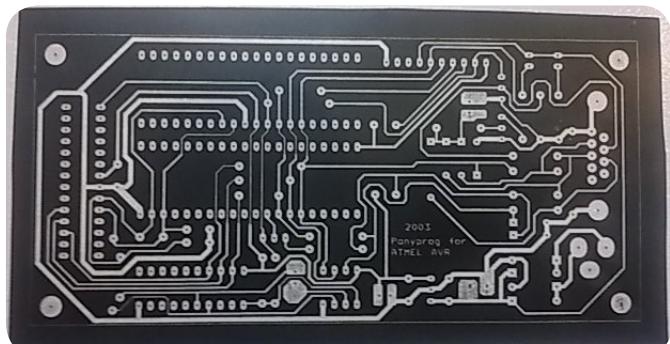
۷- نقشه نگاتیو پرینت شده PCB

۸- نور لامپ W ۲۰۰ رشته ای یا W ۸۰ فلور سنت یا نور خورشید.

مراحل ساخت:

اول طرح PCB مورد نظر را پس از طراحی به نگاتیو (بخش های سیاه و سفید جاها ایشان باهم عوض می شود) تبدیل کرده و سپس به یکی از این سه طریق تهیه می نماییم.

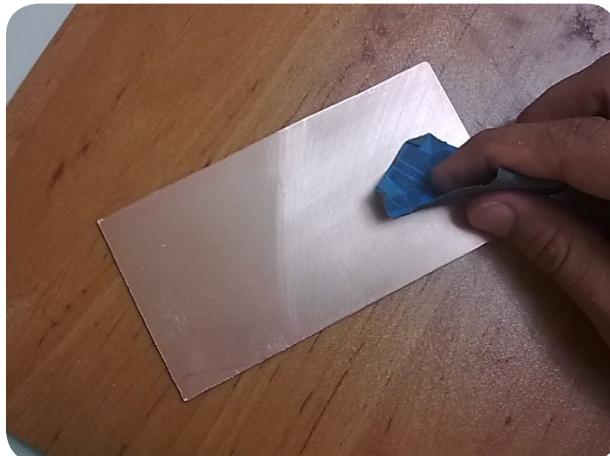
۱- اولین روش استفاده از فیلم بوده که در اولویت اول است و در کارهای ظریف از آن استفاده می شود. برای تهیه فیلم می توانید از طلق های transparent استفاده کرده و یا اینکه فایل کامپیوترا آن را به عکاسی ها و یا مهرسازی بدھید تا از آن فیلم تهیه کنند. فیلم یک طلق حساس به نور شدید است که در آنجا به این صورت طرح شما بر روی آن نقش می بندد و قابل شستشو نیز می باشد.



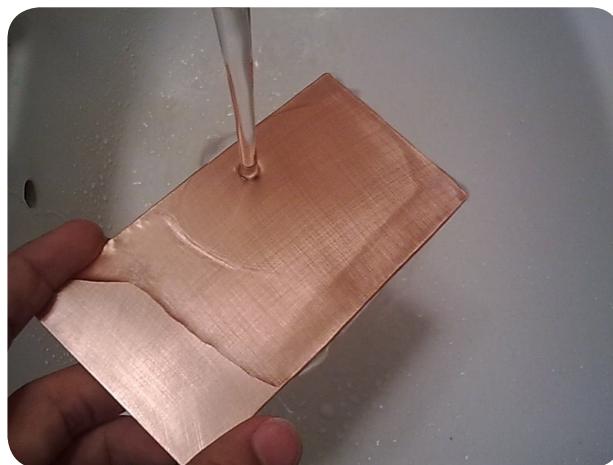
طرح PCB چاپ شده بصورت نگاتیو

مقاله آموزشی کامل و گام به گام کار با لامینت

توجه کنید که پس از این کار تا بعد از زمان اسید کاری به هیچ وجه سطح مس را لمس نکنید و از چرب شدن آن نیز جلوگیری کنید. بهتر است برای جلوگیری از دوباره اکسید شدن آن تا زمان استفاده سریعاً فیبر را درون آب مقطر قرار دهید.



سمباده زدن فیبر مسی



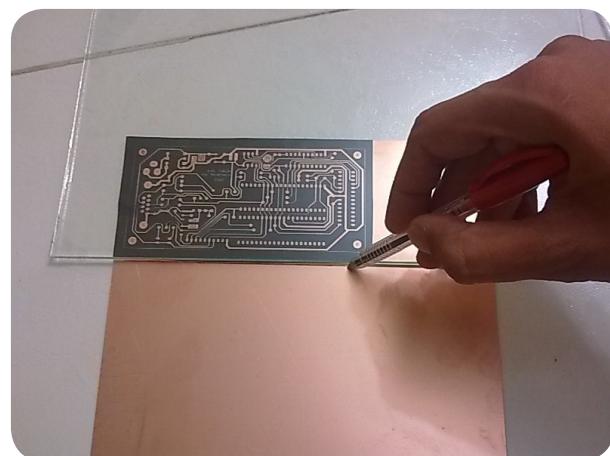
شستن فیبر مسی با آب

به دلیل حساس بودن لامینت به نور مستقیم، آن را در یک جای کم نور یا بهتر است در تاریک خانه (مکان تاریکی که در آن لامپ قرمز ۴۰W روشن باشد) برده و از پوشش تیره رنگش خارج کنید. سپس به اندازه نیاز بایک کاتر یا تیغ لامینت را برش دهید.



برش دادن لامینت به اندازه کافی

فیبر مسی را برداشته و به وسیله اره آهنگر یا کاتر به اندازه مورد نیاز برش دهید.



اندازه گذاری فیبر مسی



بریدن فیبر مسی

با یک سمباده کاغذی یا سنگی چهار طرف لبه های فیبر مسی را کاملاً صاف کنید. در غیر این صورت نگاتیو به خوبی بر روی فیبر نمی نشینند و در نتیجه کیفیت کار را پایین می آورد(خیلی مهم).



سمباده زدن لبه های فیبر مسی

تمامی سطح مسی را با سمباده پوست آب آرام و با کمترین فشار سمباده زده تا اکسید های موجود بر روی مس از بین بروند و سپس آن را با آب بشویید.

مقاله آموزشی کامل و گام به گام با لامینت

اگر در زیر لامینت حباب های هوا مشاهده کردید حتما آنها را با فشار انگشت به کنارهای فیبر مسی منتقل کرده و از آنجا خارج کنید. اگر باز هم حبابی جای مانده بود آن را با نوک سوزن، سوراخ ریزی ایجاد کرده و هوا را از زیر آن خارج کنید. حال طرح نگاتیو را بر روی قرار دهید و یک شیشه شفاف و سنگین یا ته یک ظرف پیرکس را بر روی آن قرار دهید و نور دهی نمایید.

استفاده از فیلم:

۳۰- ۳ ثانیه زیر نور مستقیم خورشید

۱-۲ دقیقه زیر نور لامپ فلور سنت ۸۰ وات

۳-۵ دقیقه زیر نور لامپ ۲۰۰ وات رشته ای

استفاده از کاغذ کالک:

۱-۲ دقیقه زیر نور مستقیم خورشید

۳-۵ دقیقه زیر نور لامپ فلور سنت ۸۰ وات

۵-۸ دقیقه زیر نور لامپ وات رشته ای

استفاده از کاغذ ساده:

۱-۵ دقیقه زیر نور مستقیم خورشید

۱۵-۲۵ دقیقه زیر نور لامپ فلور سنت ۸۰ وات

۲۵-۳۵ دقیقه زیر نور لامپ ۲۰۰ وات رشته ای

بته این زمان ها نسبت به کیفیت لامینت متغیر است.

لامینت را با فاصله ۱۰ سانتیمتر از لامپ فلور سنت و با فاصله ۲۰ سانتیمتر از لامپ رشته ای قرار دهید.

چند نکته:

اگر بر روی کاغذ کالک یا کاغذ ساده طرح خود را پرینت می کنید، طرح مدار را آینه نکرده و از طرفی که پرینت گرفته اید بر روی لامینت قرار داده و پشت کاغذ که سفید است به سمت نور باشد، با این روش کیفیت کار بالا می رود.

اگر بیش از حد به لامینت نور دهی کنید لامینت به اصطلاح می سوزد و در موقع انجام ظهور به مشکل جدی برخواهد خورد. در پرینت با کاغذ ساده ترک های موجود بر روی مس نازک تر خواهد شد. یعنی اگه خطوط را با اندازه ۵۰ کار کرده باشید پس از ساخت فیبر این اندازه به ۳۰ برمی گردد.

همیشه به صورت مستقیم به لامینت نوردهی کنید تا در لبه ترک ها سایه به وجود نیاید.



نمایی از فیبر مسی به همراه نگاتیو طرح PCB

فرض کنید که لامینت مانند یک لواشکی است که دو طرف آن با دو عدد پلاستیک پوشیده شده است.

اما یک طرف آن پوشش پلاستیکی نازک و کدر و در طرف دیگر پوشش پلاستیکی ذخیم و شفاف تر میباشد. در این مرحله باید به وسیله نوک یک کاتر یا سوزن آن لایه نازک را پیدا کرده و کمی از لامینت را جدا کنید. در تصویر فوق پلاستیک سمت راست پوشش نازک و پلاستیک سمت چپ پوشش ذخیم می باشد.



تصویری از دو پوشش پلاستیکی لامینت

با یک سشوار از فاصله ۰۴ سانتیمتری به فیبر حرارت دهید اما مواطبه باشید به هیچ وجه فیبر خیلی داغ نشود.



سشوار زدن به فیبر مسی

حالا قسمتی که لامینت از پلاستیک جدا شده را به سطح مس بچسبانید و همزمان با فشار انگشت به جلو، مابقی پلاستیک نازک را جدا کنید.



چسباندن لامینت به فیبر مسی

مقاله آموزشی کامل و گام به گام با لامینت

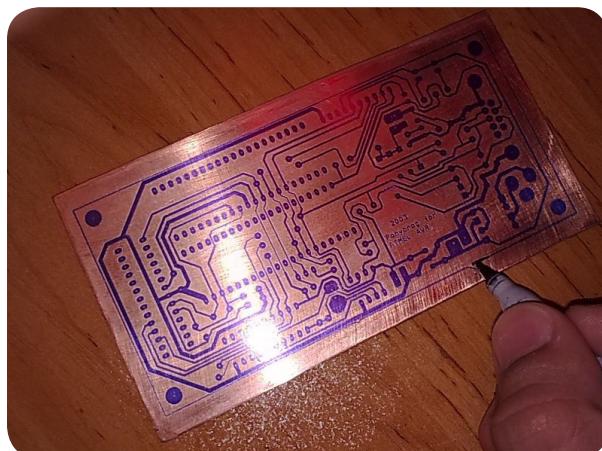
توجه: به دقت تمامی ترک ها را نگاه کنید تا کاملا مطمئن شوید که هیچ آثاری از لامینت های نور نخورده مخصوصا بین پین ها باقی نماند باشد.

سپس از تاریک خانه خارج شوید و آن را زیر شیر آب قرار داده و با دست آرام روی آن بکشید تا تمامی لیزی حاصل از این مواد از سطح فیبر مسی پاک شود.

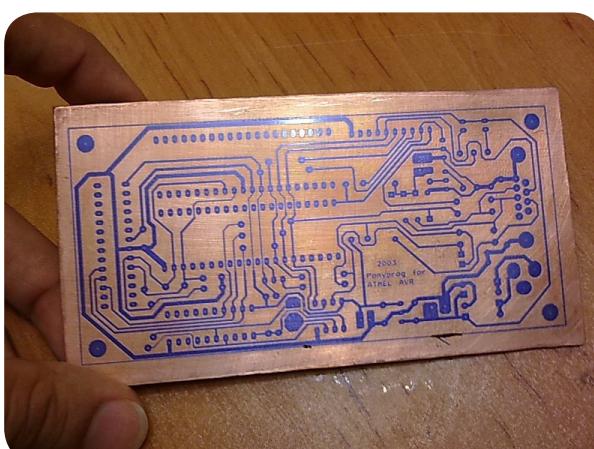


شستن مواد اضافی بوسیله آب معمولی

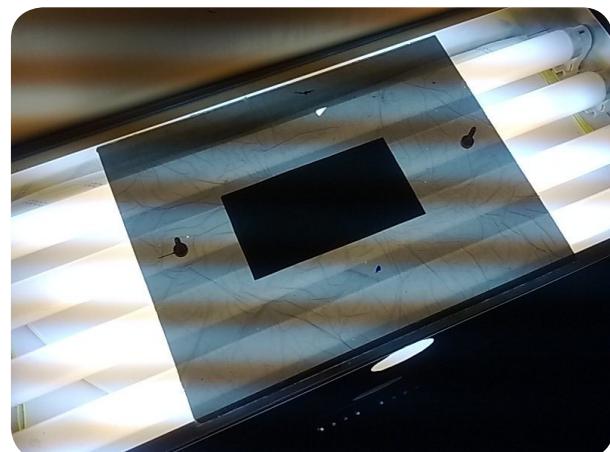
اگر پس از پایان کار قسمتی از لامینت به دلایلی از فیبر جدا شده بود آن را با یک مازیک CD یا هر نوع مازیک ضد آب دیگر ترمیم کنید.



ترمیم ترک های قطع شده



فیبر مسی آماده اسید کاری



تاباندن نور به لامینت

پس از اتمام کار لامینت را سریعا به تاریک خانه برگردانید. با نوک یک وسیله مثل کاتر، از گوشه فیبر کم لایه پلاستیک دوم روی لامینت که ضخیم تر است را با احتیاط کامل از آن جدا کنید.



جدا کردن لایه پلاستیکی از لامینت

مرحله ظهور: در این مرحله که مهم ترین بخش به شمار می رود باید با احتیاط عمل کنید تا زحمات شما به یکباره از بین نرود. حال یک قاشق بی کربنات سدیم (جوش شیرین) را با ۵۰ میلی گرم واکتس در یک ظرف ریخته و یک و نیم لیتر آب به آن اضافه کنید و کاملا با هم مخلوط کنید.

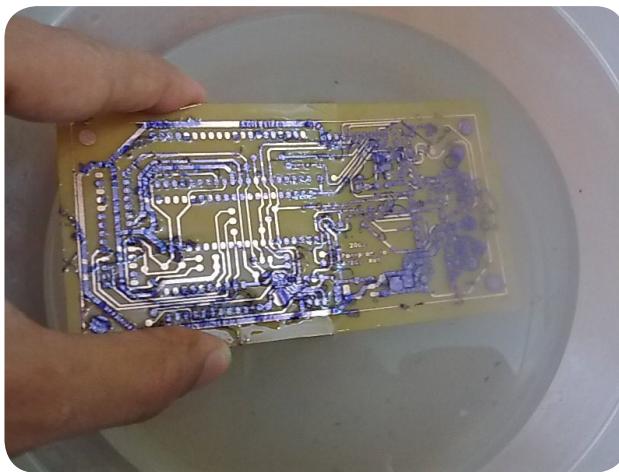
فیبر را کاملا در ماده ظهور قرار داده و بیرون آورید. این کار را ۳۰-۴۰ بار انجام دهید و همزمان با یک وسیله مثل مسوک نرم دائما و به آرامی با کمترین فشار بر روی سطح لامینت بکشید تا قسمت های نور نخورده لامینت که کمرنگ هستند کاملا پاک شوند.



پاک کردن مواد اضافی از روی فیبر مسی

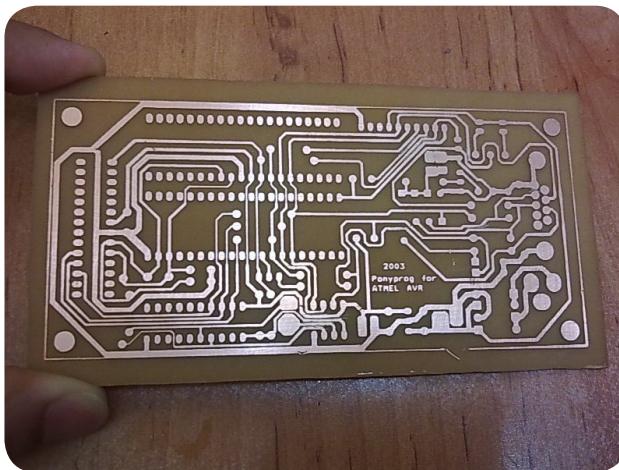
مقاله آموزشی کامل و گام به گام با لامینت

نیم لیتر آب حل کرده و فیبر را در آن رها کنید و مشاهده خواهید کرد که لامینت ها در عرض چند دقیقه از مس جدا خواهند شد.



پاک کردن لامینت

دوباره فیبر را در زیر شیر آب گرفته و آن را بشویید، در پایان فیبر شما به این شکل در خواهد آمد.



آماده PCB

اینک کار شما تقریباً به اتمام رسیده است و می‌توانید جای پین‌ها را با یک متنه ۱ سوراخ کاری کنید و قطعات را بر روی آن قرار داده و موتنژ کنید.

اما سطح مس در مجاورت با هوا اکسید می‌شود و باعث فرسایش آن می‌گردد که بهتر است برای جلوگیری از این کار سطح مس را با یک عایق پوشانیم.

برای ایجاد کردن عایق دو راه پیشنهادی وجود دارد:

- ۱- چاپ سبز زده و بعد سوراخ کاری کنید.
- ۲- فیبر را قلع انود کنید و سپس سوراخ کاری کنید.

برای قلع انود کردن و یا چاپ سبز می‌توانید به مرکز تهیه pcb مراجعه کنید یا خود به روش ابتکاری این کار را انجام دهید. روش قلع انود کردن برای مدارهای فرکانس بالا توصیه نمی‌گردد و بهتر است برای این نوع مدارات از چاپ سبز استفاده کنید. برای چاپ سبز ابتکاری ابتدا فیر را با تینر و آب و صابون بشویید تا چربی از سطح مس پاک شود. سپس در قسمت‌هایی که قرار است لحیم کنید یک پوشش با چسب

حال نوبت ساخت اسید می‌رسد که بر اساس آزمایشات انجام گرفته متوجه شده ام که برای این روش بهتر است از همان اسید ساده و کم خطر (پرکلرودوفر) استفاده کرد. این اسید نیز به هوا و رطوبت حساس است پس بهتر است آن را در یک ظرف شیشه‌ای قرار دهید و درب آن را محکم ببندید.

در یک ظرف غیر فلزی به عمق ۲ سانتی متر آب ولرم بریزید و به مقدار نصف آن اسید اضافه کنید و کاملاً مخلوط کنید.



آماده سازی اسید

فیبر را درون آن بیاندازید و ۳۵-۴۰ دقیقه با احتیاط آن را تکان دهید تا مس‌های اضافی در اسید حل شود. اگر در این مدت به دلایلی مس اضافی کاملاً حل نشد، می‌توانید آن را تا پایان کار، حتی یک روز در اسید بگذارید و مشکلی هم پیش نخواهد آمد.

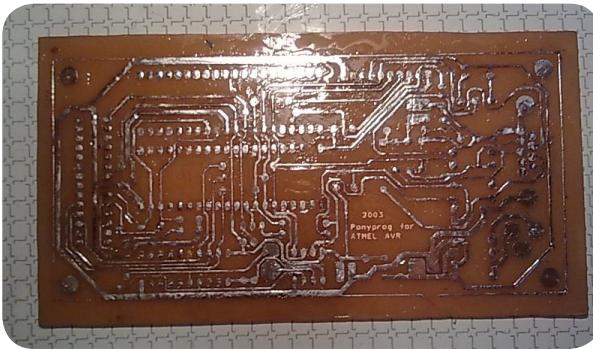
توجه: خودم به خاطر بی احتیاطی تا چند هفته بعد که این کار را انجام دادم به سختی می‌توانستم حرف بزنم. می‌بايست این کار را در یک محیط باز انجام دهید و از ماسک فیلتردار استفاده کنید.



اسید کاری PCB

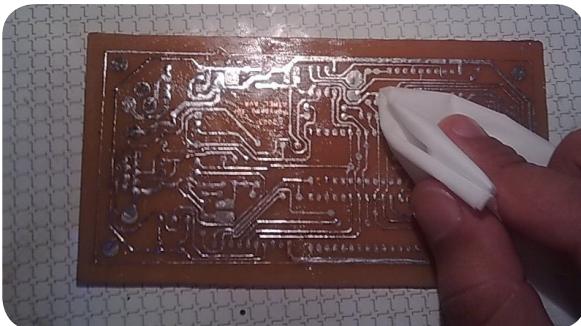
پس از اتمام کار دوباره فیبر را در زیر شیر آب گرفته و آن را بشویید و متوجه خواهید شد که استقامت لامینت بیشتر شده است به طوری که حتی با ناخن یا سمباده به سختی قابل جدا شدن از مس می‌باشد. برای حل این مشکل باید از سودسوز آور استفاده نمایید. برای ساخت این حلال باید ۱-۵ گاشق سود سوز آور که پولکی شکل است را در

مقاله آموزشی کامل و گام به گام با لامینت



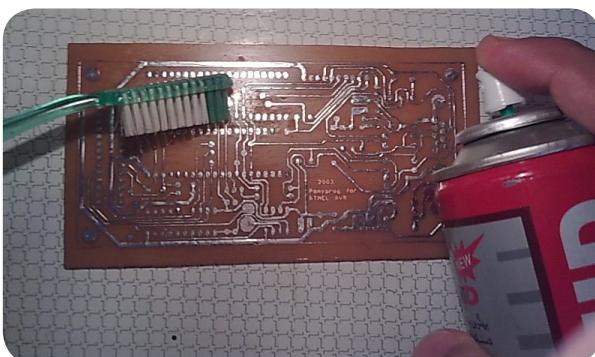
PCB آغشته به روغن

سپس با یک دستمال روغن های موجود بر روی مس را پاک کنید

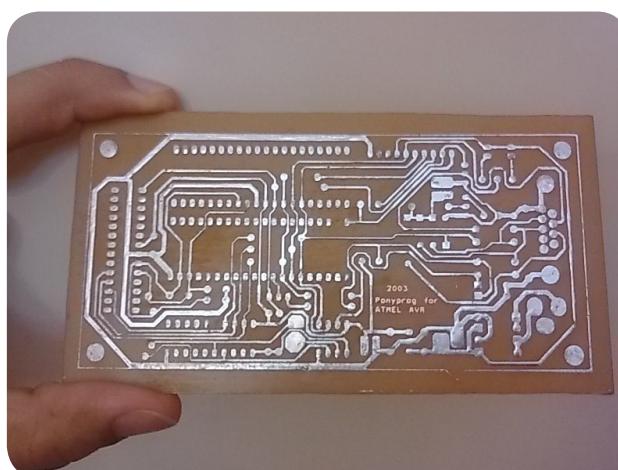


پاک کردن روغن های اضافی

و حالا بهتر است با تینر یا یک اسپرہ خشک و مسواک آن را بشویید



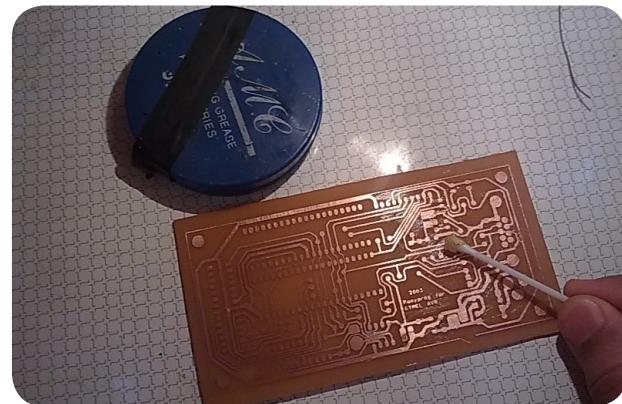
تمیز کردن PCB آغشته به روغن



PCB آماده و قلع انود شده

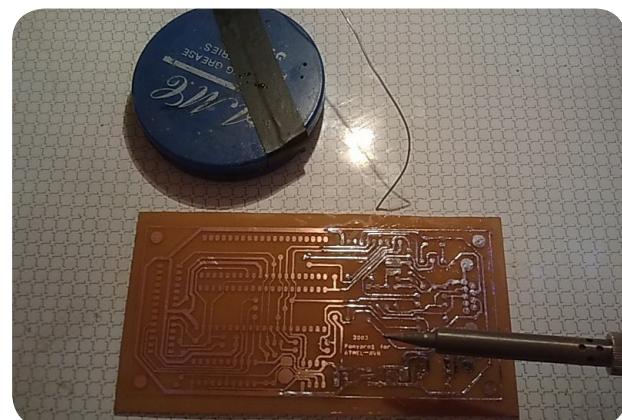
نواری ایجاد کنید. سپس با یک اسپرہ رنگ مثلا سبز از فاصله ۳۰ سانتیمتری تمام سطح مس را رنگ کنید و یا با قلمو برروی سطح مس روغن جلا بزنید و بگذارید با هوای محیط خشک شود. سپس برچسب ها را با نوک چاقو از فیبر جدا کنید و فیبر را سوراخ کاری کنید. اینک فیبر شما آماده است.

روشی ساده برای قلع انود کردن فیبر مسی: ابتدا به وسیله کمی پنبه یا گوش پاک کن مقداری روغن لحیم برداشته و روی تمام مس را بپوشانید.



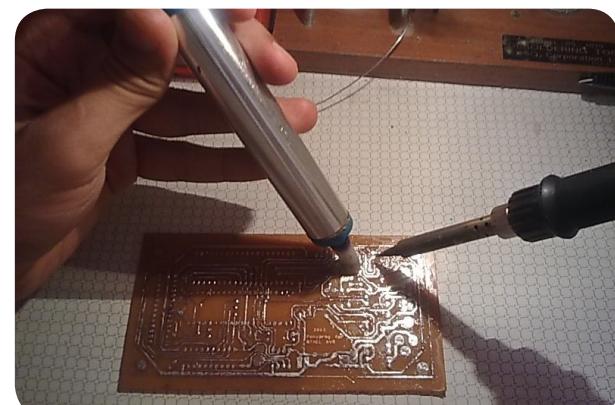
آغشته کردن PCB به روغن لحیم

سپس با گوشه نوک هویه و سیم لحیم شروع کنید به ایجاد یک لایه نازک قلع بر روی مس.



ایجاد یک لایه نازک قلع بر روی مس

اگر در قسمتی قلع زیاد جمع شد می توانید لحیم های اضافی را با قلع کش بردارید.



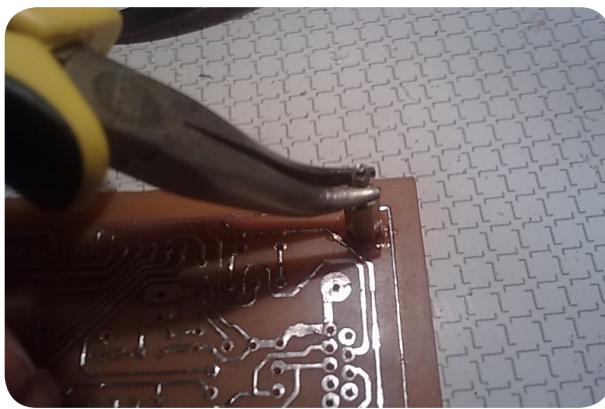
جمع آموری قلع های اضافی

مقاله آموزشی کامل و گام به گام با لامینت

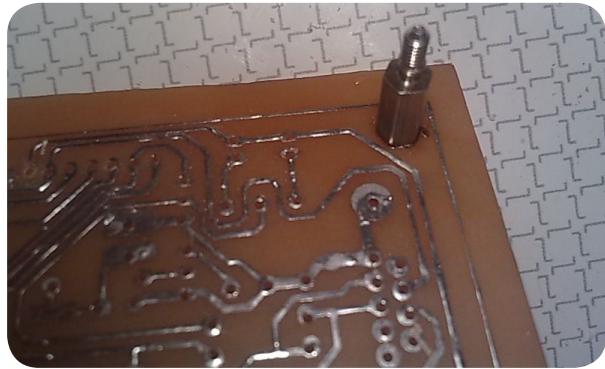
با هویه اسپیسر را کاملاً داغ کنید و سریعاً اسپیسر را بر روی لحیم قرار دهید و باز هم حرارت دهید تا کاملاً به فیر بجستد.



DAG کردن اسپیسر



چسباندن اسپیسر به محل مورد نظر



وصل کردن اسپیسر به PCB



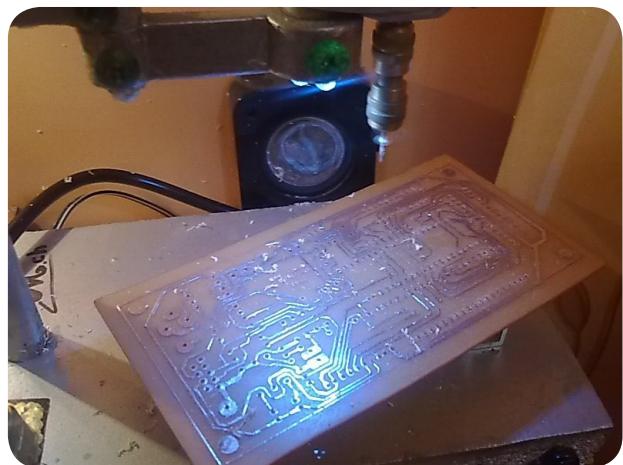
وصل شدن اسپیسر به PCB

اینک اسپیسر محکم به فیر لحیم شده است بدون اینکه پیچ یا مهره ای سطح روی فیر شما را زشت کرده باشد.

سپس با یک مته ۱ شروع به سوراخ کاری فیر مسی کنید.

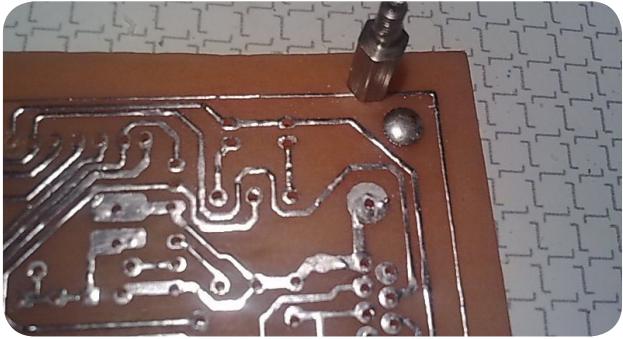


سوراخکاری PCB



آماده و سوراخکاری شده PCB

روشی ابتکاری برای نصب اسپیسر بدون پیچ یا مهره:
ابتدا قسمتی که برای نصب اسپیسر درنظر گرفته اید را کامل قلع
اندود کرده، سپس روی آن روغن لحیم بزنید.



قطع اندود کردن محل اسپیسر

مقاله آموزشی کامل و گام به گام با لامینت



تایмер استفاده شده در دستگاه



دستگاه نوردهی به لامینت

به دلیل مهم بودن مقدار زمان نور دهی به لامینت در این دستگاه یک عدد تایمر دجیتالی با قابلیت تغییر زمان نوردهی برای مدت زمان روشن و خاموش شدن لامپ ها تعییه شده است.

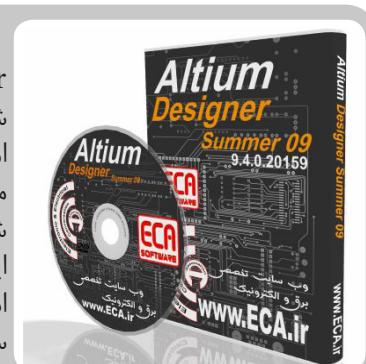
این دستگاه از ۴ عدد لامپ مهتابی ۲۰ وات تشکیل شده است.



ساختمن داخلی دستگاه

Altium Designer Summer 9 Build 9.4.0.20159

AltiumDesigner یا همان PROTEL DXP نرم افزار قدرتمندی است که برای پیاده سازی شماتیک ، طراحی PCB و آنالیز مدارهای آنالوگ و برخی مدارهای دیجیتالی طراحی شده است. یکی از مزایای این نرم افزار دسته بندی مناسب کتابخانه ها بنحوی است که با صرف زمان کوتاهی قطعه مورد نظر را خواهید یافت. آنالیز مدارهای آنالوگ در پروتول، توسط تحلیل گر بی اسپایس انجام می شود. محیط طراحی PCB در پروتول، بدلیل داشتن کتابخانه هایی کامل و بدون نقص معروف است و این امر سبب رفاه بیشتر کاربر در حین طراحی انواع PCB با این نرم افزار، خواهد شد. در این نسخه امکان شبیه سازی و کد نویسی برخی از FPGA ها نیز فرآهنم شده است که زمان طراحی و پیاده سازی را حداقل می کند. ورژن جدید این نرم افزار حرفة ای دارای تحولات و پیشرفت های زیادی بوده که کار شما را برای طراحی نسل های بعدی مدارات الکترونیک بسیار ساده کرده است . Altium



Designer توانسته است که طراحی شما را از لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری بصورت یک پارچه در آورده و شما بتوانید مراحل طراحی خود را به سادگی انجام دهید. امکانات ویژه ای به این نسخه از نرم افزار افزوده شده که شامل افزایش لایه های طراحی مکانیکی ، کلاس های جدید و پیشرفت های باور نکردنی در هوش مصنوعی این نرم افزار می باشد . هوش مصنوعی در این نسخه به قدری تقویت گشته که شما بدون هیچ مشکلی می توانید طرح های خود را به سرعت طراحی و اشکال زدایی کرده و آنها را هر چه نزدیکتر به استانداردهای جهانی کرده و از دیگر مهندسین و متخصصین این زمینه کاری پیشی بگیرید. این نرم افزار در قالب یک DVD به همراه لایسننس معتبر ارائه گشته است.

امکانات این نسخه :

- » Additional Mechanical Layers
- » C++ Support
- » Blankets in Schematic
- » Supplier Data Improvements
- » Designators / Board Level Annotation
- » Assembly Variants
- » Testpoints / Testpoint Manager
- » 3D Single Layer Mode

- » PCB Design Rules Visualization
- » Altium Labs
- » Customization of Net Colors
- » Memory Instrument



نیروگاه بادی بینالود



عکسی از توربین های بادی نیروگاه بینالود

موقعیت جغرافیایی منطقه وزش باد خراسان

این منطقه در جنوب شرقی و جنوب شهرستان نیشابود در جنوب ارتفاعات بینالود واقع شده است و به لحاظ مختصات جغرافیایی بین ۳۵ و ۵۵ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۱۰ دقیقه عرض شمالی و ۵۸ درجه و ۵۴ دقیقه تا ۵۹ درجه و ۲۶ دقیقه طول شرقی محدود می باشد. از نظر آب و هوایی جزو مناطق بیابانی است. ارتفاع متوسط این منطقه از سطح دریا تقریبا ۱۳۰۰ متر می باشد که از شرق به غرب بین ۱۴۵۵ تا ۱۱۵۰ متر اختلاف ارتفاع را نشان می دهد. شرایط توپولوژی منطقه و همچوواری آن با رشته کوه های بینالود در راستای شرق به غرب در سمت شمال و ارتفاعات منطقه فریمان و تربت حیدریه در جنوب، یک دالان طبیعی باد تحت تاثیر اختلاف فشار هوا را ایجاد نموده است. این دالان از حوالی روستای امام تقی (بخش احمد آباد مشهد شروع می شود)، در گستره‌ی تقریبی خود از جنوب شهرستان های نیشابور و سیزوار عبور کرده و به کویر می پیوندد. این باد علاوه بر دشت دیزباد (که قسمتی از دشت نیشابور است)، بخش های زبرخان، مرکزی، تحت جلگه، میان جلگه و طاغنکوه نیشابور را تحت تاثیر قرار می دهد. البته در نواحی کوهپایه ای و کوهستانی شمال و جنوب شهرستان نیشابور این باد سرعت چندانی پیدا نمی کند.

بشر از دیرباز به طور سنتی از انرژی های تجدیدپذیر استفاده کرده است. آسیاب های بادی قدیمی در ایران و سایر کشورهای بادخیز و به خصوص معماری سنتی ایران خود حفایت از بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر در زمان های گذشته می نماید (در ۲۲۰۰ سال قبل اولین آسیاب بادی به نام ایرانیان در اختراعات جهان ثبت شد).

تحولات جهانی در زمینه توجه به حفظ محیط زیست و فناپذیر بودن منابع انرژی فسیلی، گرایش استفاده از انرژی های تجدید پذیر را سرعت بخشیده است و روز به روز توجه بیشتری را به خود معطوف می دارد. انجام کارهای تحقیقاتی نمونه سازی و تولید انبوه در شرایط حاضر زمینه را برای توجه هرچه بیشتر و اقتصادی نمودن انرژی های تجدیدپذیر به خصوص در برخی از شاخه های آن از جمله انرژی باد فراهم نموده است. استفاده از باد برای تولید انرژی برق برای اولین بار در سال ۱۹۳۱ میلادی توطیق روس ها در کنار دریای سیاه و با استفاده از توربینی به قدرت ۱۰۰ KW انجام گرفت و بعد از دوره ای تحول و پس از بحران انرژی ۱۹۷۳ میلادی کار تحقیق و ساخت توربین های بادی با شتاب بیشتری ادامه یافت. طبق محاسبات انجام شده، عامل انرژی باد در کره زمین به ۱۸۰۰ تراوات (۱۸۰۰x۱۰۱۲) می رسد. از این مقدار حدود ۱۰٪ خشکی و بقیه در سطح اقیانوس ها پراکنده اند. اگر مصرف انرژی سکنه زمین را ۱۰٪ تراوات به حساب بیاوریم حدود ۶٪ کل انرژی باد می تواند جوابگوی احتیاجات ساکنین کره زمین باشد.

امروزه کاربرد توربین های بادی مورد توجه جدی محافل علمی و صنعتی و اقتصادی قرار گرفته است به گونه ای که ظرفیت نصب شده توربین های بادی جهان از ۵۵۰۰ مگاوات در اواسط سال ۱۹۹۶ در سپتامبر ۱۹۹۹ در ۳۷ کشور جهان به اندکی بیش از ۱۲۳۱۰ مگاوات تولید رسیده است. اران در این میان با ۱۱ مگاوات تولید برق بادی مقام ۲۶ دنیا را دارا می باشد.

با توجه به وجود باد مناسب و اقتصادی در منطقه نیشابور از اوایل دهه ۱۳۷۰ شمسی، توسط جهاد دانشگاهی مشهد و جهاد سازندگی خراسان پیشنهاد مطالعات ایجاد نیروگاه مطرح گردید.

در ابتدای امر به دلیل نبود ایستگاه هواشناسی در منطقه مورد مطالعه (دشت دیزباد) از اوایل سال ۱۳۷۴ کار مطالعاتی با نصب دستگاه های ثبات دار توسط جهاد سازندگی در ارتفاع ۲۰ متری از سطح زمین آغاز شد. اطلاعات ایستگاه بادسنجی حسین آباد رازان که در سال های ۷۵ و ۷۶ جمع آوری شده بود ایجاد نیروگاه و مزرعه بادی در دشت دیزباد را از نظر اقتصادی توجیه کرد و بعد از انجام مذاکره با یک شرکت آلمانی مجری طرح های نیروگاه های بادی، دو واحد نیروگاه باید بصورت آزمایشی در منطقه احداث شد و ایجاد مزارع بادی در برنامه آینده قرار گرفت.

ویژگی های باد

باد محلی دیزباد یا تیزباد با جهت شرقی-غربی می وزد و اثرات فرسایشی آن در جنوب دشت نیشابور و تمابل درختان کوچک و بزرگ به سمت غرب نشان از قدمت این باد دارد.

باد دیزباد دارای دو نوع نوسان عمده است نوسان فصلی و نوسان روزانه

۱- نوسانات فصلی: سرعت باد در حوالی نیمه شب کم شده و تا اوایل شب ادامه دارد و در نیم روز سرعت باد به بیشترین مقدار خود میرسد.

عرض متوسط دالان باد حدود هفت کیلومتر است که در ناحیه دهانه آن (اطراف روستاهای امام تقی و حسین آباد رازان) به حدود چهار کیلومتر می رسد. گستره‌ی طولی و قابل استفاده آن در راستای شرق به غرب به بیش از ۵۰ کیلومتر می رسد (یعنی تا نواحی جنوب غربی نیشابور) این باد در طول سال تغییر جهت ناچیزی دارد. باد دیزباد حدود هشت تا نه متر در ثانیه سرعت دارد و تداوم وزش آن بیش از ساعات سال می باشد. در سطح جهان بادی اقتصادی تلقی می شود که حدود ۶ متر در ثانیه سرعت داشته و در دو سوم ایام سال جریان داشته و جهت نسبتاً ثابت داشته باشد. با توجه به اینکه انرژی و قدرت تولیدی باد با توان سوم سرعت مناسب است و سرعت باد دیزباد زیاد است، مسلماً تولید انرژی بسیار بالا خواهد بود.

تجهیزات نیروگاه بادی بینالود

نیروگاه بادی بینالود از ۴۳ توربین ۶۶۰ کیلووات، ۶۹۰ ولت تشکیل شده است. در این نوع نیروگاه ها بسته به میزان بادی که در منطقه قرار دارد، نوع تولید متفاوت است.

در این منطقه متوسط سرعت باد ۸/۵ متر بر ثانیه است و توربین هایی که در این منطقه قرار دارند از بادی با سرعت ۴/۵ متر بر ثانیه تا ۱۶ متر بر ثانیه را پشتیبانی می کنند و تولید خواهند داشت. هر چقدر قدرت توربین بیشتر باشد، ارتفاع برج آن و هم ارتفاع پره های آن هم تغییر می کند.

توربین هایی به کار رفته در این منطقه دارای ارتفاع برج ۴۰ متر و طول پره ی ۲۳ متر می باشند. در حال حاضر تولید این نوع توربین ها کم شده است و بیشتر توربین های مگاواتی تولید می شود. در ایران فقط دو نیروگاه بادی داریم، یکی نیروگاه بادی بینالود و دیگری نیروگاه بادی منجیل است. تعداد توربین های منجیل بیش از بینالود است و توربین هایی با قدرت ۳۰۰، ۵۰۰ و ۶۶۰ کیلووات دارند. در این نیروگاه ها انرژی باد به انرژی مکانیکی تبدیل شده و موجب چرخش پره می شود. تعداد دور پره ها حداقل ۳۲rpm است. این پره ها موجب چرخیدن یاتاقان ها می شوند. یاتاقان ها به گیربکس که از نوع افزاینده می باشند وصل شده است. نسبت دور گیربکس ها ۱ به ۵۲ است. یعنی اگر یاتاقان ها ۱ دور بزنند، در خروجی گیربکس ۵۲ دور می زند. پس ژنراتور حدود ۱۵۰۰ دور به بالا در دقیقه می چرخد.



عکسی از توربین های بادی نیروگاه بینالود

نیروگاه بادی بینالود

تمام کارهای توربین به طور اتوماتیک انجام میشود مگر اینکه مشکلی در سیستم کنترل به وجود آید که در این صورت باید به صورت دستی توربین را کنترل کرد.

در زیر ناسل ۲ موتور قرار دارد که به گیربکس متصل شده است و طبق فرمانی که به این موتورها میرسد شروع به حرکت میکنند. یکی از گیربکس ها توربین را به سمت چپ میچرخاند و دیگری به سمت راست. به این صورت تنظیم دقیق دوربین در جهتی که بادنا مشخص میکند انجام میشود.

بادسنج که روی ناسل قرار دارد باد را سنس میکند و اگر سرعت باد از 4.5 m/s بیشتر باشد دور ژنراتور زیاد شده و با شبکه سنکرون میشود و تولید شروع می گردد. و در سرعت 16 m/s تولید حداقل است و نهایتاً در 25 m/s تولید به طور اتومات قطع میگردد تا به اجزا واحد آسیب نرسد.

البته شرایط بالا با شرط ایزو میباشد(فشار ۱ اتمسفر و دمای 25°C درجه) و در جو نیروگاه بینالود (1550°C متر ارتفاع از سطح دریا) فول

وقتی تعداد دور ژنراتور از 1500 بیشتر شد با شبکه سنکرون میشود و تولید برق انجام می گیرد. سپس از طریق کابل های نسبتاً قطور برق تولید شده به اتاقک کنترلی که در پایین برج قرار دارد هدایت می شود. در داخل تابلو بلوک هایی تعییه شده مثل بلوک حفاظت، بلوک کنترل، بلوک بانک خازنی و... سپس برق تولیدی به بیرون از برج در یک ترانس افزاینده هدایت می شود. این ترانس 690 ولت را به 20 کیلو ولت تبدیل می کند.

ژنراتور هایی که در این نیروگاه استفاده می شود از نوع ژنراتور سنکرون می باشد. به این دلیل که تغییرات دور توربین در این نیروگاه وابسته به تغییرات سرعت باد است و چون سرعت باد دائماً در حال تغییر است پس دور ژنراتور نیز دائماً متغیر است به همین دلیل نمی توان از ژنراتورهای سنکرون استفاده کرد. علاوه بر آن تولید برق ژنراتورهای سنکرون از نوع DC می باشد. اما در نیروگاه های حرارتی از ژنراتورهای سنکرون با دور 3000 rpm استفاده می کنند.



عکسی از کارخانه تولید توربین های بادی

تولید در سرعت 14 m/s بدست می آید.

در برخی مواقع پیش می آید که سرعت باد پایین است و توربین ها به صورت هرزگرد می چرخند و تولیدی ندارند. ژنراتوری که در اینجا وجود دارد لغزشی بین $1\% \text{--} 10\%$ را دارا می باشد این لغزش توسط سیستم Roter Current Control (RCC) که به پشت ژنراتور متصل شده محاسبه و کنترل می شود و در واقع جریان رتور را کنترل می کند. وقتی لغزش بیشتر باشد، ژنراتور در بازه بیشتری بازدهی دارد. لغزش این مولد 10% می باشد. طبق روابط ریاضی:

$$150 = 150 \times 10\% + 150$$

پس از روابط بالا نتیجه میگیریم که این ژنراتور میتواند از 1500 rpm تا 1650 rpm بچرخد بدون اینکه فرکانس تغییر کند.

برای تولید برق و انتقال آن به شبکه سراسری باید فرکانس ثابت باشد، چون اگر فرکانس ثابتی نداشته باشیم شبکه ناپایدار می شود.

در نیروگاه بادی از ژنراتور سنکرون در موقع خاصی استفاده می شود مثلاً اگر یک طرح تحقیقاتی داشته باشد.

بیشتر تجهیزات نیروگاه بادی در بالای برجک در اتاقکی که به آن ناسل می گویند(اصطلاحاً ماشینخانه نیز نامیده می شود). قرار دارد. مثلاً گیربکس، ژنراتور، فن های خنک کننده، تایلوی کنترل(تاب

کنترل نیز نامیده می شود)، سیستم هیدرولیک و ...

در بالای ناسل یک بادنما، یک بادسنج و یک برق گیر وجود دارد. برق گیر برای جلوگیری از برخورد صاعقه با برج می باشد. علاوه بر برق گیر موجود بر روی ناسل، هر پره یک برق گیر مجزا روی نوک خود دارد و تمام برق گیرها توسط کابلهای مربوطه به چاه ارت وصل شده اند. بادنما جهت باد را نشان می دهد، که در اینجا باد بیشتر به سمت شرق و غرب است.

بادسنج جهت باد را سنس میکند و ناسل که قابلیت چرخش 360° درجه را دارد، می تواند به آن سمت بچرخد.

روش های ثابت نگه داشتن فرکانس:

۱) استفاده از RCC که جریان را تنظیم می کند و در نتیجه لغزش و فرکانس تنظیم می شوند.

۲) استفاده از خود شبکه برق سراسری، چون این نیروگاه یک تولید کننده کوچک متصل به شبکه برق بی نهایت است هنگامی که فرکانس کمتر از مقدار خواسته شده باشد، شبکه فرکانس را به توربین تحمیل کرده و در نتیجه فرکانس ثابت می ماند. شایان ذکر است که حد مجاز ترانس فرکانس ۱ تا ۳- می باشد یعنی از ۵۱ هرتز تا ۴۷ هرتز می تواند تغییر کند.

۳) زاویه ی پره ها هم به این دلیل که تعداد دور با فرکانس نسبت مستقیم دارد یکی دیگر از راه های ثابت نگه داشتن فرکانس است.

برای متوقف کردن توربین دو روش وجود دارد:

(۱) استفاده از ترمز اضطراری که در موقع خاص مثل آتش سوزی و مجاز به استفاده از این ترمز هستیم.

(۲) ترمز آیرودینامیکی که در این روش هر پره میتواند حول محور خود دوران داشته باشد، این دوران از صفر تا ۹۰ درجه میباشد، هنگامی که میخواهیم پره را ثابت نگه داریم باید زاویه پره را روی صفر درجه قرار داده و به این ترتیب دیگر بادی با پره برخورد نمیکند، پس در نتیجه پره ثابت می ماند.

اما نکته جالب اینجاست که خود پره ها هم در هنگامی که باد از حد تنش تسلیم بیستر باشد، پره زاویه خود را طوری تنظیم میکند که



عکسی از مرحله کاشت توربین بادی

۴- منوی بعدی ریموت کنترل است که بعدا توضیح داده می شود.

۵- منوی آلام، که تمام آلامها در این منو دیده می شود.

در زیر صفحه مانیتور چراغهایی وجود دارد، مثلا اگه چراغ یک روشن شود یعنی توربین جهت پادساعتگرد می چرخد.

در زیر تابلو یک بریکر تعییه شده، کار آن ایزووله کردن توربین با شبکه میباشد . برای جریانهای خط در ژنراتور به علت وجود جریان های بالا مثلا A500 آمپر مترها قادر به اندازه گیری نیستند به همین دلیل از ابزاری که در حقیقت یک نوع آمپر متر است به نام

آسیب نمیبند و از این خاصیت در ثابت نگه داشتن دور نیز استفاده میشود، به این دلیل که خود پره را با سرعت باد هماهنگ میکند. توجه به این نکته جالب است که پره ها دارای انعطاف پذیری ۲ متر میباشند که این موجب جلوگیری از آسیب پره و شکسته شدن آن در هنگام وزش باد شدید می شود.

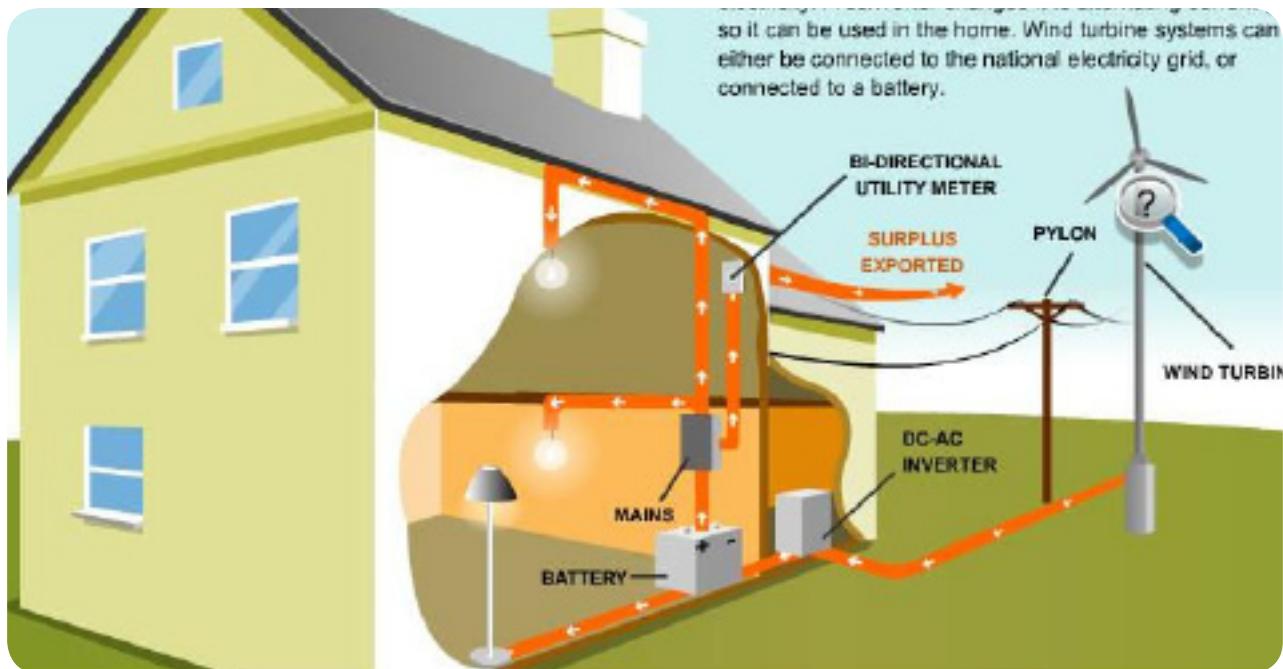
نیروگاه بادی بینالود

یک لحظه خیلی کند می شود.

به طور خلاصه فعالیت کار نیروگاه اینطور شد که:
برق تولیدی از ژنراتور (۶۹۰ ولت) به یک ترانس افزاینده انتقال پیدا

استفاده می شود.

CT مانند آمپر متر به صورت سری در مدار قرار می گیرد و طرز
کارش اینگونه است که یک سیم پیچ با سیم های حامل ولتاژ سری



کرده و به ۲۰ کیلو ولت تبدیل می شود و از اینجا به پست ۶۳ کیلو
ولت انتقال داده می شود. لازم به ذکر است که هر توربین قابلیت برق
دهی تقریبی به ۳۰۰ تا ۳۵۰ خانوار را دارد می باشد.

اما در مورد ترانس افزاینده:
در کنار هر برج توربین یک ترانس افزاینده وجود دارد، این ترانس
دارای یک مخزن روغن، سیم پیچ ها، رله بوخلهتس، ترمومتر، پره
های خنک کننده و رگولاتور تنظیم ولتاژ می باشد.
مشخصات ترانسفورمر به صورت زیر است:

۲۰۰۰۰۷-۶۹۰۷	نسبت تبدیل
۸۰۰ KVA	ظرفیت
۲۳۰ ۱.۶۶۹	جریان اسمی
HZ ۵۰. DY n۵	گروه اتصال
A	نوع عایق بندی
%6.18	ولتاژ اتصال کوتاه
kg۲۴۸۲	وزن کل
ONAN	نوع خنک کنندگی
۴۵C	درجہ حرارت محیط

این ترانس در سمت اولیه یا فشار ضعیف به صورت اتصال ستاره
قرار گرفته و در سمت فشار قوی به صورت اتصال مثلث می باشد.
در سمت فشار ضعیف ولتاژ کم و جریان زیاد می باشد، اما در سمت
فشار قوی ولتاژ زیاد و جریان کم می باشد و دلیل آن این است که
باید توان های اولیه و ثانویه با هم برابر باشند.

همانطور که در توضیحات قبلی اشاره شد در این ترانس یک رگولاتور
تنظیم ولتاژ وجود دارد که به آن تپ چنجر نیز می گویند.

شده و یک سیم پیچ در مقابل آن قرار دارد مانند یک ترانسفورمر،
جریان از سیم پیچ اولیه به ثانویه القا شده و پس از القا جریان ضعیف
شده به صفحه مدرج متصل می شود. این صفحه مثل آمپر متر دارای
عقربه می باشد یا از نوع دیجیتال می باشد که جریان ضعیف را باید
در ضریب تبدیل ضرب نموده جریان واقعی بدست می آید. جنس
پرره ها از پلی استر و چند آلیاژ دیگر تشکیل شده و خلیل مقاوم و
در عین حال سبک می باشد. البته اینکه گفته می شود پرره از جنس
مقاوم ولی سبک ساخته شده به این معنا نیس که وزن پرره کم باشد.
وزن هر پرره حدود ۲۳ تن می باشد.

برجی که ناسل و پرره ها رویش قرار گرفته اند حدود ۴۰ متر ارتفاع
دارد و به سیله پیچ های زیادی با یک شاسی که پی ریزی خلیل
محکمی دارد نگه داشته می شود این شاسی در داخل زمین که
فندانسیون بسیار محکمی دارد قرار گرفته است. به گفته مسئولان
۱۸ دستگاه بتونیر برای پر کردن این فندانسیون استفاده شده است.
برج در دو قسمت توسط پیچ و مهره به هم متصل شده و در نهایت
یک شاسی روی برد قرار گرفته که ناصب روی آن نیز پیچ و مهره
می شود.

برقی که در این نیروگاه تولید می شود ۲۰ کیلو وات بوده و به پست
دیزی باد انتقال داده می شود سپس در آنجا به ۶۳ کیلو وات تبدیل
می شود و به شبکه وصل می شود. همانطور که می دانید برقی که ما
صرف می کنیم معلوم نیس که حاصل کار کدام نیروگاه می باشد
و به طور سراسری از تمام نیروگاه ها استفاده می شود. نکته دیگر
اینکه این نیروگاه در تمامی سال فعال نیست از ۳۶۰ روز سال
روز آن فعال می باشد.

تفاوتش که این نیروگاه با نیروگاه منجیل دارد این است که در منجیل
بادها به صورت لحظه ای میوزد یعنی در یک لحظه خیلی تند و در

garazhian@gmail.com

نویسنده : محمد گاراژیان

منابع :

نیروگاه بادی بینالود
شرکت صبا نیرو

موارد استفاده تپ چنجر:

اگر ولتاژ تولیدی از ۲۰۰۰۰ ولت بیشتر شد به طور مثال ۲۰۵۰۰ ولت شد توسط تپ چنجر ولتاژ را کم می کنیم. در کل سه بر روز ترانس وجود دارد که هر کدام ۵۰۰ ولت قابلیت تنظیم دارند که جملاً ۱۵۰۰ ولت می شود. نکته ای که باید توجه شود این است که در ترانس های توضیع تغییر تپ چنجر به صورت no load (بدون بار) می باشد.



توربین های بادی بکار گرفته شده در منطقه بینالود



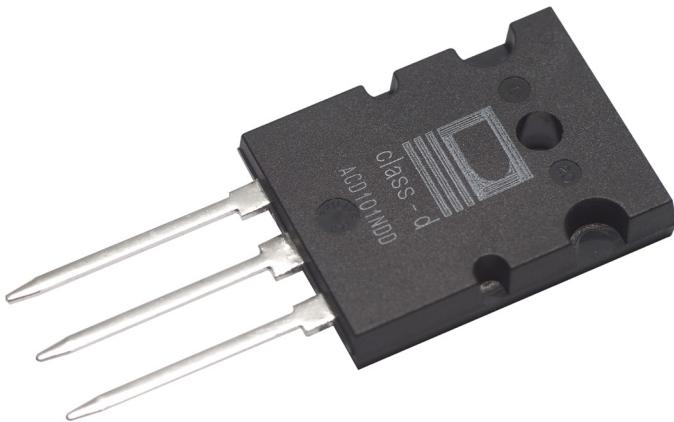
توربین های بادی بکار گرفته شده در منطقه بینالود

قطعات الکترونیکی Components

Active and Passive components



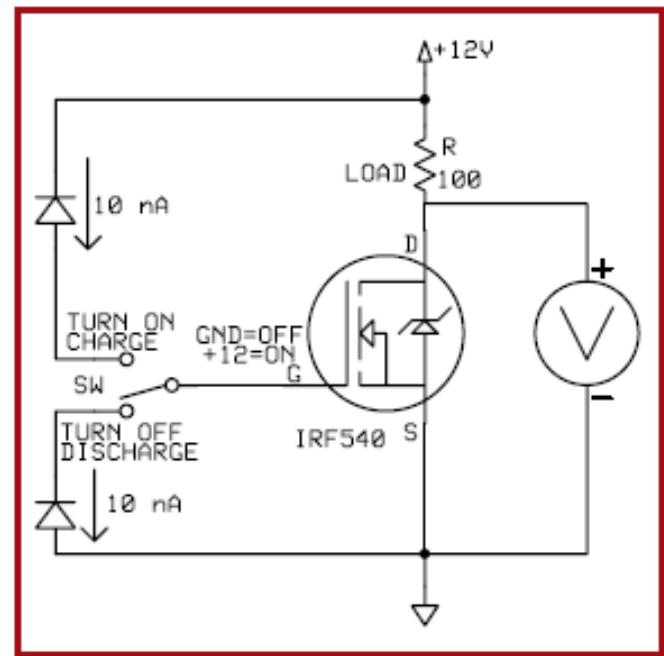
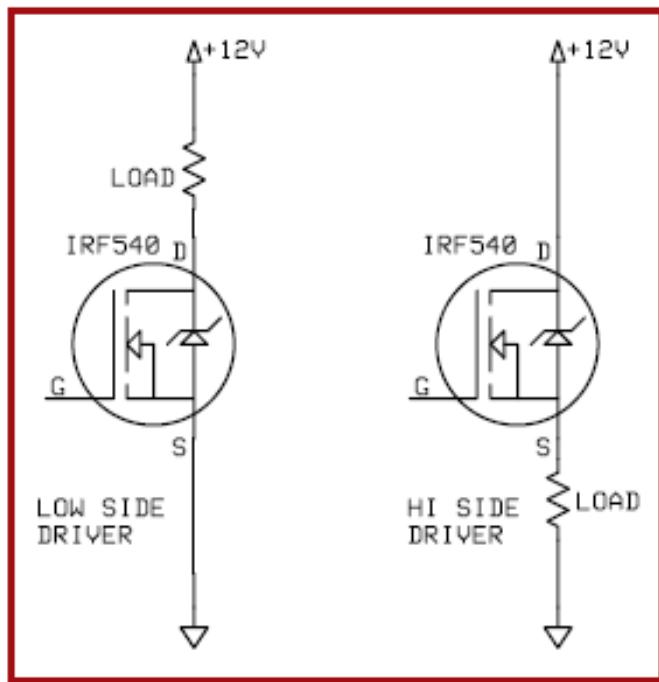
های قدرت ا MOSFET



طور کامل روشن خواهد کرد (به کار خواهد انداخت). هنگامی که دستگاه روشن است این قطعه بدون هرگونه افت ولتاژ مستقیم غیر خطی، همانند ترانزیستور های دوقطبی، مقاومت کمی را از خودشان نشان می دهد. MOSFET های جدید در حال روشن مقاومت کمتر از ۱۰ میلی اهم دارند. انجام چند معادله ریاضی نشان می دهد که این قطعه می تواند ۱۰ آمپر را همراه با یک وات تبدیل شده به

تئوری MOSFET های قدرت (ترانزیستورهای اثر میدان نیمه هادی اکسید فلز) از ویژگی های خوب بسیاری برخوردارند که ظاهرآ نادیده گرفته شده اند. طی دو بحث پیش رو، این قطعات سودمند را آزموده و نشان خواهیم داد که چگونه می توان آنها را برای ساخت : ۱) یک دوبرا برق کننده ولتاژ ساده و بدون مبدل که می تواند جریان را تامین نماید. ۲) یک منبع جریان ثابت ۲۰ آمپری، به کار گرفت.

مبانی های قدرت Mosfet های قدرت HEXFET ها نام علامت تجاری یکسو کننده های بین المللی برای محصولاتشان می باشد. عموماً در کاربرد های سوئیچینگ قدرت مورد استفاده قرار گرفته و در زمرة ترانزیستور ها قرار می گیرند. MOSFET ها نیز همانند سایر ترانزیستورها ۳ پایه



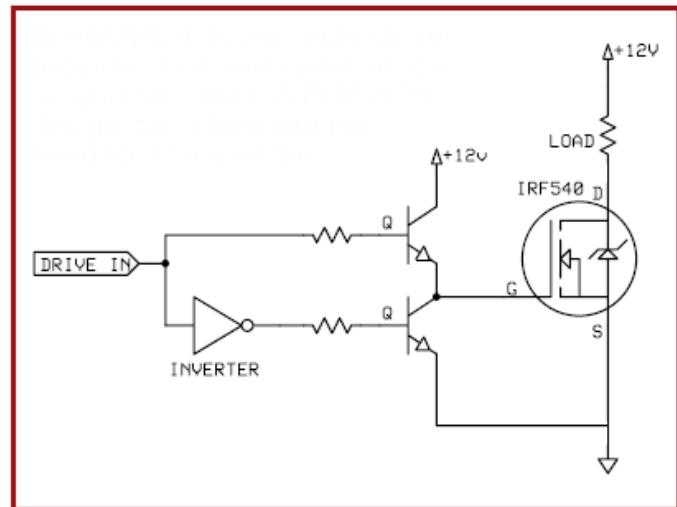
دارند اما قطعاتی از نوع ولتاژ ورودی و جریان خروجی می باشند که این موضوع به این دلیل می باشد که گیت آنها از دیگر بخش های دستگاه کاملاً مجزا می باشد و هیچ گونه جریان DC قابل توجه ای نمی تواند از گیت به سورس یا درین جریان یابد. در عوض، شارژ واردہ بر گیت رسانایی بین درین و سورس را تحت تاثیر قرار می دهد. این عمل مشابه تاثیر گذاری شارژ موجود بر روی یک صفحه ی خازن بر دیگر صفحه ها است. عموماً حدود ۸ ولت، قطعه را به

شکل ۱: عملکرد زمان کوتاهی MOSFET روشن یا خاموش شود. در این حالت دیودهایی که با پاس معکوس شده اند، جریانی در حدود ۱۰ نانو آمپر خواهند داشت. ولت متر در حالتی که MOSFET روشن (در حال هدایت) است، صفر را نشان می دهد.

گرمای تلف شده (مقاومت \times جریان = توان) اداره کند . از زمانیکه MOSFET های پرشماری در بسته بندی TO-220 عرضه شده اند، در این نمونه، دیگر نیازی به هیئت سینک گرما وجود ندارد. بنابراین ، اگر در ۱۰ آمپر ولتاژ ۱۰۰ ولت باشد، آنگاه توان ۱۰۰۰ واتی فقط با اتلاف ۱ وات سوئیچ می شود که این مقدار معادل ۹۹,۹ % بازده توان است. IRFB-4410 دارای این مشخصه می باشد.

که این گریز روی می دهد، ترانزیستور ها معمولاً به همراه آسیب دائمی از کار می افتد.

ضریب دمایی مثبت به این معنی است که موازی کردن MOSFET های مشابه برای بدست آوردن توان اضافی نسبتاً آسان است. در صورتی که یکی از MOSFET ها بسیار گرم شود، مقاومت افزایش یافته آن عملاً به صورت خودکار جریان اضافی را به دیگر بخش ها اعمال می کند. در حقیقت، بحث مذکور چگونگی ساخته شدن MOSFET است. صدها و حتی هزاران MOSFET کوچک وجود دارند که برای ساختن بلوکی با توان زیاد به صورت موازی به یکدیگر متصل شده اند.



شکل ۴: درایور Totem-pole زمان های روشن و خاموش شدن سریع و متقارنی بدست میدهد. یک طراحی PNP/NPN می تواند نیاز به معکوس کننده را برطرف کند.

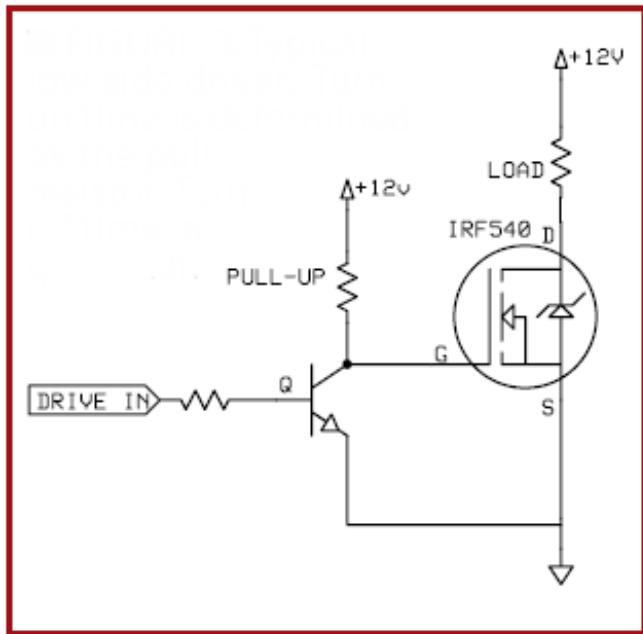
کاربرد MOSFET ها

ابتدا صرفاً به دلیل اینکه MOSFET ها محصولات قدرت می باشند نمی توان این استنباط را کرد که نسبت به الکتریسیته ساکن مقاوم اند. به طور اخّص، گیت آنها مجرأ از سورس بوده و توسط یک لایه بسیار نازک از جنس اکسید، عایق می شود. در صورتی که این لایه توسط یک تخلیه الکترواستاتیکی (esd) سوراخ شده باشد، به طور جدی می تواند بر چگونگی کیفیت عملکرد دستگاه تاثیر گذارد. ولتاژ گذاری کوتاه مدت بالای ولتاژ نامی گیت که به سبب طرح ضعیف تابلو یا مدار روی می دهد نیز مسائلی هستند که به دلایل مشابه باید از آنها اجتناب نمود.

نکته مهم در استفاده از MOSFET ها این است که ولتاژ گیت مقاومت بین سورس و درین را کنترل می کند. برای عملکرد DC نیازی به جریان واقعی وجود ندارد این عدم نیاز در شکل ۱ قابل مشاهده است. در این شکل، دیود های بایاس معکوس برای تامین ولتاژ گیت به کار برده شده اند. در این مثال جریان موجود در تغذیه معکوس $1n4748$ حدود ۱۰ نانو آمپر برآورد شده است. لذا، می توانید مشاهده کنید که روشن یا خاموش کردن یک MOSFET قدرت چندان زمان بر نیست. اگر شکل ۲ را آزمایش کنید خواهید دید که تغییر از حالت خاموش به روشن و یا بر عکس چندین ثانیه طول می کشد و در صورتی که قطعه به مدت طولانی در یک حالت

مقاومت موجود در حالت خاموش به قدری زیاد است که معمولاً در دیتابیتیت بیان نمی شود در عوض عموماً ولتاژ breakdown همانند زمانی که جریان $250\mu A$ از طریق این قطعه جریان می یابد، تعریف می شود. MOSFET قدرت را برای اغلب اهداف عملی می توان یک کلید در نظر گرفت که یا روشن است یا خاموش است (در قسمت بعدی، نظری بر کاربرد های خطی غیر سوئچینگ خواهیم انداخت).

اما نکته کلیدی این است که رفتان از مقاومت بسیار بالا به مقاومت بسیار پایین قدری زمان بر است. این زمان سوئچینگ میزان کارایی سیستم را تعیین می نماید و اندکی بعد با جزئیات بیشتر مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. MOSFET ها با دو ویژگی بخصوص عرضه می شوند کanal p و کanal n. هر چند به خاطر فیزیک موجود، n نوع کanal p نمی توانند با مقاومت کم نوع کanal n تطبیق یابند.



شکل ۳: یک نمونه درایو Low-side. زمان روشن شدن توسط مقاومت pullup می شود. زمان خاموش شدن نیز بسیار سریع می باشد.

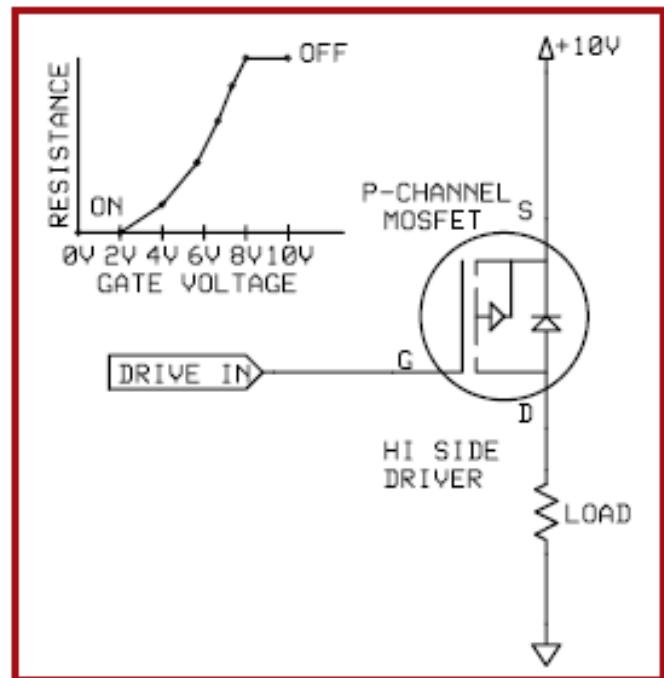
به همین دلیل، قطعات کanal n به تعداد بیشتر و ارزانتر موجود است و در اغلب طراحی ها حتی اگر نیازمند تلاش بیشتری باشد، از قطعات کanal n استفاده می شود. قطعات کanal p معمولاً به جز در کاربرد های خاص، در کاربردهای دیگر به چشم نمی خورند. برخلاف ترانزیستور های دوقطبی، MOSFET ها دارای ضریب دمایی مثبت می باشند. این بدين معنی است که مطابق با دما مقاومتشان افزایش می یابد. این افزایش مقاومت می تواند بسیار سودمند باشد. این MOSFET ها همچنانکه گرمتر می شوند، از جریان یافتن بیشتر جریان ممانعت می کنند که این امر سبب پایداری سیستم می گردد. ترانزیستور های تک قطبی همزنان با گرم شدن امکان افزایش جریان را فراهم می کنند. این جریان افزایش یافته آنها را گرمتر می کند به طوری که جریان بیشتری را از خود عبور می دهد که این خود مجدداً منجر به افزایش گرمایشان شده و به همین منوال ادامه پیدا می کند. این فرآیند گریز گرمایی نیز خوانده می شود. هنگامی

MOSFET های قدرت ۱

غالباً چند صد میلی آمپر یا بیشتر برای سوئیچینگ سریع مورد نیاز است. خود MOSFET ها می توانند بسیار سریع و اغلب در ۲۰ نانو ثانیه روشن و خاموش شوند که انجام چنین کاری نیازمند وارد آوردن ضربه قدرتمندی به گیت می باشد.

باشد، حتی ممکن است مدت زمان بیشتری نیز طول بکشد. باید توجه هنگامی که این قطعه در حالت کارکردن یا روشن باشد صفر ولت را نشان می دهد.

اینکه چرا مدت زمانی برای سوئیچ شدن صرف می شود به این دلیل است که تمامی گیت ها موازی و مجزا شده مانند جوش خازن عمل می نمایند. احتمالاً مهمترین ویژگی گیت ظرفیت خازنی آن است. مقاومت در حال روشن برای IRF540 نشان داده شده در شکل ۱ ۷۷ .۰ .۰ اهم بوده و ظرفیت خازنی گیت ۱۵۰۰ پیکو فاراد است. به طور کلی، هر چقدر مقاومت کمتر در حالت روشن کمتر باشد، ظرفیت ورودی بیشتر می شود. به منظور رسیدن به مقاومت کمتر باید MOSFET های کوچک بیشتری را به صورت موازی درآورد که این به معنی گیت های بیشتر و مساحت سطح گیت به معنی ظرفیت بیشتر است. این مساحت افزایش یافته سطح گیت به معنی ظرفیت بیشتر است. این امر یک نگرانی اساسی عملی را در مورد به کار گیری MOSFET های قدرت موجب می شود. به منظور خاموش یا روشن کردن قطعه، باید خازن گیت را به سرعت شارژ و دشارژ کرد. اگر این کار انجام نشود، در ناحیه‌ی خطی زمان بسیار زیادی را صرف کرده و مقدار زیادی انرژی به صورت گرمایشی هدر می رود. لذا، جهت خاموش و روشن کردن سریع دستگاه، باید مسیری با مقاومت بسیار کم ایجاد شود. این امر به خاطر ترکیب مقاومت خازن گیت و درایو برای ایجاد یک شبکه‌ی RC می باشد.



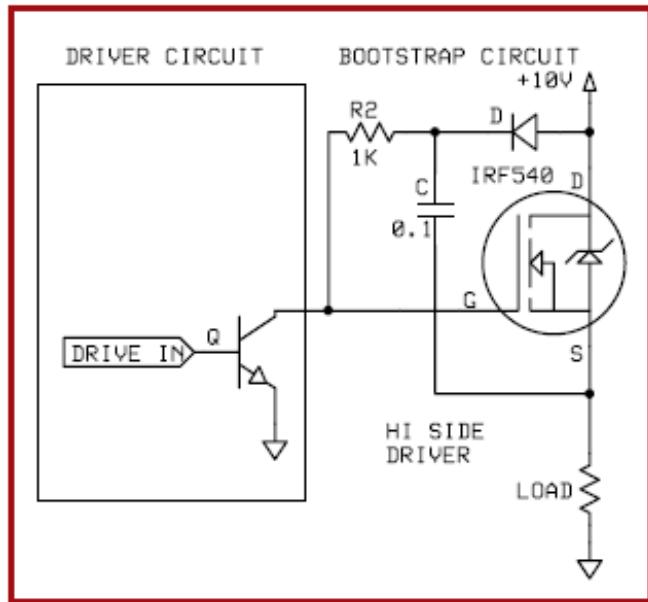
شکل ۵ : یک قطعه کانال P می تواند برای تنظیمات درایو high-side ، بطور نسبتا ساده ای به کار بردشود. این قسمت هنگامی که ولتاژ گیت تقریباً به اندازه ۸ ولت کمتر از پایه سورس است، بطور کامل روشن می شود. توجه داشته باشید که سورس به پایه مثبت تغذیه متصل شده است.

این شبکه‌ی RC مشخص میکند که این قطعه چقدر سریع می تواند تغییر حالت دهد. همین امر موجب بروز ویژگی های نامطلوب درایو MOSFET می شود در حالیکه MOSFET حقیقتاً جریان مدامی را برای روشن و خاموش کردن قطعه فراهم نمی کند بنابراین جریان پالس قابل توجهی برای شارژ و دشارژ کردن سریع دستگاه می باشد.

راه انداز low-side

ساده ترین و رایج ترین مدار، مدار راه انداز LOW SIDE نام دارد (رجوع شود به شکل ۲A). (تذکر، اساساً این بحث را جهت اختصار و سادگی به شکل ۲A های کانال N محدود خواهیم کرد) . دراین مقوله، MOSFET مستقیماً به زمین متصل شده است. راه انداز HIGH-SIDE (شکل ۲B) بار را در زمین قرار داده و MOSFET به منبع نیرو متصل می شود . به منظور روشن نمودن

همچنین مدار های مجزای ترانزیستوری پر شماری وجود دارد که می توان مورد استفاده قرار داد. این مدار ها می توانند همانند شکل ۳ راه اندازهای ترانزیستور مجزا باشند. نقص این طرح این است که مقاومت ایجاد شده جریان را محدود می کند، در نتیجه سرعت روشن شدن کند تر از سرعت خاموش شدن است. یک طرح Totem-pole می تواند بسیار کارآمد باشد (شکل ۴). نیز می توان یک طرح NPN / PNP را جهت رفع نیاز به مبدل به کار برد. تراشه های خاصی به نام «راه انداز های گیت» وجود دارند که جریان زیادی را برای سوئیچینگ بسیار سریع فراهم می آورند. اگر نیاز به سرعت احساس شود، احتمالاً این روشی است که می توان آن را به کار برد که مشکلات عملی ناشی از طراحی مدار و آزمایش آن را از میان بر می دارد. طبعاً راه انداز های گیت high-side، راه انداز های گیت نیم پل (Half Bridge) و راه انداز های گیت پل کامل (Full Bridge) نیز وجود دارند. جدول ۱ خلاصه از سرعت های راه اندازی نمونه ای اندازه گیری شده را در بار و نه در گیت نشان می دهد (توجه داشته باشید که مقدار راه انداز گیت ۱۷۵ نانو ثانیه به طرز شبه بر انگیزی کند است که احتمالاً به علت ساده بودن آزمایش می باشد. اندازه گیری مدار دوبرابر کننده ولتاژ نشانگر سرعت های سوئیچینگ ۵۰ نانو ثانیه ای متقارن بود که در ۱۵ نانو ثانیه / ۱۰۰۰ پیکو محاسبه شده است).



شکل ۷: استفاده از یک ساختار Open-Collector نیاز به استفاده از مقاومت های گیت و Pullup را برطرف می کند.

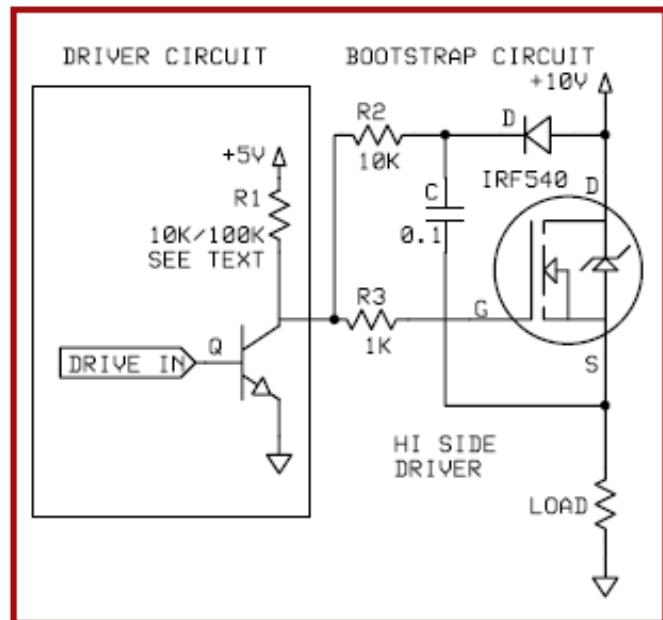
راه اندازی high-side

راه اندازی high-side یک قطعه‌ی کانال N ممکن است پیچیده باشد. (رجوع شود به شکل ۲) گیت باید ۸ ولت بیش از ولتاژ سورس باشد تا آن را روشن نماید. لذا، به دلیل وجود مقاومت بسیار کم به هنگام روشن بودن آن، افت ولتاژ اندکی بین درین و منبع وجود دارد. بنابراین ولتاژ پین سورس اغلب به VCC بسیار نزدیک است. در نتیجه ممکن است برای روشن نمودن قطعه، ولتاژ گیت بیشتری از VCC مورد نیاز باشد.

low-side MOSFET به روش تمام آنچه که باید انجام دهید این است که گیت را به میزان حدود ۸ ولت بالاتر از سطح زمین بالا ببرید. اتصال گیت به زمین آن را خاموش خواهد کرد.

به کار گیری سیگنال های سطح منطقی TTL ۵ ولتی برای به کار انداختن مستقیم MOSFET امکان پذیر می باشد اما، این کار دستگاه را به طور کامل روشن نخواهد کرد. با این وجود، اغلب اوقات همین مقدار کافی است. برای IRF540 ولتاژ راه اندازی (درایو) ۵ ولتی حدود ۱۰ آمپر را برای سوئیچ شدن (به طور معمول) به جای ۲۸ آمپر تعیین شده، فراهم می آورد.

بنابراین اگر کاربرد مورد نظر نیازمند توان کامل قطعه نباشد، احتمالاً سیگنال های TTL موثر خواهد بود. همواره می توان یک قطعه کلکتور باز را مورد استفاده قرار داد که امکان رسیدن خروجی منطقی را بیش از ۵ ولت فراهم می آورد. همچنین، MOSFET های خاصی وجود دارند که برای کارکردن با یک ولت محرک ۵ ولتی طراحی شده اند. طبعاً این MOSFET ها گران قیمت تر هستند. اما ممکن است با توجه به هزینه اضافی و دشواری طراحی مدار راه انداز گیت با ولتاژ بالا، ارزشمند باشد. به طور معمول، این MOSFET ها عنوان قطعات «سطح منطقی» شناخته می شوند.



شکل ۶: ساختار bootstrap فوق باعث افزایش ولتاژ گیت می شود ولی بسیار کند می باشد.

منطق CMOS دارای این مزیت می باشد که می تواند در ۸ ولت یا بیشتر بدون هیچ مشکلی کار کند. هر چند، این منطق هنگامی که زمان به جریان انداختن جریان می رسد. حتی با وجود خروجی های موازی بسیار بد عمل می کنند عموماً. آنها فقط یک جفت MA یا چیزی در این حدود برای هر خروجی فراهم می‌آورند بنابراین راه انداری یک گیت MOSFET در سرعت بالا امری دشوار است اگر چه بسیار از کاربرد ها نیاز به سوئیچینگ با سرعت زیاد وجود ندارد. یک تایмер 555 به خوبی می تواند به عنوان یک راه انداز عمل نماید. اطمینان یابید که به جای یک نقطه (CMOS) XXC555 (رجوع شود به تصویر ۱ و ۲) از یک قطعه دو قطبی (NE555) استفاده نماید.

MOSFET های قدرت ۱



عکس ۱A : تایمر ۵۵۵ دوقطبی که توانایی روشن خاموش کردن MOSFET را در حدود ۵۰ ns را دارد.

هدایت می کند) در عمل، قطعه ولتاژ گیت را از طریق خود راه انداز خود قطعه افزایش می دهد.

طبعاً، تئوری و عمل با یکدیگر متفاوت اند. حافظن حداقل باید ۱۰ برابر ظرفیت گیت باشد. در اکثر موارد، یک MF موثر خواهد بود. دیوید به هر نوع نیرویی با میزان مناسبی از ولتاژ اطلاق می شود.

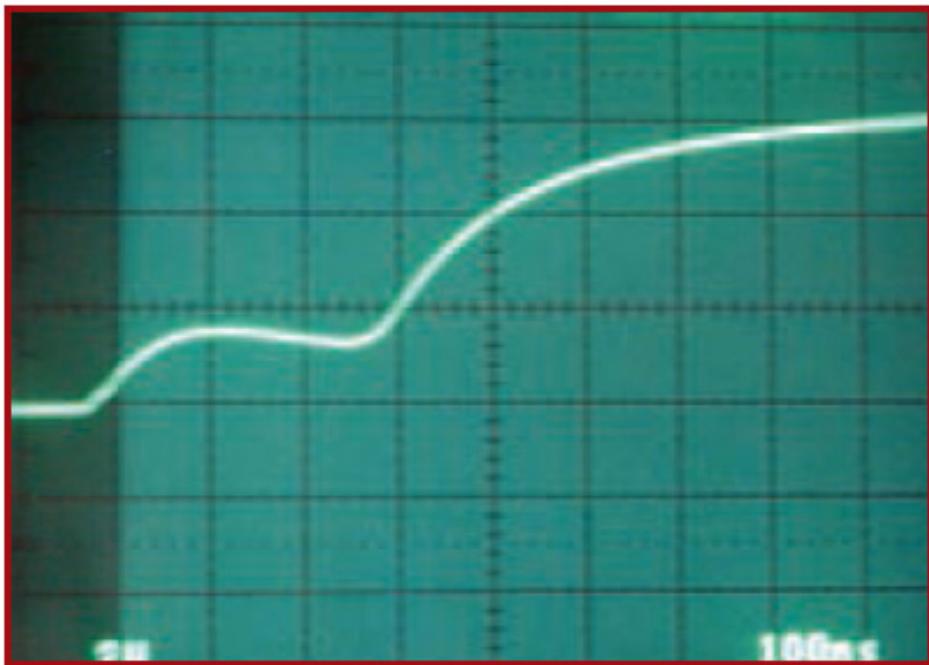
مقاومت های R_2 , R_1 مولفه‌ی پیچیده‌ای می باشند.

مقاومت افزایش یافته (R_1) تعیین می کند که افزایش ولتاژ تا چه میزان زیاد است و به این دلیل است که این مقاومت راه انداز گیت را به منبع ۵ ولتی متصل می کند. هر ولتاژی که بیشتر از ۵ ولت باشد توسط این مقاومت تا ۵ ولت پایین می آید. توجه داشته باشید که این مقاومت ممکن است همواره قابل رویت نباشد. به عنوان مثال، یک تایمیر ۵۵۵ (متصل به R_2 , R_3) می توان ۱۰۰ mA را برای یک مقاومت افزایش یافته‌ی هم ارز ۵۰ اهمی تامین نماید (در ۵ ولت). همچنان که در شکل ۶ نشان داده شده است، مقدار k برای R_2 صرفاً ۱۰ ولت را برای گیت تامین می کند. که این مقدار در صورتی که منبع نیز در ۱۰ ولت باشد، کافی نیست اگر R_2 تا K ۱۰۰ اهم افزایش یابد، بیش از ۱۷ ولت به گیت اعمال میشود که احتمالاً این مقادار برای اکثر کاربردی مربوط به یک IRF540 کافی می باشد. توجه کنید که زمان روشن شدن نیز توسط R_2 کنترل می شود (زمان خاموش شدن توسط R_3 کنترل می شود). شارژ گیت به میزان ۱۵۰۰ پیکو فاراد به واسطه K ۱۰۰ حدوداً برای روشن نمودن دستگاه $30\ \mu s$ طول می کشد. بنابراین سرعت را با ولتاژ جایگزین می کنید. حساب تخمینی (سر انگشتی) کلی به این ترتیب است که R_2 باید حدوداً یک دهم مقاومت افزایش یافته‌ی هم ارز یعنی R_1 باشد.

مقاومت R_3 زمان خاموش شدن را کنترل می نماید و بیشتر به منظور کامل بودن گنجانده شده است. در اغلب موارد مقاومت سری گیت نشان داده شده است. که ضروری می باشد. طبق آنچه که نشان داده شده زمان خاموش شدن حدود ۲ میلی ثانیه می باشد. اگر R_3 با یک سیم جایگزین شود، زمان خاموش شدن تا حدود ۵۰۰

راه حل هایی در زمینه رفع این مشکل وجود دارد. نخست، ساختن یک تقویت کننده ولتاژ است. بدیهی است که این راه حل یک راه حل ساده نیست یک قطعه کانال P ممکن است با وجود هزینه‌ی بالا و عملکرد ضعیف، راه حل آسانی باشد.

شکل ۵ یک نقشه HOOK-UP نمونه را نشان می دهد. توجه داشته باشید که سورس به ولتاژ مثبت متصل است. در این ساختار، دستگاه کanal P با ولتاژ گیتی ۸ ولت کمتر از ولتاژ سورس روشن خواهد شد. بنابراین اگر سورس VCC ۱۰ ولت است، در این صورت هنگامی که ولتاژ گیت حدود ۷ ولت افت کند، قطعه شروع به کار خواهد کرد و در ۲ یا ۸ ولت زیر ولتاژ سورس به طور کامل روشن خواهد بود. اگر به طور مداوم بار مذکور در کمتر از یک ثانیه یا در این حدود در حال روشن و خاموش شدن باشد، روش دیگری وجود خواهد داشت که میتوان آن را برای قطعه کانال N مورد استفاده قرار داد. این روش خود راه اندازی نام دارد و در شکل ۶ نشان داده شده است این شکل یک مدار اصلاح شده است که در کتاب مرجع SILICONIX MOSPOWER APPLICATION میباشد. طرح مفهومی این مدار دقیق بوده اما نسبتاً ابتدایی است. هنگامی که ترانزیستور روشن است، گیت MOSFET به پایین کشیده شده و حافظن از طریق دیود ایزولاسیون تا VCC (۱۰ ولت) شارژ شده است. هنگامی که ترانزیستور خاموش است، راه اندازی گیت به خاطر حافظن شارژ شده تا VCC افزایش می یابد (اغلب از طریق R_2 , R_3). تا زمانی که MOSFET خاموش است، ولتاژ پین سورس از طریق بار پایین می آید. این بدین معنی است که ولتاژ گیت به خوبی بیش از ولتاژ پین سورس است و MOSFET شروع به کار خواهد نمود. هنگامی که این عمل روی می دهد، حافظن به عنوان منبع ولتاژ به صورت سری با سورس عمل خواهد کرد. لذا تمامی ولتاژ موجود در پایه سورس از طریق حافظن به گیت اضافه شده است. (بخش منفی حافظن از طریق ولتاژ پین سورس در حال افزایش بالا میرود که بخش مثبت را نیز با مقداری مساوی به بالا



عکس B: تایمیر 555 CMOS که در حدود 800ns زمان برای روشن کردن MOSFET نیاز دارد که ۱۶ برابر بیشتر از مدل دوقطبی خود می باشد.

۱۵ میلی ثانیه روشن و خاموش نماید با توجه به زمان و تلاش انجام گرفته در طراحی راه اندازه high-side به نظر معامله خوبی است.

نتیجه گیری

در ماه جاری به MOSFET های قدرت پرداختیم و دریافتیم که دارای چند ویژگی بسیار مفید می باشند. ارزان قیمت و قدرتمند هستند و نسبتاً به سهولت می توان آنها را به کار برد. طبعاً علاوه بر بررسی های تئوری بررسی های عملی نیز وجود دارند.

میلی ثانیه تقلیل می یابد. این مشکلات را میتوان با استفاده از یک مدار ترانزیستور کلکتور باز مرتفع ساخت که در شکل ۷ نشان داده شده است.

دراین مورد، هیچگونه رابطه ای با منبع ۵ ولتی وجود ندارد، در نتیجه مشکل PULL DOWN وجود ندارد. این امکن R₁ را حذف نموده و امکان استفاده از مقاومت بسیار کوچک تر را برای R₂ فراهم می آورد. اکنون این مقاومت به منظور محدود کردن جریان در ترانزیستور برای سطح ایمنی انتخاب شده است.

(۱۰۰ میلی آمپر طبق آنچه که نشان داده شده است) مقاومت R₃ را نیز میتوان حذف نمود این مدا حدود ۱۸ ولت را برای گیت تامین نموده و زمان سوچینگ حدود ۴ میلی ثانیه برای روشن نمودن و حدود ۵۰۰ میلی ثانیه برای خاموش کردن است.

اما اگر بخواهید که از قطعه کanal N₊ استفاده کنید باید lm5109b حقيقة استفاده از چیپ راه انداز را مدنظر قرار دهید. یک low-side و high-side MOSFET را طبق ساختار نیم پل راه اندازی می نماید. این دستگاه برای ۹۰ ولت ارزیابی شده (برای MOSFET) و میتواند آنها را با ظرفیت گیت ۱۰۰ پیکو فاراد، در

Nuts and Volts Magazine-January 2009

منبع :

مترجم : فریبا سماواتیان

Circuit	Turn off time	Turn on time	Comments (10V D-S with 100 mA load)
TTL 'LS04	500 ns	100,000 ns	Can't drive fully on. Logic-level parts available.
TTL/pullup	200 ns	3,000 ns	Speed limited by pullup 1K resistor. (74145)
CMOS	8,000 ns	1,000 ns	Very slow but turns on all the way. Easy. (CD4069)
CMOS x 6	2,000 ns	400 ns	Better than above, but still slow. (CD4069)
NE555	175 ns	60 ns	Bipolar good, CMOS poor. (Photos 1 and 2)
Discreet	400 ns	2,500 ns	Speed limited by 1K pullup resistor. (Figure 4)
Totem pole	175 ns	150 ns	Very good. (Figure 5)
Driver	175 ns	50 ns	Best speed (see text). (LM5109B)

فروشگاه تخصصی برق و الکترونیک

ECA SOFTWARE **ECA** UTILITY
ECA EBOOK **ECA** MAGAZINE **ECA** PAPER **ECA** HARDWARE

www.eShop.ECA.ir

کارا الکترونیک

Kara Electronic
PCB & PCBA Manufacturing Services

تولید کننده انواع مدار چاپی

- یک لایه
- دو لایه
- دولایه متالیزه
- چندلایه (تا ۳۲ لایه)

تلفن: ۰۲۹۲ (۳۴۲۶۳۴۳) - ۰۲۹۲ (۳۴۲۶۳۴۰) فکس: info@karapcb.com www.karapcb.com

مرکز تخصصی XMEGA در ایران

* فروش ویژه برق آموزشی
MKII و پروتکل امن XMEGA

* پردازهای دو راه های آموزشی
XMEGA - ARM - DSP
AVR - FPGA - PROTEL

ترجمه متن‌ها و مقالات تجربی

شرکت مهندسی نوین تراشه البر www.novintarashe.com

ترجمه تخصصی متون برق و الکترونیک

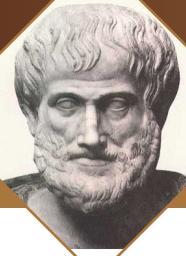
Translate.ECA

ترجمه کلیه متون تخصصی ، علمی ، دانشگاهی ، فنی و ...

www.Translate.ECA.ir

وب سایت تخصصی برق و الکترونیک (ECA) افتخار دارد با بیش از ۸۶۰۰ عضو، یکی از بزرگترین وب سایت های تخصصی ایران را تشکیل داده و پاسخگوی نیاز دانشجویان، متخصصان، محققان و صنعتگران عرصه برق و الکترونیک کشور باشد. بی شک یکی از اهداف این انجمن، برقراری ارتباط بین صنعت و جامعه می باشد. لذا از تمام شرکت ها، کارخانجات و موسسات صنعتی علمی آموزشی دولتی و خصوصی، تقاضا مندیم در صورت تمایل به عقد قرارداد تبلیغاتی و یا قبول اسپانسری برای مجله تخصصی نویز از طرق زیر با ما در ارتباط باشند.

تلفن: ۰۴۱۱-۵۵۷۱۲۶۱
فکس: ۰۴۱۱-۵۵۳۹۷۶۹
ایمیل: adver.eca@gmail.com



Celebrities

UNFORGETTABLE PERSONS

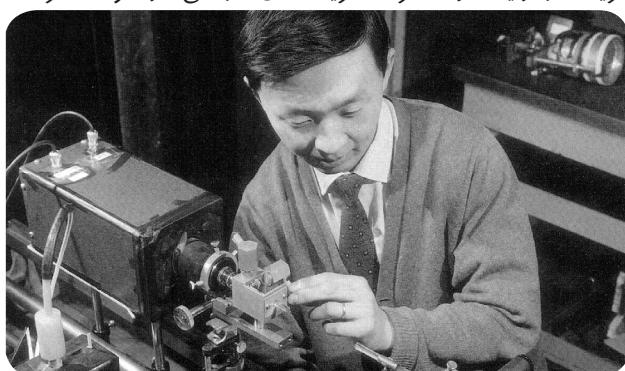


دکتر Charles K. Kao

سال ۱۹۶۸ پروفسور Kao و M.W. Jones به افت 4 dB/km توسط شیشه‌ای بسیار شفاف دست پیدا کردند.

وی به توسعه تکنیک‌ها و تصمیمات مهم در مورد موج برهای نوری و همچنین توسعه انواع مختلفی از فیبرهای نوری که برای مقاصد نظامی و غیر نظامی استفاده می‌شود پرداخت. بیش از صد مقاله و بالای ۳۰ اختراع از این دانشمند گرفتار به جای مانده است. همچنین Charles K. Kao از پیشگامان کابل‌های زیر دریایی برای ارتباطات بین کشورها می‌باشد، در سال ۱۹۸۳ پروفسور Kao پیش‌بینی کرد که دریاهای جهان مملو از فیبرهای نوری خواهد بود و کمتر از ۵ سال بعد این ایده اجرایی گردید.

پروفسور Kao متأسفانه از سال ۲۰۰۴ تا کنون چار آزاریم است بیماری که پدر وی نیز به آن مبتلا بوده. پروفسور با اینکه به سختی می‌تواند صحبت کند اما بدون مشکل می‌توان افراد و آدرس‌ها را شناسایی کند. همسر پروفسور Kao اعلام کرده است که مبلغ دریافتی به عنوان جایزه نوبل را پس از پرداخت مالیات به دولت آمریکا در اولیت اول صرف هزینه‌های درمانی او خواهد کرد.



عکسی از دکتر Charles K. Kao در حال تحقیق
aliyaghoobi88@yahoo.com

مترجم: علی یعقوبی

چهره‌های ماندگار

Charles K. Kao

Charles K. Kao در سال ۱۹۳۳ در شانگهای متولد شد اما خانه اجدادی آنها در جیان سو بوده است، زبان انگلیسی و فرانسه را در مدرسه بین المللی شانگهای که توسط تعدادی از مریبان مترقبی چینی بنا شده بود فرا گرفت و در سال ۱۹۴۸ به هنگ کنگ مهاجرت و در آنجا تحصیلات متوسط خود را در کالج سنت جوزف گذراند. تحصیلات دوره لیسانس خود را در دانشگاه پلی تکنیک ولیوچ (گرینیوچ کنونی) گذراند و دکترای خود را در رشته مهندسی برق در سال ۱۹۶۵ از دانشگاه کالج لندن زیر نظر پروفسور هارولد بارلو به عنوان دانشجوی خارجی ضمن خدمت در آزمایشگاه مخابرات استاندارد STL در هارلو انگلستان دریافت کرد.

در سال ۱۹۶۰ پروفسور Kao و تعدادی از همکارانش کار پیشگامانه خود را در زمینه موجبرهای نوری برای ارتباطات راه متوسط آغاز کردند Kao در ابتدا همراه با Antoni Karbowiak در IEEE شروع به فعالیت می‌کند. وظیفه وی بررسی میرایی فیبرهای گوناگون بود که از تولید کنندگان مختلف جمع آوری شده بود.

در سال ۱۹۶۳ پروفسور Kao به ریاست گروه پژوهشی الکتروپاتیک STL در آمد. اگر چه در این زمینه نیز موفق ظاهر شد اما تصمیم به رها کردن برنامه Karbowiak گرفت و مسیر کلی پژوهشی را به کمک همکارش George Hockham تغییر داد و آنها در برنامه جدید خود علاوه بر در نظر گرفتن مباحث فیزیک نوری به خواص مواد نیز توجه ویژه ای کردند. نتایج این تحقیقات برای اولین بار در IEEE لندن در ژانویه ۱۹۶۰ ارائه شد و اطلاعات بیشتری از این پژوهش در جولای همان سال توسط George Hockham منتشر گشت.

این اولین مطالعه تئوریزه شده و پیشنهادهایی قبل اجرا استفاده از الیاف نوری برای پیاده سازی ارتباطات تا آن زمان بود و ایده‌های شرح داده شده در آن پژوهش تا حدود زیادی اساس ساختار ارتباطات فیبر نوری کنونی می‌باشد.

در سال ۱۹۶۵ Kao و Hockham به این نتیجه رسیدند که تضعیف در فیبرهای نوری باید زیر 20 dB/km باشد. در این زمان فیبرهایی با تضعیف $1,000 \text{ dB/km}$ نیز به نمایش گذاشته می‌شدند. این تصمیم باعث ایجاد رقابت شدید برای تولید فیبرهای نوری با تضعیف کم شد.

SiO₂ یا سلیس ذوب شده با خلوص بالا، گزینه ایده آل برای ارتباطات نوری مطرح شد و پروفسور Kao همچنین تاکید کرد که ناخالصی مواد بیشترین تاثیر را در انتقال دارد نه خواص فیزیکی که بیشتر دانشمندان در آن زمان به آن فکر می‌کردند. این مطالعه منجر به تولید فیبرهای نوری با خلوص بالا در سراسر جهان شد. در



Robust Control of a Mobile Inverted Pendulum Robot Using a RBF Neural Network Controller

Abstract – This article presents robust control of the mobile inverted pendulum system(MIPS) whose structure is a combination of a wheeled mobile robot and an inverted pendulum with two arms. The MIPS navigates on the horizontal plane while balancing the pendulum. Control of the MIPS is difficult since the system is non-holonomic and nonlinear so that simple linear controllers may have poor performances for the system. The radial basis function(RBF) network is used as an auxiliary controller to help the primary PID controllers to perform better. The back propagation algorithm has been developed for the RBF function network. Real time control of the RBF network has been achieved by embedding the learning algorithm onto the DSP board. The performance of the RBF network controller has been tested for the remotely controlled MIPS by conducting experiments of climbing the slanted surface while balancing.

Index Terms –RBF network, mobile inverted pendulum system.

I. INTRODUCTION

Balancing systems are quite attractive to educators and researchers in the educational purposes as well as research purposes. Our bodies are balancing systems whose balance is controlled to keep from falling while walking. When humans are walking, they are simply considered as an inverted pendulum system. Thus, balancing control has become an important subject in the control and robotics communities. The inverted pendulum system has been considered as a well known prototype system of representing nonlinear systems for testing control algorithms[1-4]. A single input to the inverted pendulum system has to control both the pendulum angle and the cart position simultaneously. The typical characteristic of the inverted pendulum system has attracted researcher as well as educators to demonstrate control performances by the designed control algorithms. PID controllers can balance the pendulum by select-

ing suitable gains. However, simultaneous control of both angle and position by PID controllers has been known to be very difficult since the inverted pendulum system is nonlinear. As an extension of the inverted pendulum system, the mobile inverted pendulum system(MIPS) is a more challenging system whose uncertainties are more complicated. The MIPS can navigate on the plane by differential wheel velocities while balancing the pendulum. Control of the MIPS is difficult since the system is non-holonomic and nonlinear so that simple linear controllers cannot satisfy the specifications.

There has been active research on the mobile pendulum systems. Successful demonstrations by the commercial product Segway have affected on the possibility of applying the inverted pendulum system to the real world problems such as a human carrier device[5]. Currently, the research of using the Segway as an astronaut in the space has been introduced[6]. A small MIPS called ‘JOE’ has been implemented and successful results have been presented[7]. The state feedback control algorithm has been applied to the MIPS to control velocity and position[8].

To overcome nonlinear behaviours, nonlinear control methods, adaptive control methods and intelligent control approaches have been proposed. In our previous research, an intelligent technique has been applied to control tracking the desired trajectory of the BalBot II[9]. A neural network controller has been implemented and position tracking tasks have been successfully demonstrated. The pendulum was a simple rod and navigation of the system has not been considered.

In this paper, therefore, the different MIPS, called the BoxingBot has been built to have two arms to move instead of a simple rod. The robust control of the BoxingBot by using the radial basis function(RBF) network is presented. The RBF controller is added as an auxiliary controller to help the primary PID controllers to perform better. The backpropagation algorithm for the on-line control and learning has been developed for the RBF function network. Real-time control of the RBF network has been achieved

Robust Control of a Mobile Inverted Pendulum Robot Using a RBF Neural Network Controller

by embedding the learning algorithm onto the DSP board developed in our Lab.

Experimental studies are conducted to show the performance of the RBF network controller. The MIPS is controlled by the joystick located remotely through the wireless communication and tested for experiments of balancing under impacts and climbing the slanted surface while balancing.

II. THE MOBILE PENDULUM SYSTEM

A. Kinematics

The kinematics of the MIPS is the same as the wheeled drive mobile robot as shown in Fig. 1.

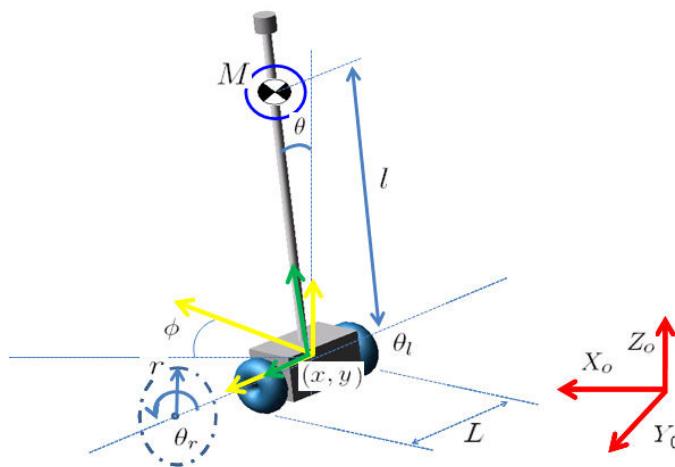


Fig. 1. Mobile inverted pendulum system

The Cartesian velocities have the relationship with a linear velocity v and an angular velocity ω of the robot as

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & -d \cdot \sin \phi \\ \sin \phi & d \cdot \cos \phi \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix}$$

where ϕ is the heading angle, d is the distance between the center of an actuating axis, and the center of the mass. The Cartesian velocities and joint velocities have the relationship as

$$\begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{r}{2} & \frac{r}{2} \\ \frac{r}{L} & -\frac{r}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_R \\ \dot{\theta}_L \end{bmatrix}$$

where r is the radius of a wheel, L is the distance between two wheels. $R \theta_R$ is the angular velocity of the right wheel and $L \theta_L$ is the angular velocity of

a left wheel. Combining (1) and (2) yields the Jacobian relationship between velocities in two domains.

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{r}{2} \cos \phi - \frac{rd}{L} \sin \phi & \frac{r}{2} \cos \phi + \frac{rd}{L} \sin \phi \\ \frac{r}{2} \sin \phi + \frac{rd}{L} \cos \phi & \frac{r}{2} \sin \phi - \frac{rd}{L} \cos \phi \\ \frac{r}{L} & -\frac{r}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_R \\ \dot{\theta}_L \end{bmatrix}$$

In our system, wheels are located in the center of the body such that $d = 0$.

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{r}{2} \cos \phi & \frac{r}{2} \cos \phi \\ \frac{r}{2} \sin \phi & \frac{r}{2} \sin \phi \\ \frac{r}{L} & -\frac{r}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_R \\ \dot{\theta}_L \end{bmatrix}$$

B. Dynamics

The MIPS is a nonholonomic system whose kinematic equations are constrained. The motion equation of the wheeled drive mobile robot with kinematics constraints is described as

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q}) + G(q) = P\tau - A^T \lambda$$

Where T

$R L \quad q = [x, y, \phi, \theta, \theta_R, \theta_L]^T$, $M(q)$ is the inertia matrix, $C(q, \dot{q})$ is the Coriolis and centrifugal force vector, $G(q)$ is the gravity force, A is the constraint matrix, P is the input transform matrix, τ is the input torque vector, and λ is the Lagrangian multiplier.

A new velocity vector v is defined as $T v = [v, \dot{\phi}, \dot{\phi}]^T$ where ϕ is the pendulum pitch angle. Then the Jacobian relationship yields

$$\dot{q} = S(q)v$$

where the vector $\dot{q} = [\dot{x}, \dot{y}, \dot{\phi}, \dot{\theta}_R, \dot{\theta}_L]^T$. To satisfy the relationship $S^T A^T \lambda = 0$, $S(q)$ is given as

$$S(q) = \begin{bmatrix} \cos \phi & 0 & 0 \\ \sin \phi & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{r} & \frac{L}{2r} & 0 \\ \frac{1}{r} & -\frac{L}{2r} & 0 \end{bmatrix}$$

Robust Control of a Mobile Inverted Pendulum Robot Using a RBF Neural Network Controller

where the constraint $A(q)$ matrix is given by kinematic constraint equations.

$$A(q) = \begin{bmatrix} \sin \phi & -\cos \phi & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \cos \phi & \sin \phi & \frac{L}{2} & 0 & -r & 0 \\ \cos \phi & \sin \phi & -\frac{L}{2} & 0 & 0 & -r \end{bmatrix}$$

Differentiating (6) yields the acceleration

$$\ddot{q} = \dot{S}\dot{\nu} + S\ddot{\nu}$$

Considering the gravity term and substituting (9) into (5) yields

$$MS\dot{\nu} + M\dot{S}\dot{\nu} + C + G = P\tau - A^T \lambda$$

Multiplying S^T to both sides to eliminate the Lagrangian multiplier yields

$$S^T MS\dot{\nu} + S^T M\dot{S}\dot{\nu} + S^T (C + G) = S^T P\tau$$

III. RADIAL BASIS FUNCTION NETWORK CONTROL

A. PID Control

Two separate PID controllers are used for the pendulum angle and the cart position as shown in Fig. 2. Although the MIPS is a nonlinear system, PID controllers can stabilize the system by balancing itself. The PID controller output for the angle control is given by

$$u_\theta = k_{p\theta} e_\theta(t) + k_{i\theta} \int e_\theta(t) dt + k_{d\theta} \dot{e}_\theta(t)$$

where the pendulum angle error is defined as $e_\theta = \theta_d - \theta$, where θ_d is the desired angle of the pendulum and θ is the actual angle of the pendulum, $k_{p\theta}$, $k_{i\theta}$, $k_{d\theta}$ are PID gains for pendulum control. The PID controller output for the position control is

$$u_x = k_{px} e_x(t) + k_{ix} \int e_x(t) dt + k_{dx} \dot{e}_x(t)$$

where the mobile pendulum position error is defined by $e_x = x_d - x$, where x_d is the desired cart position and x is the actual position of the cart. k_{px} , k_{ix} , k_{dx} are PID gains for the cart control. The overall control input is the sum of two PID controller outputs, u_θ and u_x .

$$u = u_x + u_\theta .$$

Thus, control of the MIPS is dependent upon the combination of two PID controllers. Since controller gains are quite sensitive to the performance of the system, careful selection of gains is required. In this paper, controller gains are selected through experimental works by trial and error procedures. There are many cases of different angle position and different cart position for the PID controllers to satisfy the specification. Each PID controller fights each other to satisfy the requirements of the angle and the cart, but not enough to control both control actions. This leads to the introduction of the RBF network to improve the performance.

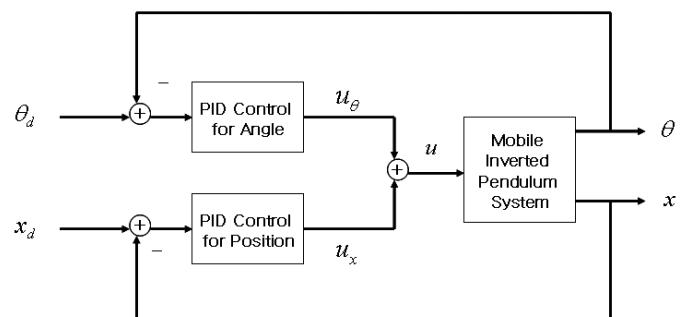


Fig. 2. RBF neural network structure

B. RBF Network Control

The RBF network is known for simplicity and well formulated whose analysis is easier than other neural network in control applications. The RBF network consists of input, hidden, and output layer whose hidden layer is the only nonlinear layer as shown in Fig. 3. The nonlinear function for the hidden layer of

$$\psi_j(X_I) = \exp\left(-\frac{|X_I - \mu_j|^2}{\sigma_j^2}\right),$$

the RBF network is given by the Gaussian function. where X_I is an input vector, μ_j is the centre value and σ_j is the width value. Then the output of the RBF

$$y_k = \sum_{j=1}^{N_H} \psi_j w_{jk} + b_k$$

network can be calculated as the sum.

where N_H is the number of hidden units, w_{jk} is the weight value and b_j is the bias.

Robust Control of a Mobile Inverted Pendulum Robot Using a RBF Neural Network Controller

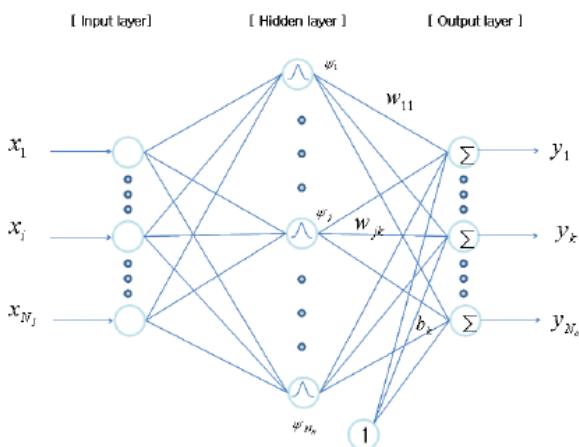


Fig. 3. RBF neural network structure

The RBF network outputs are added to the PID controller input to form the new control inputs as shown in Fig. 4. The RBF network compensates for uncertainties by adding signals to the controller.

$$u_\theta = k_{p\theta}(e_\theta + \varphi_1) + k_{d\theta}(\dot{e}_\theta + \varphi_2) + k_{i\theta}(\int e_\theta dt + \varphi_3)$$

$$u_x = k_{px}(e_x + \varphi_4) + k_{dx}(\dot{e}_x + \varphi_5) + k_{ix}(\int e_x dt + \varphi_6)$$

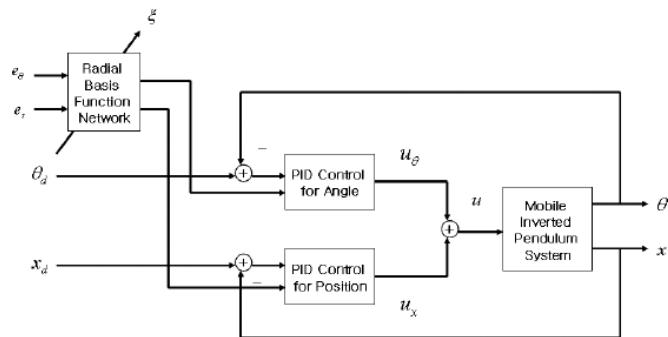


Fig. 4. RBF neural network structure

C. RBF Network Learning Algorithm

When neural networks are used in control applications, online learning and control is preferred. To achieve on-line learning and control, real-time control hardware has to be implemented in advance[10]. In this paper, we developed a DSP board for fast calculation of the learning algorithm called the back-propagation algorithm based on the gradient. In this section, the back-propagation algorithm for the RBF network is derived.

Define the neural network output as

$$\Phi = \Phi_\theta + \Phi_x$$

$$\text{where } \Phi_\theta = k_{p\theta}\varphi_1 + k_{d\theta}\varphi_2 + k_{i\theta}\varphi_3$$

$$\Phi_x = k_{px}\varphi_4 + k_{dx}\varphi_5 + k_{ix}\varphi_6$$

Then From (14), (17), and (18), we have

$$k_{p\theta}e_\theta + k_{d\theta}\dot{e}_\theta + k_{i\theta}\int e_\theta dt + k_{px}e_x + k_{dx}\dot{e}_x + k_{ix}\int e_x dt = \tau - \Phi$$

The back-propagation learning algorithm is derived to generate neural network output signals i to iden-

$$\xi = k_{p\theta}e_\theta + k_{d\theta}\dot{e}_\theta + k_{i\theta}\int e_\theta dt + k_{px}e_x + k_{dx}\dot{e}_x + k_{ix}\int e_x dt$$

tify the inverse dynamics as given in (20). The left side of (20) is the error functions to be minimized.

$$E = \frac{1}{2} \xi^2$$

Then, the training signal ξ is defined as

If $\xi = 0$, then $\Phi = \tau$ in (20). Define the objective

$$\frac{\partial E}{\partial w} = \frac{\partial E}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial w} = \xi \frac{\partial \xi}{\partial w} = -\xi \frac{\partial \Phi}{\partial w} = -\xi \left(\frac{\partial \Phi_\theta}{\partial w} + \frac{\partial \Phi_x}{\partial w} \right)$$

where

$$\frac{\partial \Phi_\theta}{\partial w} = k_{p\theta} \frac{\partial \varphi_1}{\partial w} + k_{d\theta} \frac{\partial \varphi_2}{\partial w} + k_{i\theta} \frac{\partial \varphi_3}{\partial w}$$

$$\frac{\partial \Phi_x}{\partial w} = k_{px} \frac{\partial \varphi_4}{\partial w} + k_{dx} \frac{\partial \varphi_5}{\partial w} + k_{ix} \frac{\partial \varphi_6}{\partial w}$$

function to be minimized as

Differentiating (22) yields the gradient with respect

$$\Delta w_{jk} = \eta_c k e_k \psi_j$$

$$\Delta \theta_k = \eta_b k e_k$$

$$\Delta \mu_j = \eta_\mu k \psi_j \sum_{i=1}^{N_I} \frac{(x_i - \mu_j)}{\sigma_j^2} \sum_{k=1}^{N_o} e_k w_{jk}$$

$$\Delta \sigma_j = \eta_\sigma k \psi_j \sum_{i=1}^{N_I} \frac{(x_i - \mu_j)^2}{\sigma_j^3} \sum_{k=1}^{N_o} e_k w_{jk}$$

to weights, $w(w_{jk}, b_k, \mu_j, \sigma_j)$ as

The detailed weight update equations are given by where η is the learning rate, N_I is the number of inputs, and N_o is the number of outputs,. The gain k becomes $k_{p\theta}, k_{d\theta}, k_{i\theta}, k_{px}, k_{dx}, k_{ix}$ with respect to compensating points. The DSP has to update 4 weight values at each sampling time.

IV. EXPERIMENTS

A. Experimental Setups

The BoxingBot is shown in Fig. 5. It has two arms and each arm has 3 d.o.f. The BoxingBot is remotely controlled by the joystick through wireless communication. Fig. 6 shows the overall system structure of the boxing robot system. A user can control the movement of the boxing robot by a joystick controller through Bluetooth

Robust Control of a Mobile Inverted Pendulum Robot Using a RBF Neural Network Controller

communication modules.

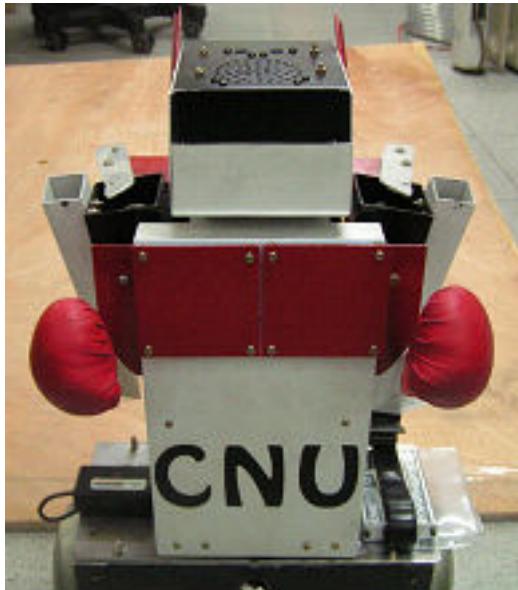


Fig. 5. The BoxingBot

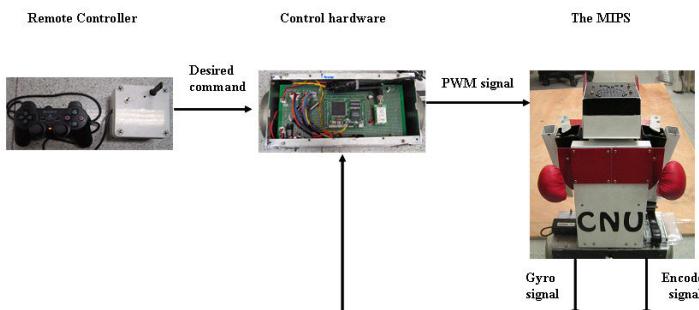


Fig. 6. The overall system

B. Balancing Control

First experiment of balancing control is conducted. The BoxingBot is required to maintain balancing under external disturbances. The BoxingBot is able to maintain balance even if impact has been applied to the system as shown in Fig. 7.

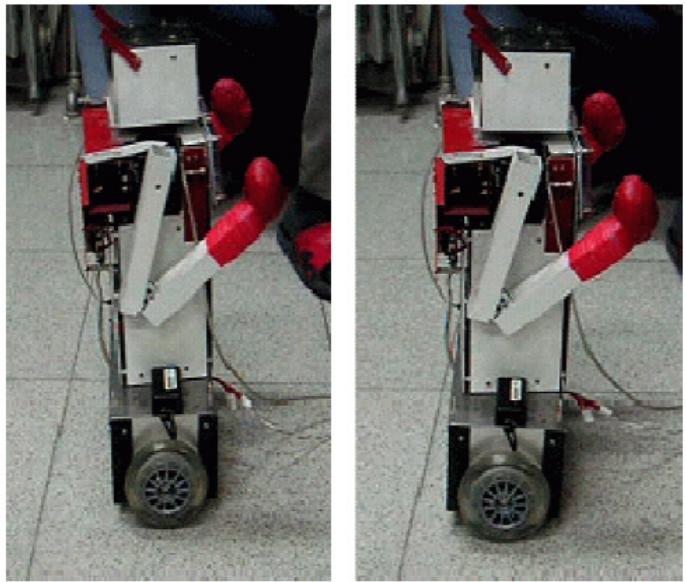
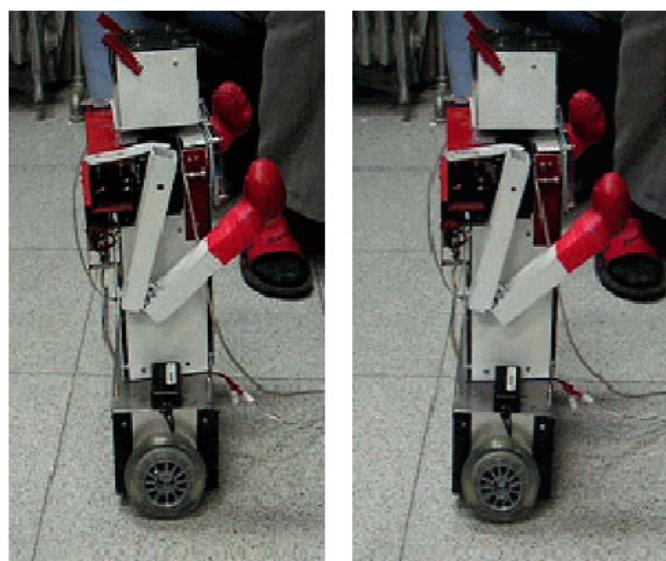


Fig. 7. Balancing Task

The next experiment is a turning task. The BoxingBot is required to make turns while balancing. Fig. 8

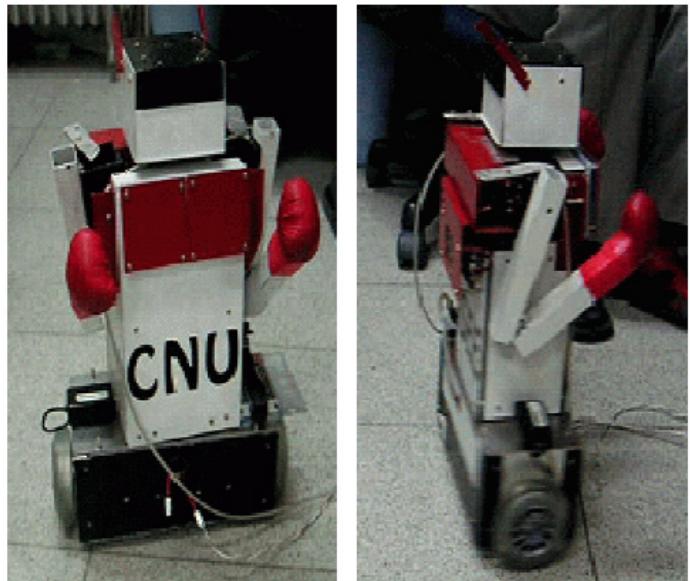


Fig. 8. Turning Task

shows the clip of turning motions.

C. Climbing the Slanted Surface Control Finally, a more challenging task is for the BoxingBot to climb the slanted surface as shown in Fig. 9 whose material is wood. The wooden surface is not too slippery. Initially, the BoxingBot is commanded to balance itself and then a user sends signals to move on the surface by a remote controller.

The BoxingBot successfully climbed up although there is a discontinuity at the beginning. Fig. 10 shows video clips of the BoxingBot of moving up. The results confirm that the proposed intelligent control algorithm is robust enough to control both the pendulum angle and the cart navigation.

Robust Control of a Mobile Inverted Pendulum Robot Using a RBF Neural Network Controller

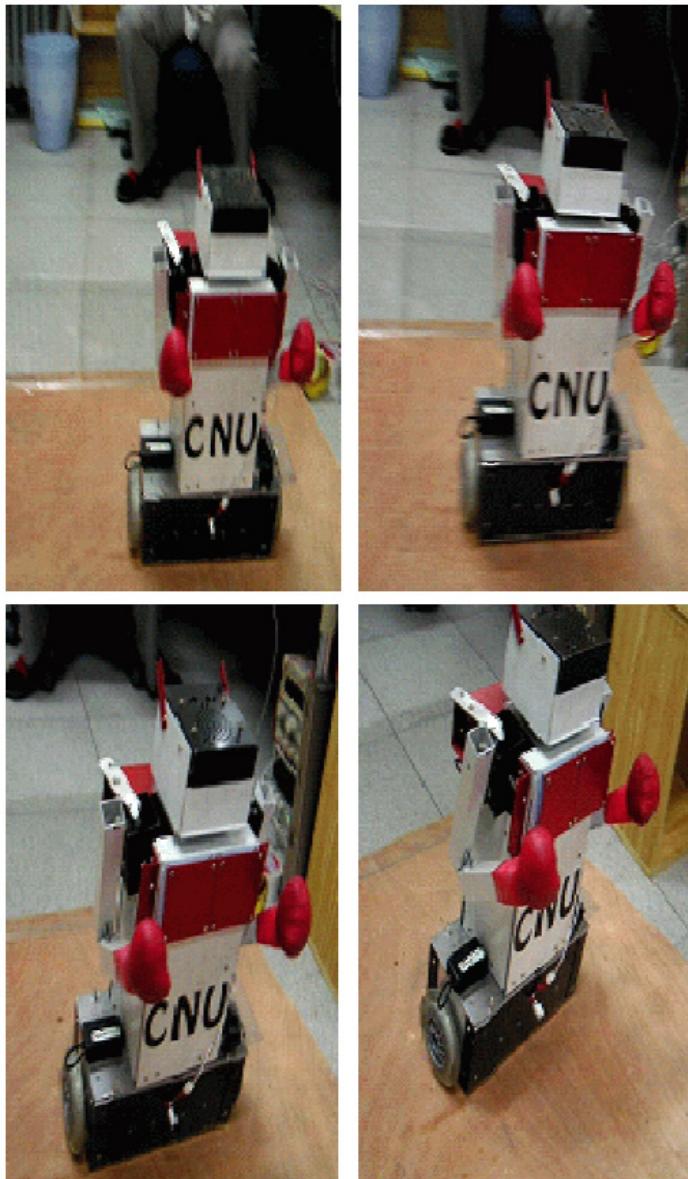


Fig. 10 The Mobile inverted pendulum climbing the slanted surface

IV. CONCLUSION

The mobile pendulum system has been implemented and controlled. The RBF network works quite well to control both balancing of the pendulum and tracking of the cart. The robots are remotely controlled by a joystick through wireless communication. Although the BoxingBot in this paper mainly balances itself, the idea can be extended to the boxing robot whose arms move while balancing. The RBF network seems robust enough to be used a boxing robot systems to balance the BoxingBot under uncertainties such as arm moving conditions, disturbance by intentional impacts, and surface conditions.

Acknowledgement

This research was financially supported by the Ministry of Education and Science Technology

(MEST) through the basic research and Korea Industrial Technology Foundation (KOTEF) through the Human Resource Training Project for Regional Innovation.

REFERENCES

- [1] M. W. Spong, P. Corke, and R. Lozano, "Nonlinear control of the inertia wheel pendulum", *Automatica*, 37, pp. 1845-1851, 2001
- [2] M. W. Spong, "The swing up control problem for the acrobat", *IEEE Control Systems Magazine*, 15, pp. 72-79, 1995
- [3] W. White and R. Fales, "Control of double inverted pendulum with hydraulic actuation : a case study", *Proc. Of the American Control Conference*, pp.495-499, 1999
- [4] Seul Jung, H. T. Cho, T. C. Hsia , "Neural network control for position tracking of a two-axis inverted pendulum system: Experimental studies", *IEEE Transaction on Neural Networks*, vol. 18, no.4, pp. 1042-1048, 2007
- [5] H. Tirmant, M. Baloh, L. Vermeiren, T. M. Guerra, and M. Parent, "B2, An alternative two wheeled vehicle for an automated urban transportation system", *IEEE Intelligent Vehicle System*, pp. 594-603, 2002
- [6] R. O. Ambrose, R. T. Savy, S. M Goza, P. Strawser, M. A. Diftler, I. Spain, and N. Radford, "Mobile manipulation using NASA's robonaut", *IEEE ICRA*, pp. 2104-2109, 2004
- [7] F. Grasser, A. Darrigo, S. Colombi, and A. Rufer, "JOE: A mobile, inverted pendulum", *IEEE Trans. on Industrial Electronics*, Vol. 49, No. 1, pp. 107-114, 2002
- [8] K. Pathak, J. Franch, and S. Agrawal, "Velocity and position control of a wheeled inverted pendulum by partial feedback linearization", *IEEE Trans. on Robotics*, vol. 21, pp. 505-513, 2005
- [9] Seul Jung and S. S. Kim, "Control Experiment of a Wheel-Driven Mobile Inverted Pendulum Using Neural Network", to appear in *IEEE Transaction on Control Systems Technology*

Proceedings of the 2008 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics Bangkok, Thailand, February 21 - 26, 2009